本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

江苏神州半导体科技股份有限公司

Jiangsu Shenzhou Semiconductor Technology Co., Ltd.

（扬州市邗江区蜀岗西路 19 号 1）

首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
（申报稿）

本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

声明及承诺

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

致投资者声明

一、发行人上市的目的

公司以半导体制造关键工艺技术——等离子体源技术为基础，为我国半导体先进制程产业链提供高端等离子体电源系统产品和全方位技术支持服务。通过本次上市，公司可以完成以下战略目标：

（一）通过高强度的研发投入，助力半导体先进制程关键设备的国产化进程

等离子体电源系统是半导体先进制程中刻蚀、薄膜沉积等关键设备不可或缺的核心零部件。该产品市场长期以来被美国、日本等国家的国际半导体巨头企业所垄断，国产化率长期维持在较低区间。国内等离子体电源系统的技术发展水平，不仅直接制约着刻蚀、薄膜沉积等半导体关键设备的国产化进程，亦直接影响着我国在先进制程芯片制造领域对国外巨头的追赶速度。

作为国内头部的等离子体电源系统供应商，公司将通过此次上市所募集的资金，进一步加大在半导体先进制程领域的研发投入，解决下游客户的产品升级需求，助力我国半导体先进制程关键设备的国产化进程，并为我国先进制程芯片制造早日实现技术赶超贡献力量。

（二）通过全方位的服务布局，为我国存量芯片产线的安全稳定生产保驾护航

近年来，随着国际贸易冲突加剧，美国、日本等国家的等离子体电源系统原厂技术支持服务团队逐渐撤出中国大陆市场，国内芯片产线面临巨大的断供风险，亟需国内技术支持服务团队填补缺口，保障芯片产线的安全稳定运行。

公司经过多年行业深耕，已发展成为国内规模领先的等离子体电源系统专业技术支持服务商，多年以来一直承担着芯片产线的保供重任。通过此次上市所募集的资金，公司可以全方位的加强自身技术支持服务布局，建立更加完善的技术支持服务体系，以先进的技术、优质的服务和及时的响应，进一步为我国存量芯片产线的安全稳定运行提供有效保障。

（三）通过完善的公司治理，提升管理水平，为社会创造长期价值

通过本次上市，公司将进一步优化公司治理结构，提升企业管理水平，进一步提升公司核心竞争力，并借助资本市场平台，深耕研发投入和市场拓展，推动

公司的高质量、可持续发展，以先进的技术水平和良好的业绩表现，回报广大投资者的支持与认可，持续为社会创造长期价值。

二、发行人现代企业制度的建立健全情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关要求并结合公司实际情况，建立了由股东会、董事会和管理层组成的公司法人治理架构，制定和完善了《公司章程》等公司治理及内部控制制度，已建立了符合上市公司治理要求的、能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构和现代企业制度。同时，公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立长期、合理的分红政策，让全体投资者共享企业经营发展的成果。

三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划

公司本次募集资金将投资于“先进工艺节点集成电路领域电源类零部件研发及产业化项目”、“技术支持服务体系升级扩容项目”、“上海产业化基地建设项目”、“技术研发创新中心建设项目”和“补充流动资金项目”。公司募集资金围绕公司的主营业务展开，聚焦国家战略和重大需求，进一步加大研发创新投入，进一步完善产业链和产品结构，增强公司产品和技术的竞争力。

四、发行人持续经营能力及未来发展规划

经过多年的技术积累和业务深耕，公司已经成为中国大陆半导体等离子体电源系统领域产品布局最全面、技术最先进、服务最完善的企业之一。公司部分产品技术水平对标国际品牌，且获得国内外多个头部芯片产线和设备厂商的认可，取得了一定的市场地位。报告期内，公司多个自研产品进入大规模商业化阶段，技术支持服务持续进入了多个知名客户的供应链，营业收入高速增长，并保持着较高的盈利水平，具备良好的持续经营能力。

未来，在自研产品板块，公司将进一步提升在等离子体电源系统的核心竞争力，一方面发挥技术优势，推进行业及下游领域的国产替代进程；另一方面，加强与头部客户的战略合作，持续在先进制程的尖端领域展开技术攻关和探索。

在技术支持服务板块，公司将进一步升级服务能力，完善服务体系，为全球更多的知名产线客户提供优质服务，进一步提升自身的市场地位和行业影响力。

在团队建设方面，公司将持续加强团队能力建设，完善公司治理水平，不断引入优秀的研发人才和管理人才。

在品牌建设方面，公司将进一步开拓国际市场，进入到更多的国际厂商供应链中，完成全球范围内的技术服务网点布局，持续提升公司产品在全球范围内的品牌影响力。

公司秉承“创造等离子能量，驱动人类科技未来”之使命，将在等离子体电源系统领域持续深耕、开拓创新，全力推动我国半导体装备国产化进程，助力我国半导体行业突破发展瓶颈、勇攀技术高峰，为实现“中国芯”自主可控的战略目标贡献核心力量，在全人类半导体先进制程“无人区”领域攻坚克难，不懈探索。

实际控制人、董事长：



朱培文

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	本次公开发行股票总量不超过 2,200 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于公开发行后总股本的 25%；本次发行全部为公司公开发行新股，公司原股东不进行公开发售股份
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【 】元
预计发行日期	【 】年【 】月【 】日
拟上市的证券交易所和板块	上海证券交易所科创板
发行后总股本	不超过 8,800 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）
保荐人（主承销商）	国泰海通证券股份有限公司
招股说明书签署日期	【 】年【 】月【 】日

目录

声明及承诺 1

致投资者声明 2

一、发行人上市的目的 2

二、发行人现代企业制度的建立健全情况 3

三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 3

四、发行人持续经营能力及未来发展规划 3

本次发行概况 5

目录 6

第一节 释义 12

一、基本术语 12

二、专业术语 14

第二节 概览 16

一、重大事项提示 16

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 19

三、本次发行概况 20

四、发行人主营业务经营情况 21

五、发行人符合科创板定位 25

六、发行人报告期主要财务数据及财务指标 26

七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 26

八、发行人选择的具体上市标准 26

九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 27

十、募集资金运用与未来发展规划 27

第三节 风险因素 29

一、与发行人相关的风险 29

二、与行业相关的风险 34

三、其他风险 35

第四节 发行人基本情况 38

一、发行人概况 38

二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.....38
三、发行人报告期内重大资产重组情况.....42
四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.....42
五、发行人的股权结构.....42
六、发行人的控股、参股公司和分支机构情况.....43
七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.....47
八、发行人股本情况.....51
九、发行人董事、审计委员会、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.....59
十、发行人与董事、高级管理人员及核心技术人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议情况.....65
十一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年的变动情况.....65
十二、发行人董事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.....66
十三、董事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况.....66
十四、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.....67
十五、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.....69
十六、发行人员工及其社会保障情况.....71
第五节 业务与技术.....75
一、发行人主营业务、主要产品及演变情况.....75
二、发行人所处行业的情况.....98
三、发行人市场竞争情况.....133
四、发行人销售情况和主要客户情况.....148
五、发行人采购情况和主要供应商情况.....150
六、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产.....153
七、发行人核心技术与科研、研发情况.....160

八、环境保护和安全生产情况.....172
九、发行人境外经营情况.....173
第六节 财务会计信息与管理层分析.....174
一、经审计的财务报表.....174
二、审计意见.....178
三、关键审计事项、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准.....178
四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.....181
五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....182
六、经注册会计师核验的非经常性损益表.....211
七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策.....211
八、主要财务指标.....214
九、分部信息.....216
十、经营成果分析.....216
十一、资产质量分析.....236
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.....249
十三、现金流量分析.....255
十四、持续经营能力分析.....258
十五、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项.....259
十六、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项等.....259
十七、盈利预测.....260
第七节 募集资金运用与未来发展规划.....261
一、本公司募集资金运用情况.....261
二、募集资金投资项目实施的必要性和可行性.....263
三、未来发展战略规划.....267
第八节 公司治理与独立性.....269
一、公司治理制度情况.....269
二、内部控制情况.....269
三、发行人报告期内违法违规情况.....270
四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况.....270

五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力.....270
六、同业竞争.....271
七、关联方与关联关系.....272
八、关联交易情况.....275
第九节 投资者保护 287
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排.....287
二、股利分配政策情况.....287
三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排.....291
第十节 其他重要事项 292
一、重大合同.....292
二、对外担保.....295
三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项.....295
四、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项.....295
第十一节 声明 296
一、发行人及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明.....296
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....297
三、保荐人（主承销商）声明.....299
四、保荐人（主承销商）董事长、总经理声明.....300
五、发行人律师声明.....301
六、承担审计业务的会计师事务所声明.....302
七、承担评估业务的资产评估机构声明.....303
八、承担验资业务的机构声明.....304
第十二节 附件 305
一、备查文件.....305
二、查询时间及地点.....305
附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况 307
一、发行人关于投资者关系的主要安排.....307
二、发行人股利分配决策程序.....307

三、股东投票机制的建立情况.....310
附件二：与投资者保护相关的承诺.....312
一、关于股份锁定的承诺.....312
二、关于持股意向及减持意向的承诺.....325
三、稳定股价的措施和承诺.....327
四、关于构成欺诈发行时购回股份的承诺.....332
五、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺.333
六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.....335
七、关于利润分配的承诺.....337
八、未履行承诺的约束措施.....338
九、关于避免同业竞争的承诺.....341
十、关于规范和减少关联交易的声明与承诺.....342
十一、关于避免资金占用和违规担保的承诺.....344
十二、关于股东信息披露的承诺.....344
十三、关于保持发行人资产、人员、财务、机构和业务独立的承诺函.....345
附件三：股东会、董事会、审计委员会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.....346
一、股东会运行情况.....346
二、董事会运行情况.....346
三、审计委员会运行情况.....347
四、独立董事制度的建立健全及履行职责情况.....347
五、董事会秘书制度的建立健全及履行职责情况.....347
六、公司治理存在的缺陷及改进情况.....347
附件四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.....348
一、董事会战略委员会.....348
二、董事会提名委员会.....349
三、薪酬与考核委员会.....349
四、审计委员会.....349
附件五：发行人及其子公司拥有的土地使用权清单.....351
附件六：发行人及其子公司拥有或使用的商标清单.....352

附件七：发行人及其子公司拥有的专利权清单 358
一、发行人及其子公司在中国境内拥有的专利权 358
二、发行人及其子公司在中国境内许可使用的专利权 368
三、发行人及其子公司在中国境外拥有的专利权 369
附件八：发行人及其子公司拥有的其他无形资产 370
一、发行人及其子公司拥有的软件著作权 370
二、发行人及其子公司拥有的作品著作权 376
附件九：募集资金运用具体情况 378
一、募集资金运用具体情况 378

第一节 释义

本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

一、基本术语

发行人/神州半导体/股份公司/公司	指	江苏神州半导体科技股份有限公司
神州有限	指	江苏神州半导体科技有限公司，系发行人前身
实际控制人	指	朱培文
众芯聚能	指	扬州众芯聚能企业管理合伙企业（有限合伙），发行人第一大股东、员工持股平台
江苏芯越	指	江苏芯越半导体科技有限公司，发行人全资子公司
晟州聚能	指	上海晟州聚能半导体科技有限公司，发行人全资子公司
上海昇州	指	上海昇州半导体科技有限公司，发行人全资子公司
辽宁聚芯	指	辽宁聚芯智能装备创新中心有限公司，发行人参股公司
武汉分公司	指	江苏神州半导体科技股份有限公司武汉分公司
北京分公司	指	江苏神州半导体科技股份有限公司北京分公司
大连分公司	指	江苏神州半导体科技股份有限公司大连分公司
深圳分公司	指	江苏神州半导体科技股份有限公司深圳市分公司
江苏信基	指	江苏信基科技有限公司
英特尔亚太	指	英特尔亚太研发有限公司
大基金二期	指	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
智微攀峰	指	上海智微攀峰创业投资合伙企业（有限合伙）
长存产业基金	指	长存产业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）
浦宸基金	指	上海浦宸私募投资基金合伙企业（有限合伙）
宜兴高易	指	宜兴高易二期创业投资合伙企业（有限合伙）
上海岩泉	指	上海岩泉科技有限公司
中微半导体	指	中微半导体（上海）有限公司
华虹二期基金	指	上海华虹虹芯二期创业投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴脉波	指	嘉兴脉波稳芯股权投资合伙企业（有限合伙）
扬州产发华映	指	扬州产发华映创业投资合伙企业（有限合伙）
丰泉创投	指	丰泉创业投资（张家港）合伙企业（有限合伙）
拓荆芯链	指	上海道禾拓荆芯链私募基金合伙企业（有限合伙）
金资创兴	指	上海金资创兴一期创业投资合伙企业（有限合伙）
产发正德	指	无锡产发正德翔华伟潮创业投资合伙企业（有限合伙）
华海金浦	指	华海金浦创业投资（济南）合伙企业（有限合伙）
智微厚德	指	嘉兴智微厚德创业投资合伙企业（有限合伙）
光创基金	指	武汉光创新兴技术一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）
精选基金	指	江城精选（武汉市）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

上海智微	指	上海智微私募基金管理有限公司
扬州神州	指	扬州市神州科技有限公司
MKS	指	MKS Instruments, Inc.及其子公司
AE	指	Advanced Energy Industries, Inc.及其子公司
NPP	指	New Power Plasma 及其子公司
DAIHEN	指	株式会社ダイヘン、DAIHEN Corporation 及其子公司
霍廷格	指	TRUMPF Hüttinger 及其子公司
恒运昌	指	深圳市恒运昌真空技术股份有限公司及其子公司
英杰电气	指	四川英杰电气股份有限公司及其子公司
先锋精科	指	江苏先锋精密科技股份有限公司及其子公司
富创精密	指	沈阳富创精密设备股份有限公司及其子公司
中微公司	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司及其子公司
拓荆科技	指	拓荆科技股份有限公司及其子公司
北方华创	指	北方华创科技集团股份有限公司及其子公司
三星电子	指	Samsung Electronics Co., Ltd 及其子公司
SK 海力士	指	Sk Hynix Inc.及其子公司
台积电	指	台湾积体电路制造股份有限公司及其子公司
华润微	指	华润微电子有限公司及其子公司
英特尔	指	Intel Corporation 及其子公司
应用材料	指	Applied Materials, Inc.及其子公司
研微半导体	指	研微（江苏）半导体科技有限公司及其子公司
北京中科信	指	北京中科信半导体股份有限公司，曾用名为北京烁科中科信电子装备有限公司
诺远科技	指	诺远科技（苏州）有限公司
爱晶玖	指	上海爱晶玖半导体技术有限公司
苏州微骏	指	苏州微骏瑞芯精密科技有限公司
扬州邃芯	指	扬州邃芯半导体有限公司
SEMI	指	Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导体设备与材料产业协会
WSTS	指	World Semiconductor Trade Statistics，世界半导体贸易统计协会
QYResearch	指	北京恒州博智国际信息咨询有限公司，第三方行业研究机构
Wind	指	万得信息技术股份有限公司，金融数据、信息和软件服务企业
弗若斯特沙利文	指	Frost&Sullivan，是一家国际咨询公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
基金业协会	指	中国证券投资基金业协会
国泰海通/保荐人/保荐机构/主承销商	指	国泰海通证券股份有限公司
容诚/容诚会计师/会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

金杜/金杜律师/律师	指	北京市金杜律师事务所
嘉学/嘉学评估/评估机构	指	厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司
《招股说明书（申报稿）》	指	《江苏神州半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》
本次发行上市/本次发行/本次上市	指	发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市的行为
《公司章程》	指	现行有效的《江苏神州半导体科技股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	公开发行股票并在科创板上市后适用的《江苏神州半导体科技股份有限公司章程（草案）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《注册管理办法》	指	《首次公开发行股票注册管理办法》
报告期	指	2023 年、2024 年、2025 年**及 2026 年 1-6 月**
报告期各期末	指	2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日**、2026 年 6 月 30 日**
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业术语

半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体产品可分为集成电路、分立器件、光电器件和传感器四大类，其中集成电路是半导体产业的核心。
IC、芯片、集成电路	指	Integrated Circuit，指通过特定工艺将晶体管、二极管、电阻、电容、电感等元件及布线互连，制作在半导体晶片或介质基片上并封装成管壳，具备特定电路功能的微型电子器件。
晶圆	指	Silicon Wafer，半导体级单晶硅片，经氧化/扩散、光刻、刻蚀、离子注入等特定工艺加工后用于制造各类半导体产品。按直径主要分为 4/6/8/12 英寸等规格。
制程	指	半导体芯片制造的全套工艺规范。逻辑芯片制程通常以晶体管最小栅极宽度衡量（如 65/28/14/7/5/2 纳米等）；NAND 存储芯片制程通常以堆叠层数衡量（如 24/32/64/128/321 层等）。
晶圆反应腔室/腔室	指	半导体工艺设备的核心腔体结构，为晶圆提供真空、洁净、可控的工艺环境。
等离子体射频电源系统	指	Radio Frequency System，主要由射频电源（RF Generator，RF）、阻抗匹配器（Match）等构成，是在晶圆反应腔室内原位产生等离子体的核心激发装置，主要用于半导体刻蚀、薄膜沉积等工艺。
RPS/远程等离子体源系统	指	Remote Plasma Source，采用与晶圆反应腔室远程分离的设计，在远端产生等离子体的激发装置，主要应用于半导体腔室清洗、去胶、刻蚀、薄膜沉积等工艺。
等离子体	指	物质除固态、液态、气态外的第四种形态，由大量正离子、电子和中性自由基组成。
等离子体源技术	指	通过电场或磁场等方式激发与维持等离子体状态的技术，广泛用于半导体制造、材料加工等领域。

中性自由基	指	等离子体分解气体产生的不带电荷的中性活性粒子，化学活性高，易与材料发生反应，不易受电场控制。
阻抗	指	电路对交流信号的阻碍程度，由电阻、电感、电容共同构成。
阻抗匹配	指	使电路输出阻抗与负载输入阻抗相匹配的过程，目的是消除信号反射、实现功率高效传输。
负载	指	电路中消耗功率的电子器件或装置。
刻蚀	指	Etch，通过化学或物理方法有选择性的去除材料，与光刻配套的图形化关键工艺，按工艺原理主要分为湿法刻蚀和干法刻蚀。
薄膜沉积/镀膜/沉积	指	Deposition，在晶圆表面沉积不同材料薄膜以构建特定结构、实现特定电气特性的关键工艺。
离子注入	指	Ion Implantation，通过高能离子束注入材料内部，实现掺杂调控，从而改变半导体电学特性的工艺。
去胶/光刻胶去胶	指	Strip，半导体制造中去除晶圆表面光刻胶及残留物的工艺。
键合	指	Bonding，将表面清洗和活化处理的半导体材料，在特定条件下通过范德华力、分子力或原子力相结合的先进封装技术。
堆叠	指	通过沟道通孔、硅通孔、混合键合等工艺，将多个芯片或晶圆在垂直方向进行物理集成与电气互连，实现更高集成度与性能。
沟道通孔	指	Channel Hole，沟道通孔技术，从顶层到底层垂直刻蚀贯穿多层存储单元的细长通孔的工艺技术。
硅通孔	指	Through Silicon Via，硅通孔技术，可以穿过硅基板实现硅片内部垂直电互联。
三维异构集成	指	将不同功能、不同制程等的芯片/芯粒通过垂直堆叠与电气互连，形成具有三维空间结构芯片的先进技术。
深宽比	指	Aspect Ratio，半导体器件结构深度与横向特征尺寸的比值，深宽比越高，工艺难度越大。
SOD	指	Spin-On Dielectric，旋涂介质沉积，通过旋涂方式形成介质层的技术。
CVD	指	Chemical Vapor Deposition，化学气相沉积，通过化学反应使前驱体在晶圆表面沉积形成薄膜，是半导体应用最广泛的薄膜沉积技术之一。
PVD	指	Physical Vapor Deposition，物理气相沉积，通过蒸发、溅射等物理手段实现材料沉积的技术，常用于金属薄膜制备。
PECVD	指	Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition，等离子体增强化学气相沉积，借助等离子体激活反应气体来提高沉积效率与质量的沉积技术。
FCVD	指	Flowable Chemical Vapor Deposition，流动性化学气相沉积，用于高深宽比结构填充的先进沉积技术，兼具良好流动性与填充能力。
ALD	指	Atomic Layer Deposition，原子层沉积，基于自限制反应实现原子级精度薄膜生长的先进沉积技术。
ALE	指	Atomic Layer Etch，原子层刻蚀，基于自限制反应实现原子级精度刻蚀的先进刻蚀技术。
AI、人工智能	指	Artificial Intelligence，研究、开发用于模拟、延伸和扩展执行人类思维和行为的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、重大事项提示

（一）特别风险提示

发行人特别提醒投资者仔细阅读招股说明书“第三节 风险因素”全文，并提醒投资者特别关注如下风险：

1、客户集中及单一客户依赖的风险

公司产品主要面向半导体领域的先进制程，下游主要系半导体设备厂商和芯片产线，由于半导体先进制程领域技术壁垒和投资壁垒较大，下游行业竞争格局呈现集中度较高的状态，导致公司客户集中度亦相对较高。

报告期内，公司前五大客户收入占比分别为 39.31%、61.55%、72.89%及**73.53%**，占比较高。公司自研产品批量进入了中微公司、拓荆科技、北方华创等我国头部半导体设备厂商，服务于客户 C、客户 A、客户 B、客户 D 等国内头部芯片产线所致。

等离子体电源系统作为半导体设备的核心零部件，需要得到设备厂商及芯片产线的双重认证，设备定型通过芯片产线验证后，通常不再轻易更换供应商；同时，半导体设备厂商为保证核心零部件的安全供应，通常会选择与头部等离子体电源系统供应商长期合作。中微公司、拓荆科技、北方华创等企业系国内半导体设备龙头，行业地位稳固、经营状况良好，公司与上述企业合作稳定，但如果上述主要客户未来的经营状况、技术路线、公司战略、产品价格等发生较大变化，或下游行业竞争格局发生较大变化，则可能对公司经营业绩产生不利影响。

报告期各期，公司对中微公司销售收入占主营业务收入比例分别为 2.94%、31.12%、49.19%**及 38.89%**；对中微公司销售毛利润占公司综合毛利润比例分别为 2.95%、33.90%、52.63%**及 43.36%**，公司对中微公司具有一定的业绩依赖风险。

中微公司是国产刻蚀设备、薄膜沉积设备龙头，龙头地位稳固、经营情况良好，公司与中微公司合作历史长、合作关系稳固。但如果未来公司无法持续拓展中微公司以外的新客户，或中微公司等主要客户的生产经营情况、经营战略、技术路线、价格等商业条款发生重大不利变化，或行业竞争格局发生重大变化，都将对公司经营业绩产生不利影响。

2、新技术、新产品研发失败风险

公司的等离子体电源系统属于半导体核心零部件，主要面向先进制程，需要持续进行高强度的研发投入。报告期内，公司的研发投入合计超过 2 亿元，且呈现高速增长的趋势。公司下游客户主要系国内半导体领域的头部芯片产线和设备厂商，下游客户有着持续的技术迭代需求，核心零部件厂商须持续配合下游客户，展开相应的技术攻关和研究探索。

在上述背景下，公司须持续进行新技术、新产品的研发，下游市场亦会对新技术、新产品不断提出更高的要求。持续的技术创新能力系公司保持核心竞争力的关键因素，如果公司的技术创新无法跟上行业技术迭代的速度，导致未来相关研发项目无法满足市场需求，或导致相关研发技术与产品无法通过客户验证而实现商业化，则公司可能面临研发失败的风险，将对公司的发展前景和经营业绩产生不利影响。

3、市场竞争地位变化的风险

等离子体电源系统国产化率较低，市场份额长期被美国、日本等国家的半导体巨头垄断，国内收入成规模的企业相对较少，在自研产品和技术支持服务两个业务板块，公司目前均系国内头部企业，具备较强的市场竞争地位。

一方面，公司依靠多年来的探索与创新，已经具备在先进制程领域对标国际品牌的技术水平，但整体与国际巨头仍存在一定差距，目前仅有技术支持服务业务覆盖了部分国外设备厂商或产线，而自研产品尚未进入国外厂商的供应链；另一方面，随着我国半导体装备行业的高速增长，国内等离子体电源系统市场的竞争亦可能有所加剧。若公司未能持续提升技术水平，保障产品品质并维持核心竞争力，则有可能拉大与国际巨头的差距，或面临更加激烈的竞争，并可能导致公司市场竞争地位发生变化，对公司业绩带来不利影响。

4、收入高速增长持续性的风险

报告期内，公司营业收入分别为 26,105.54 万元、44,627.90 万元、65,424.00 万元及 **37,545.34 万元**，最近三年营业收入复合增长率为 58.31%，主要系公司自研产品产业化进展快速，产品相关技术参数指标达到或超越国际竞品水平，并且随着下游客户国产化需求提升，公司自研业务增长迅速。公司报告期各期自研产品收入金额分别系 2,117.65 万元、17,214.64 万元、35,391.86 万元和 **18,721.76 万元**，自研产品收入的快速增长，带动了公司报告期内收入呈现高速增长的态势。

未来，随着公司收入达到一定规模，可能会出现收入增速放缓的情况，提醒投资者关注收入高速增长持续性的风险。

5、毛利率下降的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 62.56%、66.94%、66.65%和 **62.56%**，公司报告期各期自研产品毛利率分别系 60.17%、69.63%、71.37%和 **64.41%**；各期技术支持服务毛利率分别系 62.20%、65.06%、61.50%和 **60.73%**。报告期公司主营业务毛利率整体处于较高水平，主要系公司下游主要系半导体行业，产品面向先进制程，前期研发投入较大，技术壁垒较高，因此价格相对较高所致。

公司毛利率水平受下游行业需求、市场竞争、销售产品结构、产品价格、原材料价格、人工成本等多种因素的影响，未来若上述因素发生不利变化，可能会导致公司毛利率出现下降的情况。

6、国际贸易摩擦变化的风险

公司产品主要应用于半导体设备行业。

在自研产品板块，公司主要为国内头部芯片产线和半导体设备企业供货。近年来受国际地缘政治形势影响，国际贸易摩擦有所加剧。若未来相关国家和地区出于贸易保护、地缘政治等原因，进一步通过出口限制等政策加强贸易壁垒，将可能影响国内芯片产线和半导体设备企业生产经营和供应链的稳定性，进而对公司经营发展产生一定的不利影响。公司亦采购了部分海外品牌的元器件，虽然公司不断推进相关元器件的国产化进程，但国际贸易摩擦的加剧仍会对公司供应链稳定产生一定的不利影响。

在技术支持服务领域，为满足半导体行业“精确复制”的特点，公司存在部分采购国际原厂品牌电源系统备机的需求，若国际贸易摩擦加剧，可能导致电源系统备机的价格、交期等受到不利影响。此外，公司技术支持服务客户亦覆盖多个国际知名产线和设备厂商，若国际贸易摩擦加剧，亦可能会影响到相关业务的发展。

（二）本次发行的相关重要承诺

公司及相关责任主体按照中国证监会及上交所等监管机构的要求，出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺，包括限售安排、自愿锁定股份、业绩下滑延长锁定期限的承诺、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺、填补被摊薄即期回报的承诺等。

上述承诺事项详见本招股说明书之“第十二节/附件二”。

（三）本次发行前滚存利润分配方案及本次发行后股利分配政策

为充分保护投资者合法权益，公司已制定了切实可行的发行前滚存利润分配方案和发行后股利分配政策，详细内容参见本招股说明书“第九节”。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况			
发行人名称	江苏神州半导体科技股份有限公司	成立日期	2016-04-26
注册资本	6,600 万元	法定代表人	朱培文
注册地址	扬州市邗江区蜀岗西路 19 号 1	主要生产经营地址	扬州市邗江区蜀岗西路 19 号 1
控股股东	朱培文	实际控制人	朱培文
行业分类	C35 专用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	曾于 2024 年 12 月开始在江苏股权交易中心展示挂牌，2026 年 4 月终止展示挂牌
（二）本次发行的有关中介机构			
保荐人	国泰海通证券股份有限公司	主承销商	国泰海通证券股份有限公司
发行人律师	北京市金杜律师事务所	其他承销机构	无
审计机构	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	评估机构	厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系		保荐人国泰海通证券股份有限公司间接持有发行人 **0.2536%**的股份； 除此以外，发行人与本次发行有关中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直	

		接或间接的股权关系或其他利益关系。	
（三）本次发行其他有关机构			
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	收款银行	【 】
其他与本次发行有关的机构		无	

三、本次发行概况

（一）本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	1.00 元		
发行股数	不超过 2,200 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）	占发行后总股本比例	不低于 25%
其中：发行新股数量	不超过 2,200 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）	占发行后总股本比例	不低于 25%
股东公开发售股份数量	无	占发行后总股本比例	无
发行后总股本	不超过 8,800 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）		
每股发行价格	【 】元		
发行市盈率	【 】倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算）		
发行前每股净资产	【 】元/股	发行前每股收益	【 】元/股
发行后每股净资产	【 】元/股	发行后每股收益	【 】元/股
发行市净率	【 】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行		
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者和在上海证券交易所人民币普通股（A 股）证券账户上开通科创板股票交易权限的符合资格的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。中国证监会或上交所等监管部门另有规定的，按其规定处理		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	252,226.33 万元		
募集资金净额	【 】万元		
募集资金投资项目	先进工艺节点集成电路领域电源类零部件研发及产业化项目		
	技术支持服务体系升级扩容项目		
	上海产业化基地建设项目		
	技术研发创新中心建设项目		
	补充流动资金		
发行费用概算	【 】		

高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	若公司决定实施高管及员工战略配售，则将在本次公开发行股票注册后、发行前，履行内部程序审议该事项具体方案，并依法进行披露
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐人将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上海证券交易所相关规定执行。保荐人及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上海证券交易所提交相关文件
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	不适用
（二）本次发行上市的重要日期	
刊登发行公告日期	【 】年【 】月【 】日
开始询价推介日期	【 】年【 】月【 】日
刊登定价公告日期	【 】年【 】月【 】日
申购日期和缴款日期	【 】年【 】月【 】日
股票上市日期	【 】年【 】月【 】日

四、发行人主营业务经营情况

（一）主要业务、主要产品或服务及其用途

公司主要从事半导体关键工艺设备核心零部件的研发、生产、销售和技术支持服务，以半导体制造关键工艺技术——等离子体源技术为基础，为我国半导体先进制程产业链提供高端等离子体电源系统产品和全方位技术支持服务。

等离子体源技术被广泛应用在半导体、光伏、显示面板、光学镀膜、医疗器械和科研仪器等领域。特别是在半导体领域，等离子体源技术是实现半导体芯片先进制程的必要技术手段。

等离子体电源系统是等离子体源技术的核心载体，其通过电离 CH_3F、HF、Cl_2、NF_3、NH_3等制程气体产生等离子体，在多物理场与化学场的强耦合复杂工况下，通过电源系统参数的精准调控，在极短时间内实现对等离子体密度、均匀性、方向性、能量等方面的精确控制，进而驱动等离子体完成刻蚀、薄膜沉积、离子注入等半导体关键工艺，是先进制程关键工艺设备不可或缺的核心底层部件。

作为半导体领域的核心零部件，等离子体电源系统国产化率较低，市场主要被美国、日本等国际半导体企业占据，根据弗若斯特沙利文统计，2025 年中国大陆半导体领域等离子体射频电源系统国产化率仅 13%；根据 QYResearch 统计，2025 年中国大陆半导体领域远程等离子体源系统的国产化率不足 7%。上述领域

是我国亟待发展突破实现自主可控的重点领域之一。

在半导体等离子体电源系统领域，公司是中国大陆产品布局最全面、技术最先进、服务最完善的企业之一。公司自研的多款等离子体电源系统产品已批量应用于我国先进制程芯片产线，填补国内高端等离子体电源系统的应用空白；与此同时，公司完成了多项储备技术与产品研发攻关。

在自研产品方面，公司主要产品包括等离子体射频电源系统、远程等离子体源系统、高压脉冲电源系统等；在等离子体射频电源系统方面，公司产品具有甚高频（最高可达 60MHz）、大功率（最高可达 50kW）等特点，支持多级高频同步脉冲及变频、快速阻抗匹配、多级脉冲匹配、自动功分等功能，适配先进刻蚀、薄膜沉积等工艺；在远程等离子体源系统方面，公司具备自主研发生产其阳极氧化解离腔体的能力，产品具备高洁净度、耐腐蚀、高稳定性、高解离率、高点火成功率等特点，适配先进薄膜沉积、去胶、清洗等工艺；公司高压脉冲电源系统属于新型刻蚀工艺方案电源产品，具有高电压（最高可达 15kV）、大功率（最大可达 120kW）等特点，支持重构脉冲波形、多级高频同步脉冲及变频等功能，适配先进刻蚀等工艺，已经通过国内先进制程芯片产线的工艺验证，更是未来实现 4XX 层级别芯片制程不可或缺的核心配套技术方案之一。

目前，公司自研的产品已批量导入中微公司、拓荆科技、北方华创等国内头部半导体设备厂商，服务于客户 C、客户 A、客户 B、客户 D 等国内头部芯片产线，可适配 14 纳米及以下逻辑芯片、2XX 层及以上存储芯片等先进制程产线，有力推动了我国半导体先进制程关键工艺设备的国产化进程，为我国半导体先进制程“高深宽比”场景下的三维异构集成等前沿技术突破提供核心底层支撑。

在技术支持服务方面，公司已发展成为国内规模领先的等离子体电源系统专业技术支持服务商，为全球主要芯片产线提供等离子体电源系统的检测、维修和性能升级等技术支持服务。在国际贸易冲突持续升级、海外原厂服务收缩的行业背景下，公司有效保障了国内芯片产线的正常运转。目前，公司的技术支持服务已覆盖客户 A、台积电、英特尔、三星电子、SK 海力士、美光科技、德州仪器、客户 B、客户 E、客户 C、客户 D、华润微等国内外主流芯片产线，以及应用材料、中微公司、拓荆科技、北方华创等国内外知名半导体设备厂商。公司系国内少数在该领域同时进入应用材料、英特尔、三星电子、SK 海力士等国际头部厂

商供应链的本土企业。

（二）公司主要生产模式、所需主要原材料及重要供应商

1、生产模式

公司主要采取“以销定产”的生产模式，通过自主生产与委外加工相结合的方式从事生产活动。获取订单后，公司进行订单审评，综合评估技术方案、物料库存、产能状况及交付周期等，形成可行的生产计划。其中对于通用性较强的标准产品或组件，公司会结合销售预测进行适度的安全库存生产，以快速响应客户紧急需求。

对于涉及产品性能、可靠性与软件算法的关键生产环节，如精密电路组装后的功能测试、核心软件烧录与校准、模块级与整机级的性能调试、可靠性测试以及最终的系统集成与验证等，公司均自行生产完成以确保技术秘密的安全与产品品质的一致性与高标准。

为优化资源配置、提升生产效率，公司将部分工艺成熟、标准化程度高或需特殊设备或资质的非核心工序，如标准 PCB 板 SMT 贴装、钣金件加工、线缆组件加工等委托给合格供应商完成。公司对合格供应商实行严格管理，确保质量完全符合公司技术标准。

2、所需主要原材料及重要供应商

公司自研产品业务主要采购的原材料包括定制结构件、电容、功率器件、腔体、电子材料等。公司技术支持服务业务采购的主要材料还包括电源系统备机。

报告期内，公司的主要供应商包括康姆艾德机械设备（上海）有限公司、诺远科技、扬州双盈商贸有限公司、大南贸易（昆山）有限公司、**K.TECH Semiconductor Repair Inc.**等企业。

（三）公司销售方式和渠道及重要客户

1、销售方式和渠道

公司产品销售采取直销模式，主要通过客户介绍、主动拜访、行业展会等多个渠道获取客户资源。

对于自研产品业务，公司直接向下游客户销售自主研发的等离子体电源系统。

半导体行业对供应商的遴选要求较为严苛，公司需经过客户严格的调查评估、验厂考察等认证程序，才能进入客户的合格供应商体系或目录。在与客户合作对接过程中，公司销售、研发、生产等部门与客户开展深入沟通，洽谈和确定客户需求信息，拟定合适方案。公司根据正式订单及客户预测相结合的方式进行排产，并按交货期向客户交付。

对于技术支持服务业务，公司一般会与客户签订合作框架协议，对于具体的需求，下游客户向公司进行询价，公司会根据等离子体电源系统的不同型号情况、故障情况向客户报价，双方达成一致后，公司为下游客户提供技术支持服务，并收取服务相应的对价。

2、重要客户

公司下游客户主要为国内外知名芯片产线客户和半导体设备厂商。

目前，公司自研的产品批量进入了中微公司、拓荆科技、北方华创等国内头部半导体设备厂商，服务于客户 C、客户 A、客户 B、客户 D 等国内头部芯片产线。公司的技术支持服务已覆盖客户 A、台积电、英特尔、三星电子、SK 海力士、美光科技、德州仪器、客户 B、客户 E、客户 C、客户 D、华润微等国内外主流芯片产线，以及应用材料、中微公司、拓荆科技、北方华创等国内外知名半导体设备厂商。公司系国内少数在该领域同时进入应用材料、英特尔、三星电子、SK 海力士等国际头部厂商供应链的企业。

（四）公司行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

等离子体电源系统作为半导体设备核心零部件，全球市场呈现高度集中的寡头垄断竞争格局，全球市场主要被美国、日本等国际半导体企业占据。

在中国大陆新品市场，等离子体电源系统的国产化率仍处于较低水平，根据弗若斯特沙利文统计，2025 年中国大陆半导体领域等离子体射频电源系统国产化率仅 13%，相关市场主要被 MKS、AE、DAIHEN 等占据；根据 QYResearch 统计，2025 年中国大陆半导体领域远程等离子体源系统的国产化率不足 7%，相关市场主要被 MKS、AE、NPP 等占据，国内仅有少量厂商如公司、恒运昌、英杰电气、华丞电子等参与竞争。

在面向半导体领域的等离子体电源系统行业，公司已经具备较强的市场竞争

地位。根据弗若斯特沙利文数据、可比公司公告等结合公司收入情况估计，公司2025 年等离子体射频电源系统的市场占有率与恒运昌较为接近；根据QYResearch 数据，公司 2025 年远程等离子体源系统市场占有率均排名国内企业第一。

在中国大陆存量设备配套技术支持服务市场，公司已经成为国内规模领先的半导体等离子体电源系统技术支持服务供应商。根据 QYResearch 统计，2025 年公司在中国大陆等离子体电源系统技术支持服务市场中的市场份额排名第一，该市场的主要竞争对手系 MKS、AE 等国际原厂的技术支持服务部门。

五、发行人符合科创板定位

（一）公司符合行业领域要求

根据《科创属性评价指引（试行）（2024 修订）》和《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》等有关规定，公司科创属性符合科创板定位要求：

公司所属行业领域	☑新一代信息技术	根据《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》隶属于“新一代信息技术产业（1）”之“电子核心产业（1.2）”之“新型电子元器件及设备制造（1.2.1）”
	□高端装备	
	□新材料	
	□新能源	
	□节能环保	
	□生物医药	
	□符合科创板定位的其他领域	

（二）公司符合科创属性相关指标要求

发行人具有科创属性，符合《科创属性评价指引（试行）》和《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的要求，公司科创属性的符合情况如下：

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例≥5%，或最近三年累计研发投入金额≥8,000 万元	√是 □否	公司最近三年累计研发投入合计 20,383.07 万元，占最近三年累计营业收入比例为 14.97%，超过 5%且超过 8,000 万元，符合条件
研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%	√是 □否	截至 2025 年末，公司的研发人员数量为 124 人，占当年员工总数的比例为 24.46%，超过 10%，符合条件

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 7 项以上	√是 □否	截至 **2026 年 6 月 30 日**，发行人形成主营业务收入的发明专利为 **71** 项，符合条件
最近三年营业收入复合增长率≥25%，或最近一年营业收入金额≥3 亿元	√是 □否	公司 2025 年营业收入金额为 6.54 亿元，超过 3 亿元，符合条件

六、发行人报告期主要财务数据及财务指标

项目	**2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月**	**2025 年度/末**	**2024 年度/末**	**2023 年度/末**
资产总额（万元）	**139,720.11**	122,720.86	64,709.84	38,202.85
归属于母公司所有者权益（万元）	**121,894.03**	109,212.23	54,408.90	29,166.70
资产负债率（母公司）	**12.38%**	10.93%	14.81%	22.00%
营业收入（万元）	**37,545.34**	65,424.00	44,627.90	26,105.54
净利润（万元）	**11,717.95**	20,935.66	13,575.51	-2,231.88
归属于母公司所有者的净利润（万元）	**11,717.95**	20,935.66	13,575.51	-2,157.60
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	**10,941.86**	19,827.12	13,359.95	5,639.27
基本每股收益（元）	**1.78**	8.56	-	-
稀释每股收益（元）	**1.78**	8.56	-	-
加权平均净资产收益率	**10.15%**	31.95%	29.06%	-8.50%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	**4,660.59**	22,926.66	1,718.86	2,045.63
现金分红（万元）	**-**	-	-	-
研发投入占营业收入的比例	**16.38%**	16.69%	12.98%	14.05%

七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

公司财务报告审计截止日为 **2026 年 6 月 30 日**。财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营情况良好，公司所处行业的产业政策等未发生重大不利变化，公司经营模式、采购、生产、销售情况均未发生重大变化，公司董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员、核心技术人员亦未发生重大变化，也未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

八、发行人选择的具体上市标准

发行人选择的上市标准为《上市规则》第二章 2.1.2 中规定的第（一）条：

“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。

根据容诚会计师出具的审计报告，2024 年度、2025 年度公司净利润（扣非后孰低）分别为 13,359.95 万元、19,827.12 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。结合公司同行业可比公司在境内市场近期估值情况，基于对公司市值的预先评估，预计公司本次发行后总市值不低于人民币 10 亿元，满足市值及财务指标标准。

九、发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，公司在公司治理中不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排等需要披露的重要事项。

十、募集资金运用与未来发展规划

（一）募集资金用途

经公司 2026 年第二次临时股东会会议审议，本次发行募集资金扣除发行费用后拟用于投资项目的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	先进工艺节点集成电路领域电源类零部件研发及产业化项目	104,896.82	85,069.82
2	技术支持服务体系升级扩容项目	27,061.27	27,061.27
3	上海产业化基地建设项目	53,451.90	53,451.90
4	技术研发创新中心建设项目	55,643.34	55,643.34
5	补充流动资金	31,000.00	31,000.00
合计		**272,053.33**	**252,226.33**

上述项目实施主体均为发行人及其全资子公司，不涉及与其他方合作的情形。上述项目实施后，发行人不会新增同业竞争，不会对发行人的独立性产生不利影响。

本次公司公开发行新股募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金进行先期投入，待本次发行募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。

（二）未来发展规划

经过多年的技术积累和业务深耕，公司已经成为中国大陆半导体等离子体电源系统领域产品布局最全面、技术最先进、服务最完善的企业之一。公司部分产品技术水平对标国际品牌，且获得国内外多个头部芯片产线和设备厂商的认可，取得了一定的市场地位。报告期内，公司多个自研产品进入大规模商业化阶段，技术支持服务持续进入了多个知名客户的供应链，营业收入高速增长，并保持着较高的盈利水平，具备良好的持续经营能力。

未来，在自研产品板块，公司将进一步提升在等离子体电源系统的核心竞争力，一方面发挥技术优势，推进行业及下游领域的国产替代进程；另一方面，加强与头部客户的战略合作，持续在先进制程的尖端领域展开技术攻关和探索。

在技术支持服务板块，公司将进一步升级服务能力，完善服务体系，为全球更多的知名产线客户提供优质服务，进一步提升自身的市场地位和行业影响力。

在团队建设方面，公司将持续加强团队能力建设，完善公司治理水平，不断引入优秀的研发人才和管理人才。

在品牌建设方面，公司将进一步开拓国际市场，进入到更多的国际厂商供应链中，完成全球范围内的技术服务网点布局，持续提升公司产品在全球范围内的品牌影响力。

公司秉承“创造等离子能量，驱动人类科技未来”之使命，将在等离子体电源系统领域持续深耕、开拓创新，全力推动我国半导体装备国产化进程，助力我国半导体行业突破发展瓶颈、勇攀技术高峰，为实现“中国芯”自主可控的战略目标贡献核心力量。

第三节 风险因素

投资者在评价发行人此次公开发行股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别考虑下述各项风险因素。以下风险因素可能直接或间接对发行人经营状况、财务状况和持续盈利能力以及对本次发行产生重大不利影响。发行人提请投资者仔细阅读本节全文。

一、与发行人相关的风险

（一）技术风险

1、新技术、新产品研发失败风险

公司的等离子体电源系统属于半导体核心零部件，主要面向先进制程，需要持续进行高强度的研发投入。报告期内，公司的研发投入合计超过 2 亿元，且呈现高速增长的趋势。公司下游客户主要系国内半导体领域的头部芯片产线和设备厂商，下游客户有着持续的技术迭代需求，核心零部件厂商须持续配合下游客户，展开相应的技术攻关和研究探索。

在上述背景下，公司须持续进行新技术、新产品的研发，下游市场亦会对新技术、新产品不断提出更高的要求。持续的技术创新能力系公司保持核心竞争力的关键因素，如果公司的技术创新无法跟上行业技术迭代的速度，导致未来相关研发项目无法满足市场需求，或导致相关研发技术与产品无法通过客户验证而实现商业化，则公司可能面临研发失败的风险，将对公司的发展前景和经营业绩产生不利影响。

2、技术人才流失与核心技术泄密的风险

截至报告期末，公司拥有专利 128 项，其中境内发明专利 72 项，另有软件著作权 71 项，发行人对各项专利及技术等均拥有自主知识产权，并针对全部的核心技术完善了知识产权布局。截至 2026 年 6 月 30 日，公司共有研发人员 138 人，占员工总数的比例为 24.64%。

核心技术和技术人才是公司保持创新发展的基础。若公司无法持续为技术人才提供更具竞争力的薪酬待遇和发展平台，公司将面临技术人才流失的风险。同时，公司存在因技术人才流失、外界窃取等原因导致核心技术泄密的风险，进而

对公司生产经营产生不利影响。

（二）经营风险

1、客户集中及单一客户依赖的风险

公司产品主要面向半导体领域的先进制程，下游主要系半导体设备厂商和芯片产线，由于半导体先进制程领域技术壁垒和投资壁垒较大，下游行业竞争格局呈现集中度较高的状态，导致公司客户集中度亦相对较高。

报告期内，公司前五大客户收入占比分别为 39.31%、61.55%、72.89%及**73.53%**，占比较高。公司自研产品批量进入了中微公司、拓荆科技、北方华创等我国头部半导体设备厂商，服务于客户 C、客户 A、客户 B、客户 D 等国内头部芯片产线所致。

等离子体电源系统作为半导体设备的核心零部件，需要得到设备厂商及芯片产线的双重认证，设备定型通过芯片产线验证后，通常不再轻易更换供应商；同时，半导体设备厂商为保证核心零部件的安全供应，通常会选择与头部等离子体电源系统供应商长期合作。中微公司、拓荆科技、北方华创等企业系国内半导体设备龙头，行业地位稳固、经营状况良好，公司与上述企业合作稳定，但如果上述主要客户未来的经营状况、技术路线、公司战略、产品价格等发生较大变化，或下游行业竞争格局发生较大变化，则可能对公司经营业绩产生不利影响。

报告期各期，公司对中微公司销售收入占主营业务收入比例分别为 2.94%、31.12%、49.19%及 **38.89%**；对中微公司销售毛利润占公司综合毛利润比例分别为 2.95%、33.90%、52.63%**及 43.36%**，公司对中微公司具有一定的业绩依赖风险。

中微公司是国产刻蚀设备、薄膜沉积设备龙头，龙头地位稳固、经营情况良好，公司与中微公司合作历史长、合作关系稳固。但如果未来公司无法持续拓展中微公司以外的新客户，或中微公司等主要客户的生产经营情况、经营战略、技术路线、价格等商业条款发生重大不利变化，或行业竞争格局发生重大变化，都将对公司经营业绩产生不利影响。

2、市场竞争地位变化的风险

等离子体电源系统国产化率较低，市场份额长期被美国、日本等国家的半导体巨头垄断，国内收入成规模的企业相对较少，在自研产品和技术支持服务两个业务板块，公司目前均系国内头部企业，具备较强的市场竞争地位。

一方面，公司依靠多年来的探索与创新，已经具备在先进制程领域对标国际品牌的技术水平，但整体与国际巨头仍存在一定差距，目前仅有技术支持服务业务覆盖了部分国外设备厂商或产线，而自研产品尚未进入国外厂商的供应链；另一方面，随着我国半导体行业的高速增长和国产化进程的不断推进，国内等离子体电源系统市场的竞争亦可能有所加剧。若公司未能持续提升技术水平，保障产品品质并维持核心竞争力，则有可能拉大与国际巨头的差距，或面临更加激烈的竞争，并可能导致公司市场竞争地位发生变化，对公司业绩带来不利影响。

3、产品商业化进程不达预期的风险

等离子体电源系统属于半导体关键工艺设备中的核心零部件，下游设备厂商和芯片产线对产品性能和稳定性等技术指标有着严苛的要求，一般会经历较长时间的产品验证，才能够导入供应链。公司目前有多款新产品正在客户验证中，若未来公司产品技术水平无法满足客户需求，则可能导致公司产品商业化进程推迟或终止，进而对公司新产品的经营业绩带来不利影响。

（三）内部控制风险

1、管理风险

报告期内，公司业务规模扩张较快，自研产品大规模量产，形成了“自研产品+技术支持服务”的双头发展模式。公司业务规模的增长延伸了公司的管理跨度，增加了公司的管理难度，对公司经营管理能力提出了更高的要求。

本次发行上市后，随着募集资金的到位和募集资金投资项目的实施，公司资产规模和业务规模将进一步扩大，公司经营管理将面临新的考验。如公司管理层管理水平不能适应公司业务规模迅速扩张的需要，则可能影响公司经营效率和盈利水平。

2、实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人系朱培文，合计控制公司 64.74%的股份对应的表决权。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，但公司实际控制人仍可凭借其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策等施加重大影响，如实施不当将会损害公司及公司中小股东的利益。

（四）财务风险

1、收入增速放缓的风险

报告期内，公司营业收入分别为 26,105.54 万元、44,627.90 万元、65,424.00 万元及 **37,545.34 万元**，最近三年营业收入复合增长率为 58.31%。随着下游客户国产化需求提升，报告期内，公司自研业务增长迅速，收入高速增长。

未来，随着公司收入达到一定规模，可能会出现收入增速放缓的情况，提醒投资者关注相关风险。

2、毛利率下降的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 62.56%、66.94%、66.65%及 **62.56%**，处于较高水平，主要原因是公司下游主要系半导体行业，产品面向先进制程，前期研发投入较大，技术壁垒较高，因此产品毛利率相对较高。

公司毛利率水平受下游行业需求、市场竞争、销售产品结构、产品价格、原材料价格、人工成本等多种因素的影响，未来若上述因素发生不利变化，可能会导致公司毛利率出现下降的情况。

3、存货规模增加及跌价风险

报告期各期末，公司存货的账面价值分别为 11,323.20 万元、19,514.90 万元、21,265.57 万元及 **26,995.18 万元**，占流动资产比例分别为 36.39%、36.31%、20.38%及 **22.95%**，存货跌价准备的余额分别为 1,295.17 万元、1,198.40 万元、1,975.23 万元及 **2,486.76 万元**，占各期末存货账面余额的比例分别为 10.26%、5.79%、8.50%及 **8.43%**。

存货规模较大对公司的存货管理能力提出了较高要求，若未来由于公司产品更新迭代、市场环境恶化、客户需求变化等不利因素出现订单需求降低的情况，

导致某些原材料或在产品不再满足进一步加工需求，或库存商品出现积压，则可能导致存货跌价风险，影响公司运营效率。

4、应收账款无法及时回收的风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 8,567.47 万元、16,958.26 万元、20,009.11 万元及 **25,604.39 万元**，占流动资产的比例分别为 27.53%、31.55%、19.18%及 **21.77%**。报告期各期末，公司账龄在 1 年以内的应收账款余额保持在 90%以上，账龄结构稳定。

随着公司经营规模和营业收入持续增长，未来应收账款余额可能维持在较高水平。公司客户主要为国内半导体芯片产线或设备厂商头部企业，商业信誉及资金实力较强，但客户自身经营状况与现金流水平受到其发展战略、产业政策、市场环境、收入结构及特征等因素影响。若未来产业政策、市场环境等发生不利变化或主要客户经营业绩、信用状况或履约能力发生不利变化，且公司采取的收款措施未达预期成效，公司应收账款可能存在无法及时收回的风险。

5、汇率波动的风险

报告期内，公司外销收入占主营业务收入的比例分别系 10.94%、8.74%、6.12%及 **12.43%**。公司外销产品主要以美元结算，汇率的波动将会增加或减少以人民币计量的销售收入，同时由于付款周期的存在及公司持有的其他外币货币性资产，汇率变动同样会影响财务费用。如未来汇率波动幅度扩大，将对公司经营业绩产生一定的影响。

6、税收优惠政策变化的风险

发行人为高新技术企业，发行人于 2019 年 12 月 5 日通过了高新技术企业的认定，自 2019 年 1 月 1 日起持续享受企业所得税税率为 15%的税收优惠政策，并分别于 2022 年 12 月 12 日、2025 年 12 月 19 日通过了高新技术企业复审，企业所得税优惠期直至 2027 年 12 月 31 日，覆盖了公司整个报告期。如果国家所得税相关税收政策发生变化，或公司将来未能获得高新技术企业认定导致适用所得税率发生变化，将影响公司的经营业绩。

二、与行业相关的风险

（一）行业周期的风险

公司主要面向半导体行业，产品系半导体设备中的核心零部件。半导体行业在全球范围内均呈现较强的周期性特点。一般来说，新技术的应用和新产品的创新，会带动终端市场的需求，进而带来半导体行业规模的增长。

目前，全球半导体产业进入了由人工智能、云计算、大数据、高速通信等新技术驱动的新一轮成长阶段。半导体周期的波动以及新技术的应用，将直接影响下游芯片产线对新增产能的战略决策，从而影响其固定资产投资，并最终影响到半导体设备和核心零部件的市场需求。

未来，若因半导体行业周期波动的影响，导致下游芯片产线降低资本开支，则可能会导致半导体设备和核心零部件的市场需求降低，从而对公司自研产品业务板块的收入及利润水平产生不利影响。

（二）国际形势变化风险

1、国际贸易摩擦变化的风险

公司产品及服务主要应用于半导体设备行业。

在自研产品板块，公司主要为国内头部芯片产线和半导体设备企业供货。近年来受国际地缘政治形势影响，国际贸易摩擦有所加剧。若未来相关国家和地区出于贸易保护、地缘政治等原因，进一步通过出口限制等政策加强贸易壁垒，将可能影响国内芯片产线和半导体设备企业生产经营和供应链的稳定性，进而对公司经营发展产生一定的不利影响。公司亦采购了部分海外品牌的元器件，虽然公司不断推进相关元器件的国产化进程，但国际贸易摩擦的加剧仍会对公司供应链稳定产生一定的不利影响。

在技术支持服务领域，为满足半导体行业“精确复制”的特点，公司存在部分采购国际原厂品牌电源系统备机的需求，若国际贸易摩擦加剧，可能导致电源系统备机的价格、交期等受到不利影响。此外，公司技术支持服务客户亦覆盖多个国际知名产线和设备厂商，若国际贸易摩擦加剧，亦可能会影响到相关业务的发展。

2、美国对华跨境投资政策调整的风险

《Provisions Pertaining to U.S. Investments in Certain National Security Technologies and Products in Countries of Concern》（简称“《对华投资限制最终规则》”）系美国财政部依据《国际紧急经济权力法》（International Emergency Economic Powers Act，简称“IEEPA”）制定的跨境投资监管专项规则，于 2024 年 10 月发布、2025 年 1 月正式生效。该规则对美国人士等在中国大陆、中国香港及中国澳门地区半导体和微电子、量子信息技术、人工智能系统三大领域的特定投资设置禁止性规定与强制申报要求，违规交易将面临被美国财政部认定无效、作废、强制剥离对应投资，及民事、刑事追责的法律后果。

截至本招股说明书签署日，发行人美国背景股东对发行人的历史投资行为不存在违反现行规则的情况。但不排除未来美国有权监管部门修订规则、出台新规或作出不利解释，导致相关投资被认定违规，触发股权强制处置等后果，进而导致发行人股权结构发生重大变动等不利影响，提示投资者关注相关风险。

（三）产业政策变化风险

公司报告期内产品主要应用于半导体领域。半导体产业是我国信息技术产业的基础和重要组成部分，半导体行业的发展及国产化的推进对国家产业升级具有至关重要的意义。国家对高质量发展半导体行业高度重视，相继出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》等支持性政策，对行业及公司业务发展起到了积极的促进作用。但若未来国家对半导体相关产业政策发生重大调整，或者下游行业的产业政策出现不利变化，将可能对公司的业务发展或行业需求产生不利影响，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

三、其他风险

（一）募集资金投资风险

1、募集资金项目实施的风险

公司本次募集资金主要用于“先进工艺节点集成电路领域电源类零部件研发及产业化项目”、“技术支持服务体系升级扩容项目”、“上海产业化基地建设

项目”、“技术研发创新中心建设项目”和“补充流动资金项目”。如果募集资金不能及时或足额到位，或项目组织管理、厂房建设工期、生产设备安装调试、量产达标等不能按计划顺利实施，则会直接影响项目的投产时间、投资回报及公司的预期收益，进而影响公司的经营业绩。

募集资金投资项目建成后，每年将会产生一定的折旧费用和人工支出，公司若不能及时有效地开拓市场，消化新增的产能，将使募集资金投资项目无法按照既定计划实现预期的经济效益。公司存在可能因固定资产折旧和人工成本的增加而导致利润下滑的风险。

2、新增产能消化不及预期的风险

本次募集资金投资项目达产后，公司产能将在现有基础上大幅提升。在项目建成后，可能出现宏观经济形势变动、下游市场需求变化、市场竞争格局变化等情况，届时将对项目的新增产能消化带来不利影响。

（二）股东特殊权利恢复的风险

根据 2025 年 11 月签署的《关于江苏神州半导体科技有限公司股东特殊权利条款的终止协议》，由发行人承担回购义务的约定已于 2025 年 11 月彻底终止且自始无效；根据 2026 年 4 月签署的《关于江苏神州半导体科技股份有限公司股东特殊权利条款的终止协议》，涉及的朱培文、陈觉晓、江苏信基及众芯聚能的回购义务及其他股东特殊权利自公司提交的境内上市申请材料被正式受理之日（以证券交易所出具受理函之日为准）起立即终止，但附有恢复生效条款。

上述股东特殊权利安排不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形，但恢复生效后可能对公司股权结构及公司治理产生影响。

（三）发行失败风险

本次发行的发行结果将受证券市场整体情况、公司经营业绩、公司发展前景及投资者对本次发行的认可程度等多种内外部因素影响。公司存在发行认购不足或未能达到预计市值上市条件的情形而导致发行失败的风险。

（四）净资产收益率及每股收益被摊薄的风险

本次发行完成后，公司的净资产规模及股本总额将在短期内大幅增长。由于

募集资金投资项目存在一定建设周期，且从投产到产生效益需要一定时间，因此，本次发行完成后，如果公司的盈利增幅不达预期，则净资产规模及股本总额的扩大将导致公司的净资产收益率和每股收益出现一定幅度的下降。

第四节 发行人基本情况

一、发行人概况

发行人	江苏神州半导体科技股份有限公司
英文名称	Jiangsu Shenzhou Semiconductor Technology Co., Ltd.
注册资本	6,600 万元
法定代表人	朱培文
有限公司成立日期	2016-04-26
整体变更为股份公司日期	2025-12-09
住所	扬州市邗江区蜀岗西路 19 号 1
邮政编码	225100
电话	0514-87958862
传真	0514-87958862
互联网网址	https://www.szsemicon.com
电子信箱	ir@asiaexact.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
负责人	丁昊
联系方式	0514-87958862

二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况

（一）神州有限设立

2016 年 4 月 11 日，江苏省工商行政管理局出具《名称预先核准通知书》（（00000309）名称预核登记[2016]第 04110043 号），预先核准企业名称为“江苏神州半导体科技有限公司”。

2016 年 4 月 20 日，徐茂元、朱培文、张利娜和扬州神州签署《江苏神州半导体科技有限公司章程》，决定共同出资设立神州有限。神州有限设立时的注册资本为 2,000 万元，其中徐茂元、朱培文、张利娜和扬州神州分别以货币认缴出资 934.56 万元、522.72 万元、522.72 万元和 20 万元。

2017 年 3 月 21 日，扬州邗瑞会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（扬邗瑞验字（一）[2017]第 013 号），经审验，截至 2017 年 2 月 21 日，神州有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计 2,000 万元，均为货币出资。

神州有限成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	徐茂元	934.56	46.73%	货币
2	朱培文	522.72	26.14%	货币
3	张利娜	522.72	26.14%	货币
4	扬州神州	20.00	1.00%	货币
合计		**2,000.00**	**100.00%**	

（二）股份公司设立

2025 年 11 月 6 日，容诚会计师出具《审计报告》（容诚审字[2025]210Z0264 号）。根据该审计报告，截至 2025 年 8 月 31 日，神州有限经审计的净资产值为 755,353,737.79 元。

同日，厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具《江苏神州半导体科技有限公司拟股份制改造涉及的净资产资产评估报告》（嘉学评估评报字[2025]8310094 号）。根据该评估报告，以 2025 年 8 月 31 日为基准日，神州有限净资产评估值为 86,900.19 万元。

同日，神州有限召开股东会并作出决议，同意公司整体变更为股份公司的折股方案，将神州有限经审计的净资产值 755,353,737.79 元按 12.589:1 的比例折 60,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，将神州有限整体变更为股份公司。其中，股份公司注册资本为 60,000,000 元，净资产其余部分 695,353,737.79 元计入资本公积。

同日，神州有限全体发起人签署《江苏神州半导体科技股份有限公司之发起人协议》，同意采取有限责任公司依法整体变更方式设立股份有限公司，股本总额为 60,000,000 股。

2025 年 11 月 24 日，神州半导体召开成立大会暨第一次股东会，会议审议并通过了股份公司章程等议案，选举并产生了公司第一届董事会董事（除职工代表董事）；同日，神州半导体召开第一届董事会第一次会议，选举并产生了董事长，聘任了相关高级管理人员；同日，神州半导体召开职工代表大会，选举并产生了职工代表董事。

同日，容诚会计师出具《验资报告》（容诚验字[2025]210Z0012 号）。根据该验资报告，截至 2025 年 11 月 24 日，江苏神州半导体科技股份有限公司（筹）

已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 60,000,000.00 元，出资方式为净资产出资。

2025 年 12 月 9 日，扬州市数据局向发行人核发营业执照。

本次整体变更为股份公司后，神州半导体的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	股份数（万股）	持股比例（%）
1	众芯聚能	1,534.7340	25.5789
2	朱培文	1,397.1120	23.2852
3	江苏信基	1,341.0060	22.3501
4	英特尔亚太	568.4220	9.4737
5	大基金二期	315.7920	5.2632
6	长存产业基金	210.0000	3.5000
7	浦宸基金	142.1040	2.3684
8	宜兴高易	125.0520	2.0842
9	上海岩泉	117.8820	1.9647
10	中微半导体	90.0000	1.5000
11	华虹二期基金	90.0000	1.5000
12	智微攀峰	60.6120	1.0102
13	智微厚德	7.2840	0.1214
合计		**6,000.0000**	**100.0000**

（三）报告期内股本和股东变化情况

报告期期初至招股说明书签署日，发行人共历经 2 次增资、6 次股权转让及 1 次股份制改制，具体情况如下：

序号	时间	变化情况	变化前注册资本（万元）	变化后注册资本（万元）
1	2023.5	朱培文以 0 万元对价受让江苏信基持有公司的 5.0000%股权	2,222.2200	2,222.2200
2	2023.11	宜兴高易以 3,563.9935 万元对价受让江苏信基持有公司的 2.2%股权；上海岩泉以 3,359.64 万元对价受让江苏信基持有公司的 2.0738%股权	2,222.2200	2,222.2200
3	2024.5	浦宸基金以 4,050 万元对价受让江苏信基持有公司的 2.50%股权	2,222.2200	2,222.2200
4	2025.1	大基金二期以 10,000 万元对价认缴新增注册资本 123.4568 万元	2,222.2200	2,345.6790
5	2025.3	中微半导体以 3,000 万元对价受让朱培文持有公司的 1.5%股权	2,345.6790	2,345.6790

序号	时间	变化情况	变化前注册资本（万元）	变化后注册资本（万元）
6	2025.11	长存产业基金以 7,000 万元对价受让江苏信基持有公司的 3.50%股权；华虹二期基金以 3,000 万元对价受让朱培文持有公司的 1.50%股权；智微攀峰以 2,263 万元对价受让朱培文持有公司的 1.132%股权	2,345.6790	2,345.6790
7	2025.11	智微厚德以 242.4643 万元对价受让智微攀峰持有公司的 0.1212%股权	2,345.6790	2,345.6790
8	2025.12	股份制公司成立，以 2025 年 8 月 31 日作为基准日经容诚会计师审计的净资产折合 6,000.0000 万股，差额计入资本公积	2,345.6790	6,000.0000
9	2025.12	智微攀峰以 10,000 万元认缴新增股份 187.5 万股；智微厚德以 1,200 万元认缴新增股份 22.5 万股；金资创兴以 2,300 万元认缴新增股份 43.125 万股；丰泉创投以 2,750 万元认缴新增股份 51.5625 万股；拓荆芯链以 2,750 万元认缴新增股份 51.5625 万股；嘉兴脉波以 4,000 万元认缴新增股份 75 万股；扬州产发华映以 3,000 万元认缴新增股份 56.25 万股；产发正德以 2,000 万元认缴新增股份 37.5 万股；华海金浦以 2,000 万元认缴新增股份 37.5 万股；光创基金以 1,000 万元认缴新增股份 18.75 万股；精选基金以 1,000 万元认缴新增股份 18.75 万股	6,000.0000	6,600.0000

截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴股份数（万股）	持股比例（%）
1	扬州众芯聚能企业管理合伙企业（有限合伙）	1,534.7340	23.2535
2	朱培文	1,397.1120	21.1682
3	江苏信基科技有限公司	1,341.0060	20.3183
4	英特尔亚太研发有限公司	568.4220	8.6125
5	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	315.7920	4.7847
6	上海智微攀峰创业投资合伙企业（有限合伙）	248.1120	3.7593
7	长存产业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	210.0000	3.1818
8	上海浦宸私募投资基金合伙企业（有限合伙）	142.1040	2.1531
9	宜兴高易二期创业投资合伙企业（有限合伙）	125.0520	1.8947
10	上海岩泉科技有限公司	117.8820	1.7861
11	中微半导体（上海）有限公司	90.0000	1.3636
12	上海华虹虹芯二期创业投资合伙企业（有限合伙）	90.0000	1.3636

序号	股东名称/姓名	认缴股份数（万股）	持股比例（%）
13	嘉兴脉波稳芯股权投资合伙企业（有限合伙）	75.0000	1.1364
14	扬州产发华映创业投资合伙企业（有限合伙）	56.2500	0.8523
15	丰泉创业投资（张家港）合伙企业（有限合伙）	51.5625	0.7813
16	上海道禾拓荆芯链私募基金合伙企业（有限合伙）	51.5625	0.7813
17	上海金资创兴一期创业投资合伙企业（有限合伙）	43.1250	0.6534
18	无锡产发正德翔华伟潮创业投资合伙企业（有限合伙）	37.5000	0.5682
19	华海金浦创业投资（济南）合伙企业（有限合伙）	37.5000	0.5682
20	嘉兴智微厚德创业投资合伙企业（有限合伙）	29.7840	0.4513
21	武汉光创新兴技术一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	18.7500	0.2841
22	江城精选（武汉市）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18.7500	0.2841
合计		**6,600.0000**	**100.0000**

发行人的设立、报告期内的历次股权变更、增资等均已经履行了必要的法律程序并办理了相应的工商登记手续，符合法律、法规及规范性文件的规定。

三、发行人报告期内重大资产重组情况

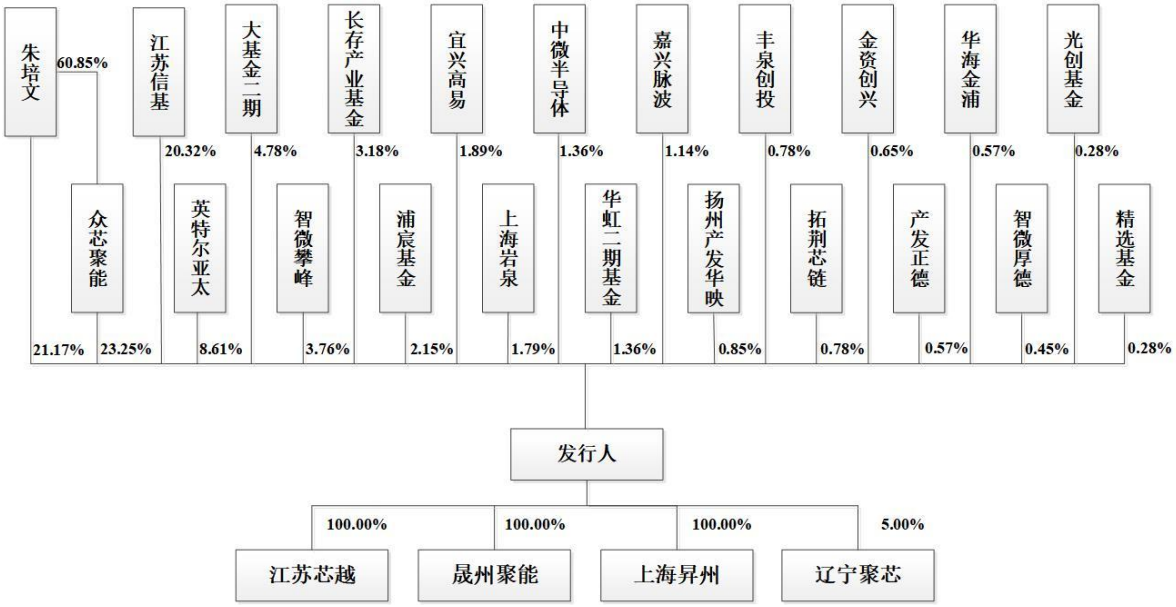
报告期内，发行人不存在重大资产重组情况。

四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况

发行人曾于 2024 年 12 月开始在江苏股权交易中心专精特新专板展示挂牌，并于 2026 年 4 月终止在该区域股权交易中心展示挂牌，展示挂牌期间未在该区域股权交易中心进行股权交易。在展示挂牌期间，公司未受到任何行政处罚或者自律监管措施。

五、发行人的股权结构

截至本招股说明书签署日，公司的股权结构图如下：



六、发行人的控股、参股公司和分支机构情况

截至本招股说明书签署日，发行人下设有 3 家全资子公司，分别为江苏芯越、晟州聚能、上海昇州，1 家参股公司辽宁聚芯，及 4 家分公司，分别为武汉分公司、北京分公司、大连分公司、深圳分公司。具体情况如下：

（一）发行人控股公司情况

1、江苏芯越

项目	基本情况
公司名称	江苏芯越半导体科技有限公司
统一社会信用代码	91321091MA22PLAG0N
成立日期	2020-10-16
注册资本	1,000 万元人民币
实收资本	1,000 万元人民币
法定代表人	朱培文
股东构成及控制情况	发行人持有其 100%股权
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地	扬州市邗江区吉安路 203 号 1 幢
主要生产经营地	扬州市邗江区吉安北路 203 号 C 幢
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；半导体分立器件制造；特种陶瓷制品制造；变压器、整流器和电感器制造；实验分析仪器制造；电子测量仪器制

项目	基本情况	
	造；电子元器件批发；电子元器件零售；配电开关控制设备销售；电子专用设备销售；电子测量仪器销售；特种陶瓷制品销售；光学仪器制造；功能玻璃和新型光学材料销售；光学仪器销售；环境监测专用仪器仪表制造；电子元器件制造；环境监测专用仪器仪表销售；泵及真空设备销售；合成材料销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
经营期限	2020 年 10 月 16 日至 2050 年 10 月 15 日	
主营业务及其与发行人主营业务的关系	公司的生产基地之一，主要负责远程等离子体源系统的腔体镀膜工序	
最近一年的财务数据（经审计）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年
	总资产（万元）	1,843.25
	净资产（万元）	928.28
	营业收入（万元）	3,600.43
	净利润（万元）	192.95

2、晟州聚能

项目	基本情况
公司名称	上海晟州聚能半导体科技有限公司
统一社会信用代码	91310115MADHPQYF2P
成立日期	2024-04-19
注册资本	3,000 万元人民币
实收资本	3,000 万元人民币
法定代表人	朱培文
股东构成及控制情况	发行人持有其 100%股权
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地	中国（上海）自由贸易试验区宁桥路 600 号 5 幢 208 室
主要生产经营地	上海市浦东锦绣东路 2777 号 1 号楼 3 层
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；软件开发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：第一类医疗器械销售；软件销售；专用设备修理；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电子产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；机械设备销售；电气设备修理；电气设备销售；工业设计服务；电子专用材料研发；五金产品零售；五金产品研发；环境保护专用设备销售；照相机及器材销售；金属材料销售；电力设施器材销售；通讯设备销售；电工器材销售；机械电气设备销售；照明器具销售；电线、电缆经营；照明器具生产专用设备销售。
经营期限	2024 年 4 月 19 日至无固定期限
主营业务及其与发行	上海研发中心，从事等离子体电源系统的研发

项目	基本情况	
人主营业务的关系		
最近一年的财务数据（经审计）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年
	总资产（万元）	1,540.45
	净资产（万元）	887.26
	营业收入（万元）	68.18
	净利润（万元）	-557.15

3、上海昇州

项目	基本情况	
公司名称	上海昇州半导体科技有限公司	
统一社会信用代码	91310000MA1H40M73P	
成立日期	2021-08-03	
注册资本	1,000 万元人民币	
实收资本	1,000 万元人民币	
法定代表人	朱培文	
股东构成及控制情况	发行人持有其 100%股权	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	
注册地	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼	
主要生产经营地	上海市浦东新区锦绣东路 2777 号 1 号楼 3 层	
经营范围	许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事半导体科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；软件开发；进出口代理；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；环境保护专用设备销售；照相机及器材销售；金属材料销售；通讯设备销售；电线、电缆经营；机械设备销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；软件销售；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	
经营期限	2021 年 8 月 3 日至 2041 年 8 月 2 日	
主营业务及其与发行人主营业务的关系	上海交付与服务中心，从事等离子体电源系统的交付与服务	
最近一年的财务数据（经审计）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年
	总资产（万元）	691.77
	净资产（万元）	568.76
	营业收入（万元）	748.21
	净利润（万元）	93.98

（二）发行人参股公司情况

1、辽宁聚芯

项目	基本情况
企业名称	辽宁聚芯智能装备创新中心有限公司
入股时间	2026 年 5 月
注册资本	10,000 万元
发行人出资金额	500 万元
持股比例	神州半导体持股 5.00%
控股方	第一大股东系拓荆科技股份有限公司
主营业务	应用于先进制程领域的高端集成电路装备新产品、新技术的需求，开展关键零部件的核心技术开发、验证与应用，并搭建设备及零部件研发、测试平台，孵化相关技术实现产业化。

（三）发行人分公司情况

1、武汉分公司

名称	江苏神州半导体科技股份有限公司武汉分公司
统一社会信用代码	91420100MAK1WWBR78
主要经营场所	湖北省武汉市东湖新技术开发区左岭街道韩杨路 1 号光电创新园 1 号楼 6 层 A601-1 座
负责人	王焕雯
企业类型	分公司
成立日期	2025 年 11 月 10 日
营业期限	2025 年 11 月 10 日至 2045 年 11 月 10 日
主营业务	等离子体电源系统的技术支持服务

2、北京分公司

名称	江苏神州半导体科技股份有限公司北京分公司
统一社会信用代码	91110400MAK5M45X0J
主要经营场所	北京市北京经济技术开发区荣华南路 1 号院 7 号楼 3 层 301
负责人	苑磊
企业类型	分公司
成立日期	2026 年 1 月 5 日
营业期限	2026 年 1 月 5 日至无固定期限
主营业务	等离子体电源系统的技术支持服务

3、大连分公司

名称	江苏神州半导体科技股份有限公司大连分公司

名称	江苏神州半导体科技股份有限公司大连分公司
统一社会信用代码	91210213MAK3RPP192
主要经营场所	辽宁省大连经济技术开发区松岚街 100-2 号 1-6 层
负责人	熊都
企业类型	分公司
成立日期	2026 年 1 月 6 日
营业期限	2026 年 1 月 6 日至无固定期限
主营业务	等离子体电源系统的技术支持服务

4、深圳分公司

名称	江苏神州半导体科技股份有限公司深圳市分公司
统一社会信用代码	91440300MAK44J5W48
主要经营场所	深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道 76 号智慧家园 B 座 2201
负责人	刘建华
企业类型	分公司
成立日期	2026 年 1 月 9 日
营业期限	2026 年 1 月 9 日至无固定期限
主营业务	等离子体电源系统的技术支持服务

七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况

（一）控股股东、实际控制人情况

1、控股股东

截至本招股说明书签署日，朱培文直接持有发行人 21.1682%的股份，同时担任众芯聚能执行事务合伙人并控制众芯聚能，其通过众芯聚能间接持有发行人 14.1498%的股份。据此，朱培文直接或间接合计持有发行人 35.3180%的股份。

朱培文直接持有公司 21.1682%的股份，并通过员工持股平台众芯聚能间接控制发行人 23.2535%股份。朱培文通过与陈觉晓、江苏信基、众芯聚能签署的《一致行动人协议书》，约定朱培文、江苏信基及众芯聚能在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东会、董事会提出议案前，或在行使股东会或董事会等事项的表决之前，一致行动人内部先对相关议案表决事项进行协调，直至达成一致意见，不能达成一致意见时以朱培文的意见为准，该协议自各方签字或盖章后长期有效。因此朱培文通过《一致行动人协议书》控制发行人 20.3183%股份，

合计控制公司 64.74%的股份对应的表决权。朱培文持有公司的股份比例虽然低于 50%，但其所享有的表决权足以对股东会的决议产生重大影响，系发行人的控股股东。

2、实际控制人

截至本招股说明书签署日，朱培文系公司的实际控制人，直接持有公司 21.1682%的股份，并通过员工持股平台众芯聚能间接控制发行人 23.2535%股份。朱培文通过与陈觉晓、江苏信基、众芯聚能签署的《一致行动人协议书》，约定朱培文、江苏信基及众芯聚能在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东会、董事会提出议案前，或在行使股东会或董事会等事项的表决之前，一致行动人内部先对相关议案表决事项进行协调，直至达成一致意见，不能达成一致意见时以朱培文的意见为准，该协议自各方签字或盖章后长期有效。因此朱培文通过《一致行动人协议书》控制发行人 20.3183%股份，合计控制公司 64.74%的股份对应的表决权；同时朱培文作为公司的董事长、总经理、法定代表人，因此朱培文为公司的实际控制人。报告期内，发行人实际控制人未发生变化。

朱培文，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为江苏省扬州市******，身份证号码为：32102719751006****。朱培文先生的简历情况参见本招股说明书“第四节/九/（一）”相关内容。

（二）控股股东和实际控制人持有发行人股份的质押或其他有争议情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。

（三）控股股东、实际控制人的重大违法行为

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

（四）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况

截至本招股说明书签署日，除公司实际控制人外，直接持有公司 5%以上股

份的股东为众芯聚能、江苏信基和英特尔亚太。具体情况如下：

1、众芯聚能

截至本招股说明书签署日，众芯聚能持有公司 23.2535%的股份，众芯聚能系公司的员工持股平台，基本情况如下：

名称	扬州众芯聚能企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91321003MA2744EW0H
主要经营场所	扬州市邗江区蜀岗西路 19 号 1
执行事务合伙人	朱培文
注册资本	1000 万元
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；软件开发；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2021-09-22
营业期限	2021-09-22 至无固定期限
主营业务及其与发行人主营业务的关系	员工持股平台，无实质业务

众芯聚能的合伙人出资构成如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例	性质	在发行人处主要任职
1	朱培文	608.50	60.85%	普通合伙人	董事长、总经理、核心技术人员
2	朱国俊	133.30	13.33%	有限合伙人	副总经理、研发总监、核心技术人员
3	叶剑	78.20	7.82%	有限合伙人	上海研发中心负责人、核心技术人员
4	丁书龙	53.30	5.33%	有限合伙人	董事、副总经理、销售总监
5	张梅菊	53.30	5.33%	有限合伙人	运营总监
6	耿微	40.00	4.00%	有限合伙人	晟州聚能副总经理
7	徐秀云	16.70	1.67%	有限合伙人	财务总监
8	丁昊	16.70	1.67%	有限合伙人	董事会秘书

2、江苏信基

截至本招股说明书签署日，江苏信基持有公司 20.3183%的股份。江苏信基的基本情况如下：

企业名称	江苏信基科技有限公司
成立时间	2018-01-18
注册地址及主要经营场所	扬州市邗江区吉安路 203 号 1 幢
注册资本	1,000 万元
实收资本	50 万元
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主要从事投资业务，与发行人无竞争关系

截至本招股说明书签署日，江苏信基的股东、出资比例如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	陈觉晓	980.00	98.00
2	扬州汇禧管理咨询有限公司	20.00	2.00
合计		**1,000.00**	**100.00**

3、英特尔亚太

截至本招股说明书签署日，英特尔亚太持有公司 8.6125%的股份。英特尔亚太的基本情况如下：

企业名称	英特尔亚太研发有限公司
成立时间	2004-08-30
注册地址及主要经营场所	上海市闵行区紫竹科学园区紫星路 880 号
注册资本	1,800 万美元
实收资本	1,800 万美元
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主要从事投资业务，与发行人无竞争关系

截至本招股说明书签署日，英特尔亚太的股东、出资比例如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	持股比例（%）
1	英特尔（中国）有限公司	1,800.00	100.00
合计		**1,800.00**	**100.00**

（五）控股股东、实际控制人控制的其他企业的基本情况

除发行人及其子公司、众芯聚能外，截至本招股说明书签署日，发行人控股股东及实际控制人朱培文无其他直接或间接控制的企业。

八、发行人股本情况

（一）本次发行前后股本情况

公司本次发行前总股本 6,600.00 万股，本次发行不超过 2,200.00 万股，本次发行的股份占发行后股份总数的比例不低于 25%，本次发行后总股本不超过 8,800.00 万股。本次发行前后股本结构如下（按发行 2,200.00 万股计算）：

序号	股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构	
		股数（万股）	比例（%）	股数（万股）	比例（%）
1	扬州众芯聚能企业管理合伙企业（有限合伙）	1,534.7340	23.2535	1534.7340	17.4402
2	朱培文	1,397.1120	21.1682	1397.1120	15.8763
3	江苏信基科技有限公司	1,341.0060	20.3183	1341.0060	15.2387
4	英特尔亚太研发有限公司	568.4220	8.6125	568.4220	6.4593
5	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	315.7920	4.7847	315.7920	3.5885
6	上海智微攀峰创业投资合伙企业（有限合伙）	248.1120	3.7593	248.1120	2.8195
7	长存产业投资基金（武汉）合伙企业(有限合伙）	210.0000	3.1818	210.0000	2.3864
8	上海浦宸私募投资基金合伙企业（有限合伙）	142.1040	2.1531	142.1040	1.6148
9	宜兴高易二期创业投资合伙企业（有限合伙）	125.0520	1.8947	125.0520	1.4210
10	上海岩泉科技有限公司	117.8820	1.7861	117.8820	1.3396
11	中微半导体（上海）有限公司	90.0000	1.3636	90.0000	1.0227
12	上海华虹虹芯二期创业投资合伙企业（有限合伙）	90.0000	1.3636	90.0000	1.0227
13	嘉兴脉波稳芯股权投资合伙企业（有限合伙）	75.0000	1.1364	75.0000	0.8523
14	扬州产发华映创业投资合伙企业（有限合伙）	56.2500	0.8523	56.2500	0.6392
15	丰泉创业投资（张家港）合伙企业（有限合伙）	51.5625	0.7813	51.5625	0.5859
16	上海道禾拓荆芯链私募基金合伙企业（有限合伙）	51.5625	0.7813	51.5625	0.5859
17	上海金资创兴一期创业投资合伙企业（有限合伙）	43.1250	0.6534	43.1250	0.4901
18	无锡产发正德翔华伟潮创业投资合伙企业(有限	37.5000	0.5682	37.5000	0.4261

序号	股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构	
		股数（万股）	比例（%）	股数（万股）	比例（%）
	合伙）				
19	华海金浦创业投资（济南）合伙企业(有限合伙）	37.5000	0.5682	37.5000	0.4261
20	嘉兴智微厚德创业投资合伙企业（有限合伙）	29.7840	0.4513	29.7840	0.3385
21	武汉光创新兴技术一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	18.7500	0.2841	18.7500	0.2131
22	江城精选（武汉市）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18.7500	0.2841	18.7500	0.2131
本次发行股份				2,200.00	25.0000
本次公开发售股份				-	-
合计		**6,600.00**	**100.00**	**8,800.00**	**100.00**

（二）本次发行前的前十名股东

本次发行前，公司前十名股东如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	扬州众芯聚能企业管理合伙企业（有限合伙）	1,534.7340	23.2535
2	朱培文	1,397.1120	21.1682
3	江苏信基科技有限公司	1,341.0060	20.3183
4	英特尔亚太研发有限公司	568.4220	8.6125
5	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	315.7920	4.7847
6	上海智微攀峰创业投资合伙企业（有限合伙）	248.1120	3.7593
7	长存产业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	210.0000	3.1818
8	上海浦宸私募投资基金合伙企业（有限合伙）	142.1040	2.1531
9	宜兴高易二期创业投资合伙企业（有限合伙）	125.0520	1.8947
10	上海岩泉科技有限公司	117.8820	1.7861
合计		**6,000.2160**	**90.9122**

（三）发行人发行前的前十名自然人股东及其担任发行人职务情况

截至本招股说明书签署日，公司共有 1 名自然人股东，该等股东直接持股及在公司的任职情况如下：

序号	股东姓名	股份数量（万股）	持股比例（%）	担任发行人任职情况

序号	股东姓名	股份数量（万股）	持股比例（%）	担任发行人任职情况
1	朱培文	1,397.1120	21.1682	董事长、总经理、核心技术人员
合计		**1,397.1120**	**21.1682**	-

（四）发行人国有股份或者外资股份的情况

1、发行人国有股份情况

截至本招股说明书签署日，公司共有 1 名国有股东，即大基金二期，国有股东合计持有发行人 315.7920 万股股份，占总股本的 4.7847%，具体情况如下：

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	大基金二期	315.7920	4.7847
合计		**315.7920**	**4.7847**

截至本招股说明书签署日，发行人总股本 6,600 万股，其中大基金二期持有 315.7920 万股，持股比例为 4.7847%。根据《上市公司国有股权监督管理办法》，大基金二期应标注“SS”标识。

2026 年 3 月，财政部出具了《财政部关于确认国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司江苏神州半导体科技股份有限公司项目国有股权管理方案的函》（财建函[2026]3 号），确认大基金二期为国有股东（SS），所持有的发行人 315.7920 万股（持股比例 4.7847%）股份性质为国有法人股。

2、发行人外资股份情况

截至本招股说明书签署日，公司股东中不存在外资股份。

（五）私募投资基金等金融产品持有发行人股份情况

发行人现有股东中，长存产业基金、浦宸基金、宜兴高易等共 16 名机构股东属于《中华人民共和国证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金。上述股东及其管理人均已办理私募投资基金备案或私募基金管理人登记，具体如下：

序号	股东名称	基金管理人名称	私募基金管理人编号	基金备案情况
1	大基金二期	华芯投资管理有限责任公司	P1009674	SJU890
2	宜兴高易	江苏高易创业投资管理有限公司	P1072105	STS277
3	浦宸基金	上海国盛资本管理有限公司	P1068692	SABA07

序号	股东名称	基金管理人名称	私募基金管理人编号	基金备案情况
4	长存产业基金	长存（武汉）私募基金管理有限公司	P1075012	SABY22
5	华虹二期基金	上海国方私募基金管理有限公司	P1065092	SAQF88
6	智微攀峰	上海智微私募基金管理有限公司	P1074969	SBEN20
7	智微厚德	上海智微私募基金管理有限公司	P1074969	SBFK13
8	金资创兴	上海盛盎私募基金管理有限公司	P1071785	SASJ63
9	丰泉创投	上海道禾长期投资管理有限公司	P1071092	SBHF12
10	拓荆芯链	上海道禾长期投资管理有限公司	P1071092	SAQP20
11	嘉兴脉波	海南超越摩尔私募基金管理有限公司	P1074508	SBLL47
12	扬州产发华映	温州聚彤创业投资有限公司	P1032919	SBLA71
13	产发正德	无锡华鼎创业投资管理有限公司	P1072111	SXY606
14	华海金浦	上海金浦创新股权投资管理有限公司	P1063861	SALU95
15	光创基金	武汉光谷产业投资基金管理有限公司	P1064746	SB6938
16	精选基金	武汉光谷科创投私募股权基金管理有限公司	P1068773	SBFJ63

（六）最近一年发行人新增股东情况

1、最近一年公司新增股东的持股数量、取得股份时间、价格和定价依据

序号	取得时间	转让方	新增股东名称	股份来源	增资/转让金额（万元）	计入注册资本金额（万元）	定价依据
1	2025.11	江苏信基	长存产业基金	受让	7,000	82.0988	协商定价
2	2025.11	朱培文	华虹二期基金	受让	3,000	35.1852	协商定价
3	2025.11	朱培文	智微攀峰	受让	2,263	26.5430	协商定价
4	2025.11	智微攀峰	智微厚德	受让	242.4643	2.8469	协商定价
5	2025.12	-	智微攀峰	增资	10,000	187.5000	协商定价
6	2025.12	-	智微厚德	增资	1,200	22.5000	协商定价
7	2025.12	-	金资创兴	增资	2,300	43.1250	协商定价
8	2025.12	-	丰泉创投	增资	2,750	51.5625	协商定价
9	2025.12	-	拓荆芯链	增资	2,750	51.5625	协商定价
10	2025.12	-	嘉兴脉波	增资	4,000	75.0000	协商定价
11	2025.12	-	扬州产发华映	增资	3,000	56.2500	协商定价
12	2025.12	-	产发正德	增资	2,000	37.5000	协商定价
13	2025.12	-	华海金浦	增资	2,000	37.5000	协商定价
14	2025.12	-	光创基金	增资	1,000	18.7500	协商定价
15	2025.12	-	精选基金	增资	1,000	18.7500	协商定价

2、新增股东的锁定期承诺

最近一年发行人新增股东出具的锁定期承诺详见本招股说明书“第十二节/附件二”。

3、最近一年新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系的情况、是否存在股份代持情况

公司各股东间的关联关系参见本招股说明书“第四节八/（七）”之叙述。

除上述情况外，最近一年的新增股东与公司其他股东、董事、历史监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本招股说明书签署日，国泰海通存在间接持有发行人**0.2536%**股份的情形，持股比例较少，持股情形系相关投资主体依据市场化原则所作出的投资决策，不属于法律法规禁止持股的情形或利益冲突情形。除上述情况外，新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排。

最近一年的新增股东不存在股权代持情形。

（七）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股比例具体如下：

序号	股东姓名/名称	直接持股比例（%）	关联关系/一致行动关系说明
1	朱培文	21.1682	1、朱培文系众芯聚能的执行事务合伙人，并持有众芯聚能 60.85%财产份额； 2、陈觉晓系江苏信基控股股东，其直接持有江苏信基 98%股权； 3、朱培文与陈觉晓、江苏信基、众芯聚能签署了《一致行动人协议书》，江苏信基、众芯聚能系朱培文的一致行动人。
	江苏信基	20.3183	
	众芯聚能	23.2535	
2	中微半导体	1.3636	1、智微攀峰和智微厚德的执行事务合伙人和基金管理人均系上海智微私募基金管理有限公司，智微攀峰和智微厚德存在一致行动关系，互为一致行动人； 2、中微半导体持有智微攀峰和智微厚德的
	光创基金	0.2841	
	智微攀峰	3.7593	
	智微厚德	0.4513	

序号	股东姓名/名称	直接持股比例（%）	关联关系/一致行动关系说明
			执行事务合伙人和基金管理人上海智微私募基金管理有限公司 45%股权； 3、中微半导体、光创基金系智微攀峰有限合伙人。
3	丰泉创投	0.7813	1、丰泉创投和拓荆芯链的执行事务合伙人和基金管理人均系上海道禾长期投资管理有限公司，丰泉创投和拓荆芯链存在一致行动关系，互为一致行动人； 2、上海岩泉系拓荆芯链有限合伙人。
	上海岩泉	1.7861	
	拓荆芯链	0.7813	
4	光创基金	0.2841	1、光创基金和精选基金的实际控制人均为武汉东湖新技术开发区管理委员会，但不存在一致行动关系[注]； 2、武汉光谷半导体产业投资有限公司系精选基金、长存产业基金的有限合伙人，武汉光谷产业投资有限公司系光创基金、长存产业基金的有限合伙人； **3、光创基金系长存产业基金的有限合伙人。**
	精选基金	0.2841	
	长存产业基金	3.1818	

注：根据光创基金、精选基金的《合伙协议》及其出具的《关于关联关系/一致行动关系的声明》，鉴于光创基金与精选基金的执行事务合伙人、私募基金管理人为不同主体且决策机制独立，光创基金和精选基金系同一实际控制人控制的独立管理、独立运营的不同基金，不存在一致行动关系，不互为一致行动人。

除上述情况外，发行人股东不存在其他关联关系或一致行动关系。

（八）发行人股东公开发售股份的情况

本次发行不涉及发行人股东公开发售股份的情况。

（九）发行人与股东之间的特殊权益安排及解除情况

公司及其实际控制人朱培文及其他现有股东之间曾经存在对赌条款等特殊权利安排，具体情况如下：

1、特殊权利安排情况

2025 年 10 月发行人与当时的全体股东签署的《股东协议》中约定了以发行人为回购义务人的赎回权。为推进发行人整体变更为股份有限公司，2025 年 11 月，发行人与当时的全体股东签署了《关于江苏神州半导体科技有限公司股东特殊权利条款的终止协议》（以下简称《终止协议（一）》），各方确认，2025 年 10 月签署的《股东协议》项下以公司为回购义务人的赎回权彻底终止并自始无效，且不附带任何恢复条件。

发行人整体变更为股份公司后，因开展新一轮融资，2025 年 12 月，发行人

与全体股东签署了新的《股东协议》（以下简称新股东协议），约定新股东协议构成各方有关各股东的股东权利以及公司治理事项所达成的全部理解，并取代各方先前以书面或口头形式就相同事项达成的所有协议、承诺等，包括但不限于历轮融资中签署的股东协议。新股东协议中约定了各投资人享有的股东特殊权利，包括但不限于：公司治理方面的特殊权利、优先认购权、投资人股东股份的转让和锁定期、主要股东的不转让承诺、优先受让权、非控制权变更的共同出售权、控制权变更、知情权、检查权、清算优先权、投资人的反稀释保护、随惠权、赎回权。在新股东协议中，发行人并非对赌条款的回购义务人。

2、特殊权利的终止情况

（1）涉及发行人为回购义务主体的特殊权利终止

根据《终止协议（一）》的约定，以公司为回购义务人的赎回权已彻底终止并自始无效，且不附带任何恢复条件。

（2）其他特殊权利

2026 年 4 月，发行人与全体股东签署了《关于江苏神州半导体科技股份有限公司股东特殊权利条款的终止协议》（以下简称《终止协议（二）》，与《终止协议（一）》合称《终止协议》），相关约定包括：（1）新股东协议中约定的各投资人享有的全部股东特殊权利条款自公司提交的境内上市申请材料被正式受理之日（以证券交易所出具受理函之日为准）终止；（2）新股东协议中除赎回权（以主要股东为回购义务人）外，约定的各投资人享有的其他股东特殊权利条款将在下列事项较早发生的一项发生之日自动恢复法律效力且视为从未失效或被终止：(i) 公司境内上市申请被撤回或主动撤回、被终止审查或者不予批准或不予注册，(ii) 截至 2029 年 10 月 21 日无论因任何原因导致公司境内上市申请未能通过主管证券监管机构审核或公司未能完成境内上市；（3）若截至 2029 年 10 月 21 日无论因任何原因导致公司境内上市申请未能通过主管证券监管机构审核或公司未能完成境内上市的，大基金二期依据新股东协议相关约定享有的特殊赎回权（以主要股东为回购义务人）将自动恢复法律效力且视为从未失效或被终止。

根据《终止协议》的约定，发行人对赌协议已彻底解除，符合《监管规则适

用指引——发行类第 4 号》之“4-3 对赌协议”的规定，具体情况如下：

《监管规则适用指引——发行类第 4 号》之“4-3 对赌协议”的规定		发行人实际情况	是否符合相关规定
投资机构在投资发行人时约定对赌协议等类似安排的，保荐机构及发行人律师、申报会计师应当重点就以下事项核查并发表明确核查意见		涉及发行人作为回购义务人的赎回权已彻底终止并自始无效，且不附带任何恢复条件。除此之外，其他股东特殊权利在发行人提交本次发行上市申请材料被正式受理之日终止，并在约定的特定情形下恢复效力。	符合
不符合相关要求的对赌协议原则上应在申报前清理	发行人是否对赌协议当事人	发行人作为回购义务人的对赌协议已彻底终止并自始无效，发行人并非对赌协议的回购义务人	符合
	对赌协议是否存在可能导致公司控制权变化的约定	针对主要股东（指朱培文、陈觉晓、江苏信基和众芯聚能）的回购约定，自本次发行上市申请被正式受理之日终止，仅在约定的情形下恢复大基金二期的回购权，不存在可能导致公司控制权变化的对赌协议约定	符合
	对赌协议是否与市值挂钩	不存在涉及与市值挂钩的对赌协议约定	符合
	对赌协议是否存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形	不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形	符合

（十）关于股权代持及解除情况

发行人历史沿革中曾经存在徐茂元代持陈觉晓股权的情形，具体如下：

1、股权代持关系的建立

徐茂元系陈觉晓朋友。在发行人设立时，由于陈觉晓系中国澳门籍人士，为避免因外商投资企业的公司性质对业务开拓造成潜在影响，陈觉晓委托徐茂元在发行人设立时代持其股权，将出资款 934.56 万元转给徐茂元，由徐茂元出资到发行人。

2、股权代持关系的解除

2018 年 5 月，徐茂元与江苏信基、朱培文分别签署《股权转让协议》，将其持有的神州半导体 35.864%股权以 717.28 万元的价格转让给江苏信基、10.864%股权以 217.28 万元的价格转让给朱培文，并退出神州半导体，徐茂元将收到的股权转让对价全部转还给了陈觉晓。由此，前述股权代持关系解除。

经代持各方确认，就股权代持的形成、执行及解除等与股权代持相关的全部事宜，系各方的真实意思表示，各方对此不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷。

截至本招股说明书签署日，发行人不存在股权代持的情形。

九、发行人董事、审计委员会、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

（一）董事情况

公司现有董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司董事基本情况如下：

姓名	职务	提名人	任职期限
朱培文	董事长	朱培文	2025 年 11 月至 2028 年 11 月
陈觉晓	董事	江苏信基	2025 年 11 月至 2028 年 11 月
丁书龙	职工董事	职工代表大会	2025 年 11 月至 2028 年 11 月
郭正	董事	大基金二期	2025 年 11 月至 2028 年 11 月
陈卓	独立董事	朱培文	2025 年 11 月至 2028 年 11 月
WEI CHEN（陈伟）	独立董事	朱培文	2025 年 11 月至 2028 年 11 月
江希和	独立董事	朱培文	2025 年 11 月至 2028 年 11 月

公司现任董事简历如下：

1、朱培文

朱培文，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，江苏省非公有制经济优秀建设者。2001 年 7 月至 2022 年 2 月，任扬州市神州科技有限公司（2022 年 2 月已注销）执行董事、总经理；2016 年 4 月至今，历任发行人总经理、董事长。

2、陈觉晓

陈觉晓，男，1975 年出生，中国澳门籍，专科学历。1999 年 9 月至 2001 年 12 月，任宏顺科技有限公司设备维修工程师；2002 年 1 月至 2002 年 6 月，脱产筹备创业；2002 年 7 月至今，历任扬州广德信息有限公司总经理、董事长；2018 年 1 月至今，任江苏信基科技有限公司董事长；2016 年 4 月至今，历任发行人董事长、董事、高级顾问。

3、郭正

郭正，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017 年 7 月至 2021 年 7 月，历任国家开发银行评审一局、行业一部、行业四部行员；

2021 年 7 月至 2023 年 9 月，任华芯投资管理有限责任公司战略发展部经理；2023 年 9 月至 2025 年 2 月，任华芯投资管理有限责任公司投资三部高级主管；2025 年 2 月至 2025 年 9 月，任华芯投资管理有限责任公司业务三部高级主管；2025 年 9 月至今，任华芯投资管理有限责任公司业务三部资深主管；2025 年 5 月至今，任发行人董事。

4、丁书龙

丁书龙，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 9 月至 2017 年 8 月，历任扬州市神州科技有限公司维修服务工程师、销售工程师、销售经理；2017 年 8 月至今，历任发行人销售经理、销售总监；2025 年 5 月至今，历任发行人董事、职工董事。

5、陈卓

陈卓，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2020 年 8 月至 2022 年 5 月，任美国美利坚大学 Kogod 商学院战略学助理教授；2022 年 5 月至今，任中欧国际工商学院战略与创业创新系助理教授；2025 年 11 月至今，任发行人独立董事。

6、WEI CHEN（陈伟）

WEI CHEN（陈伟），男，1965 年出生，美国国籍，博士学历。1994 年 6 月至 1998 年 9 月，历任中科院半导体研究所副研究员、研究员；1998 年 10 月至 1999 年 3 月，任瑞典隆德大学化学院高级访问学者；1999 年 4 月至 2000 年 3 月，任西安大略大学化学系高级访问学者；2000 年 4 月至 2006 年 7 月，任 Nomadics 高技术公司项目负责人和纳米技术部门主管；2006 年 8 月至 2023 年 12 月，历任德州大学 Arlington 分校物理系助理教授、副教授、教授、校级教授、中心主任；2024 年 1 月至今，任西交利物浦大学芯片学院教授、院长；2025 年 11 月至今，任发行人独立董事。

7、江希和

江希和，男，1958 年出生，中国国籍，博士学历，会计学教授，中国注册会计师协会非执业会员。1980 年 7 月至 1995 年 6 月，历任江苏连云港财经学校教师、会计教研组组长；1995 年 7 月至 2000 年 5 月，历任南京动力高等专科学

校经济系教师、系主任；2000 年 5 月至 2018 年 6 月，历任南京师范大学金陵女子学院教师、副院长、党委书记；2018 年 9 月至 2023 年 12 月，历任南京师范大学泰州学院纪检监察办公室主任、审计办公室主任、图书馆馆长；2023 年 12 月至 2025 年 2 月，任南京师范大学泰州学院商学院书记；2007 年 9 月至今，任南京师范大学会计与财务发展研究中心教授；2025 年 11 月至今，任发行人独立董事。

（二）审计委员会情况

审计委员会成员为 3 名，为陈卓、WEI CHEN（陈伟）和江希和，由江希和担任召集人。前述成员的简历参见本招股说明书“第四节/九/（一）”。

（三）高级管理人员情况

截至本招股说明书签署日，公司高级管理人员共 5 名，基本情况如下：

姓名	担任高级管理人员职务	任职期限
朱培文	总经理	2025 年 11 月至 2028 年 11 月
朱国俊	副总经理	2025 年 11 月至 2028 年 11 月
丁书龙	副总经理	2025 年 11 月至 2028 年 11 月
徐秀云	财务总监	2025 年 11 月至 2028 年 11 月
丁昊	董事会秘书	2025 年 11 月至 2028 年 11 月

高级管理人员简历如下：

1、朱培文

朱培文的简历参见本招股说明书“第四节/九/（一）”。

2、朱国俊

朱国俊，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 4 月至 2010 年 4 月，任无锡宜科半导体设备维护有限公司服务部工程师；2010 年 4 月至 2016 年 4 月，历任扬州市神州科技有限公司工程经理、工程总监；2016 年 4 月至今，历任发行人工程总监、研发总监、副总经理。

3、丁书龙

丁书龙的简历参见本招股说明书“第四节/九/（一）”。

4、徐秀云

徐秀云，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1985 年 7 月至 1993 年 6 月，历任仪征化纤股份有限公司涤纶二厂财务副科长、科长；1993 年 7 月至 2013 年 5 月，历任仪化集团公司审计处副处长、财务处处长，中国石化仪征化纤股份有限公司经营计划处副处长、财务处处长；2013 年 5 月至 2019 年 3 月，任扬州化工产业园区投资发展有限公司财务负责人；2019 年 3 月至 2022 年 9 月，历任辽宁奥克化学股份有限公司财务中心总经理、财务总监；2022 年 9 月至今，任发行人财务总监。

5、丁昊

丁昊，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015 年 7 月至 2025 年 6 月，历任海通证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司投资银行部项目经理、副总裁、高级副总裁、总监；2025 年 7 月至今，任发行人董事会秘书。

（四）核心技术人员情况

公司现有核心技术人员共 5 名，核心技术人员基本情况如下：

姓名	主要任职
朱培文	董事长、总经理
朱国俊	副总经理、研发总监
叶剑	上海研发中心负责人
尹巧星	研发总监
潘小刚	研发总监

公司现有核心技术人员简历如下：

1、朱培文

朱培文的简历参见本招股说明书“第四节/九/（一）”。

2、朱国俊

朱国俊的简历参见本招股说明书“第四节/九/（三）”。

3、叶剑

叶剑，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工

程师，上海市集成电路行业协会理事会理事，《半导体视界》国际期刊编委，西交利物浦大学客座教授，中国国际科技促进会半导体产业发展分会专家智库成员。1985 年 9 月至 1999 年 12 月，**在解放军部队服役**；2000 年 1 月至 2002 年 11 月，任诺发系统半导体设备（上海）有限公司现场工程师；2002 年 12 月至 2003 年 9 月，任优仪半导体设备（上海）有限公司服务工程师；2003 年 10 月至 2019 年 3 月，历任万机仪器（上海）有限公司 Country Service Manager、工会主席；2019 年 6 月至 2021 年 7 月，任发行人上海办事处总经理；2024 年 9 月至今，任发行人公司工会法人；2025 年 5 月至 2025 年 11 月，任发行人监事；2021 年 8 月至今，任发行人上海研发中心负责人。

4、尹巧星

尹巧星，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 9 月至 2016 年 4 月，任扬州市神州科技有限公司电子工程师；2016 年 4 月至今，历任发行人电子工程师、研发工程师、研发经理、研发总监。

5、潘小刚

潘小刚，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，正高级工程师，入选工信部制造业人才支持计划，江苏省工业和信息化厅专家，江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象，扬州市有突出贡献的中青年专家。2007 年 7 月至 2021 年 12 月，历任国充充电科技江苏股份有限公司研发工程师、研发主管、研发经理、研发总监；2021 年 12 月至今，历任发行人研发经理、研发总监。

（五）董事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日，除发行人及其子公司外，发行人董事、高级管理人员与核心技术人员的主要兼职情况具体如下：

姓名	职务	其他任职单位	主要职务	其他任职单位与公司关系
朱培文	董事长、总经理	扬州众芯聚能企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	关联方
		上海优澳美德医院管理有限公司	董事	关联方
陈觉晓	董事	江苏信基科技有限公司	董事长、执行公司事务的董事	关联方

姓名	职务	其他任职单位	主要职务	其他任职单位与公司关系
		扬州汇禧管理咨询有限公司	执行公司事务的董事	关联方
		扬州广德信息有限公司	董事长、总经理	关联方
		上海优澳美德医院管理有限公司	董事	关联方
郭正	董事	江苏镨芯电子科技有限公司	董事	关联方
		北京中科信半导体股份有限公司	董事	关联方
		华芯投资管理有限责任公司	业务三部资深主管	无
江希和	独立董事	南京药石科技股份有限公司	独立董事	无
		江苏联众出版传媒集团股份有限公司[注]	独立董事	无
		南京师范大学会计与财务发展研究中心	教授	无
		江苏亨通华海科技股份有限公司	独立董事	无
WEI CHEN（陈伟）	独立董事	西交利物浦大学	芯片学院院长、教授	无
陈卓	独立董事	中欧国际工商学院	战略与创业创新系战略学助理教授	无

注：根据江希和的说明，其在江苏联众出版传媒集团股份有限公司独立董事任职期限已于2014年6月届满并已辞任，但相关工商手续尚未变更。江希和目前担任独立董事的企业中，仅有南京药石科技股份有限公司系境内上市公司。

（六）董事、高级管理人员与核心技术人员相互之间存在的亲属关系

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。

（七）最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员和核心技术人员最近三年不涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。

十、发行人与董事、高级管理人员及核心技术人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议情况

（一）公司与董事、高级管理人员和核心技术人员所签订的协议

除独立董事及外部董事郭正以外，公司与其董事、高级管理人员及核心技术人员分别签署了《劳动合同》或《劳务合同》，以及《竞业限制协议》。此外，公司与独立董事签订了《独立董事聘任合同》。截至本招股说明书签署日，上述合同、协议履行正常，不存在违约情形。

（二）董事、高级管理人员和核心技术人员作出的重要承诺

公司董事、高级管理人员和核心技术人员作出的重要承诺具体参见本招股说明书“第十二节/附件二”。

十一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年的变动情况

最近两年，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况如下：

（一）公司董事

时间	董事
2024.1-2025.5	朱培文、陈觉晓、耿微
2025.5-2025.11	朱培文、陈觉晓、丁书龙、郭正
2025.11 至今	朱培文、陈觉晓、丁书龙、郭正、陈卓、WEI CHEN（陈伟）、江希和

最近两年，发行人董事不存在重大不利变化。发行人最近两年的董事有所增加，主要是公司为完善治理结构新增外部董事及独立董事。

（二）公司监事

时间	监事
2024.1-2025.5	陈蓉
2025.5-2025.11	叶剑
2025.11 至今	无

最近两年，发行人监事不存在重大不利变化。发行人最近两年的监事变动的主要原因系原监事陈蓉因个人职业发展规划离职，以及神州有限整体变更为股份有限公司后取消监事设置，由董事会审计委员会行使监事职责。

（三）公司高级管理人员

时间	高级管理人员
2024.1-2025.7	朱培文、徐秀云
2025.7-2025.11	朱培文、徐秀云、丁昊
2025.11 至今	朱培文、徐秀云、丁书龙、朱国俊、丁昊

最近两年，发行人高级管理人员不存在重大不利变化。发行人最近两年的高级管理人员变动的主要原因系发行人报告期内业务发展需要，以及神州有限整体变更为股份有限公司，进一步完善了公司治理结构所致。

（四）公司核心技术人员

最近两年，发行人核心技术人员未发生变动，分别为朱培文、朱国俊、叶剑、尹巧星、潘小刚。

十二、发行人董事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及核心技术人员不存在与发行人及其业务相关的对外投资。

十三、董事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况

董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况如下：

（一）直接持股情况

截至本招股说明书签署日，本公司董事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接持有发行人股份的情况如下：

序号	姓名	主要职务	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	朱培文	董事长、总经理、核心技术人员	1,397.1120	21.1682

（二）间接持股情况

本公司董事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属通过江苏信基、员工持股平台众芯聚能间接持有发行人股份，具体情况如下：

1、江苏信基

序号	姓名	在发行人处主要职务	在江苏信基持有出资额（万元）	直接或间接持有江苏信基股份比例（%）	间接持有公司的股份比例（%）
1	陈觉晓	董事、高级顾问	994.00	99.40	20.1964
2	陈心悦	无	6.00	0.60	0.1219

2、众芯聚能

序号	姓名	在发行人处主要职务	持有众芯聚能财产份额（万元）	持有众芯聚能份额比例（%）	间接持有公司的股份比例（%）
1	朱培文	董事长、总经理、核心技术人员	608.50	60.85	14.1498
2	朱国俊	副总经理、研发总监、核心技术人员	133.30	13.33	3.0997
3	叶剑	上海研发中心负责人、核心技术人员	78.20	7.82	1.8184
4	丁书龙	董事、副总经理、销售总监	53.30	5.33	1.2394
5	耿微[注]	晟州聚能副总经理	40.00	4.00	0.9301
6	徐秀云	财务总监	16.70	1.67	0.3883
7	丁昊	董事会秘书	16.70	1.67	0.3883

注：耿微系实际控制人朱培文之配偶

截至本招股说明书签署日，除上述情况外，公司董事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属不存在以其他方式直接或间接持有公司股份的情况。公司董事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有的公司股份不存在质押或者冻结的情况。

十四、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据、所履行的程序

发行人的董事、历史监事、高级管理人员及核心技术人员依据其在发行人处担任的职务、对发行人生产经营活动的重要性、发行人经营计划的完成情况、市场平均薪酬水平等因素领取薪酬，薪酬总额由基本工资和奖金等组成。独立董事领取独董津贴，未在公司担任管理职务的外部董事不在公司领取薪酬。

公司董事、历史监事的薪酬方案由公司股东会批准确定；公司高级管理人员

的薪酬方案由公司董事会批准确定；公司核心技术人员的薪酬方案由公司的管理层按照《公司章程》等治理制度，并根据相关人员的实际工作情况进行确定。独立董事在公司领取的津贴，参照同行业其他上市公司标准拟定并经股东会批准确定。

（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内薪酬总额情况

公司董事、历史监事、高级管理人员、核心技术人员报告期内薪酬总额占当期利润总额比例情况如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
薪酬总额（万元）	**617.39**	2,428.63	2,156.20	1,620.28
利润总额（万元）	**12,823.54**	22,881.20	15,349.69	-1,455.64
占当期利润总额比例	**4.81%**	10.61%	14.05%	-

注：关键管理人员薪酬口径为个人应发工资总额，不包含公司缴纳的社保公积金及股份支付。**2026 年 1-6 月预提的年终奖未对应到个人，故 2026 年 1-6 月统计口径中未包含预提的年终奖。**

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入情况

公司现任董事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从公司及关联企业领取薪酬的情况如下：

单位：万元

序号	姓名	公司任职情况	2025 年度从公司领取薪酬
1	朱培文	董事长、总经理、核心技术人员	321.63
2	陈觉晓	董事	115.27
3	丁书龙	职工董事、副总经理	200.45
4	郭正	董事	-
5	陈卓	独立董事	0.67
6	陈伟	独立董事	0.67
7	江希和	独立董事	0.67
8	朱国俊	副总经理、核心技术人员	199.46
9	徐秀云	财务总监	154.61
10	丁昊	董事会秘书	72.03
11	叶剑	核心技术人员	179.54
12	尹巧星	核心技术人员	152.81
13	潘小刚	核心技术人员	135.15

注 1：公司于 2025 年 12 月选聘独立董事

注 2：薪酬总额包含税后工资、奖金及由公司承担的社会保险、公积金，不含股权激励

费用

公司董事郭正未在公司领取薪酬，独立董事只领取独立董事津贴，不享受其他福利待遇。截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及核心技术人员均未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领取薪酬。

（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所享受的其他待遇和退休金计划

除独立董事津贴外，公司独立董事未享受公司提供的其他待遇和退休金计划。除正常薪酬、股权激励、社会保险、公积金（退休返聘人员未缴纳社会保险和公积金）外，公司未向在公司领薪的董事、高级管理人员和核心技术人员提供其他待遇和退休计划。

十五、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排

（一）股权激励基本情况

为增加对核心人员及骨干员工的凝聚力及稳定性，发行人本次公开发行申报前共实施 3 次股权激励计划，分别为：

1、江苏信基向朱培文以 0 元对价转让其持有公司的 5%股份，对公司实际控制人进行股权激励；

2、设立众芯聚能作为员工持股平台，对公司核心员工进行了 2 次股权激励。

为建立对公司核心员工的中长期激励约束机制，将激励对象利益与股东价值紧密联系起来，使激励对象的行为与公司的战略目标保持一致，促进公司可持续发展，发行人实施了员工持股计划。

截至本招股说明书签署日，发行人设立了众芯聚能作为员工持股平台，其中朱培文作为众芯聚能的普通合伙人及执行事务合伙人控制该平台。众芯聚能具体情况参见本招股说明书“第四节/七/（四）”。

除上述情况外，截至本招股说明书签署日，公司不存在其他对董事、高级管理人员、核心技术人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。

众芯聚能仅以其自有资金认购发行人股份，不开展除投资发行人以外的其他

任何业务，不开展其他证券投资活动，不存在以任何公开或非公开方式向投资者募集资金的情形，不存在资产由私募投资基金管理人管理的情形，亦不存在担任任何私募投资基金产品的管理人的情形，众芯聚能不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金产品或私募投资基金管理人，无需履行基金管理人登记或基金备案程序。

（二）员工持股平台的锁定期和减持安排

关于员工持股平台股东股份锁定的承诺，参见本招股说明书“第十二节/附件二”。

（三）员工持股平台的规范运作情况

众芯聚能依据相关法律法规合法设立并有效存续。众芯聚能作为发行人的直接股东，与其他股东权益平等、盈亏自负、风险自担，并以货币出资。

为有序管理发行人员工持股计划，建立健全员工持股在平台内部的流转、退出机制以及股权管理机制，本次持股计划通过《扬州众芯聚能企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》《扬州众芯聚能企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议补充协议》等规定对持股平台的有关事项进行了详细约定。

截至本招股说明书签署日，众芯聚能的运营情况符合合伙协议规定，不存在因开展违法经营或其他违法活动而受到政府主管部门处罚或存在失信记录的情形。

（四）股权激励对公司的影响

1、股权激励对公司经营情况的影响

通过实施股权激励计划，公司建立健全了激励机制，充分调动了公司中高层管理人员及骨干员工的工作积极性。

2、股权激励对公司财务状况的影响

员工持股计划对发行人财务状况的影响参见本招股说明书“第六节/十/（四）”。

3、股权激励对公司控制权变化的影响

股权激励实施前后，公司控制权未发生变化。

4、上市后的行权安排

截至本招股说明书签署日，公司上述股权激励计划已实施完毕，不涉及上市后的行权安排。

十六、发行人员工及其社会保障情况

（一）员工基本情况

1、员工人数及变化

报告期各期末，公司员工人数如下表所示：

项目	2026.6.30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
员工人数（人）	560	507	444	322

2、员工结构情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司员工的情况如下：

（1）专业结构

专业分工	员工人数（人）	占员工总数比例
研发人员	138	24.64%
销售人员	45	8.04%
生产人员	321	57.32%
管理人员	56	10.00%
合计	560	100.00%

（2）学历结构

受教育程度	员工人数（人）	占员工总数比例
硕士及以上	49	8.75%
本科	277	49.46%
大专	180	32.14%
大专以下	54	9.64%
合计	560	100.00%

（3）年龄结构

年龄区间	员工人数（人）	占员工总数的比例
30 岁及以下	**248**	**44.29%**
31-40 岁	**235**	**41.96%**
41-50 岁	**61**	**10.89%**
51 岁及以上	**16**	**2.86%**
合计	**560**	**100.00%**

（二）发行人执行社会保障制度情况

报告期内各期末，发行人及子公司的社会保险费和住房公积金缴纳情况如下：

1、社会保险缴纳情况

项目	2026.6.30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
员工总人数（人）	**560**	507	444	322
社会保险缴纳人数（人）	**544**	488	430	318
缴纳社会保险人数占员工总人数比例	**97.14%**	96.25%	96.85%	98.76%
未缴纳社保人数（人）	**16**	19	14	4
未缴纳社会保险人数占员工总人数比例	**2.86%**	3.75%	3.15%	1.24%

注：已缴纳人数包含公司因员工个人需求而委托第三方代缴社会保险的员工人数。

报告期内上述相关员工未在发行人或下属子公司缴纳社会保险费的原因主要为：（1）存在个别退休返聘人员或劳务合同用工，无需根据《中华人民共和国劳动法》缴纳社会保险；（2）存在新入职员工当月在前任职单位已缴纳社会保险或尚未办理完毕社保缴纳手续，次月才能缴纳社会保险；（3）存在个别处于试用期的员工未缴纳社会保险，转正后缴纳社会保险；（4）1 名中国澳门籍员工自愿放弃公司为其在境内缴纳社会保险；（5）1 名员工处于见习期尚未转正，未缴纳社会保险，转正后缴纳社会保险。2、发行人缴纳公积金情况

项目	2026.6.30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
员工总人数（人）	**560**	507	444	322
住房公积金缴纳人数（人）	**544**	489	403	308
缴纳住房公积金人数占员工总人数比例	**97.14%**	96.45%	90.77%	95.65%
未缴纳住房公积金人数（人）	**16**	18	41	14
未缴纳住房公积金人数占员工总人数比例	**2.86%**	3.55%	9.23%	4.35%

注：已缴纳人数包含公司因员工个人需求而委托第三方代缴住房公积金的员工人数。

报告期内上述相关员工未在发行人或下属子公司缴纳住房公积金的原因主

要为：（1）存在个别退休返聘人员或劳务合同用工，无需根据《中华人民共和国劳动法》缴纳住房公积金；（2）存在新入职员工当月在前任职单位已缴纳住房公积金或尚未办理完毕住房公积金缴存手续；（3）存在个别处于试用期的员工未缴纳住房公积金，转正后缴纳住房公积金；（4）1 名中国澳门籍员工自愿放弃在境内缴纳住房公积金；（5）1 名员工处于见习期尚未转正，未缴纳住房公积金，转正后缴纳住房公积金；（6）1 名异地工作员工自愿放弃缴纳住房公积金。

报告期内，发行人存在委托第三方机构为部分员工代缴社会保险和住房公积金的情形。因业务发展需要，发行人部分销售人员及技术人员在异地工作，分布较为分散，为保障该部分员工享有社会保险及住房公积金的待遇，并尊重员工在其实际工作地缴纳社会保险及住房公积金的意愿，发行人通过第三方机构为相关员工在其实际工作地缴纳社会保险及住房公积金。

针对部分员工在公司注册地以外提供劳动并由第三方机构代缴社会保险和住房公积金的情况，发行人已积极采取规范措施，逐步在武汉、大连、深圳地区设立了分公司，员工的社保及公积金由分公司直接缴纳，截至招股说明书出具日，**已经不存在**通过第三方机构为相关员工在其实际工作地缴纳社会保险及住房公积金**的情形**。

根据发行人及其子公司的企业信用报告和/或所在地相关主管部门出具的证明，并登录发行人及其子公司所在地人力资源和社会保障、住房公积金主管部门网站查询，发行人及子公司报告期内已按规定进行了社会保险登记，不存在因违反劳动和社会保险相关法律、法规、规章和规范性文件而受到行政处罚的情形；发行人及子公司报告期内未因违反有关住房公积金法律、法规而受到行政处罚的情形。

（三）劳务外包、劳务派遣情况

报告期内，公司存在委托劳务外包公司向公司提供少量保洁、保安等劳务外包服务的情形，相关工作操作简单重复、技术含量较低，公司不存在将较多劳务活动交由专门劳务外包公司实施的情况。

报告期末，公司不存在劳务派遣员工。2024 年 7 月至 2024 年 10 月期间，

公司存在劳务派遣用工情况，派遣员工为 3 人，劳务派遣人员所在岗位均为简单装配类岗位，符合临时性、替代性和辅助性的要求，劳务派遣人数未超过用工总量的 10%，符合《中华人民共和国劳动法》《劳务派遣暂行规定》等相关法律规定。

报告期内，公司不存在因劳务派遣用工而受到行政处罚的情形。

第五节 业务与技术

一、发行人主营业务、主要产品及演变情况

（一）发行人主营业务

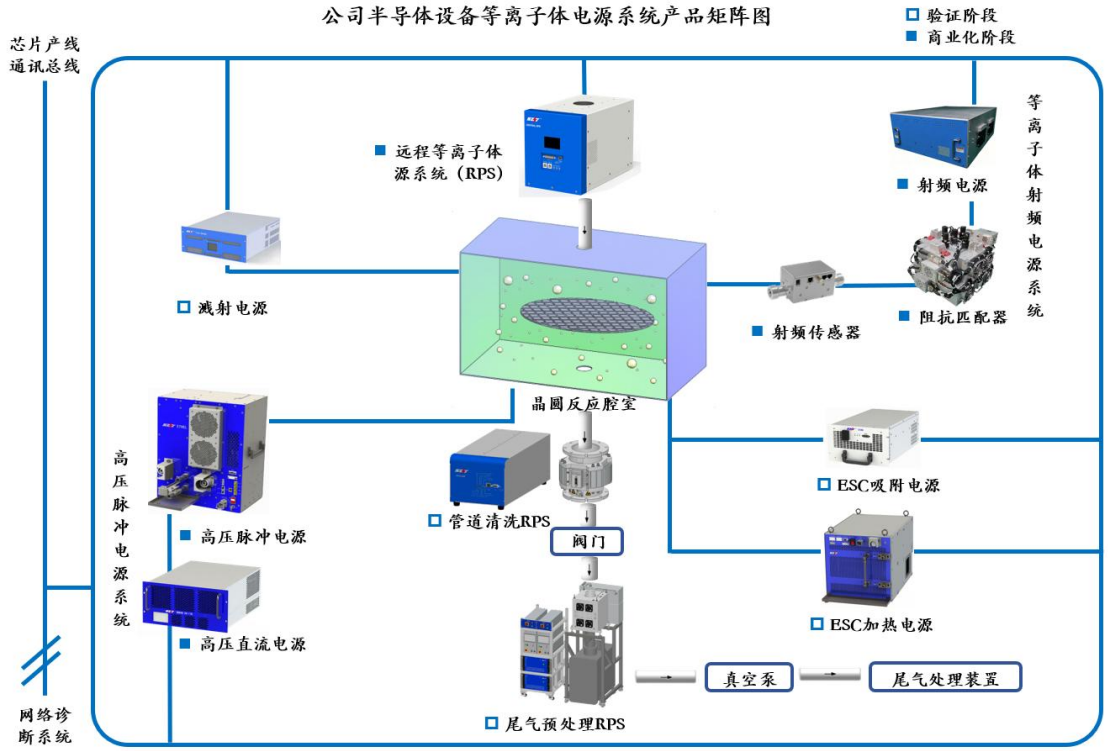
公司主要从事半导体关键工艺设备核心零部件的研发、生产、销售和技术支持服务，以半导体制造关键工艺技术——等离子体源技术为基础，为我国半导体先进制程产业链提供高端等离子体电源系统产品和全方位技术支持服务。

等离子体源技术被广泛应用在半导体、光伏、显示面板、光学镀膜、医疗器械和科研仪器等领域。特别是在半导体领域，等离子体源技术是实现半导体芯片先进制程的必要技术手段。

等离子体电源系统是等离子体源技术的核心载体，其通过电离 CH_3F、HF、Cl_2、NF_3、NH_3等制程气体产生等离子体，在多物理场与化学场的强耦合复杂工况下，通过电源系统参数的精准调控，在极短时间内实现对等离子体密度、均匀性、方向性、能量等方面的精确控制，进而驱动等离子体完成刻蚀、薄膜沉积、离子注入等半导体关键工艺，是先进制程关键工艺设备不可或缺的核心底层部件。

作为半导体领域的核心零部件，等离子体电源系统国产化率较低，市场主要被美国、日本等国际半导体企业占据，根据弗若斯特沙利文统计，2025 年中国大陆半导体领域等离子体射频电源系统国产化率仅 13%；根据 QYResearch 统计，2025 年中国大陆半导体领域远程等离子体源系统的国产化率不足 7%。上述领域是我国亟待发展突破实现自主可控的重点领域之一。

在半导体等离子体电源系统领域，公司是中国大陆产品布局最全面、技术最先进、服务最完善的企业之一。公司自研的多款等离子体电源系统产品已批量应用于我国先进制程芯片产线，填补国内高端等离子体电源系统的应用空白；与此同时，公司完成了多项储备技术与产品研发攻关。



在自研产品方面，公司主要产品包括等离子体射频电源系统、远程等离子体源系统、高压脉冲电源系统等；在等离子体射频电源系统方面，公司产品具有甚高频（最高可达 60MHz）、大功率（最高可达 50kW）等特点，支持多级高频同步脉冲及变频、快速阻抗匹配、多级脉冲匹配、自动功分等功能，适配先进刻蚀、薄膜沉积等工艺；在远程等离子体源系统方面，公司具备自主研发生产其阳极氧化解离腔体的能力，产品具备高洁净度、耐腐蚀、高稳定性、高解离率、高点火成功率等特点，适配先进薄膜沉积、去胶、清洗等工艺；公司高压脉冲电源系统属于新型刻蚀工艺方案电源产品，具有高电压（最高可达 15kV）、大功率（最大可达 120kW）等特点，支持重构脉冲波形、多级高频同步脉冲及变频等功能，适配先进刻蚀等工艺，已经通过国内先进制程芯片产线的工艺验证，更是未来实现 4XX 层级别芯片制程不可或缺的核心配套技术方案之一。

目前，公司自研的产品已批量导入中微公司、拓荆科技、北方华创等国内头部半导体设备厂商，服务于客户 C、客户 A、客户 B、客户 D 等国内头部芯片产线，可适配 14 纳米及以下逻辑芯片、2XX 层及以上存储芯片等先进制程产线，有力推动了我国半导体先进制程关键工艺设备的国产化进程，为我国半导体先进制程“高深宽比”场景下的三维异构集成等前沿技术突破提供核心底层支撑。

在技术支持服务方面，公司已发展成为国内规模领先的等离子体电源系统专业技术支持服务商，为全球主要芯片产线提供等离子体电源系统的检测、维修和性能升级等技术支持服务。在国际贸易冲突持续升级、海外原厂服务收缩的行业背景下，公司有效保障了国内芯片产线的正常运转。目前，公司的技术支持服务已覆盖客户 A、台积电、英特尔、三星电子、SK 海力士、美光科技、德州仪器、客户 B、客户 E、客户 C、客户 D、华润微等国内外主流芯片产线，以及应用材料、中微公司、拓荆科技、北方华创等国内外知名半导体设备厂商。公司系国内少数在该领域同时进入应用材料、英特尔、三星电子、SK 海力士等国际头部厂商供应链的本土企业。

公司凭借较强的技术实力，承担了发改委集成电路专项项目 A、科技部重大专项项目 C 子课题、工信部国家重点小巨人“三新”“一强”推进计划项目 D 等国家级重大科研任务攻关；此外，公司还深度参与了多个发改委集成电路专项项目等，解决我国半导体产业链“卡脖子”领域问题。

公司为国家高新技术企业、国家级专精特新重点小巨人企业，先后获评 2024 年和 2025 年江苏省潜在独角兽企业、2025 年江苏省瞪羚企业；获批建设江苏省等离子源工程技术研究中心、江苏省企业技术中心；同时为中国电子专用设备工业协会会员单位、中国集成电路零部件创新联盟会员单位。公司凭借核心技术实力与全链条服务能力，斩获多项行业权威奖项，并获得头部客户的高度认可：荣获 **2026 年中国证券报“2025 年度新质企业金牛奖（人工智能）”**、2026 年 SEMICON“年度新锐企业奖”、中国 IC 独角兽联盟“2024-2025 中国半导体产线电源领军企业”“2024-2025 中国半导体产线电源最佳解决方案”、2026 年中微公司供应商“合作创新奖”“卓越质量进步奖”、2025 年拓荆科技全球合作伙伴“协作创新奖”、2025 年客户 C 供应商“最佳服务奖”、2025 年格科微零备件组“精诚服务奖”、2025 年研微半导体“锐意新星奖”等。截至报告期末，公司拥有专利 **128** 项，其中**境内**发明专利 **72** 项，软件著作权 **71** 项。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）发行人主要产品

公司主要产品为半导体关键工艺设备核心零部件——等离子体电源系统，包

括等离子体射频电源系统、远程等离子体源系统、高压脉冲电源系统等，并为芯片产线提供相应技术支持服务。

1、产品技术情况介绍

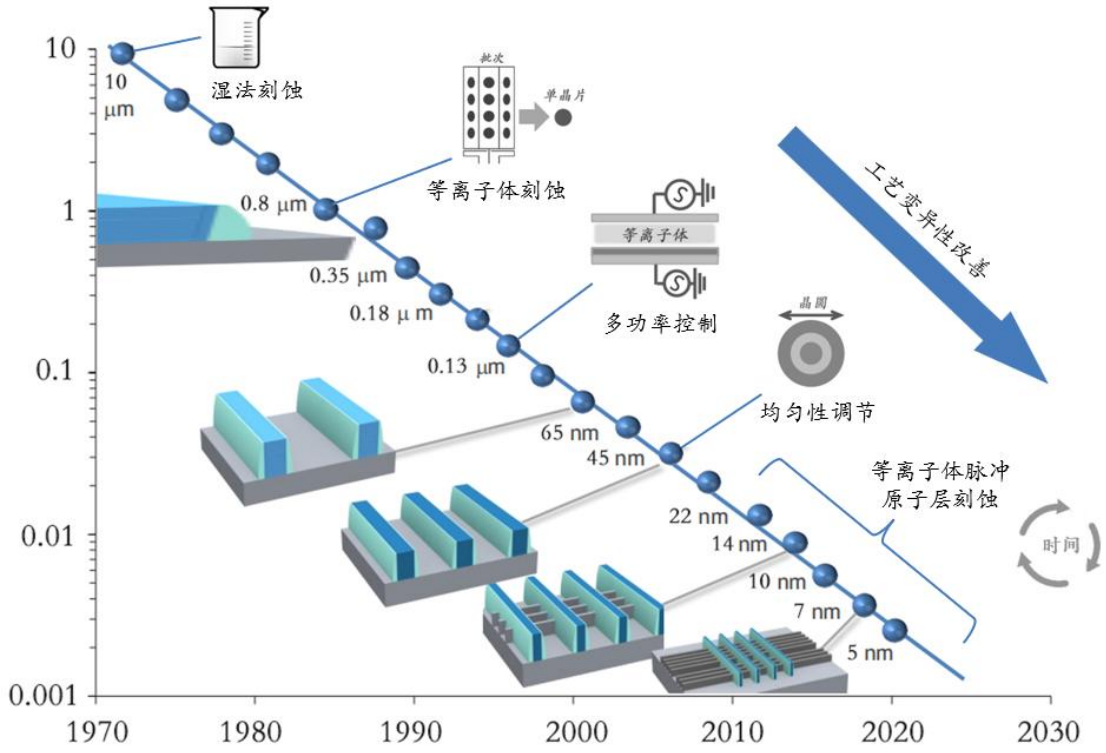
（1）等离子体源技术及应用

等离子体是自然界中区别于固、液和气三态的物质第四态，由带电粒子、中性粒子及自由基等组成，具有高活性、高能量等特殊性质，能够实现半导体制造所需的较为理想的工艺效果。

等离子体主要由半导体设备电源系统对晶圆反应腔室内的制程气体电离产生，直接参与晶圆加工过程。半导体制造早期主要以纯化学工艺为主。但随着行业持续向先进制程发展，晶体管尺寸不断微缩，芯片结构日益复杂，纯化学工艺已经难以满足先进制程的严苛要求，等离子体源技术成为半导体先进制程的最佳选择之一。以刻蚀为例，早期半导体制造中主要采用纯化学工艺——湿法刻蚀，但由于其各向同性的局限性等，难以实现纳米级精度和高深宽比刻蚀，而等离子体刻蚀工艺具备对材料的各向异性和高选择性的定向刻蚀能力，可精准实现纳米级精度及高深宽比刻蚀，在先进制程半导体设备中得到广泛应用。

根据 LAM 报告，其中关于等离子体源技术在半导体刻蚀工艺演进中的作用，主要如下：

等离子体源技术在半导体刻蚀工艺演进中的作用

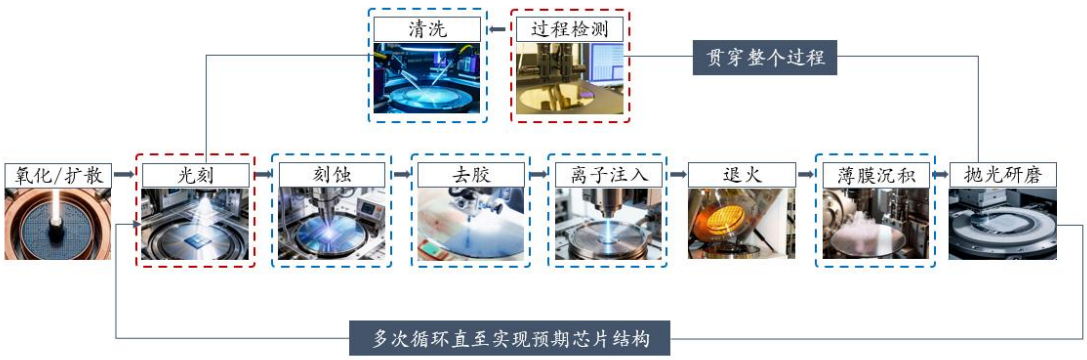


注：根据 LAM 研究报告整理。

目前，等离子体源技术已广泛应用于刻蚀、薄膜沉积、离子注入、去胶、清洗等半导体制造前道工艺环节。此外，在光刻、过程检测等工艺环节中亦有潜在的应用空间。同时，随着先进封装技术的发展，等离子体源技术在后道工艺的应用场景正持续拓展。

未来，随着制程不断演进、芯片结构持续复杂化，等离子体源技术在半导体制造中的关键作用将进一步凸显。

等离子体源技术在半导体前道工艺中的应用及潜在应用



蓝色框体为应用，红色框体为潜在应用

注：根据行业公开信息整理。

（2）等离子体电源系统技术概况

等离子体电源系统系半导体制程中调控等离子体状态与行为的核心部件，承担等离子体“激发与稳定存续”的功能，技术难度较高。其性能直接决定了半导体制造的工艺效果和稳定性，进而影响芯片的量产良率和生产效率，是半导体工艺设备中的核心零部件。

在半导体制造中，等离子体的产生与调控是一个极其复杂的多场耦合过程，涉及电场、磁场、流场等多物理场与化学场的强互相作用，即受功率、频率、波形、同步相位误差等电源系统维度参数影响，也与制程气体成分、流量、压强、温度、腔室结构与材料属性等晶圆反应腔室环境参数密切相关。

随着半导体制程不断演进，刻蚀、薄膜沉积等关键工艺对等离子体的控制精度提出了越来越严苛的要求：等离子体密度、均匀性、方向性、能量等状态的动态调控，需覆盖纳秒级电磁场微观变化至秒级晶圆表面化学反应，时间尺度跨越 9 个数量级；调控动作需与工艺流程实时适配，确保等离子体按预期状态参与晶圆加工反应，稍有偏差即会影响加工质量。特别是在先进制程中，纳米级尺寸、三维复杂结构芯片对工艺波动的容忍度更低，任何参数偏差都可能导致晶圆失效甚至直接损毁。因此，先进制程对等离子体电源系统提出了更高的技术要求。

综上所述，等离子体电源系统系驱动半导体关键工艺的“能量引擎”，其重要性堪比汽车的发动机，为整个半导体制造的可行性和可靠性提供底层支撑。

2、主要产品情况介绍

公司以等离子体源技术为基础，为半导体先进制程产业链提供等离子体电源系统领域的全面解决方案，产品包括等离子体射频电源系统、远程等离子体源系统、高压脉冲电源系统等，并提供全面的技术支持服务。具体如下：

（1）等离子体射频电源系统

等离子体射频电源系统（Radio Frequency System）是半导体设备使用最广泛的等离子体电源系统方案之一，通常集成于刻蚀设备、薄膜沉积设备等半导体工艺设备的晶圆反应腔室附近，原位产生等离子体。

等离子体射频电源系统主要包含射频电源（RF Generator）、阻抗匹配器

（Match），其核心作用系通过产生高频电磁场，将腔室内的特定制程气体电离，产生并维持高活性、特定能量的等离子体，实现对等离子体密度、均匀性、方向性及能量的精准动态控制，完成纳米级精度的复杂晶圆加工。

在等离子体射频电源系统中，射频电源主要负责实时调节输出功率与频率；阻抗匹配器则通过动态调节阻抗匹配网络，实现系统与腔室的阻抗匹配，保障功率最大化传输。半导体先进制程对等离子体电源系统的时间要求极短，其需在纳秒级时间尺度内完成状态感知与参数调控。同时，等离子体阻抗会随状态动态变化，若负载阻抗与系统输出阻抗不匹配，不仅会导致功率传输效率下降，还会产生反射功率造成能量损耗，因此阻抗匹配器需实时匹配系统与负载阻抗，否则将影响制程能力。

在先进制程中，为实现对等离子体的更高程度的控制，普遍采用多频射频电源、阻抗匹配器等协同配置的方案，同时支持连续波与脉冲模式，以满足复杂工艺需求。目前，双频等离子体射频电源系统已成为先进制程刻蚀、薄膜沉积等工艺的主流技术路线之一。

公司等离子体射频电源系统产品主要包括 Advance（APG、AVG 等）、Advocate 等系列射频电源，APD、Focus 等系列阻抗匹配器。产品可适配 14 纳米及以下逻辑芯片、2XX 层及以上存储芯片等先进制程产线，主要情况如下：

产品类型	产品系列	产品特点	产品图示	主要应用工艺
射频电源	Advance 系列	频率覆盖 200kHz-60MHz；大功率特点，最高可达 50kW；支持 4 级脉冲；具备自动变频调谐功能。		高深宽比刻蚀
	Advocate 系列	频率覆盖 200kHz-60MHz；中低功率特点，功率覆盖 1kW-12kW；支持 4 级脉冲；具备自动变频调谐功能。		刻蚀、薄膜沉积
阻抗匹配器	APD 系列	可满足多种频段组合；最快匹配速度可达 0.2s；多频隔离度可达 50dB 以上；数字化控制系统，具备多输出通道集成自动匹配、自动按比例功分等智能化功能，可实现半导体工艺设备一腔多站式应用。		主要配套射频电源使用
	Focus 系列	频率覆盖 400kHz-60MHz，单频或多频应用；可满足连续波/脉冲信号检测和匹配；最快匹配速度可达 0.2s；数字化控制系统，具备双输出通道集成自动匹配、自动按比例功分等智能化功能。		主要配套射频电源使用

此外，针对等离子体射频电源系统，公司自研了配件产品射频传感器、**滤波**

器等。主要情况如下：

产品类型	产品特点	技术定位	产品图示	主要应用工艺
射频传感器	实时监测射频电压、电流、功率、相位和阻抗等参数；检测精度可达±1%；支持连续波和脉冲等波形检测，以及谐波检测。	有效提升系统的状态感知精度与动态调控能力，适配工艺设备一腔多站、多通道功率分配等先进制程应用场景。		主要配套射频电源使用
滤波器	**可精准滤除工艺过程产生的射频干扰，对半导体工艺常用的 400kHz、13.56MHz、27.12MHz、40MHz 等射频频率实现高效抑制，干扰抑制性能可达 40dBc。**	**抑制工艺过程中的射频干扰，保障供电回路纯净度，提升工艺的稳定性和可靠性。**		**主要配套射频电源使用**

（2）远程等离子体源系统

远程等离子体源系统（Remote Plasma Source，RPS）是等离子体源技术在半导体制造领域的另一核心应用。与等离子体射频电源系统原位产生等离子体的方式不同，远程等离子体源系统与晶圆反应腔室采用远程连接设计，通过变压器耦合，在特殊结构的解离腔体内产生并维持工艺所需等离子体，将其中具有活性的中性自由基传输至晶圆反应腔室内参与工艺反应。

在半导体制造中，晶圆反应腔室清洗贯穿整个制造流程。腔室组件随工艺流程推进会残留大量污染物，若不及时清洗，污染物会在工艺中剥离脱落形成颗粒物，严重影响工艺效果与稳定性。早期腔室清洗主要依靠射频电源系统在腔室内原位产生等离子体完成，但高能等离子体在清洗过程中易对腔室组件造成物理轰击与热损伤等，不仅会导致腔室组件加速磨损、使用寿命缩短等，还会产生新的颗粒物污染。

与等离子体射频电源系统相比，远程等离子体源系统是腔室清洗工艺的更优技术方案。其在腔室外远程产生等离子体，将更适配工艺要求的活性中性自由基传输至腔室内参与反应，在提升工艺效果、增强工艺稳定性的同时，可最大程度避免腔室组件被高能等离子体损伤，有效延长组件使用寿命，减少二次颗粒物污染。同时，远程等离子体源系统传输的活性中性自由基不带电，不受腔室内电磁场干扰，能够通过扩散与对流的协同作用传输至腔室及组件的各个位置，实现较为彻底的清洗。

此外，这种远程产生并传输活性中性自由基的方式，可使腔室内维持比常规工艺更低的温度，保障腔室内良好的流动性环境。基于前述优势，远程等离子体源系统的应用场景已逐步拓展至先进刻蚀、薄膜沉积等工艺中。

公司远程等离子体源系统包括 Halation、Central、Major、Pilotage 等系列。产品可适配 14 纳米及以下逻辑芯片、2XX 层及以上存储芯片等先进制程产线，主要情况如下：

产品系列	产品特点	产品图示	主要应用工艺
Halation 系列	基于变压器耦合的模块并联自主均流结构，处理气体流量最大可达 22SLM；先进腔体表面膜层处理工艺，确保腔体长时间稳定运行；高解离率，有效提高工艺效率。		清洗
Central 系列	功率范围 10kW-24kW，处理气体流量最大可达 90SLM；可高效解离 H_2、NF_3等制程气体，并实现低颗粒物。		清洗、薄膜沉积
Major 系列	采用石英腔体能够高效地解离氧气等制程气体；功率最高可达 6kW；功率控制稳定性高，控制精度误差小于 1%；宽点火窗口范围，支持 O_2-N_2混合、O_2-H_2混合等多种制程。		去胶
Pilotage 系列	通过低复合率腔体表面膜层工艺，可以实现高深宽比沟槽的高质量填充；产品结构高度集成，关键参数可视化程度高，可根据客户工艺需求进行灵活定制与功能组合。		清洗、薄膜沉积

（3）高压脉冲电源系统

高压脉冲电源系统是适配高深宽比刻蚀工艺的新型电源方案之一，可与单射频电源协同形成刻蚀电源配套方案，与主流双频等离子体射频电源系统方案形成技术路线互补；该产品由直流电源与脉冲电源模块构成，通过精确控制周期性电流与电压脉冲序列，实现对高深宽比刻蚀工艺的精密调控。

在等离子体刻蚀过程中，正离子在电场作用下高速撞击晶圆表面完成刻蚀。理想的刻蚀效果，需要离子以垂直入射角度、预设能量定向刻蚀晶圆表面材料，因此离子能量与入射角度是决定等离子体刻蚀效果的核心控制参数。

当前先进制程刻蚀的主流方案为双频等离子体射频电源系统。该方案由高频与低频射频电源组合协同驱动等离子体，在晶圆表面施加射频偏置电压，驱动正离子加速轰击晶圆完成刻蚀——其中高频射频电源负责控制离子密度，低频射频电源负责控制离子能量与入射角度。该方案经过长期量产验证，具备成熟度高、

工艺适配范围广等优势，但该方案施加的偏压为正弦波，随时间周期性振荡，会导致等离子体鞘层电场强度同步波动，进而造成离子能量呈周期性起伏、入射角度相对发散，存在一定的工艺局限性。

高压脉冲电源系统协同单射频电源的配套方案，在高深宽比刻蚀场景中具备差异化技术优势：其通过重构脉冲波形，将传统连续正弦波优化为矩形脉冲波形，能在工艺关键阶段瞬时输出强稳定偏压段，使离子牵引电场强度强且恒定，确保高能正离子以近乎垂直的角度轰击晶圆表面，实现更深、更均匀的刻蚀效果。该方案是未来实现 4XX 层级别芯片制程不可或缺的核心配套技术方案之一，在先进刻蚀工艺中具备广阔的应用前景。

公司高压脉冲电源系统采取高压直流电源和高压脉冲电源相组合的方式，包括 NORAH/ETHEL 系列组合。产品可适配 7 纳米及以下逻辑芯片、3XX 层及以上存储芯片等先进制程产线，主要情况如下：

产品系列	产品特点	产品图示	主要应用工艺
NORAH/ ETHEL 系列	产品具有高电压（最高可达 15kV）、大功率（最大可达 120kW）等特点；具备多级脉冲输出能力；具备与射频电源同步能力。	 高压直流电源  高压脉冲电源	高深宽比刻蚀

（4）研发和验证阶段的储备产品

除前述已实现商业化的产品外，报告期内，公司完成了 ESC 吸附电源、ESC 加热电源、溅射电源等多项储备产品的研发布局，相关产品已处于客户验证**或商业化导入**阶段，具体情况如下：

A、ESC 吸附电源

ESC 吸附电源系半导体设备晶圆反应腔室核心部件——静电卡盘（Electrostatic Chuck，简称 ESC）的关键驱动与控制部件，其性能直接决定了 ESC 的表现。

ESC 是腔室的核心功能部件，主要作用为在半导体制程中固定晶圆，抑制晶圆翘曲形变、保障表面平坦度等。晶圆加工过程中，若出现位置偏移、倾斜、翘

曲等情况，将导致镀膜不均、刻蚀偏差等工艺异常，极端情况下甚至会造成晶圆及腔室组件等损毁。

晶圆固定早期多采用机械夹持或真空吸附方案等，普遍存在晶圆受力不均、无法紧贴电极、有效加工区域被遮挡等缺陷。而 ESC 吸附电源通过输出高精度、高稳定性的电压产生的静电力，以此吸附晶圆，使晶圆在全工艺周期内保持位置精准固定、表面高度平整，有效解决了传统固定方式的技术痛点。

公司自研的 ESC 吸附电源 Evan 系列产品，支持单通道/多通道、单极/双极输出，具备晶圆吸附状态检测、极性快速切换等功能，可广泛适配多种半导体前道工艺应用。主要情况如下：

产品系列	产品特点	产品图示	主要应用工艺
Evan 系列	支持单通道/多通道输出、单极/双极输出，输出电压可调节，电压上升速率可设定；具备晶圆吸附检测、微安电流检测、极性切换等智能化功能；支持集成射频滤波器，节省机台空间及成本。		半导体前道工艺

截至本招股说明书签署日，该产品已完成研发工作并通过客户验证，处于商业化导入阶段。

B、ESC 加热电源

ESC 加热电源系 ESC 的关键温控部件，通过对晶圆温度进行精准调控，防止因温控异常引发刻蚀偏差、薄膜应力超标、图形转移偏移等严重工艺缺陷。

公司自研的 ESC 加热电源 FLUX-Heater 系列产品，具有高精度低纹波输出、快速动态响应、宽范围功率可调、多路独立温控、抗强电磁干扰等特点，主要情况如下：

产品系列	产品特点	产品图示	主要应用工艺
FLUX-Heater 系列	产品具备恒压、恒流、恒功率三种工作模式，动态响应快，控制精度高，支持多区独立温控；具备强抗高频电磁干扰能力，适配等离子体工艺复杂电磁环境。		半导体前道工艺

截至本招股说明书签署日，该产品已完成研发工作并通过客户验证，处于商业化导入阶段。

C、溅射电源

溅射电源是适配半导体 PVD 工艺的等离子体直流电源。其工作原理为：通过输出稳定的高压电场，将制程气体电离为等离子体；再利用高能等离子体持续轰击靶材，使靶材原子溅射析出；进而沉积在基片表面形成薄膜。溅射电源是决定 PVD 工艺薄膜质量与沉积效率的核心功能部件。

公司自研的溅射电源 FLUX-Sputter 系列产品，具有高功率输出、低储能、快速电弧管理、支持多台并联等特点，可适配半导体 PVD 工艺。主要情况如下：

产品系列	产品特点	产品图示	主要应用工艺
FLUX-Sputter 系列	产品具备快速电弧管理能力，微秒级响应，主动灭弧，规避了电弧残留对设备的损伤风险；低储能电源架构，严格限制单次异常能量，为靶材、基材和薄膜层提供全方位保护。		薄膜沉积

截至本招股说明书签署日，该产品已完成研发工作，处于客户验证阶段。

3、技术支持服务

公司主要为芯片产线提供等离子体电源系统相关的技术支持服务；当产线设备中的电源系统出现老化、失准、损毁，或存在性能升级需求时，公司为其提供专业的检测、校准、维修和性能升级等服务。

（1）技术支持服务的必要性

半导体制造的核心目标为生产效率最大化、产线运行高稳定性、工艺参数一致性可控。为满足半导体行业“精确复制（Copy Exactly）”的要求，产线设备一旦定型，不得随意更换内部核心零部件。

对于存量芯片产线中刻蚀设备、薄膜沉积设备等现役设备，若其核心零部件——等离子体电源系统出现老化、失准、损毁等情况，轻则导致芯片量产良率和生产效率下降，重则引发整条产线停机停产，威胁产线的安全稳定生产，造成较大经济损失。同时，芯片产线普遍采用 24 小时不间断连续生产模式，等离子体电源系统长期处于满负荷饱和运行状态，在高压工况与高频运行负荷的双重影响下，天然具备物理损耗快、性能易衰减、参数易失准的特性。

因此，芯片产线对等离子体电源系统相关的专业、及时、精准的技术支持服务，存在刚性、持续、旺盛的市场需求。

（2）技术支持服务的急迫性

当前，等离子体电源系统系我国半导体设备零部件领域国产化率较低的细分赛道，目前尚处于关键技术突破阶段。受产业发展历史因素影响，国内存量芯片产线现役设备配套的等离子体电源系统，仍以美国 MKS、AE 等海外品牌为主。

近年来，随着国际贸易冲突持续加剧，美国 MKS 和 AE 等海外原厂技术支持服务团队逐渐撤出中国大陆市场，国内芯片产线面临严峻的服务断供风险，亟需本土技术支持服务商填补市场缺口，保障芯片产线的安全稳定运行。

而快速填补相关市场需求缺口并非一蹴而就，国内技术支持服务团队需通过长期技术积累，对现役设备中各类品牌、型号的等离子体电源系统，在产品结构、技术原理、工艺适配等方面形成全方位的深度理解，才能胜任为国内芯片产线破解“停机风险”、保障我国半导体产业链安全稳定发展的行业责任。

（3）技术支持服务的持续性

近年来，随着全球芯片制造产能不断向中国大陆转移，刻蚀设备、薄膜沉积设备等半导体关键工艺设备的装机量不断提升，直接带动配套等离子体电源系统装机规模快速扩大，进而拉动相关技术支持服务需求的持续增长。此外，半导体设备行业属于重资产投资，存在受行业周期波动等影响，而存量现役等离子体电源系统的技术支持服务需求稳定、持续性强，相关业务可为公司提供穿越行业周期的有力支撑。

（4）公司技术支持服务情况

公司通过长期的行业深耕与技术积累，已经发展为国内规模领先的等离子体电源系统专业技术支持服务商，服务能力覆盖行业几乎全部主流品牌及型号产品，可为芯片产线客户提供等离子体射频电源系统、远程等离子体源系统等各类电源系统的专业技术支持服务。针对产线设备电源系统出现失准、老化、损毁等问题，公司可提供检测、维修等服务，快速恢复其正常运行；针对产线因工艺迭代、产品换型等产生的制程调整需求，公司可对相关电源系统进行定制化性能升级，精准匹配客户要求。

目前，公司的技术支持服务已覆盖客户 A、台积电、英特尔、三星电子、SK 海力士、美光科技、德州仪器、客户 B、客户 E、客户 C、客户 D、士兰微、华

润微、长电科技等国内外主流芯片产线，以及应用材料、中微公司、拓荆科技、北方华创等国内外知名半导体设备厂商。公司是中国大陆地区少数进入美国、韩国等半导体巨头供应链的本土企业之一。

在海外原厂服务能力收缩的行业背景下，公司持续为国内芯片产线提供稳定、高效的等离子体电源系统技术支持服务，切实承担起保障国内芯片产线稳定运行、维护半导体产业链供应链安全的重要责任。

4、权威机构与头部客户认可情况

（1）中国电子专用设备工业协会

中国电子专用设备工业协会组织评审，对公司的科研成果“高深宽比等离子体刻蚀设备用多级脉冲射频电源”出具了《科学技术成果鉴定证书》（中电专设鉴字〔2026〕第 01 号），形成鉴定意见为：“项目针对多级脉冲射频电源高功率、高稳定性等技术瓶颈，结合高深宽比刻蚀设备制程的应用需求，研制了多级脉冲射频电源产品。项目成果配套国内头部半导体设备供应商，并在国内主流生产线批量应用，实现了进口替代，解决了高深宽比刻蚀设备关键核心部件的“卡脖子”问题。项目成果填补了国内空白，主要技术指标达到国际同类产品先进水平。”

（2）中国电工技术学会

中国电工技术学会组织院士领衔的专家组评审，对公司的科研成果“半导体芯片制程用高解离率高稳定性耐腐蚀远程等离子体源关键技术及应用”出具了《科学技术成果鉴定证书》（电技鉴字〔2025〕第 164 号），形成鉴定意见如下：“项目针对远程等离子体源高解离率、高稳定性、可靠激发以及耐腐蚀阳极氧化膜等技术瓶颈，结合半导体芯片不同制程工艺应用的技术需求，研制了系列化远程等离子体源产品。该项目成果填补了国内空白，整体技术达到国际先进水平，其中远程等离子体源功率稳定控制和脉冲均流阳极氧化技术处于国际领先水平。”

（3）中微公司

中微公司出具的证明，主要如下：

项目	具体表述

项目	具体表述
《江苏神州半导体科技股份有限公司阻抗匹配器（Match）技术水平评估与应用证明》	神州半导体提供的阻抗匹配器（Match），系列产品总体性能达到国际同类产品同等水平，关键技术参数对齐国际同类产品，实现了对国际品牌的国产化替代。系列阻抗匹配器（Match）已安装于我司刻蚀设备、薄膜沉积设备、物理气相沉积设备，在多种工艺制程上实现了在客户端的稳定测试。某款型号 Match 应用于刻蚀设备，产品总体性能达到国际同类产品同等水平。某款型号 Match 应用于薄膜沉积设备，产品整体技术指标满足客户需求，具有行业内先进水平。
《江苏神州半导体科技股份有限公司射频功率发生器（RFG）技术水平评估与应用证明》	神州半导体提供的射频功率发生器（RF Generator），系列产品总体性能达到国际同类产品同等水平，关键技术参数对齐国际同类产品，实现了对国际品牌的国产化替代。多款型号射频功率发生器（RF Generator）已批量安装于我司等离子体刻蚀设备，客户端相关产品线已使用该设备实现量产。
《江苏神州半导体科技股份有限公司远程等离子体源（RPS）技术水平评估与应用证明》	神州半导体提供的远程等离子体源（RPS），系列产品总体性能达到国际同类产品水平，部分关键技术参数已领先国际同类产品水平，实现了对国际品牌的国产化替代。多款型号远程等离子体源（RPS）已批量安装于我司刻蚀设备、薄膜沉积设备，在多种工艺制程上实现了在客户端的稳定量产。

（4）拓荆科技

拓荆科技出具的证明，主要如下：

项目	具体表述
《江苏神州半导体科技股份有限公司远程等离子体源（RPS）技术水平评估与应用证明》	神州半导体自主研发系列 RPS，产品具备突出的先进性，系列产品总体性能达到国际同类产品水平，关键技术参数可对标国际同类产品水平。多款型号 RPS 已应用于我司等离子体增强化学气相沉积设备、原子层沉积设备、高密度等离子体化学气相沉积设备、流动性化学气相沉积设备，在多种工艺制程上实现了在客户端的稳定量产。

（5）北方华创

根据北方华创证明：“神州半导体为我司提供的多款型号远程等离子体源系统在我司 CVD、PVD 机台上均有应用及订单交付”。

（三）发行人主营业务收入的主要构成及特征

发行人主营业务收入的主要构成情况参见本招股说明书“第六节/十/（一）/2、”。

（四）发行人主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事半导体关键工艺设备核心零部件的设计、生产、销售和技术支

持服务等。报告期内，公司主营业务收入及利润主要来源于相应业务。

2、采购模式

公司自研产品业务主要采购的原材料包括定制结构件、电容、功率器件、腔体、电子料件等。公司综合考虑技术参数、客户需求、产品交期等因素，在研发时，即对相关原材料进行选型，并在研发过程中，与上游供应商合作进行设计调整，以不断提高产品的性能和品质。公司建立了严格的合格供应商制度，对于同一种原材料，一般也会保持多家供应商合作。

公司技术支持服务业务采购的主要材料系电源系统备机。产线上存量的等离子体电源系统若发生故障，客户可能会要求公司在短时间内迅速提供相同型号的产品，以尽快恢复生产。因此，为满足客户需求，公司会事先采购部分主流型号的电源系统备机备用。若客户出现即时需求，公司可以先提供备机，优先保障客户恢复生产，再对替换下来的故障电源系统进行维修。上述电源系统备机供应充足稳定，公司一般会根据客户需求情况进行采购，保持一定的安全库存。

3、生产模式

公司主要采取“以销定产”的生产模式，通过自主生产与委外加工相结合的方式从事生产活动。获取订单后，公司进行订单审评，综合评估技术方案、物料库存、产能状况及交付周期等，形成可行的生产计划。其中对于通用性较强的标准产品或组件，公司会结合销售预测进行适度的安全库存生产，以快速响应客户紧急需求。

对于涉及产品性能、可靠性与软件算法的关键生产环节，如精密电路组装后的功能测试、核心软件烧录与校准、模块级与整机级的性能调试、可靠性测试以及最终的系统集成与验证等，公司均自行生产完成以确保技术秘密的安全与产品品质的一致性与高标准。

为优化资源配置、提升生产效率，公司将部分工艺成熟、标准化程度高或需特殊设备或资质的非核心工序，如标准 PCB 板 SMT 贴装、钣金件加工、线缆组件加工等委托给合格供应商完成。公司对合格供应商实行严格管理，确保质量完全符合公司技术标准。

4、销售模式

公司产品销售主要采取直销模式，下游主要为国内外知名芯片产线客户和半导体设备厂商。

对于自研产品业务，公司直接向下游客户销售自主研发的等离子体电源系统。半导体行业对供应商的遴选要求较为严苛，公司需经过客户严格的调查评估、验厂考察等认证程序，才能进入客户的合格供应商体系或目录。在与客户合作对接过程中，公司销售、研发、生产等部门与客户开展深入沟通，洽谈和确定客户需求信息，拟定合适方案。公司根据正式订单及客户预测相结合的方式进行排产，并按交货期向客户交付。

对于技术支持服务业务，公司一般会与客户签订合作框架协议，对于具体的需求，下游客户向公司进行询价，公司会根据等离子体电源系统的不同型号情况、故障情况向客户报价，双方达成一致后，公司为下游客户提供技术支持服务，并收取服务相应的对价。

此外，主要客户中微公司基于自身安全库存、生产计划及发行人产品产业化成熟度出发，于 2025 年开始，部分业务以“寄售”模式开展，即公司按中微公司需求，将产品送至指定地点，中微公司在领用时完成验收并出具验收单，验收时间与领用时间一致。“寄售”模式只在发货安排、发货时点上与一般销售模式存在区别，而发出商品、存货管理、收入确认政策、账期、质保期等方面，与一般销售模式完全一致。

5、研发模式

公司研发活动采用科研项目立项制，研发活动在开展前均需经过公司立项评审。公司研发活动由研发部门主导，研发活动具体包括项目立项阶段、项目实施阶段、项目结题验收阶段。研发部门牵头组织项目团队并进行研发项目立项，项目团队负责研发活动的具体实施工作，项目设计完成后研发部门组织相关人员进行评审，评审通过后对设计成果进行试制。当达到验收状态时，公司组织相关部门人员根据项目开发内容与项目验收标准进行项目验收，验收通过后研发项目结项。

（五）发行人业务发展过程、主要产品的演变情况

1、创始团队初创期（2001 年至 2015 年）

公司创始团队于 2001 年成立了扬州神州，成立初期主要从事 DVD 光盘生产设备的射频电源维修服务，并逐步切入至半导体领域，为芯片产线提供等离子体电源系统的维修服务，系中国大陆最早从事等离子体电源系统技术支持服务的本土团队之一。

创始团队凭借过硬的技术和优质的服务，逐步实现下游知名客户突破，从 2009 年起先后进入客户 A、客户 B、客户 E、索尼、士兰微、长电科技、SK 海力士、京东方、德州仪器、华星光电、三安光电、东芝、三星电子等企业的技术支持服务供应链。创始团队通过长期积累，搭建了覆盖主流品牌、型号等离子体电源系统的综合测试平台，2015 年以扬州神州为主体承接并完成了科技部国家火炬计划项目《等离子电源测试公共服务平台》。

2、技术突破期（2016 年至 2019 年）

2016 年，创始团队设立神州有限，开始深耕等离子体电源系统及其核心器件的自主研发创新，完成了从技术支持服务商向整体解决方案供应商的转变。

2017 年，公司发布首款自研产品，用于半导体芯片制造的后道工艺，实现自研产品零的突破，客户覆盖长电科技等知名企业。同时，在技术支持服务领域，公司进一步扩大自身行业影响力，先后进入了应用材料、武汉新芯、英特尔、晶合集成等知名客户的供应链。

3、高速发展期（2020 年至 2024 年）

2020 年起，全球贸易形势日趋严峻，为化解国内先进制程产线技术支持服务的断供风险。公司凭借过硬的技术积累和行业口碑，先后为客户 D、客户 C 等客户提供技术支持服务，承担起海外原厂技术支持服务团队撤出后的“保供”重任。

在自研产品方面，为推进先进制程等离子体电源系统的国产化进程，公司厚积薄发，先后发布了包括远程等离子体源系统、等离子体射频电源系统等在内的多款自研产品，应用于刻蚀设备、薄膜沉积设备等半导体前道关键工艺设备，客

户覆盖中微公司、拓荆科技、北方华创等国内头部半导体设备企业。

基于在该领域的技术实力和市场影响力，公司在此期间承担了科技部重大专项项目 C 子课题、工信部国家重点小巨人“三新”“一强”推进计划项目 D 等国家级重大科研任务攻关，并参与完成了多项发改委集成电路专项项目等。

基于公司在等离子体电源系统领域的高速发展以及在半导体制造产业链中的关键地位，2024 年 12 月，公司获得了国家大基金二期的投资认可，标志着公司的发展进入新时期。

4、发展新时期（2025 年至今）

时至今日，公司已进入发展新时期。公司将继续瞄准世界半导体技术前沿，坚持自主研发创新，以先进制程等离子体电源系统自研产品业务与全方位技术支持服务为双轮驱动：

在自研产品方面，公司等离子体射频电源系统、远程等离子体源系统、高压脉冲电源系统均实现商业化落地。2025 年，公司自研产品收入已超过 3.5 亿元且超过同期主营业务收入的 50%，客户覆盖中微公司、拓荆科技、北方华创等国内头部半导体设备厂商，服务于客户 C、客户 A、客户 B、客户 D 等国内头部芯片产线，产品可适配 14 纳米及以下逻辑芯片、2XX 层及以上存储芯片等先进制程产线。

在技术支持服务方面，公司已成为中国大陆市场规模领先的国内技术支持服务商。公司的技术支持服务已覆盖客户 A、台积电、英特尔、三星电子、SK 海力士、美光科技、德州仪器、客户 B、客户 E、客户 C、客户 D、华润微等国内外主流芯片产线，以及应用材料、中微公司、拓荆科技、北方华创等国内外知名半导体设备厂商。

公司凭借较强的技术实力，承担了发改委集成电路专项项目 A 等，并获得了 **2026 年中国证券报“2025 年度新质企业金牛奖（人工智能）”**、2026 年 SEMICON“年度新锐企业奖”、2026 年中微公司供应商“合作创新奖”“卓越质量进步奖”、2025 年拓荆科技全球合作伙伴“协作创新奖”、2025 年客户 C 供应商“最佳服务奖”等重要荣誉。

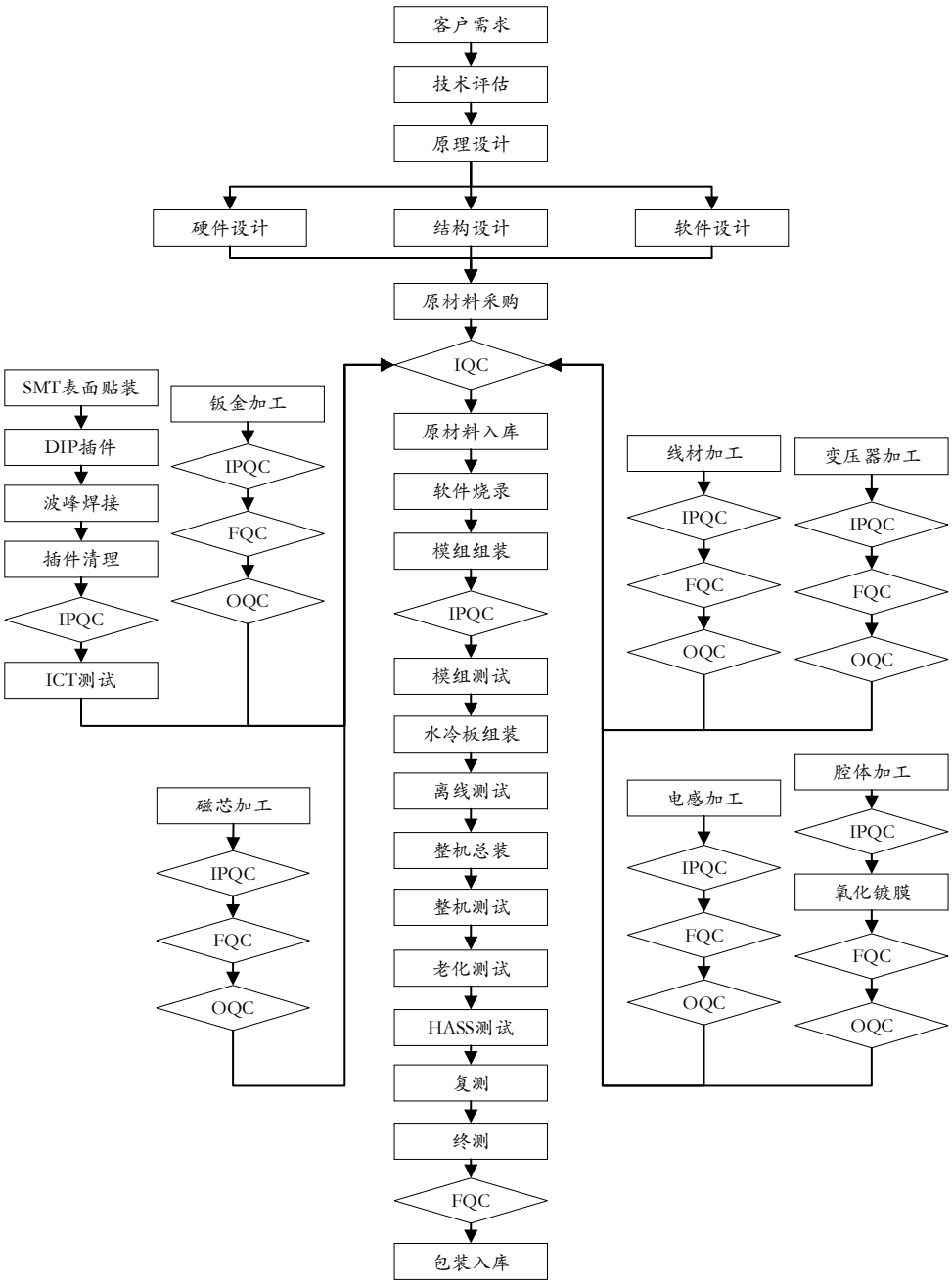
未来，公司将在保障国内存量芯片产线稳定运行的同时，以持之以恒的创新

精神助力我国半导体制造的国产化进程，为提升我国半导体产业链供应链韧性与安全水平提供核心支撑；并与产业链下游紧密合作，通过持续高强度的研发投入，对半导体行业的“无人区”领域进行探索和攻关。

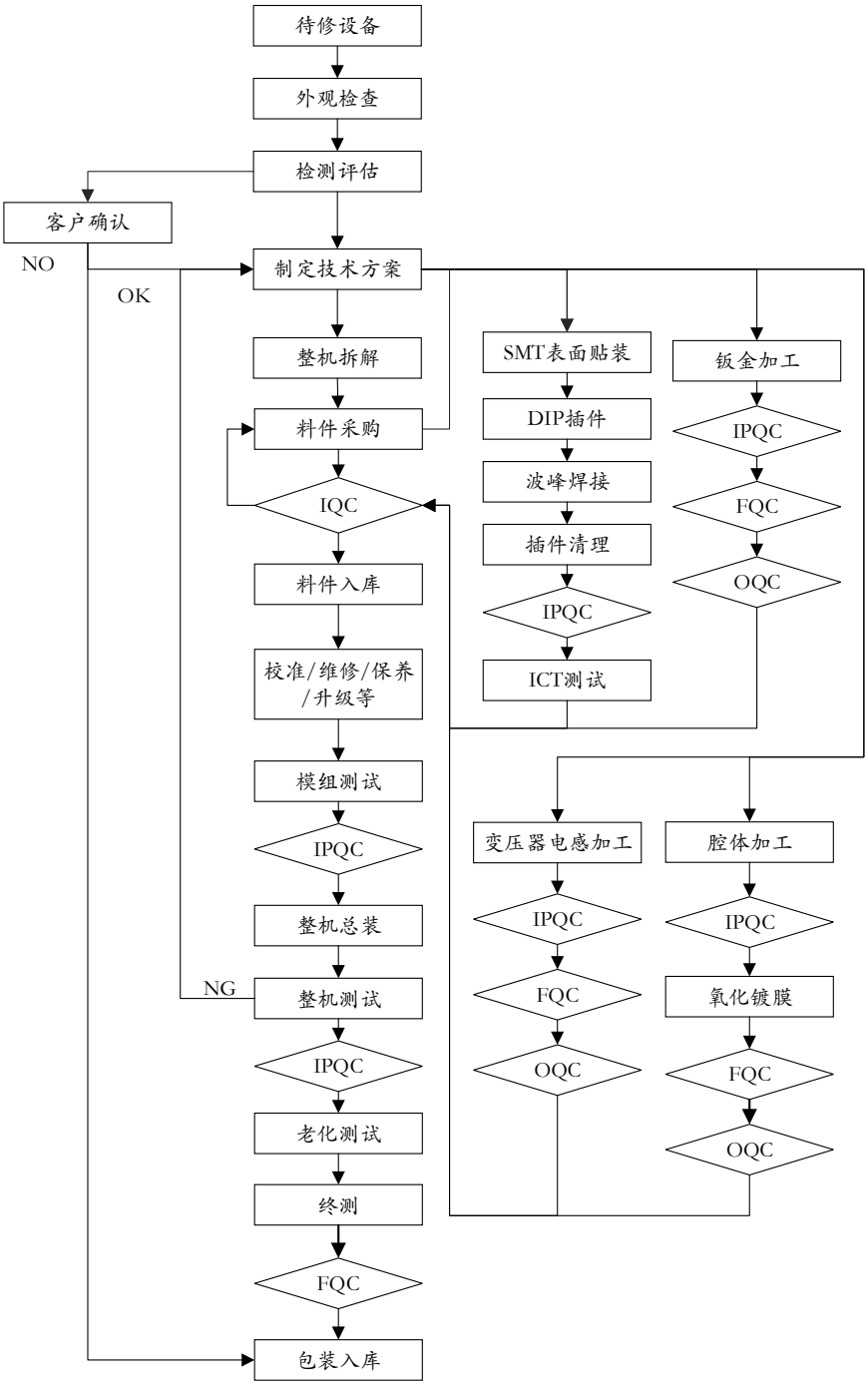
（六）发行人主要产品的工艺流程图

公司业务主要包括自研产品和技术支持服务，具体产品及服务的工艺流程图，主要如下：

1、自研产品



2、技术支持服务



（七）主要业务指标及其变动情况

发行人主要业务指标及其变动情况参见本招股说明书“第五节/三/（二）”。

（八）发行人主营业务符合产业政策和国家经济发展战略情况

1、产业政策和国家经济发展战略情况

2026 年 3 月，第十四届全国人民代表大会第四次会议审议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，明确提出要聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节，全链条推动集成电路等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破；同期会议听取并审议了国务院《2026 年政府工作报告》，报告明确提出要培育壮大新兴产业和未来产业，打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业。

2025 年 8 月，工信部、市场监督管理总局发布《电子信息制造业 2025－2026 年稳增长行动方案》，明确支持集成电路等领域科技创新，支持先进存储、三维异构集成芯片等前沿技术方向基础研究，坚定不移推动“国货国用”，持续推动短板产业补链、强化关键核心技术攻关，提升元器件、零部件等产品可靠性、安全性。

2024 年 7 月，二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》，明确要求加快构建自主可控的产业链供应链，针对集成电路等重点领域健全发展机制，推动全链条技术攻关与成果转化。

半导体行业遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的行业规律，关键技术突破孕育关键工艺升级，进而驱动半导体产业链全链条迭代升级。半导体设备是实现关键技术突破、落地关键工艺升级的核心载体，而核心零部件直接决定设备性能上限与运行可靠性，是产业链的基础支撑。因此，半导体核心零部件的自主可控与技术突破，直接关乎我国半导体产业链发展质量与安全，也是产业链中典型的“卡脖子”环节。

包括等离子体射频电源系统、远程等离子体源系统等在内的等离子体电源系统，是半导体工艺设备的“动力核心”与“控制中枢”，其性能直接决定制程的实现效果与运行稳定性，进而影响终端芯片的产品质量与量产良率，是支撑半导体产业发展的关键基础部件。然而，我国半导体等离子体电源系统市场长期被美国、日本等国际半导体企业垄断，根据弗若斯特沙利文统计，2025 年中国大陆半导体领域等离子体射频电源系统国产化率仅 13%，相关市场主要被 MKS、AE、

DAIHEN 等占据；根据 QYResearch 统计，2025 年中国大陆半导体领域远程等离子体源系统的国产化率不足 7%，主要被 MKS、AE、NPP 等占据。

现阶段，我国先进制程芯片产线中使用的等离子体电源系统等设备核心零部件，仍以海外厂商产品为主。随着美国、日本等国家对中国大陆半导体产业的出口限制持续升级，国内头部半导体设备厂商和芯片产线，已难以获取海外厂商先进制程配套的电源系统及原厂技术支持服务，国内半导体芯片产线随时面临技术迭代滞后、停产停线等重大风险，已成为制约我国半导体产业链供应链安全的“卡脖子”威胁。

2、公司主营业务符合产业政策和国家经济发展战略

公司自设立以来，始终瞄准世界半导体技术前沿，坚持自主研发创新，以先进制程等离子体电源系统自研产品业务与全方位技术支持服务为双轮驱动，在保障国内存量芯片产线稳定运行的同时，持续加速等离子体电源系统等半导体核心零部件的国产化进程，为提升我国半导体产业链供应链韧性与安全水平提供核心支撑，与国家产业扶持政策、经济发展战略形成高度契合。

在保障存量产线稳定运行方面，公司凭借深厚的技术积淀，有效填补了国际原厂技术支持服务收缩形成的市场缺口，为国内芯片产线破解“停机风险”、保障产业安全稳定发展提供关键支撑。目前，公司的技术支持服务已覆盖客户 A、台积电、英特尔、三星电子、SK 海力士、美光科技、德州仪器、客户 B、客户 E、客户 C、客户 D、华润微等国内外主流芯片产线，以及应用材料、中微公司、拓荆科技、北方华创等国内外知名半导体设备厂商。公司在长期技术支持服务中，持续积累一线经验、深化技术研发，针对等离子体电源系统及其上游关键器件、模组开展国产化创新，既保障了国内芯片产线的安全稳定生产，又能紧扣一线客户的使用痛点开展靶向技术升级。

在推进核心零部件国产化进程方面，公司成功填补国产半导体设备高端等离子体电源系统的应用空白；在远程等离子体源系统方面，公司具备自主研发生产其阳极氧化解离腔体的能力，产品具备高洁净度、耐腐蚀、高稳定性、高解离率、高点火成功率等特点，适配先进薄膜沉积、去胶、清洗等工艺，打破该领域国际品牌的长期垄断格局；在等离子体射频电源系统方面，公司 2024 年成功研发的

等离子体射频电源系统，具备甚高频（最高可达 60MHz）、大功率（最高可达 50kW）等特点，性能全面对标国际品牌同类产品。目前，公司自研产品已批量导入国内头部设备厂商，服务于国内头部芯片产线，可适配 14 纳米及以下逻辑芯片、2XX 层及以上存储芯片等先进制程产线，有力推动了我国半导体先进制程关键工艺设备的国产化进程。

依托深厚的技术积累，公司通过承担国家重大科研任务、开展核心领域技术攻关，以及与产业链协同合作等方式，持续布局半导体前沿技术研发。报告期内，公司成功研发出适配高深宽比刻蚀工艺的高压脉冲电源系统，该产品已通过国内先进制程芯片产线的工艺验证，是未来实现 4XX 层级别芯片制程不可或缺的核心配套技术方案之一，为我国半导体先进制程“高深宽比”场景下的三维异构集成等前沿技术突破提供核心底层支撑。此外，公司完成了 ESC 吸附电源、ESC 加热电源、溅射电源等多项储备产品研发，进一步丰富了公司自研产品矩阵。

通过持续技术创新，公司实现了从技术突破、产品落地到产品矩阵多元拓展的跨越式发展，积极为我国半导体产业提供自主可控的核心零部件产品，为我国半导体制造关键技术自主可控构筑坚实保障。

综上所述，公司通过向我国半导体产业链提供等离子体电源系统全面解决方案，既保障芯片产线安全稳定运转，又深度参与先进制程核心技术突破，助力国内半导体关键工艺设备国产化，以实际行动筑牢我国半导体产业链安全屏障。公司主营业务与国家产业政策及经济发展战略高度契合。

二、发行人所处行业的情况

（一）所处行业及确定所属行业的依据

公司主要从事半导体关键工艺设备核心零部件的研发、生产、销售和技术支持服务等，主要产品为等离子体电源系统和技术支持服务等，主要应用于半导体设备领域。

公司所处行业根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》隶属于“C35 专用设备制造业”之“C3562 半导体器件专用设备制造”；根据《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》隶属于“新一代信息技术产业（1）”之“电子核心产业（1.2）”之“新型电子元器件及设备制造（1.2.1）”；根据《上海证券交

易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》，隶属于“（一）新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等”之“半导体和集成电路”行业。

国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，将“集成电路装备及关键零部件制造”列为“鼓励类”产业，公司所处行业属于该领域；

工信部等发布的《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024 年版）》，其中列明“应用于 12 英寸 28 纳米及以下先进制程的关键层刻蚀等离子干法刻蚀机，以及关键层沉积的化学气相沉积设备、物理气相沉积设备”为促进首台（套）重大技术装备创新发展和推广应用领域。公司产品等离子体射频电源系统、远程等离子体源系统、高压脉冲电源系统等均为刻蚀、薄膜沉积设备的关键技术部件，并可适配于 12 英寸 28 纳米及以下先进制程芯片产线；

国家产业基础专家委员会编制的《产业基础创新发展目录（2021 年版）》，将“射频滤波器”、“射频功率放大器”列为信息通信设备领域的基础零部件和元器件。射频功率放大器、射频滤波器等均系公司产品等离子体射频电源系统的主要模块，相应模块均为公司自主研发。

此外，公司不属于金融科技、模式创新企业，或房地产和主要从事金融、投资类业务的企业，不属于限制或禁止在科创板发行上市的行业领域。

综上所述，公司符合科技创新行业领域鼓励范畴。

（二）所处行业主管部门及监管体制和行业政策、行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响

1、行业主管部门及监管体制

公司所处行业由国家有关部门进行宏观调控管理，行业协会进行自律管理，行业无准入限制。

公司所属行业主管部门主要包括发改委、工信部、科技部等。发改委主要负责研究制定产业政策、行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。工信部主要职责为拟定

实施行业规划、产业政策及标准，监测工业企业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，指导推进信息化建设等。科技部主要负责拟订国家创新驱动发展战略方针，牵头组织统一的国内科技管理平台与科研项目资金协调、评估、监管机制，推动并监督科技成果转移转化及产学研结合工作，统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革等。

公司所处行业的自律性组织主要为中国半导体行业协会、中国电子专用设备工业协会、中国电工技术学会等，通过研究行业发展状况、制定行业发展规划、组织开展国内外技术交流合作等方式维护行业公平竞争，促进行业健康发展。

2、行业主要法律法规及产业政策

法规及政策名称	颁布部门	主要内容	发布时间
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	第十四届全国人民代表大会第四次会议	聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节，全链条推动集成电路等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。超常规布局人工智能、集成电路等新兴领域急需学科专业，深入实施基础学科和交叉学科突破计划。	2026年3月
《2026年政府工作报告》	国务院	培育壮大新兴产业和未来产业。打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业。培育发展未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。	2026年3月
《电子信息制造业2025－2026年稳增长行动方案》	工信部、市场监督管理总局	通过国家重点研发计划相关领域重点专项，持续支持集成电路等领域科技创新。支持先进存储、三维异构集成芯片等前沿技术方向基础研究。坚定不移推动“国货国用”，持续推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，加大对产业链关键企业的政策支持，强化关键核心技术攻关，提升重点产业链供应链韧性和安全水平。通过集成应用牵引，提高系统整体能力，提升元器件、零部件等产品可靠性、安全性。	2025年8月
《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》	工信部	应用于12寸产线28纳米以下先进制程的关键层刻蚀等离子干法刻蚀机，以及关键层沉积的化学气相沉积设备、物理气相沉积设备”为促进首台（套）重大技术装备创新发展和推广应用。	2024年9月
《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》	二十届中央委员会第三次全体会议	健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。	2024年7月
《产业结构调整指导目录（2024年版）》	发改委	制定了鼓励、限制和淘汰三类目录。集成电路设计，集成电路线宽小于65纳米（含）的逻辑电路、存储器生产，线宽小于0.25微米（含）的特色工艺集成电路生产（含掩模版、8英寸及以上硅片生产），集成电路线宽小于0.5微米（含）的化合物集成电路生产，集成电路装备及关键零部件制造为鼓励类	2024年2月

法规及政策名称	颁布部门	主要内容	发布时间
		目录。	
《制造业可靠性提升实施意见》	工信部等5部门	“聚焦核心基础零部件和元器件，着力突破重点行业可靠性短板弱项，聚焦电子等行业，实施基础产品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基础零部件、核心基础元器件、关键基础软件、关键基础材料及先进基础工艺的可靠性水平。”	2023年6月
《质量强国建设纲要》	国务院	推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。大力发展高质量通用智能装备，提高电子等产品及其基础零部件、元器件可靠性水平，促进品质升级。	2023年2月
《“十四五”数字经济发展规划》	国务院	着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力，完善集成电路等重点产业供应链体系。	2021年12月
《“十四五”智能制造发展规划》	发改委、工信部等8部门	大力发展智能制造装备，突破一批“卡脖子”基础零部件和装置。带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级，研制一批国际先进的新型智能制造装备。研发极大规模集成电路制造成套装备等。	2021年12月
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	第十三届全国人民代表大会第四次会议	加强原创性引领性科技攻关，瞄准人工智能、量子信息、集成电路等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。深入实施智能制造，推动制造业高端化绿色化。推动集成电路等产业创新发展。	2021年3月

3、行业主要法律法规及产业政策对发行人经营发展的影响

公司主营业务属于科创板支持行业领域，符合国家需要推动、加大攻关和示范应用的行业，国家诸多扶持政策和法规的出台和落实，明确相关行业在我国经济发展中的重要地位，促进了产业的高质量发展，为企业提供了健全的市场体制，营造了良好的经营环境，有利于公司业务的持续发展。

（三）行业基本情况、技术水平及特点、行业发展态势

1、半导体与集成电路

（1）半导体与集成电路概况

半导体是指在常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，常见的半导体包括硅、锗等元素半导体及砷化镓、碳化硅、氮化镓等化合物半导体，半导体产品广泛应用于消费电子、人工智能、云计算、新能源、工业、军工、医疗等国民经济核心领域，是现代电子信息产业的底层基础支撑。按产品来划分，半导体产品可分为集成电路、分立器件、光电器件和传感器，根据 WSTS 统计，**2025** 年全球半导体市场规模为 **7,956** 亿美元，集成电路、光电器件、分立器件和传感器

的市场规模分别为 7,010 亿美元、430 亿美元、307 亿美元和 209 亿美元，集成电路占比约 88%，是半导体产业的核心组成部分。

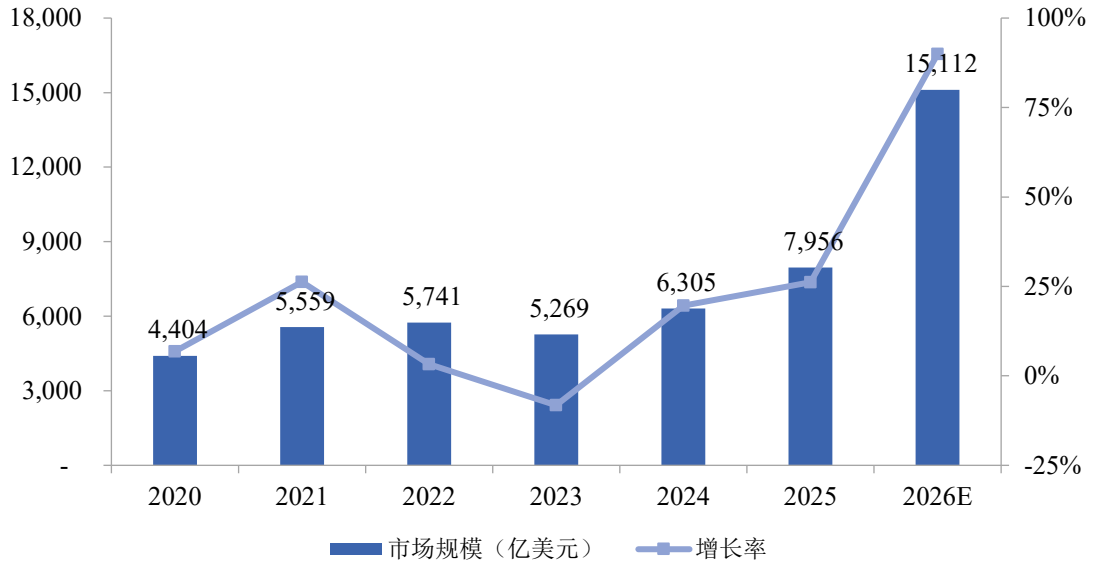
集成电路也称为芯片，是通过半导体制程工艺，将数以亿计的晶体管、二极管等半导体器件，与电阻、电容、电感等电子元件集成并封装在小块基板内，具备复杂电路功能的微型电子器件。集成电路按功能主要分为存储芯片、逻辑芯片、模拟芯片和微处理器等，根据 WSTS 统计，2025 年全球集成电路 7,010 亿美元的市场规模中，逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片和微处理器的市场规模分别为 2,995 亿美元、2,300 亿美元、865 亿美元和 849 亿美元。

半导体产业链可按照主要生产环节划分为三类：上游半导体支撑产业、中游制造产业、下游应用产业，具体内容详见本招股说明书“第五节/二/（四）”。

（2）半导体与集成电路市场情况

当前，全球半导体产业已进入由人工智能、云计算、大数据、高速通信等技术驱动的新一轮成长阶段，持续推动通用人工智能（AGI）、AI 终端、具身智能、自动驾驶等创新应用的商业化落地进程。根据 WSTS 数据，2020 年至 2025 年，全球半导体市场规模从 4,404 亿美元增长至 7,956 亿美元，复合增长率为 13%。在人工智能产业快速发展的推动下，AI 大模型、智算中心、云服务基础设施和 AI 终端等应用场景需求持续扩容，算力芯片、存力芯片的市场需求将保持长期增长态势；根据 WSTS 预计，到 2026 年全球半导体市场规模将达到 15,112 亿美元，同比增长 90%。

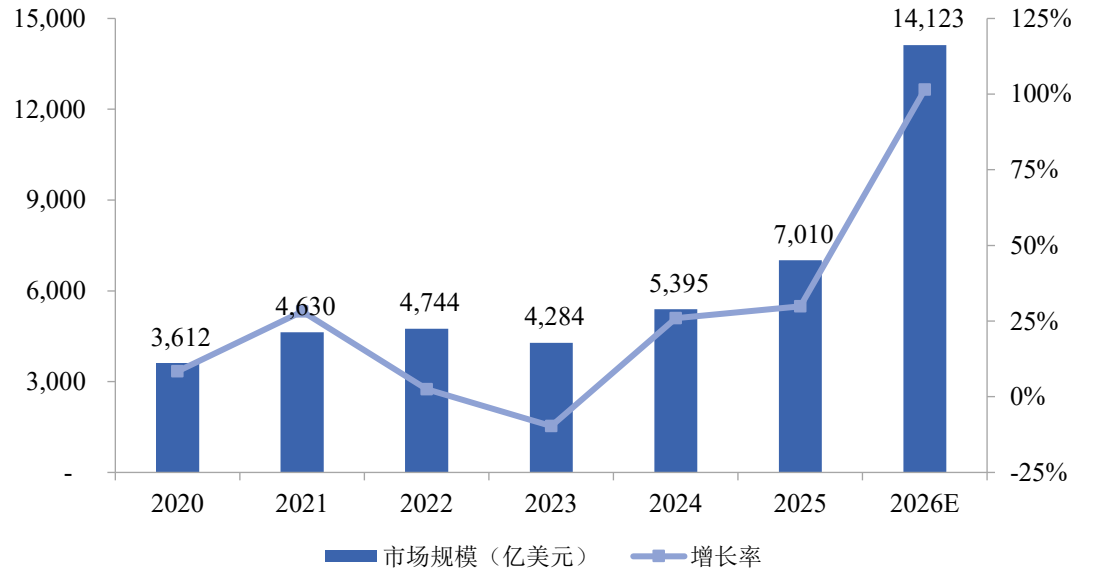
2020-2026E 全球半导体市场规模



注：根据 WSTS 数据整理。

根据 WSTS 数据，2020 年至 **2025** 年，全球集成电路市场规模从 3,612 亿美元增长至 **7,010** 亿美元，复合增长率为 **14%**，预计到 2026 年将增长至 **14,123** 亿美元，同比增长 **101%**。

2020-2026E 全球集成电路市场规模

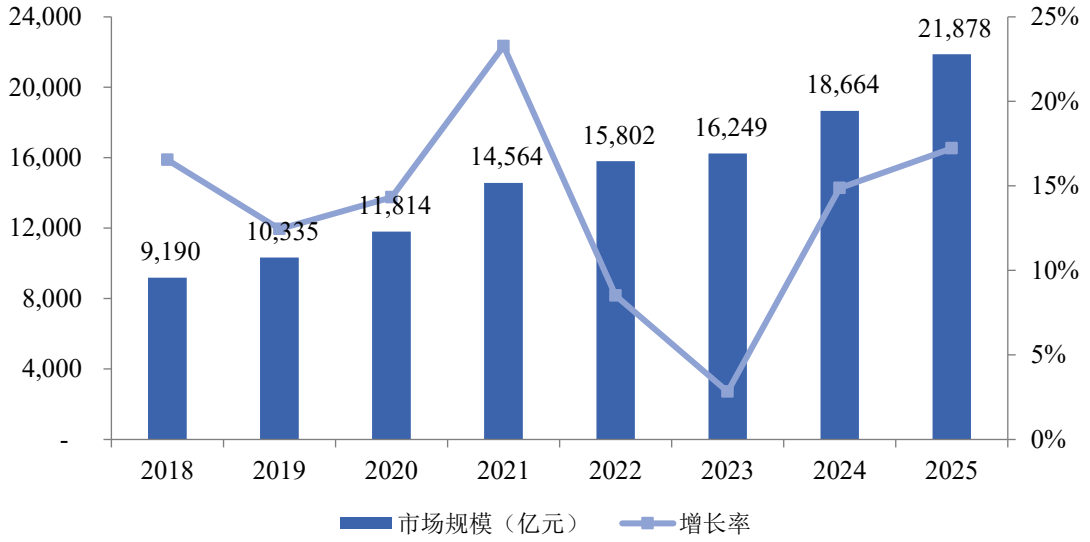


注：根据 WSTS 数据整理。

近年来，全球贸易摩擦加剧、单边保护主义抬头，全球半导体产业面临持续的技术脱钩和供应链重构压力。我国已将半导体产业全链条自主可控和关键核心技术突破，纳入国家中长期发展规划的重要攻坚方向；在国家产业政策大力扶持、

全产业链各环节协同发展的背景下，我国半导体产业展现出了极强的发展韧性与增长动能。根据中国半导体协会统计，2018 年至 **2025** 年，中国大陆半导体市场规模从 9,190 亿元增长至 **21,878** 亿元，年复合增长率为 13%。

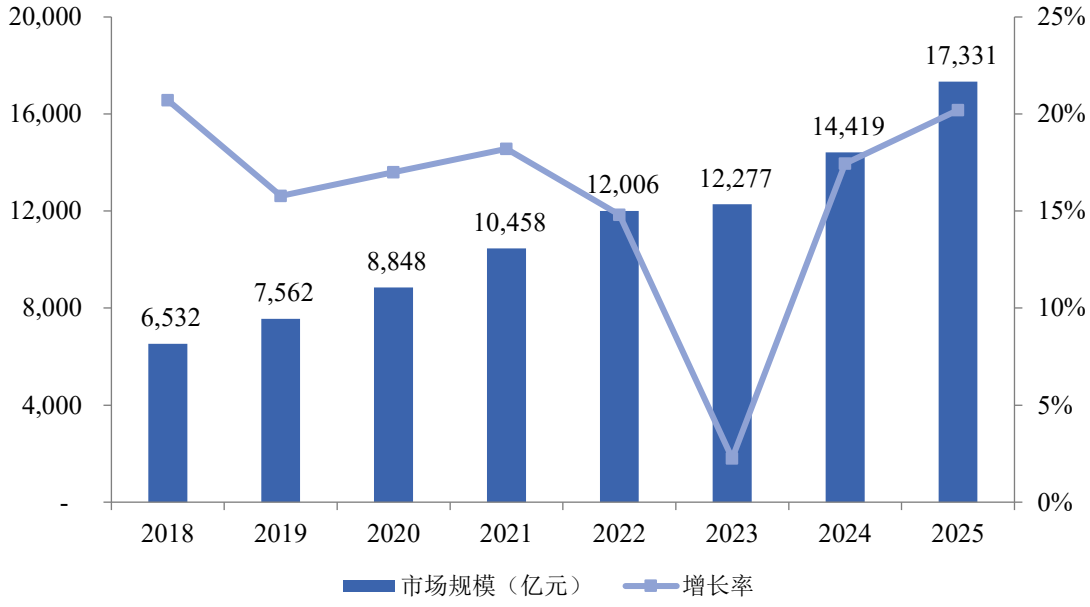
2018-2025 中国大陆半导体市场规模



注：根据中国半导体协会数据整理。

根据中国半导体协会统计，2018 年至 **2025** 年中国大陆集成电路市场规模从 6,532 亿元增长至 **17,331** 亿元，年复合增长率为 **15%**。

2018-2025 中国大陆集成电路市场规模



注：根据中国半导体协会数据整理。

2、半导体制造与设备

（1）半导体设备概况

半导体设备是指用于加工、制造各类半导体产品的专用装备，是半导体产业链中游制造环节的核心组成。半导体行业遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的行业规律，设备是先进工艺落地的核心前提，关键技术突破孕育创新工艺，进而驱动半导体产业链全链路升级，例如等离子体源技术催生了干法刻蚀工艺，成为半导体芯片制程突破至 1 微米以下节点的核心支撑。半导体设备是关键技术落地、先进工艺实现的核心载体，其性能直接决定半导体制程的工艺效果与稳定性。

半导体设备应用贯穿芯片制造全流程。一般而言，芯片制造过程可划分为晶圆/硅片制造、前道工艺、后道工艺三大环节，各环节主要工艺与对应半导体设备，主要如下：

制造环节	主要工艺	主要设备
晶圆/硅片制造	通过单晶硅拉制、切片、研磨、抛光、清洗等工序，制备符合制程加工要求的晶圆/硅片	单晶炉（长晶设备）、切磨抛设备、清洗设备等
前道工艺	核心为晶圆加工，在半导体晶圆表面通过氧化/扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜沉积、CMP、清洗、量检测等多道工艺循环迭代，形成具备特定功能的晶体管及器件结构	光刻机、刻蚀设备、离子注入机、薄膜沉积设备、CMP 设备、清洗设备、量检测设备等
后道工艺	核心为封装与测试，对完成前道加工的晶圆进行划片、引线键合、封装及性能测试，最终产出合格成品芯片	贴片设备、引线焊接/键合设备、测试设备、分选机等

注：根据行业公开信息整理。

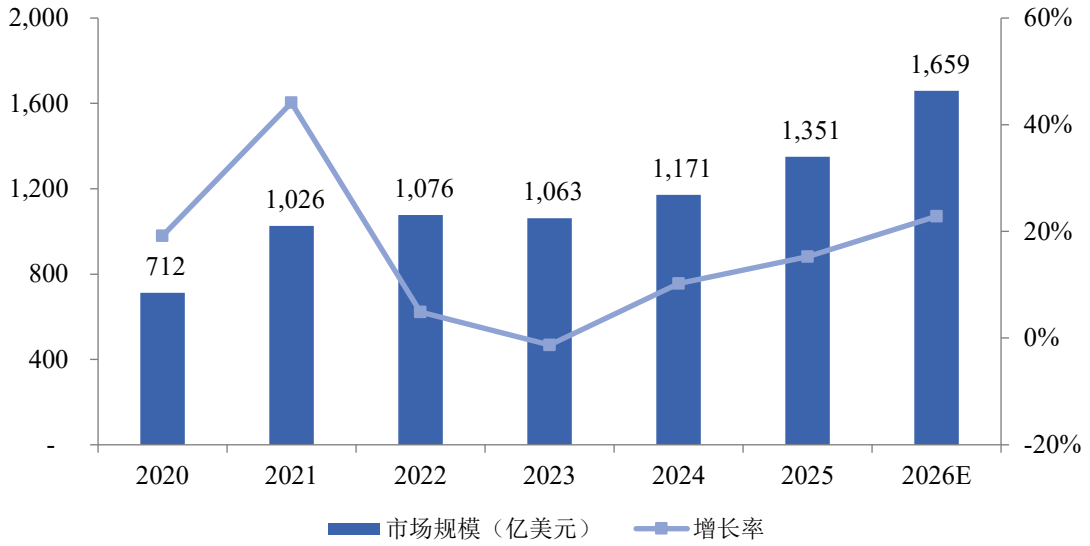
其中，光刻、刻蚀和薄膜沉积是半导体制造三大关键工艺，对应设备也是半导体制造环节价值量占比最高的三类设备。

（2）半导体设备市场情况

A、全球半导体设备市场情况

根据 SEMI 统计，2020 年至 2025 年，全球半导体设备市场规模从 712 亿美元增长至 1,351 亿美元，年复合增长率为 14%。根据 SEMI 预测，**受人工智能相关需求驱动，2026 年全球半导体设备市场规模将达到 1,659 亿美元，2028 年市场规模将有望进一步攀升至 2,295 亿美元**。

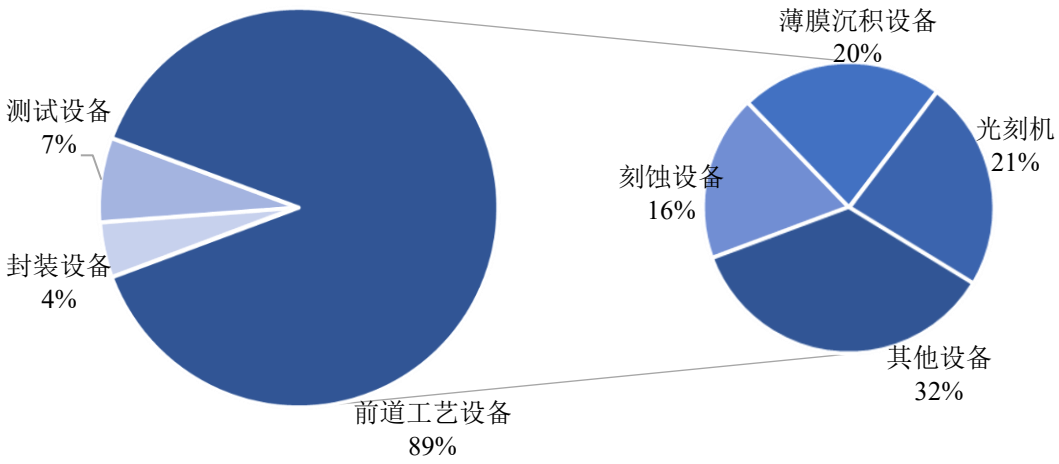
2020-2026E 全球半导体设备市场规模



注：根据 SEMI 数据整理。

半导体设备中，前道工艺设备占据了绝对地位，根据 SEMI、QYResearch 数据，2024 年全球半导体设备市场规模中，前道工艺设备市场规模为 1,047 亿美元，占比约 89%。后道工艺设备中，封装设备市场规模为 50 亿美元，占比约 4%，测试设备市场规模为 74 亿美元，占比约 7%。其中，刻蚀设备、薄膜沉积设备和光刻机共同构成半导体制造三大关键工艺设备，占全部半导体设备价值量比例接近 60%。

2024年全球半导体设备结构分布



注：根据 SEMI、QYResearch 数据整理。

随着 AI 基础设施投资的加速，以及支持更高计算密度、HBM 和复杂器件结

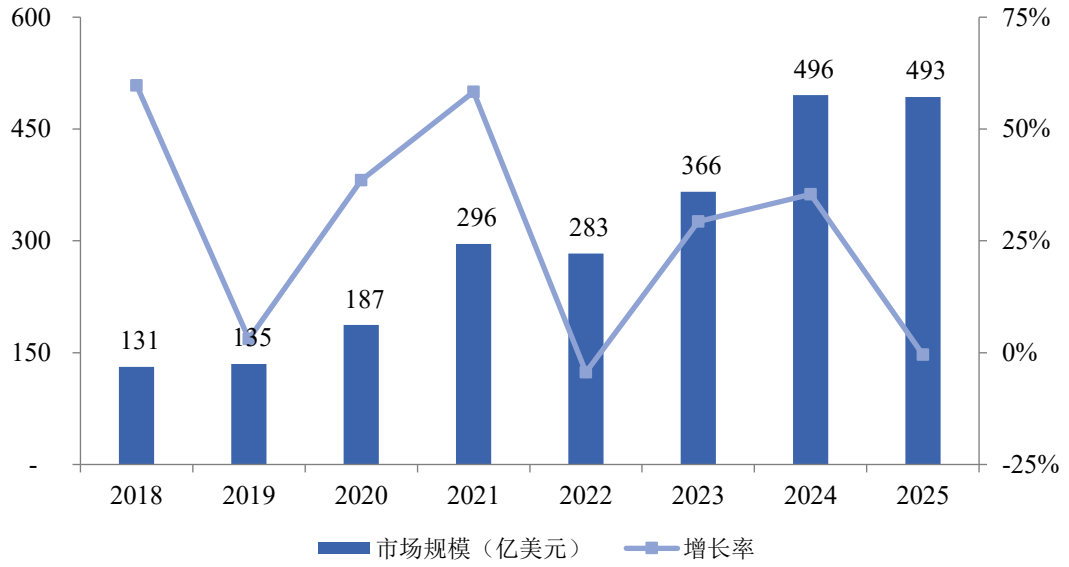
构所需的先进逻辑、存储等投资的增加，半导体设备销售额将进一步增加。根据 SEMI 预测，2026 年全球半导体设备销售额将增长至 1,659 亿美元，其中前道工艺设备市场规模约 1,439 亿美元，占比约 87%；测试设备销售额约 153 亿美元，占比约 9%；封装设备销售额约 67 亿美元，占比约 4%。

全球半导体设备行业呈现高集中度、寡头垄断的竞争格局，市场份额高度集中于国际头部厂商。根据 SEMI 数据，2024 年全球半导体设备销售额排名前五的厂商依次为阿斯麦（ASML）、应用材料（AMAT）、泛林集团（LAM）、东京电子（TEL）与科磊（KLA）；其中，ASML 在高端光刻机市场具备绝对垄断地位，是全球唯一可量产供应 EUV 光刻机的厂商；AMAT、LAM、TEL 三大国际巨头几乎垄断全球刻蚀设备、薄膜沉积设备主要市场；KLA 则稳居全球半导体量检测设备市场龙头地位，在核心量检测细分赛道具备显著的技术与市场优势。

B、中国大陆半导体设备市场情况

中国大陆是全球半导体设备第一大市场，根据 SEMI 统计，**2025** 年全球半导体设备在中国大陆的销售额为 **493** 亿美元，占全球市场份额约 **36%**。自 2018 年起，中国大陆半导体设备市场规模持续高速增长，年复合增长率约 **21%**。

2018-2025中国大陆半导体设备市场规模



注：根据 SEMI 数据整理。

中国大陆在先进逻辑、先进存储、先进封装及成熟制程等各领域产能持续扩张。根据 SEMI 预测，2024 年至 2027 年，中国大陆 12 英寸晶圆厂数量将从 29

座增长至 71 座，中国大陆晶圆厂的密集扩建与投产，将带动刻蚀、薄膜沉积等半导体关键设备市场需求长期保持旺盛态势。

近年来，在半导体产业链自主可控的国家战略推动下，国内半导体设备在去胶、清洗、成熟制程刻蚀设备等领域实现规模化突破，但在光刻机、先进制程刻蚀、薄膜沉积、离子注入等核心赛道，与国际头部厂商仍存在技术差距。

根据国泰海通 2025 年 10 月出具的《研究报告》，美国众议院“中美战略竞争特别委员会”发布的专项报告显示，阿斯麦（ASML）、应用材料（AMAT）、泛林集团（LAM）、东京电子（TEL）、科磊（KLA）五家国际巨头合计占据全球半导体设备 80%-85%的市场份额，且 2024 年上述厂商来自中国大陆的收入占其总收入的比例达 36%-44%，凸显国内半导体设备整体国产化率仍处于低位，中国大陆半导体设备行业具备广阔的国产替代空间。

与全球半导体设备市场格局一致，国内半导体设备市场同样呈现高集中度特征，头部国产厂商均在各自细分赛道形成了一定的技术壁垒与市场优势。根据东海证券 2025 年 10 月发布的《研究报告》，我国各类半导体设备的国产化率、核心参与厂商情况，主要如下：

设备	国内主要企业	国产化率
光刻机	上海微电子、中电科等	成熟制程为 10%-15%； 先进制程为＜1%
去胶设备	屹唐股份、北方华创、盛美上海等	中低端为 75%-90%； 高端为＜30%
清洗设备	盛美上海、北方华创等	50%-60%；
刻蚀设备	中微公司、北方华创等	成熟制程为 50%-60%； 先进制程为＜15%
薄膜沉积设备	拓荆科技、中微科技、北方华创、中电科等	PVD：成熟制程为 15%-20%； 先进制程为＜10%； CVD/ALD：5%-10%
CMP 设备	华海清科、盛美上海等	成熟制程为 15%-25%； 先进制程为＜10%
涂胶显影设备	盛美上海、芯源微等	成熟制程为 10%-15%； 先进制程为＜10%
离子注入机	凯世通、中电科、中信科等	成熟制程为 10%-20%； 先进制程为＜5%
量检测设备	中科飞测、精测电子等	成熟制程为 10%-15%； 先进制程为＜5%

注：根据全球半导体观察、东海证券研究报告整理。

（3）半导体先进制程概况

广义半导体制程，是指将晶圆加工为合格芯片的全流程标准化、可重复量产工艺与技术方案的总称，是半导体芯片规模化、高良率量产的核心基础。

半导体先进制程，是指通过制程线宽物理微缩、三维异构集成等技术路径，实现芯片性能提升、功耗优化、集成度跃升的高性能半导体制造工艺，是支撑半导体产业持续迭代升级的核心技术载体。当前先进制程演进中，逻辑芯片与存储芯片形成了差异化的核心技术路线。

逻辑芯片的先进制程水平，通常以晶体管栅极线宽对应的制程节点为核心衡量标准：制程节点越小，单位芯片面积内可集成的晶体管密度越高，芯片运算性能越强、功耗控制越优。当前全球逻辑芯片制程已完成 7-14 纳米节点的规模化量产，并已突破至 2-5 纳米水平；根据台积电公告，其 2 纳米制程产线已于 2025 年第四季度开始量产，并布局了 A16、A14 制程，先进制程逻辑芯片未来即将进入 1X 埃米时代。

与逻辑芯片演进路径不同，存储芯片的先进制程主要以三维异构集成等为核心升级方向，通过垂直堆叠存储单元实现存储密度跃升，同步提升芯片性能与可靠性。在 NAND 领域，行业主流堆叠层数已从早期 24-32 层迭代至 64-128 层规模化量产；2024 年 SK 海力士宣布量产 321 层 NAND 存储芯片；根据东京电子（TEL）预计，2026 年 NAND 堆叠层数将突破至 4XX 层级别；根据 SEMI 大半导体产业网 2025 年官方发布信息，国内存储芯片产线亦实现了重大技术突破，已经成功出货 294 层 NAND 存储芯片。在 DRAM 领域，制程节点微缩仍在持续迭代，同时为匹配 AI 算力爆发带来的超高带宽需求，行业内通过三维异构集成等技术推出高带宽内存产品（High Bandwidth Memory，HBM），通过多颗 DRAM 裸片的垂直堆叠，大幅提升内存带宽与综合性能。

根据 2026 年 2 月东京电子（TEL）官方披露的研究报告，逻辑芯片、DRAM、NAND 大三核心芯片产品的制程演进技术路线图，主要如下：

规模量产年份	逻辑芯片	DRAM	NAND
2024 年	3 纳米	1b	3XX 层
2025 年	2 纳米/18 埃米/16 埃米	1c	
2026 年			4XX 层

规模量产年份	逻辑芯片	DRAM	NAND
2027 年	14 埃米	1d	
2028 年		0a	5XX 层
2029 年	10 埃米		6XX 层
2030 年		0b	

注：根据 TEL 研究报告整理。

3、半导体关键工艺与等离子体源应用

公司主营业务产品等离子体电源系统，系半导体制造三大关键工艺设备中刻蚀、薄膜沉积设备等的核心零部件，其性能直接决定刻蚀、薄膜沉积等工艺效果与稳定性。

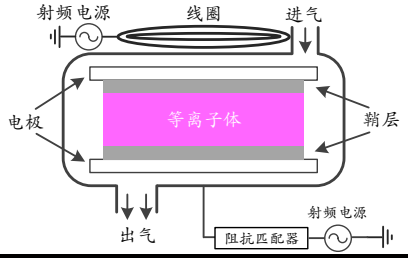
刻蚀、薄膜沉积两大关键工艺、对应设备及等离子体源应用场景，主要如下：

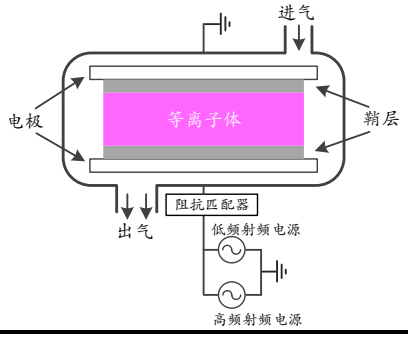
（1）刻蚀工艺与设备概况

刻蚀工艺是半导体制造三大关键工艺之一，其通过物理与化学作用，在晶圆衬底及表面膜层上，按照光刻工艺的曝光图形，精准雕刻出芯片所需的三维微观结构，实现光刻掩膜版图形向晶圆表面的精准转移。

按工艺原理划分，刻蚀可分为干法刻蚀与湿法刻蚀两大类：湿法刻蚀主要通过液体化学试剂浸泡实现刻蚀，受各向同性刻蚀特性限制，主要适用 1 微米以上线宽的半导体制程；干法刻蚀主要依托等离子体源技术实现，是当前半导体制程主流技术路线，在市场应用中占据主要市场份额。

干法刻蚀工艺中，根据等离子体射频电源的能量向晶圆反应腔室的耦合方式差异，主流技术路线分为电感性耦合等离子体（Inductively Coupled Plasma，ICP）与电容性耦合等离子体（Capacitively Coupled Plasma，CCP）等，具体如下：

能量耦合方式	具体情况	主要应用场景	主要示意图
电感性耦合等离子体（ICP）	射频电源通过电感线圈产生交变电磁场，驱动电子加速并电离制程气体形成等离子体；可独立调控等离子体密度与离子轰击能量，实现高密度等离子体生成与偏压电极的独立控制。	可通过多区线圈等设计实现等离子体均匀性调控，兼顾高速刻蚀与低器件损伤，主要用于硅、金属等材料的刻蚀。	

能量耦合方式	具体情况	主要应用场景	主要示意图
电容性耦合等离子体（CCP）	射频电源加载于反应腔室的平行电极板之间形成交变电场，电子在电场中振荡并碰撞电离制程气体形成等离子体，鞘层电场强度高，离子能量可控性强。	可生成高能等离子体，物理轰击能力强，介质材料刻蚀选择性优异，高深宽比刻蚀能力突出，主要用于氧化物、氮化物等介质材料的刻蚀。	

在 ICP 和 CCP 等主流刻蚀技术的基础上，针对半导体产品日益复杂的加工需求，原子层刻蚀（Atomic Layer Etching，ALE）作为更先进的精密刻蚀技术应运而生。ALE 是一种利用等离子体轰击的刻蚀工艺，通过 CCP 或 ICP 能量耦合方式实现，核心特征是具备原子级的刻蚀精度控制能力，其通过分步可控的自限制反应，实现单原子层的逐层均匀刻蚀，更为适配更小线宽、三维异构等先进制程需求。

（2）薄膜沉积工艺与设备概况

薄膜沉积是半导体制造三大关键工艺之一，其通过物理、化学等方式在晶圆衬底表面沉积功能薄膜，配合刻蚀、抛光等工艺的多轮循环，构建芯片所需的多层堆叠导电层与绝缘层结构。

薄膜沉积按工艺原理划分，主流技术路线可分为 PVD、CVD 和 ALD 等，分别对应不同工艺设备。具体如下：

A、物理气相沉积

物理气相沉积（Physical Vapor Deposition，PVD）是在真空环境下，通过物理方式将靶材材料转化为气态、等离子态粒子，经直线传输在晶圆衬底表面沉积成膜，过程以物理作用为主，无显著气相化学反应，是芯片高纯度金属互连层制备的关键工艺。PVD 设备主要包括真空蒸镀设备、磁控溅射镀膜设备等，其中磁控溅射镀膜设备主要依托等离子体源技术实现，是当前 PVD 市场的主流设备，占据绝大部分市场份额。

B、化学气相沉积

化学气相沉积（Chemical Vapor Deposition，CVD）是通过加热、等离子体、

光辐射等能量激发方式，使气态前驱体发生化学反应，在晶圆衬底表面沉积固态薄膜的工艺；与 PVD 的直线传输沉积不同，CVD 通过扩散与对流的协同作用实现前驱体传输，更易于覆盖各种复杂基材表面，在高深宽比等复杂结构的薄膜沉积中具有优势。

CVD 设备按技术路线可分为常压化学气相沉积（Atmospheric Pressure CVD，APCVD）、低压化学气相沉积（Low Pressure CVD，LPCVD）、等离子体增强化学气相沉积（Plasma Enhanced CVD，PECVD）、高密度等离子体化学气相沉积（High Density Plasma CVD，HDPCVD）、流动性化学气相沉积（Flowable CVD，FCVD）等，分别适配不同制程对薄膜厚度、均匀性、沟槽填充能力等的差异化需求。

其中，APCVD 是最早的实现产业化的 CVD 技术，在常压环境下完成沉积，具备设备结构简单、沉积速率高的特点；LPCVD 在 APCVD 基础上发展而来，通过低气压环境提升了薄膜均匀性与沟槽填充能力，产业化应用范围广于 APCVD。

PECVD 核心依托等离子体源技术实现，通过等离子体激发前驱体化学反应，大幅降低了沉积反应温度，同时显著提升了薄膜沉积速率，在从亚微米发展到纳米级芯片制造过程中，扮演了重要的角色。

HDPCVD 可生产高密度等离子体，沉积的薄膜致密度更高，同时具备较为优异的沟槽填充能力，可满足深宽比 6:1 左右的间隙无空洞填充需求。

FCVD 是融合旋涂介质沉积（Spin-On Dielectric，SOD）与 CVD 技术优势的创新型沟槽填充技术，其绝缘介质前驱体可自由流动填充任意形状的结构，通过液态自下而上的填充方式实现较好的无空洞成膜，可满足更高的深宽比结构、1X 纳米及以下线宽先进制程的加工需求。

C、原子层沉积

原子层沉积（Atomic Layer Deposition, ALD）通过交替引入气态前驱体、真空抽除的分步自限制反应，在晶圆衬底表面实现单原子层级的逐层镀膜；从原理上看，ALD 属于 CVD 的特殊分支，但其通过分步循环的自限制反应实现沉积过程的精准控制，每个循环仅生长一层原子膜，可通过循环次数精确控制薄膜厚度，

制备的薄膜厚度均匀性、一致性优异，台阶覆盖能力强，能够适配更小线宽、三维异构等先进制程需求。

4、半导体设备核心零部件——等离子体电源系统

半导体设备零部件系构成半导体设备的基础与核心，是半导体基石产业。根据华创证券 2025 年 1 月出具的《行业深度研究报告》，半导体零部件可分为机械类、电气类、机电一体类、气体/液体/真空系统类、仪器仪表类、光学类等，主要情况如下：

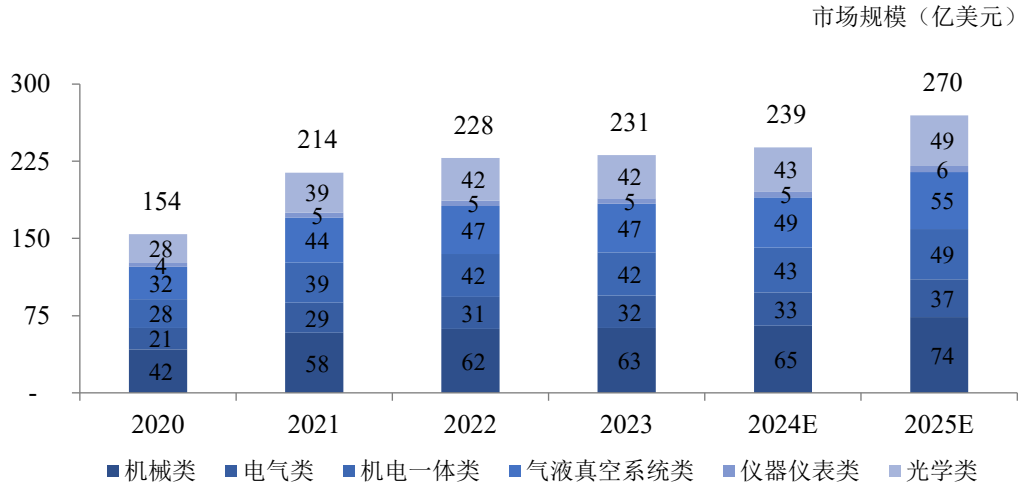
分类	零部件具体类别	国际主要企业	国产化率	技术突破难度
机械类	反应腔、传输腔、过渡腔、内衬、均气盘等金属工艺件；托盘、冷却板、底座、铸钢平台等；石英、陶瓷件、硅部件、静电卡盘、橡胶密封件等。	京鼎精密、Ferrortec、Hana、美国杜邦等。	品类繁多，国内已出现富创精密等进入国际半导体设备厂商的供应商，整体国产化率相对较高，但高端产品国产化率较低。	作为应用最广，市场份额最大的零部件类别，具体品类繁多，主要产品技术已实现突破和国产替代，应用于高制程设备的产品技术突破难度仍较高。
电气类	射频电源、射频匹配器、远程等离子源、供电系统、工控电脑等。	AE、MKS 等。	对于核心模块（射频电源等），国内企业尚未进入国际半导体设备厂商，少量应用于国内半导体设备厂商，主要应用于光伏、LED 等泛半导体设备，国产化率低，高端产品尚未国产。	设备中作为控制工艺制程的核心部件，技术突破难度较高。
机电一体类	EFEM、机械手、加热带、腔体模组、阀体模组、双工机台、浸液系统、温控系统等。	京鼎精密、Brooks Automation、Rorze 等。	品类较为繁多，国内已出现富创精密等进入国际半导体设备厂商的供应商，大多品类国内厂商主要供应国内半导体设备厂商，整体国产化率不高，功能复杂的高端产品未国产化。	品类繁多，部分产品已实现技术突破，但产品稳定性和一致性与国外有差距，技术难度适中。
气体/液体/真空系统类	气柜、气体管路、管路焊接件等气体输送系统类；干泵、分子泵、真空阀门等真空系统类；阀门、接头、过滤器、液体管路等气动液压系统类。	超科林、Edwards、Ebara、MKS 等。	品类较为繁多，少数企业通过自研或收购部分产品已进入国际半导体设备厂商，整体国产化率处于中等水平，大部分品类的高端产品未国产化。	品类繁多，部分产品已实现技术突破，但产品稳定性和一致性与国外有差距，技术难度适中。
仪器仪表类	气体流量计、真空压力计等。	MKS、Horiba 等。	国内企业通过收购进入国际半导体设备厂商，国内企业自研产品仅少量用于国内半导体设备厂商，由于产品成本占比较低，国内企业主要以采购进口产品为主，国产化率低，高端产品尚未国产化。	对测量的精准度要求极高，国产化率低，技术突破难度较高。
光学类	光学元件、光栅、激光源、物镜等。	Zeiss、Cymer、ASML。	国内企业尚未进入国际半导体设备厂商，已少量应用于国内光刻机，国产化率较低，高端产品尚未国产化。	对光学性能要求极高，鉴于光刻机国际市场高度垄断，高端产品一家独大，国内光刻机尚在发展，相应配套光学零部件国产化率低，技术突破难度较高。

注：根据华创证券研究报告整理。

对于半导体零部件厂商而言，行业需求主要来自两大核心场景：一是半导体芯片产线现役设备的零部件维修、更换等存量替换需求；二是半导体芯片产线扩产带来的新购设备零部件增量配套需求。

近年来全球芯片产能持续扩张，半导体零部件市场规模保持稳步增长态势，根据华创证券预测，2025 年全球半导体零部件市场规模将达到 270 亿美元；伴随 AI 算力爆发驱动半导体产业新一轮产能扩张，半导体零部件市场规模有望持续扩容。

2020-2025E 全球半导体设备零部件细分市场规模



注：根据华创证券研究报告整理。

等离子体电源系统是刻蚀、薄膜沉积等半导体关键工艺设备中调控等离子体状态的核心功能部件，可以实现等离子体的“激发与稳定存续”，技术壁垒高；其性能直接决定半导体制程的工艺效果与稳定性，进而影响芯片产品良率与生产效率，是半导体工艺设备的电气类核心零部件。

等离子体射频电源系统、远程等离子体源系统是当前半导体工艺设备主流应用的等离子体电源系统方案，行业市场情况主要如下：

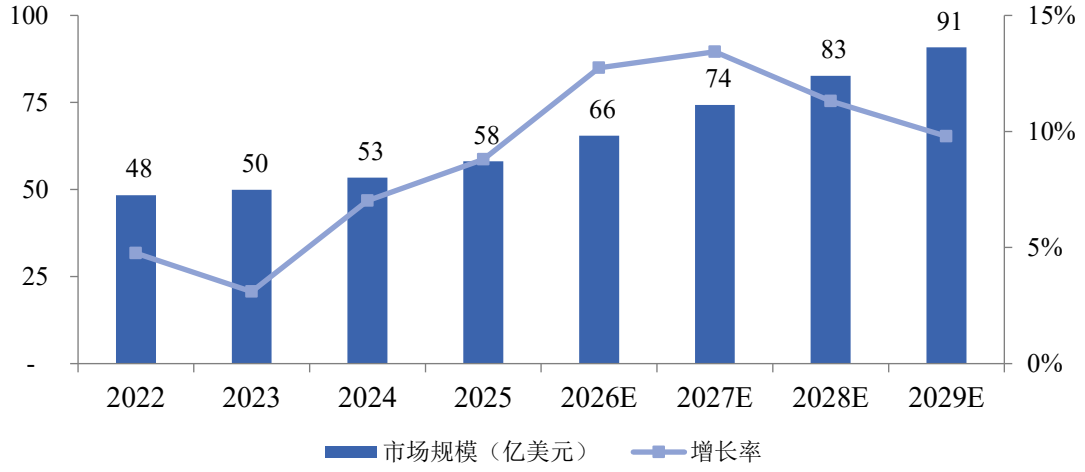
（1）等离子体射频电源系统

根据弗若斯特沙利文统计，全球等离子体射频电源系统市场规模从 2022 年 48 亿美元增长至 2025 年的 58 亿美元，未来全球等离子体射频电源系统市场规模将持续增长，预计到 2029 年全球等离子体射频电源系统市场规模将达到 91 亿

美元。

根据弗若斯特沙利文统计，2025 年全球等离子体射频电源系统市场销售额为 58 亿美元，其中半导体领域市场规模为 34 亿美元，该细分市场集中度较高，MKS、AE、DAIHEN 和霍廷格的市场份额分别为 32.3%、21.8%、10.9%和 7.8%，合计占据全球市场份额约 73%。

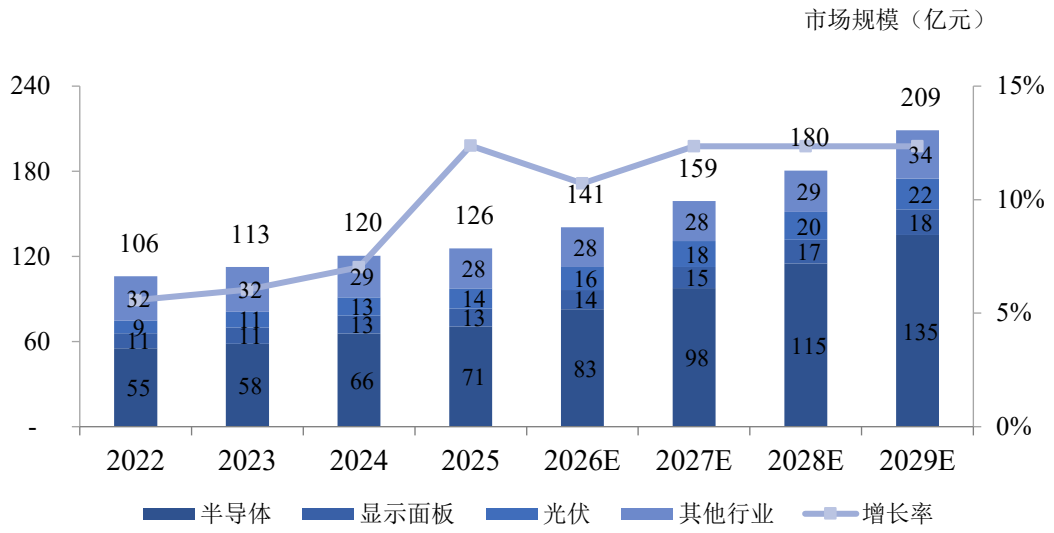
2022-2029E 全球等离子体射频电源系统市场规模



注：根据弗若斯特沙利文数据整理。

中国大陆等离子体射频电源系统行业起步相对较晚，伴随近年来中国大陆半导体产能持续扩张，市场规模保持稳步增长，2022 年至 **2025** 年市场规模从 106 亿元增长至 **126** 亿元，预计到 2029 年中国大陆市场规模将达到 209 亿元。其中，半导体行业系我国等离子体射频电源系统最大的下游应用领域，2022 年至 **2025** 年中国大陆半导体领域的市场规模从 55 亿元增长至 **71** 亿元，预计到 2029 年将达到 135 亿元。

2022-2029E 中国大陆等离子体射频电源系统市场规模



注：根据弗若斯特沙利文数据整理。

2025 年，中国大陆等离子体射频电源系统市场销售额为 126 亿元，下游覆盖半导体、光伏、面板等领域。其中，半导体是市场规模较大、未来增长较快的应用领域之一，2025 年市场销售额为 71 亿元。

中国大陆半导体领域仍以境外厂商为主。2025 年，MKS、AE、DAIHEN 和霍廷格的市场份额分别为 45.0%、14.6%、8.3%和 8.1%，合计超过 75%，市场集中度较高。境内厂商整体市场份额相对有限，其中，恒运昌和发行人的市场份额分别为 5.1%和 3.8%，分列境内厂商第一、第二位。

根据弗若斯特沙利文统计，2025 年中国大陆半导体领域等离子体射频电源系统的国产化率仅为 13%，国产替代空间较为广阔。

（2）远程等离子体源系统

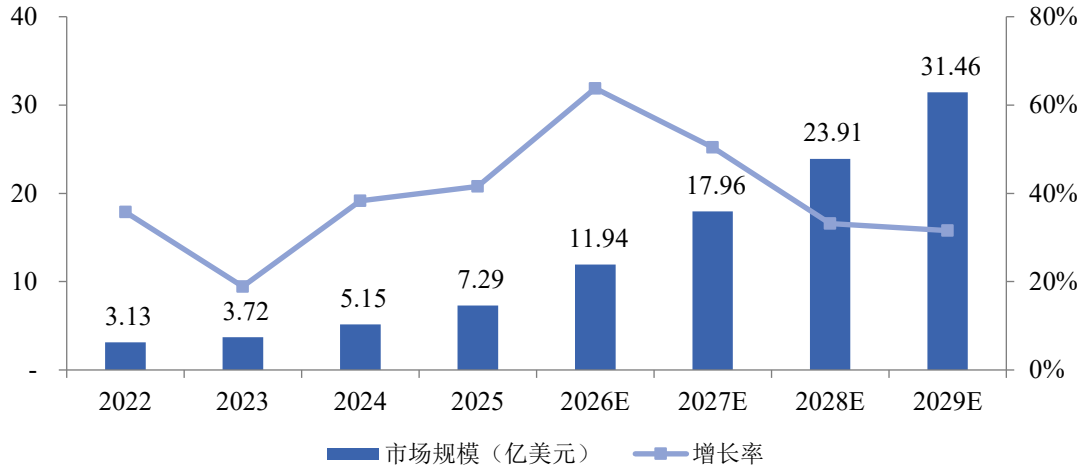
远程等离子体源系统的核心优势，在于可在晶圆反应腔室远端形成理想状态的等离子体，实现晶圆或基材表面的高精度均匀处理；同时其远端电离的特性，可大幅降低等离子体等对敏感衬底表面、晶圆腔室内壁的物理与化学损伤，实现低温工艺效果，并显著降低晶圆反应腔室颗粒物污染风险，完美适配半导体先进制程对工艺波动的极低容忍度要求，应用场景持续拓宽。

根据 QYResearch 统计，全球半导体领域远程等离子体源系统市场规模从 2022 年 3.13 亿美元增长至 2025 年的 7.29 亿美元，未来市场规模将保持高增长

态势，市场增长驱动主要来自于三大维度：一是需求端，本轮人工智能革命带动先进制程算力芯片及 NAND、HBM 等先进存储芯片需求在全球范围内呈指数级增长，成为市场扩容的核心底层动力；二是工艺端，随着先进制程下工艺窗口容忍度的大幅收窄，对等离子体工艺的损伤控制、均匀性、一致性等提出了更高要求，相较于传统原位产生等离子体的方式而言，远程等离子体源系统通过等离子体产生区与反应区的物理分离，实现活性自由基的精准输运与可控反应，已成为先进制程高精度、低损伤工艺的主流方案之一；三是应用场景端，远程等离子体源系统的应用场景从传统晶圆反应腔室原位清洁，拓展至下游管路清洁、尾气处理、高精度刻蚀、薄膜沉积辅助等多个核心工序，部分先进制程设备如 ALE、FCVD 等已将其作为主流方案之一，实现了从 0 到 1 的规模化配置渗透，需求规模将持续放量，预计到 2029 年全球市场规模将达到 31.46 亿美元。

根据 QYResearch 统计，2025 年全球半导体领域远程等离子体源市场销售额为 7.29 亿美元。其中，全球半导体远程等离子体系统市场份额主要被 MKS、AE 和 NPP 等占据，MKS、AE、NPP 在全球半导体远程等离子体源系统的市场份额分别为 26.57%、19.97%和 15.76%，三家合计占据了全球近 65%的市场份额。

2022-2029E 全球半导体远程等离子体源系统市场规模



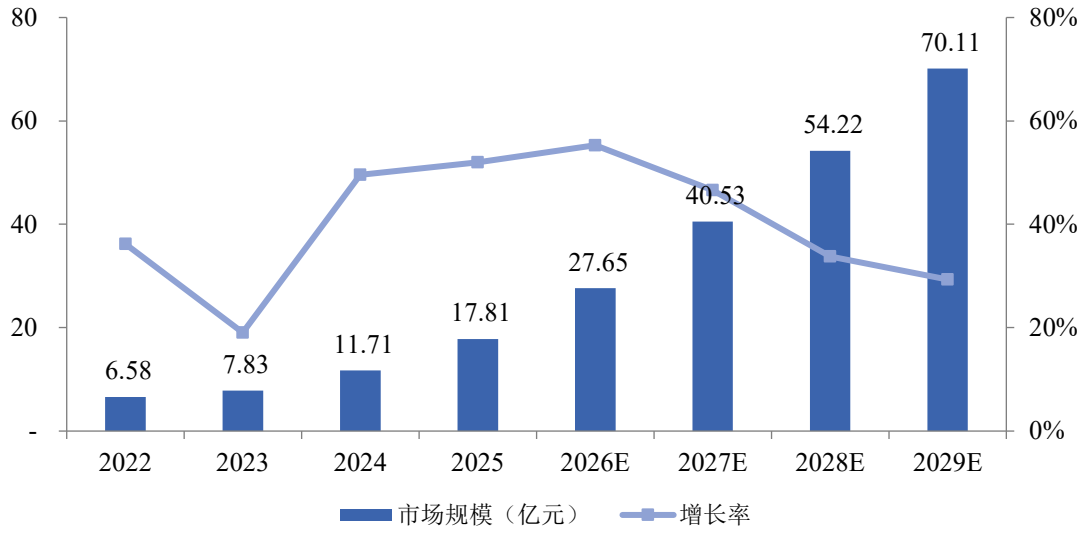
注：根据 QYResearch 数据整理。

中国大陆半导体领域远程等离子体源系统市场起步较晚，伴随近年来国内半导体产能持续扩张、先进制程产线加速落地，市场规模保持高速增长态势，2022 年至 2025 年中国大陆半导体领域远程等离子体源系统市场规模从 6.58 亿元增长至 17.81 亿元，预计 2029 年中国大陆半导体领域远程等离子体源系统市场规模

将达到 70.11 亿元。

2025 年中国大陆市场半导体远程等离子体源系统的销售额约 17.81 亿元，占全球市场约 35%。该市场主要被 MKS、AE 和 NPP 占据，前述三家在中国大陆的市场份额分别为 28.31%、27.97%和 11.46%，发行人位列第四，在中国大陆市场份额为 4.37%，同时系中国大陆市场份额最高的本土企业。根据 QYResearch 统计，2025 年中国大陆半导体领域远程等离子体源系统的国产化率不足 7%，国产替代空间较为广阔。

2022-2029E 中国大陆半导体远程等离子体源系统市场规模



注 1：根据 QYResearch 数据整理；
注 2：汇率按 2025 年 12 月 31 日央行中间价 7.0288 元/美元折算。

（3）技术支持服务

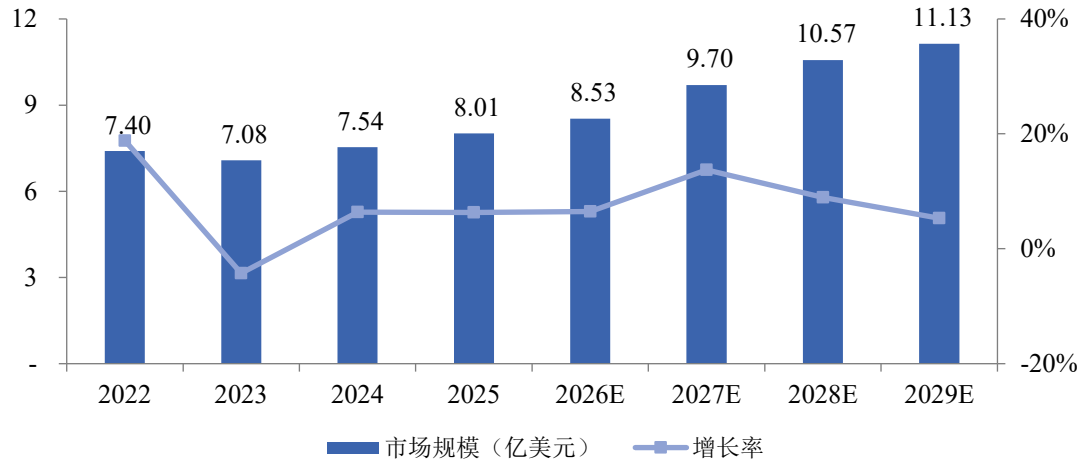
半导体制造是等离子体电源系统的主要应用领域之一，在半导体制造中，等离子体电源系统是半导体工艺设备的“动力核心”与“控制中枢”，其性能失准将直接引发工艺漂移、良率波动等问题，轻则降低芯片产线的生产效率，重则导致整批芯片报废、产线非计划停机等，造成巨额经济损失。因此，芯片制造厂商必须对产线设备配套的电源系统开展常态化维护，对原厂或高水平第三方的专业技术支持服务存在刚性需求。

等离子体电源系统技术支持服务的市场需求，主要由全球芯片产线产能规模决定；近年来全球半导体芯片产线产能持续扩产，存量产线的大量现役设备、新增产线待投产设备的配套服务需求，将直接带动相应技术支持服务市场规模的持

续增长。

根据 QYResearch 统计，2025 年全球等离子体电源系统技术支持服务的市场规模为 8.01 亿美元，预计 2029 年将达到 11.13 亿美元。2025 年全球等离子体电源系统技术支持服务市场规模为 8.01 亿美元。AE 和 MKS 是该市场的主要参与者，市场份额分别为 21.01%和 16.81%，合计接近 40%。

2022-2029E 全球等离子体电源系统技术支持服务市场规模

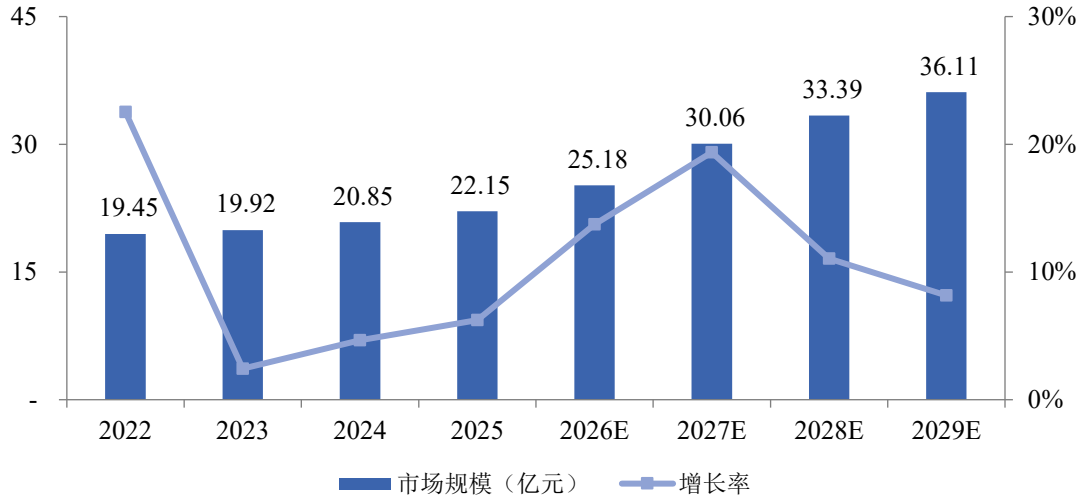


注 1：根据 QYResearch 数据整理；
注 2：统计口径包括等离子体射频电源系统、等离子体直流电源系统和远程等离子体源系统。

过去几年，随着中国大陆半导体芯片产线产能持续扩张，相应电源系统技术支持服务市场规模亦同步增长，2025 年市场规模为 22.15 亿元，预计到 2029 年将达到 36.11 亿元。

其中，2025 年，中国大陆等离子体电源系统技术支持服务市场规模约为 22.15 亿元，占全球市场的比例约为 40%。在中国大陆市场，发行人以 12.15%的市场份额位列中国大陆市场第一；AE 和 MKS 分别以 11.16%和 9.51%的市场份额位列第二、第三。

2022-2029E 中国大陆等离子体电源系统技术支持服务市场规模



注 1：根据 QYResearch 数据整理；
注 2：统计口径包括等离子体射频电源系统、等离子体直流电源系统和远程等离子体源系统；
注 3：汇率按 2025 年 12 月 31 日央行中间价 7.0288 元/美元折算。

5、行业发展趋势

（1）自主可控与国产化是行业发展核心长期主线

我国是全球最大的半导体消费市场和半导体设备应用市场，但当前国内半导体关键设备仍高度依赖进口。根据海关总署数据，2024 年中国大陆半导体设备进口额占同期全球半导体设备销售额的比重约 40%；其中 CVD 设备、等离子体干法刻蚀设备是进口额最高的两类设备，二者合计占国内 13 类主要半导体设备进口额的 65%，进口来源主要集中于美国、日本、荷兰等国家。

与此同时，美国、日本、荷兰等国家持续加大对中国大陆半导体产业链的出口管制力度，管制范围与精度持续升级。2022 年 10 月，美国商务部发布多项对中国大陆半导体出口管制措施，对 18 纳米及以下 DRAM、128 层及以上 NAND 闪存、16 纳米或 14 纳米及以下逻辑芯片相关生产设备实施管控；2023 年 7 月，日本修订后的《外汇及外国贸易法》正式实施，新增 23 类半导体制造设备出口管制品类，覆盖光刻、刻蚀、薄膜沉积、清洗等制程环节；2024 年 12 月，美国商务部更新“实体清单”，新增 140 余家中国相关企业与机构，覆盖半导体制造、关键设备等重要领域；2025 年 1 月，荷兰政府宣布自 2025 年 4 月起，对光刻机、ALD 设备、PECVD 设备、量检测设备等先进半导体设备实施进一步出口管制。

2026 年 4 月，美国参议院两党议员联合发起《硬件技术控制多边协调法案》

（简称 MATCH Act），核心目标为封堵中国大陆先进半导体制造能力关键技术突破，核心管控条款包括：一是新增 4 类半导体设备全域管制，对先进制程浸没式 DUV 光刻机、TSV 刻蚀与沉积设备、低温刻蚀设备、钴沉积设备等，对中国大陆实施全面的销售、维修及技术服务禁令；二是对 5 家中国大陆先进制程芯片厂商及其关联公司，实施类实体清单级别的全维度出口与技术服务管制，覆盖所有受美国《出口管理条例》（EAR）管辖的物项；三是推动日本、荷兰、韩国等盟友国对齐美国多边管制标准，并配套单边兜底规则——若盟友未按时完成管制对齐，美国将通过扩大 EAR 项下外国直接产品规则（FDP）的适用范围，对相关境外半导体设备实施长臂管辖。截至 2026 年 8 月，该法案已获得美国众议院外交事务委员会通过，尚需通过参议院表决、总统签署等环节后方可正式生效。

受出口管制政策持续升级影响，我国半导体产业链供应链安全面临严峻挑战，基础研究、核心技术、关键设备及核心零部件等领域的短板进一步凸显，半导体关键领域自主可控的紧迫性与必要性持续提升。当前国内产业链对关键设备、核心零部件的国产替代需求迫切，国产替代进程将持续加速。关键设备与核心零部件的自主可控，将成为我国半导体行业发展的核心长期主线。

（2）人工智能规模化应用驱动行业景气上行，带动全产业链产能持续扩容

本轮人工智能技术革命催生的规模化应用需求，是推动半导体行业进入新一轮增长周期的核心驱动力，将带动半导体核心零部件、设备厂商及芯片产能在未来数年持续扩容。具体来看，一是算力、存力需求爆发带动产业链资本开支持续加码，直接拉动算力芯片，以及 HBM、NAND 等存储芯片的需求快速增长；二是具身智能、自动驾驶等新兴应用场景商业化落地提速，叠加 AI 功能在智能眼镜、智能手表等消费电子终端的渗透率持续提升，终端换机升级需求逐步释放，进一步夯实行业长期增长动能。

在此背景下，中国大陆晶圆厂进入新一轮产能扩张周期。根据 SEMI 预测，2024 年至 2027 年，中国大陆 12 英寸晶圆厂数量将从 29 座增至 71 座。半导体设备采购通常具备 1-2 年的前置周期，需提前布局以匹配晶圆厂产能扩张节奏。本土晶圆厂产能建设浪潮，与关键设备、核心零部件的国产替代需求形成共振，将持续驱动国产半导体设备及零部件市场规模快速增长。

（3）先进制程迭代驱动刻蚀与薄膜沉积设备需求长期增长

半导体先进制程持续迭代，刻蚀与薄膜沉积工艺设备需求持续扩容，已成为半导体制造领域的长期确定性趋势。其中，先进制程逻辑芯片、存储芯片分别通过“线宽微缩”与“垂直堆叠”两条差异化技术路径，共同构成刻蚀、薄膜沉积设备需求增长的底层驱动力。

在逻辑芯片领域，制程节点已从 7-14 纳米节点逐步突破至 2-5 纳米及更先进水平。当制程线宽逼近光刻机光源物理波长与光刻材料性能极限时，单次光刻曝光已无法实现高密度精细图形的精准转移，需通过多重图案化光刻技术，将复杂图形拆解为多轮分步曝光与刻蚀等工序，直接导致刻蚀步骤成倍增加。根据 SEMI 测算，45 纳米工艺节点刻蚀次数约 28 次，28 纳米节点提升至约 40 次，7 纳米节点刻蚀次数已增至约 140 次，达到 45 纳米节点的 5 倍。

在 NAND 存储芯片领域，行业主流堆叠层数已从早期的 24-32 层迭代至 64-128 层，头部先进制程产线的 NAND 堆叠层数已突破 2XX 层。堆叠层数的提升直接导致工艺步骤增加、待刻蚀膜层厚度大幅提升，进一步打开先进刻蚀工艺的产业化应用空间。逻辑芯片刻蚀步骤的指数级增长、NAND 存储芯片等刻蚀工艺复杂度的持续提升，共同推动刻蚀设备在性能与装机量上的双重需求扩容。

与此同时，先进制程迭代同步带动薄膜沉积设备需求持续增长。在逻辑芯片制造中，多重图案光刻技术需光刻机、刻蚀设备与薄膜沉积设备协同完成，直接带动薄膜沉积工序需求增加；在 NAND 存储芯片制造中，沉积工序数量随堆叠层数呈近乎线性增长。90 纳米 CMOS 工艺仅需约 40 道沉积工序，3 纳米 FinFET 工艺则需超 100 道沉积工序。

未来，刻蚀、薄膜沉积等关键工艺设备的技术迭代与市场需求，将伴随芯片制程升级不断释放；等离子体电源系统作为上述设备的核心零部件，也将同步迎来确定性的市场增量机遇。

（4）等离子体电源系统是半导体先进制程演进的核心瓶颈

在半导体先进制程的演进历程中，随着芯片线宽微缩已逐步逼近物理极限，三维异构集成等技术方案成为了先进制程延续摩尔定律的核心路径。无论是逻辑芯片还是 NAND、DRAM 等存储芯片，通过高深宽比刻蚀、薄膜沉积等关键工

艺实现三维结构，已成为先进制程的核心发展趋势之一，而等离子体电源系统正是实现上述工艺的核心底层部件。

A、等离子体电源系统是先进刻蚀工艺落地的核心前提

三维结构的核心挑战，在于堆叠层数提升带来的工艺难度指数级增长，其中高深宽比刻蚀的技术门槛尤为突出。根据 LAM 研究报告，90 层以上 NAND 存储芯片沟道通孔刻蚀的深宽比，已超过世界最高建筑迪拜哈利法塔深宽比的 6 倍；该刻蚀工艺需穿透数百层二氧化硅与氮化硅交替堆叠的膜层，单片 12 英寸晶圆上的通孔数量超万亿个，每一个沟道通孔的刻蚀都如同“在沙堆中挖掘纳米级精度的超深竖井”，必须全程保持纳米级的垂直精度与一致性，任何微小偏差都将直接导致芯片功能失效。

高深宽比刻蚀工艺的稳定落地，对设备的等离子体控制能力提出了极致要求，而等离子体电源系统作为等离子体“激发与稳定存续”的核心部件，其性能直接决定工艺的可行性与量产稳定性。在刻蚀环节，射频功率需求随堆叠层数呈指数级增长，根据 LAM 研究报告，300 层、192 层 NAND 产品的刻蚀电源功率需求，分别是 128 层产品的 2.77 倍、1.27 倍。

电源功率的大幅提升，给等离子体电源系统的设计研发带来了严峻挑战：元器件爬电距离受限引发的绝缘击穿风险、高功率工况下器件耐压能力与长期可靠性不足、大功率输出导致的电磁兼容干扰加剧等问题，均会直接影响电源系统的输出精度与长期运行稳定性，已成为制约先进刻蚀工艺落地的关键瓶颈。

B、等离子体电源系统是先进薄膜沉积工艺突破的关键

薄膜沉积同样面临先进制程带来的严峻挑战。高深宽比结构中，晶圆表面、侧壁与沟槽底部距离沉积源的路径差，会导致薄膜沉积速率不均，易出现侧壁覆盖过厚、底部台阶覆盖不足等问题；而高深宽比结构带来的狭缝效应，会造成沉积源传输受阻，难以抵达沟槽底部，进而引发通孔过早封闭、内部形成空洞或缝隙等缺陷，严重影响芯片性能与良率。深宽比越高，上述问题越突出，薄膜沉积工艺难度越高，对等离子体电源系统的技术要求也随之大幅提升。

对此，等离子体电源系统需通过快速动态功率调节，精准控制等离子体的密度与活性，提升沉积粒子深腔穿透能力、调控侧壁与底部的差异化沉积、保障全

结构薄膜的均匀性，其长期运行稳定性更是直接决定芯片量产良率。等离子体的均匀性与活性直接决定最终沉积效果，因此对等离子体的高精度控制，成为突破先进薄膜沉积工艺瓶颈的关键。

此外，在高深宽比结构、1X 纳米及以下线宽的先进制程中，FCVD 作为创新型沟槽填充技术，可有效解决高深宽比沟槽填充的空洞、缝隙等问题，更好适配先进制程的加工需求；而 FCVD 通常采用远程等离子体源系统作为等离子体的激发装置，以保障高深宽比工况下等离子体的均匀性与一致性，因此远程等离子体源系统是 FCVD 工艺落地的关键部件之一。

根据中芯国际、应用材料研究团队在电化学权威期刊《ECS Transactions》联合发表的学术论文，以 20 纳米以下制程的沟槽填充为例，FCVD 工艺相较于其他 CVD 工艺，更能满足该制程下高深宽比芯片结构的无空洞填充需求。

其他CVD工艺与FCVD工艺中的沉积剖面对比图示



注：根据《ECS Transactions》期刊学术论文整理。

综上所述，等离子体电源系统作为高深宽比刻蚀、薄膜沉积关键工艺的底层支撑部件，其技术成熟度、性能稳定性与供应链自主可控能力，已成为制约半导体先进制程持续演进的核心因素。

（5）先进制程对等离子体电源系统的技术要求持续升级

随着半导体芯片从平面结构向三维复杂结构持续演进，刻蚀、薄膜沉积等关键工艺的复杂度不断提升，对等离子体电源系统的性能指标、功能模式、适配场景等，不断提出更高要求。

A、等离子体射频电源系统向大功率、高精度、多模式、集成化方向迭代

为匹配先进刻蚀等工艺的量产需求，等离子体射频电源系统主要沿四大方向迭代升级：一是功率等级持续攀升，从早期 1-5kW 常规等级迭代至 50kW 及以上大功率等级；二是控制精度大幅提升，控制架构完成从模拟控制到全数字闭环控制的全面升级，系统响应速度从微秒级提升至纳秒级；三是波形输出模式持续丰富，从传统连续波逐步演进至开关式脉冲、多级同步高频脉冲，精准匹配先进制程逻辑芯片、存储芯片等不同工序的差异化工艺窗口要求；四是集成化架构持续创新，适配先进制程半导体工艺设备的集成化发展趋势。

伴随半导体工艺设备“单腔多工站（一腔多站）”集成化设计的发展趋势，晶圆反应腔室从单晶圆串行处理升级至多晶圆并行加工模式。传统方案为每个工位单独配置“射频电源+阻抗匹配器”，存在硬件冗余度高、集成度低、工艺一致性相对难管控等问题；新一代集成化方案通过“大功率射频电源+带自动功率分配功能的阻抗匹配器+超高精度射频传感器”等的协同架构，可显著提升设备集成度、空间利用率与工艺一致性，高效支撑“单腔多工站”先进工艺设备的规模化量产落地。

B、高压脉冲电源系统系高深宽比工艺的核心并行技术方案之一

双频等离子体射频电源系统方案经过长期量产验证，在当前先进制程刻蚀工艺中具备成熟度高、工艺适配范围广等优势，是行业主流量产方案之一。但该方案采用的传统连续正弦波，存在离子能量分布宽、鞘层电压随交变周期大幅波动的特征，在高堆叠层数芯片制程的刻蚀场景中，刻蚀垂直度与形貌控制难度有所提升，存在一定工艺局限性。

当前 3XX 层级别存储芯片刻蚀工艺场景中，“双频等离子体射频电源系统”技术方案、“高压脉冲电源系统协同单射频电源”技术方案，系行业两大并行的主流技术路线，二者各有差异化技术优势与适配场景。其中，高压脉冲电源系统具备高压大功率输出能力、纳秒级快速上升/下降沿的高精度矩形脉冲波形控制能力，通过重构能量输出形式（从正弦波切换为矩形波脉冲），可窄化离子能量分布、增强离子方向性、抑制深孔底部电荷积累，能够更好的满足更高堆叠层数芯片制程对刻蚀垂直度与形貌的严苛要求，将成为高深宽比刻蚀工艺的核心配套

技术方案之一，具备广阔的应用前景。

C、远程等离子体源系统在先进制程中的作用将愈发凸显

随着半导体芯片从纳米级向 1X 埃米级持续演进，同时从平面结构向三维异构集成等复杂结构不断迭代，先进制程对工艺波动的容忍度已大幅收窄，任何微小的等离子体损伤、均匀性偏差、颗粒物污染，或因温度异常诱发的工艺偏移等，都会被放大为致命的良率损失。

远程等离子体源系统可在晶圆反应腔室远端生成高均匀性、高解离度的活性等离子体，不仅可实现晶圆衬底的近乎“零损伤”加工，还兼具高洁净度、易控温等优势，可有效提升工艺均匀性、一致性等，完美适配先进刻蚀、薄膜沉积等工艺要求，是先进制程落地的核心部件之一。

未来，远程等离子体源系统的应用场景将持续拓宽，在先进制程中的作用将进一步凸显。

（6）人工智能技术与半导体工艺深度融合，赋能等离子体源技术持续升级

人工智能技术赋能制造业的核心价值，在于推动工艺决策从传统经验驱动向数据驱动的精准闭环调控转型。人工智能技术与半导体等离子体工艺的深度融合，将有效助力等离子体源技术的迭代升级与应用边界拓展。

在半导体先进制程中，纳米级芯片的性能保障与量产良率稳定性，高度依赖刻蚀、薄膜沉积等关键工艺在单芯片、整片晶圆、规模化量产三个维度的一致性表现。实现该目标的核心，在于对等离子体能量、密度等参数的高精度调控，而工艺过程，需要在多物理场与化学场的强耦合复杂工况下，同步调控大量互相关联的工艺参数。以等离子体刻蚀工艺为例，需构建两大维度协同调控参数体系：一是等离子体电源系统核心参数，涵盖输出功率、工作频率、脉冲周期、波形整形、多源相位同步等；二是腔室环境参数，包括制程气体组分、流量配比、腔室压力稳态控制、衬底温度、电极间距等。两类参数的精准耦合匹配，直接决定刻蚀轮廓精度与最终量产良率水平。

面对上述多参数强耦合的行业难题，人工智能技术与等离子体源技术的深度融合，已成为行业公认可行的发展方向。根据 LAM 研究报告，依托人工智能技术构建半导体等离子体工艺仿真模型，通过模拟系统全工况运行，预判设计缺陷

并开展定向优化验证等，能够显著缩短工艺研发周期、降低试错成本、提升工艺效果与稳定性，全面推动半导体等离子体源技术的应用水平升级。

（四）所处行业在产业链中的地位和作用及与上下游行业的关联性

半导体产业链可划分为上游支撑产业、中游制造产业与下游应用产业三大环节。上游支撑产业涵盖半导体零部件、材料、软件及技术支持服务等，其中零部件系半导体设备的基础构成，材料、软件与技术支持服务等为半导体制造提供必要生产要素与运行保障；中游制造产业包括半导体设备与半导体制造；下游应用产业覆盖消费电子、人工智能、新能源、工业、军工等多个领域。

1、公司所处行业在产业链中的地位和作用

公司主营业务为半导体等离子体电源系统产品和相关技术支持服务，属于半导体产业链的上游支撑产业。等离子体电源系统作为半导体关键工艺设备的“动力核心”与“控制中枢”，直接决定中游制造的效率与良率等；技术支持服务系维持产线稳定运行的关键保障。公司主营业务产品与服务是支撑半导体产业链安全运转、规模扩张与先进制程迭代升级的核心基础环节。

2、上游行业对公司所处行业的影响

公司所处上游系各类电子元器件、电路板、芯片、精密机加工件等的原材料与元器件供应领域。由于中国大陆半导体产业起步相对较晚，目前在高端芯片、元器件等领域，仍然存在一定的进口依赖。公司通过积极布局上游关键原材料的国产化验证，持续推进核心供应链的自主可控，强化供应链安全与成本管控能力。

3、下游行业对公司所处行业的影响

公司下游直接面向半导体设备与制造环节，半导体行业遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的行业规律，当行业出现新技术、新需求时都将驱动公司所处行业的技术迭代与市场扩容。近年来，伴随人工智能、云计算、大数据等技术不断突破，新的市场需求不断涌现，全球半导体市场规模持续扩张；同时，国内持续推进半导体产业链补短板、强链固链、强化全产业链关键技术攻关等，进一步带动我国上游核心零部件行业快速发展。

综上所述，我国半导体产业长期向稳向好发展趋势明确，将持续带动公司所

处行业同步增长，为公司持续经营与高质量发展提供坚实支撑。

（五）行业发展面临的机遇与挑战

1、行业发展面临的机遇

（1）国家产业政策扶持为行业发展筑牢制度基础

近年来，我国高度重视半导体产业高质量与可持续发展，陆续出台了一系列顶层规划与产业政策，从发展指引、股权投资、专项支持、研发补助以及税收优惠等多方面，为半导体产业营造了优良稳定的发展环境，全力推动产业实现“强长板、补短板、上规模、上水平”的发展目标。

2026 年 3 月，第十四届全国人民代表大会第四次会议审议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，明确提出要聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节，全链条推动集成电路等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破；同期会议听取并审议了国务院《2026 年政府工作报告》，报告明确提出要培育壮大新兴产业和未来产业，打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业。2025 年 8 月，工信部、市场监督管理总局发布《电子信息制造业 2025－2026 年稳增长行动方案》，明确支持集成电路等领域科技创新，支持先进存储、三维异构集成芯片等前沿技术方向基础研究，坚定不移推动“国货国用”，持续推动短板产业补链、强化关键核心技术攻关，提升元器件、零部件等产品可靠性、安全性。而半导体设备核心零部件，正是我国半导体产业长期存在的短板领域与“卡脖子”关键环节之一，也是上述产业政策重点扶持的主要方向。

综上所述，国家层面持续出台的产业扶持政策，为我国半导体设备核心零部件领域的长期高质量发展提供了坚实制度保障，行业内具备核心自主技术能力的企业将迎来重大发展机遇。

（2）国际供应链格局重构加速国产替代进程

近年来，美国、日本、荷兰等国家持续加大对中国大陆半导体产业链的出口管制力度，管制范围与精度持续升级。2022 年 10 月，美国商务部发布多项对中国大陆半导体出口管制措施，对 18 纳米及以下 DRAM、128 层及以上 NAND 闪存、16 纳米或 14 纳米及以下逻辑芯片相关生产设备实施管控；2023 年 7 月，日

本修订后的《外汇及外国贸易法》正式实施，新增 23 类半导体制造设备出口管制品类，覆盖光刻、刻蚀、薄膜沉积、清洗等制程环节；2024 年 12 月，美国商务部更新“实体清单”，新增 140 余家中国相关企业与机构，覆盖半导体制造、关键设备等重要领域；2025 年 1 月，荷兰政府宣布自 2025 年 4 月起，对光刻机、ALD 设备、PECVD 设备、量检测设备等先进半导体设备实施进一步出口管制。

2026 年 4 月，美国参议院两党议员联合发起《硬件技术控制多边协调法案》（简称 MATCH Act），核心目标为封堵中国大陆先进半导体制造能力关键技术突破，核心管控条款包括：一是新增 4 类半导体设备全域管制，对先进制程浸没式 DUV 光刻机、TSV 刻蚀与沉积设备、低温刻蚀设备、钴沉积设备等，对中国大陆实施全面的销售、维修及技术服务禁令；二是对 5 家中国大陆先进制程芯片厂商及其关联公司，实施类实体清单级别的全维度出口与技术服务管制，覆盖所有受美国《出口管理条例》（EAR）管辖的物项；三是推动日本、荷兰、韩国等盟友国对齐美国多边管制标准，并配套单边兜底规则——若盟友未按时完成管制对齐，美国将通过扩大 EAR 项下外国直接产品规则（FDP）的适用范围，对相关境外半导体设备实施长臂管辖。截至 2026 年 8 月，该法案已获得美国众议院外交事务委员会通过，尚需通过参议院表决、总统签署等环节后方可正式生效。

上述限制措施，使得国内先进制程芯片产线与设备厂商，面临海外原厂设备、核心零部件及配套技术支持服务获取受限的双重困境，尽管短期内可能给国内芯片产线带来供应链波动与断供风险，但从中长期来看，将进一步强化国内半导体产业链全环节实现自主可控的决心，全面加速国内先进半导体设备、核心零部件的国产化替代进程，进而带动产业链相关企业实现快速发展。

（3）中下游产业链日趋完善，夯实行业发展根基

近年来，随着国内半导体“卡脖子”领域技术攻关持续推进，我国半导体设备与半导体制造产业已实现规模化突破，各细分领域布局持续完善，上下游协同发展的正向循环已初步形成。在半导体设备领域，北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科、中科飞测等国产头部厂商，已实现多个细分赛道设备的国产化突破与规模化量产；在半导体制造环节，国内已拥有中芯国际、华虹公司、上海华力、长江存储、长鑫科技、华润微等覆盖成熟制程与先进制程的头部芯片制造与半导体器件厂商。中游设备与制造环节的持续成熟，为上游半导体零

部件及技术支持服务产业提供了广阔的市场空间与规模化验证土壤。

（4）人工智能技术为行业发展带来新需求

近年来，人工智能技术实现关键性突破，本轮人工智能技术革命催生了大规模、高潜力的市场增量需求。算力中心、具身智能、自动驾驶等下游应用场景进入高速发展期，直接带动高性能 GPU、ASIC 等算力芯片，以及 NAND、HBM 等存储芯片的需求快速增长，强劲的下游需求为半导体全产业链带来了广阔的长期增长空间。

2、行业发展面临的挑战

（1）半导体设备核心零部件国产化率整体偏低

近年来，国内半导体产业实现快速发展，部分关键设备已逐步实现国产化突破与自主可控，但半导体设备核心零部件领域的国产化程度仍处于较低水平，是国内半导体产业链的核心短板之一。根据弗若斯特沙利文统计，2025 年中国大陆半导体领域等离子体射频电源系统国产化率仅 13%；根据 QYResearch 统计，2025 年中国大陆半导体领域远程等离子体源系统的国产化率不足 7%。上述领域是我国半导体产业亟待发展突破、实现自主可控的重点方向之一。

核心零部件的性能与可靠性，直接决定半导体设备的整体精度、运行稳定性与量产适配性，半导体设备的技术迭代升级，也高度依赖核心零部件的技术突破。因此，核心零部件的自主可控直接关乎我国半导体产业的长期安全发展，是半导体产业链亟待突破的关键卡脖子环节。我国半导体产业全链条自主可控仍任重道远。

（2）行业高端人才短缺

半导体行业属于典型的知识密集型、技术密集型、资本密集型行业，对高端人才的需求较高。由于中国大陆半导体行业起步相对较晚，人才培养和积累相对不足，导致人才供给难以与产业快速扩张的需求相匹配，尤其是高端人才较为匮乏，行业内高端人才供应存在较大的缺口。因此，高端人才短缺对我国半导体行业长期发展构成了一定影响。

（六）进入本行业的主要壁垒

1、技术壁垒

半导体设备核心零部件是支撑设备技术迭代与制程演进的关键载体，其性能直接决定半导体设备的精度、可靠性及半导体制造的整体水平。相较其他行业，半导体设备零部件的技术复杂度尤为突出。以等离子体电源系统为例，作为半导体关键工艺设备的“动力核心”与“控制中枢”，其技术门槛较高：空间维度上，需实现极致精度的能量调控，驱动等离子体完成纳米级的刻蚀、薄膜沉积等半导体关键工艺；时间维度上，调控需覆盖纳秒级电磁场微观变化至秒级晶圆表面化学反应，时间尺度跨越 9 个数量级。这种较高的技术复杂度，直接导致行业内具备核心竞争力的市场参与者数量有限。

同时，半导体制造具备高度复杂性和强协同耦合特性，先进制程的技术攻关，行业内普遍采用芯片制造厂、设备厂商与核心零部件厂商上下游协同研发的创新模式。核心零部件厂商需全程深度参与先进制程、配套设备的全流程研发与工艺验证，经过长期协同调校与迭代优化，最终实现与新制程产线的全流程精准适配。零部件企业在此过程中积累的技术诀窍（Know-How）与工艺适配经验，具有较强的不可复制性，对行业新进入者构筑了较高的技术壁垒。

2、客户壁垒

半导体制造的核心目标为生产效率最大化、产线运行高稳定性、工艺参数一致性可控。半导体制造具备高度复杂性和强协同耦合特性，一条完整的芯片产线通常集成超过千台各类工艺设备，单台设备或核心零部件的性能与稳定性，会对整条产线的制造体系产生显著的连锁影响，任何细微的性能缺陷或参数波动，都可能引发全链条工艺偏差，对产线整体良率与生产效率造成重大影响，这构成了行业客户壁垒形成的底层逻辑。

在新工艺设备与新品零部件的导入环节，芯片制造厂商与半导体设备厂商均制定了严苛的全流程系统性验证标准。除对产品提出极致精度指标要求外，还需验证其在高压、高频连续运行工况下的长期稳定性与一致性，新产品从送样到批量导入的门槛较高。而产品一旦通过全流程验证并实现规模化导入，为保障供应链安全与产品性能长期稳定，客户在设备定型量产后不会轻易更换核心零部件供

应商，芯片制造厂商、设备厂商与核心零部件厂商会形成深度绑定、高度互信的长期战略合作关系，合作粘性较强。

对于存量产线现役设备配套技术支持服务业务，行业准入门槛同样较高。以等离子体电源系统的技术支持服务为例，一方面，目前市场上现役等离子体电源系统覆盖数百种品牌与型号，其结构设计、技术原理差异显著；同时，不同制程、工艺类型、应用场景等对电源的参数要求、运行标准各不相同，对服务商的技术覆盖能力、工艺适配能力提出了全谱系的严苛要求。另一方面，客户对技术支持服务的核心诉求为原厂标准的“精确复制”，要求修复后的电源系统与产线原来的稳定运行参数一致，一旦打破产线原有工艺平衡，就存在引发非计划停机的风险。这一核心诉求决定了该业务绝非简单的零部件更换，而是具备较高技术门槛的精密技术服务，无核心技术支撑的企业难以进入头部芯片产线的合格供应商名录。

因此，无论是自研产品业务还是技术支持服务业务，现有头部企业与下游客户的深度绑定合作生态较为稳固，行业已形成全链条、高门槛的客户准入壁垒。

3、资金壁垒

半导体设备核心零部件的研发与产业化，是典型的高投入、长周期、高风险的系统性工程。一方面，企业从研发中心与量产基地建设，研发生产检测等高端设备购置，到产品自主研发、多轮验证测试，再到规模化量产与全流程品质管控，全链条各环节均需持续的大额资金投入；另一方面，半导体制程持续迭代，倒逼配套设备与核心零部件不断技术升级，企业需具备充足的资金实力，保障研发与产业化的持续投入，才能跟上行业技术迭代节奏，满足市场需求。

以等离子体电源系统领域的国际头部半导体企业 MKS 和 AE 为例，根据其官方披露，2023 年至 2025 年，MKS 累计研发投入达 8.6 亿美元，同期 AE 累计研发投入达 6.5 亿美元，持续高强度的研发投入是行业头部企业保持技术领先的基础。因此，对于产业新进入企业，发展各阶段所需要的大额资金储备，构成了较高的行业竞争壁垒。

4、人才壁垒

半导体制造是典型的多学科交叉的技术密集型领域，兼具深厚跨学科理论功

底与丰富先进制程产线实操经验的复合型高端人才，是推动企业技术突破与产品落地的核心资源。然而，这类人才培养周期漫长、市场供给存在显著缺口，且高度集中于行业头部企业，由此形成的人才壁垒，是行业新进入者面临的核心准入壁垒之一。

三、发行人市场竞争情况

（一）行业竞争格局

等离子体电源系统作为半导体设备核心零部件，全球市场呈现高度集中的寡头垄断竞争格局，全球市场主要被美国、日本等国际半导体企业占据。

在中国大陆新品市场，等离子体电源系统的国产化率仍处于较低水平，根据弗若斯特沙利文统计，2025 年中国大陆半导体领域等离子体射频电源系统国产化率仅 13%，相关市场主要被 MKS、AE、DAIHEN 等占据；根据 QYResearch 统计，2025 年中国大陆半导体领域远程等离子体源系统的国产化率不足 7%，相关市场主要被 MKS、AE、NPP 等占据，国内仅有少量厂商如公司、恒运昌、英杰电气、华丞电子等参与竞争。

在中国大陆存量设备配套技术支持服务市场，公司已经成为国内规模领先的半导体等离子体电源系统技术支持服务供应商。根据 QYResearch 统计，2025 年公司在中国大陆等离子体电源系统技术支持服务市场中的市场份额排名第一，该市场的主要竞争对手系 MKS、AE 等国际原厂的技术支持服务部门。

公司所处行业市场竞争的主要企业，情况如下：

公司名称	总部所在地	主要业务经营情况及市场地位
MKS	美国	MKS Instruments, Inc.（NASDAQ：MKSI），成立于 1961 年，全球领先的等离子体电源系统供应商，主营业务为半导体制造、先进电子等的先进制造设备解决方案；半导体领域产品矩阵覆盖硅片、薄膜沉积、刻蚀、光刻和电性能改性等主要工艺链条，等离子体电源系统产品包括等离子体射频电源系统、远程等离子体源系统、微波等离子体系统等，2025 年营业收入为 39.31 亿美元。
AE	美国	Advanced Energy Industries, Inc.（NASDAQ：AEIS），成立于 1981 年，全球领先的等离子体电源系统供应商，主营业务为半导体、工业、医疗等领域的精密电源、传感与控制解决方案；半导体领域覆盖刻蚀、薄膜沉积、腔室清洗、检测、注入和退火等工艺环节，等离子体电源解决方案包括射频等离子体发生器、射频匹配网络、远程等离子体源、脉冲和直流电源系统等，2025 年营业收入为 17.99 亿美元。
DAIHEN	日本	DAIHEN Corporation（TSE：6622.T），成立于 1919 年，全球工业自

公司名称	总部所在地	主要业务经营情况及市场地位
		动化、机器人、电力设备等领域的领先企业，核心业务涵盖电力设备、工业机器人、焊接机设备，电力设备板块产品包括等离子体射频电源系统、电动汽车充电系统等，**截至 2026 年 3 月财年集团收入 2,377.35 亿日元。**
NPP	韩国	New Power Plasma（KRX：144960），成立于 1999 年，专注于半导体、显示面板、光伏等领域的等离子体源工艺核心电源系统供应商，主要产品包括等离子体射频电源系统、远程等离子体源系统等，**2025 年集团营业收入为 5,779.90 亿韩元。**
霍廷格	德国	TRUMPF Hüttinger 系全球工业激光与智能装备头部企业 TRUMPF Group（通快集团）子公司，成立于 1922 年，全球领先的等离子体特种电源供应商，核心产品包括等离子体射频电源系统、直流脉冲电源等；2024/25 财年通快集团营业收入为 43.29 亿欧元。
恒运昌	中国大陆	恒运昌（688785.SH），成立于 2013 年，专注于等离子体射频电源系统、等离子体激发装置、等离子体直流电源等的半导体设备零部件供应商。**2025 年营业收入 5.29 亿元。**
英杰电气	中国大陆	英杰电气（300820.SZ），成立于 1996 年，业务覆盖特种电源、功率控制电源、新能源汽车充电设施等，电源产品应用于光伏、新能源、半导体等领域；其半导体领域特种电源包括射频电源、直流编程电源、高压电源等系列产品。**2025 年营业收入 15.02 亿元。**
华丞电子	中国大陆	北京华丞电子有限公司，为北方华创（002371.SH）子公司。其主要产品包括流量测控、压力测控、气路系统、射频电源、匹配器、磁流体密封装置、传输系统、自动化装备等系列产品。**2025 年华丞电子营业收入为 20.31 亿元。**

注：根据主要竞争企业官网、行业公开信息等公开资料整理。

（二）发行人与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况

1、同行业可比公司选取依据

公司主要从事半导体关键工艺设备核心零部件的研发、生产、销售和技术支持服务等，主要产品为等离子体电源系统和技术支持服务等，下游应用领域主要为半导体设备及半导体制造。

目前，国内外暂无主营业务和主要产品与公司完全一致的上市公司。公司综合考虑主营业务、产品种类及功能用途、下游应用领域、主要客户、经营数据可获取性和可比性，选取 A 股上市公司恒运昌、英杰电气、先锋精科和富创精密作为财务分析可比公司，并将 MKS、AE 作为业务可比公司。各公司的具体可比情况如下：

公司名称	主营业务、主要产品、主要客户等情况及可比程度
恒运昌（688785.SH）	恒运昌主营业务系半导体设备核心零部件业务，核心产品包括等离子体射频电源系统、等离子体激发装置、等离子体直流电源等，下游主要应用于半导体设备领域，主要客户涵盖拓荆科技、中微公司、微导纳米、北方华创、宏大真空、中电科集团、捷佳伟创等，其主营业务、核心产品功能用途、下游应用领域与公司基本一致，主要客户与公司部分重合，具备一定的可比性。
英杰电气（300820.SZ）	英杰电气主营业务系特种电源、功率控制电源及新能源汽车充电站/充电桩业务，核心产品包括功率控制电源、射频/溅射电源、感应电源、高压电源等特种电源及交流、直流充电桩产品，下游主要应用于光伏、充电桩/站、半导体及电子材料领域，主要客户涵盖隆基股份、中微公司、东方希望、晶盛机电等，其特种电源业务中部分品类为半导体设备核心零部件，主营业务、下游应用领域与公司部分一致，其射频/溅射电源的功能用途与公司产品基本一致，主要客户与公司部分重合，具备一定的可比性。
先锋精科（688605.SH）	先锋精科主营半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造业务，核心产品包括关键工艺部件、工艺部件和结构部件，下游主要应用于半导体设备领域，主要客户涵盖中微公司、北方华创、中芯国际、拓荆科技、屹唐股份、华海清科等，其主营业务、下游应用领域与公司基本一致，核心产品应用于晶圆反应腔室相关工艺，用途与公司产品基本一致，主要客户与公司部分重合，具备一定的可比性。
富创精密（688409.SH）	富创精密主营半导体设备精密零部件研发和制造业务，核心产品包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路，下游主要应用于半导体设备领域，主要客户涵盖东京电子、北方华创、中微公司、屹唐股份、拓荆科技、华海清科、芯源微等，其主营业务、下游应用领域与公司基本一致，核心产品应用于晶圆反应腔室相关工艺，用途与公司产品基本一致，主要客户与公司部分重合，具备一定的可比性。
MKS（MKSI.O）	MKS 系全球领先的等离子体电源系统供应商，主营业务系半导体制造、先进电子等的先进制造设备解决方案，半导体领域产品矩阵覆盖硅片、薄膜沉积、刻蚀、光刻和电性能改性等主要工艺链条，等离子体电源系统产品包括等离子体射频电源系统、远程等离子体源系统、微波等离子体系统等。全球主要客户涵盖应用材料、LAM、东京电子等全球主流半导体设备厂，国内客户覆盖北方华创、中微公司等头部设备厂。其等离子体电源系统类产品的功能用途、下游应用领域与公司基本一致，其整体业务覆盖范围更广、产品线更丰富，主要客户与公司部分重合，具备一定的业务可比性。
AE（AEIS.O）	AE 系全球领先的等离子体电源系统供应商，主营业务为半导体、工业、医疗等领域的精密电源、传感与控制解决方案；半导体领域覆盖刻蚀、薄膜沉积、腔室清洗、检测、注入和退火等工艺环节，等离子体电源解决方案包括射频等离子体发生器、射频匹配网络、远程等离子体源、脉冲和直流电源系统等；全球主要客户涵盖应用材料、LAM、东京电子等全球主流半导体设备厂，国内客户覆盖北方华创、中微公司等头部设备厂。其等离子体电源系统类产品的功能用途、下游应用领域与公司基本一致；其是全球该领域的标杆企业之一，主要客户与公司部分重合，具备一定的业务可比性。

注：根据可比公司的公司官网、定期报告、招股说明书等公开资料整理。

2、与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况

（1）经营情况对比

公司与同行业可比公司经营情况对比参见招股说明书“第六节”中的毛利率分析、流动性分析和偿债能力分析等内容。

（2）市场地位对比

发行人与同行业可比公司的业务不完全一致，因此市场地位不具有可比性。发行人与主要竞争对手的市场对比情况参见本招股说明书“第五节/三/（一）”。

（3）技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据等方面的比较情况

发行人与同行业可比公司在企业经营规模、专利数量、研发人员情况以及研发费用占比等指标的对比情况，主要如下：

项目	发行人	恒运昌	英杰电气	先锋精科	富创精密	MKS	AE
企业经营规模	2025 年营业收入 6.54 亿元，2025 年净利润 2.09 亿元	2025 年营业收入 5.29 亿元，2025 年净利润 1.14 亿元	2025 年营业收入 15.02 亿元，2025 年净利润 2.31 亿元	2025 年营业收入 12.38 亿元，2025 年净利润 1.89 亿元	2025 年营业收入 35.43 亿元，2025 年净利润 -0.16 亿元	2025 年营业收入 39.31 亿美元，2025 年净利润 2.95 亿美元	2025 年营业收入 17.99 亿美元，2025 年净利润 1.48 亿美元
专利数量	截至 2025 年末，发明专利 62 项	截至 2025 年末，发明专利 123 项	截至 2025 年末，发明专利约 67 项[注 2]	截至 2025 年末，发明专利 38 项	截至 2025 年末，发明专利 91 项	截至 2025 年末，美国专利 585 项，外国专利 2,217 项[注 3]	未披露
研发人员情况	截至 2025 年末，研发人员 124 人，占比 24.46%	截至 2025 年末，研发人员 158 人，占比 39.01%	截至 2025 年末，研发人员 458 人，占比 31.11%	截至 2025 年末，研发人员 156 人，占比 10.25%	截至 2025 年 6 月末，研发人员 466 人，占比 13.36%	截至 2025 年末，研发人员 1,854 人，占比 18%[注 3]	未披露
研发费用和占比情况	2023 年-2025 年，累计研发费用 2.04 亿元，累计占比 14.97%	2023 年-2025 年，累计研发费用 1.72 亿元，累计占比 12.35%	2023 年-2025 年，累计研发费用 3.77 亿元，累计占比 7.46%	2023 年-2025 年，累计研发费用 1.72 亿元，累计占比 5.86%	2023 年-2025 年，累计研发费用 7.01 亿元，累计占比 8.10%	2023 年-2025 年，累计研发费用 8.58 亿美元，累计占比 7.70%	2023 年-2025 年，累计研发费用 6.46 亿美元，累计占比 13.08%

注 1：根据可比公司定期报告、招股说明书等公开披露资料整理；
注 2：英杰电气发明专利数量根据 2023 年 6 月《向特定对象发行 A 股股票（注册稿）》《2023 年年度报告》《2024 年年度报告》《2025 年年度报告》披露口径统计；
注 3：MKS 专利数量及研发人员数量根据《MKS Annual Report 2025》披露口径统计。

（4）公司主要产品与行业内主要竞品的关键技术指标对比

A、射频电源

公司结合产品功能、性能等级和应用场景，选取规格相同或相近的 AE、MKS 产品进行比较。其中，AE Apex 为成熟主流系列，AE Paramount Plus 和 MKS EDGE 为高端系列。具体如下：

项目		神州半导体		AE		MKS	对比情况
		Advance 系列	Advocate 系列	Apex 系列	Paramount Plus 系列	EDGE 系列	
性能指标	功率等级	15kW-50kW	1kW-12kW	1.5kW-10kW	5kW-15kW	3kW-50kW	Advocate 与 AE 相当；Advance 与 MKS 相当
	功率精度	±1%	±1%	±1%	±1%	±1%	指标相当
	脉冲级数	Max：8 级	Max：4 级	无公开信息	Max：2 级	Max：4 级	Advance 优于 AE 和 MKS；Advocate 与 MKS 相当，优于 AE
	脉冲模式	on-off/Level to Level/Multi-state	on-off/Level to Level/Multi-state	无公开信息	Single-and dual-level pulsing	on-off/Level to Level/Multi-state	指标相当
	最高脉冲频率	100kHz	45kHz	50kHz	10kHz	45kHz	Advance 优于 AE 和 MKS；Advocate 与 AE Paramount Plus 和 MKS EDGE 系列相当
	最小脉宽	5μs	10μs	10μs	无公开信息	≤11μs	Advance 优于 AE 和 MKS；Advocate 与 AE 和 MKS 相当
	脉冲上升时间	≤1μs	≤5μs	≤200μs	≤1μs	≤4μs	Advance 优于 AE 和 MKS；Advocate 略低于 AE 和 MKS
	脉冲下降时间	≤1μs	≤5μs	≤2μs	≤1μs	≤4μs	Advance 优于 AE 和 MKS；Advocate 略低于 AE 和 MKS
	自动调谐频率调节时间	＜10ms	＜100ms	/	无公开信息	＜100ms	Advance 优于 AE 和 MKS；Advocate 与 MKS 指标相当
	自动调谐频率重复性	≤25kHz	≤25kHz	/	无公开信息	≤25kHz	指标相当
高级功能	脉冲同步	√	√	/	√	√	指标相当
	自动频率调谐功能	√	√	/	√	√	指标相当

注：根据 MKS 和 AE 公司官网、产品手册等公开信息整理。

由上表可知，公司 Advance 系列主要面向大功率应用，最高功率达到 50kW，与 MKS EDGE 系列相当；功率精度与竞品相当；在脉冲调控方面，Advance 系列支持同步高频脉冲，脉冲级数、最小脉宽等指标较优；在负载适配方面，调谐频率调节时间较优。

公司 Advocate 系列主要面向中低功率应用，功率等级与 AE Apex、Paramount Plus 系列相当；功率精度与竞品相当；在脉冲调控方面，Advocate 系列支持同步脉冲，脉冲级数较优；在负载适配方面与竞品相当。

B、阻抗匹配器

公司根据产品功能、性能等级、应用场景等，选取规格相近的 AE 的 Navigator II 和 Navio 系列产品进行比较。其中，Navigator II 为 AE 的高端成熟系列，Navio 为 AE 成熟主流系列，均为行业内具有代表性的商业化产品。具体如下：

项目	神州半导体		AE		对比情况
	Focus 系列	APD 系列	Navigator II 系列	Navio 系列	
匹配速度	预设小于 10%≤260ms	预设小于 10%＜1S	预设小于 10%≤260ms	合适的预设≤2S	Focus 与 Navigator II 相当、优于 Navio；APD 优于 Navio
反射功率	0.004*FWD	0.004*FWD	0.004*FWD	0.01*FWD	与 Navigator II 相当，优于 Navio
匹配位置重复性	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%	指标相当
匹配位置一致性	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%	指标相当
传输效率	＞80%	＞85%	＞80%	＞80%	Focus 与 AE 相当；APD 指标较高
自动功分	2 通道电流分配	4 通道功率、电压或电流分配	2 通道电流分配	/	Focus 与 AE 相当；APD 指标较高
脉冲匹配	CW/Pulse	CW/Pulse	CW/Pulse	仅支持 CW	指标相当

注：根据 AE 公司官网、产品手册等公开信息整理。

由上表可知，公司 Focus 系列与 AE Navigator II 高端成熟系列的主要指标总体相当，部分指标优于 AE Navio 成熟主流系列；APD 系列在反射功率、重复性、匹配位置一致性及传输效率等通用指标方面亦达到 AE 高端产品水平。同时，APD 系列可满足多种频段组合，具备多输出通道集成自动匹配、自动按比例功分等智能化功能，可实现半导体工艺设备一腔多站式应用。

C、远程等离子体源系统

a、Central 系列

Central 系列产品主要用于腔室清洗等工艺，属于中等功率、中等流量规格产品。公司选取 MKS Paragon 系列、NPP VONE 系列、AE Xstream 系列产品进行比较，其中，MKS 和 NPP 相关型号为同规格高端产品，AE Xstream 系列产品为成熟主流的中等功率产品。具体如下：

项目		神州半导体	MKS	AE	NPP	对比情况
		Central 系列	Paragon 系列	Xstream 系列	VONE NVA 系列	
性能指标	最大输出功率	10kW	10kW	8kW	10kW	与 MKS 和 NPP 相当，高于 AE
	运行气体最大流量	8 SLM	8 SLM	6 SLM	8 SLM	与 MKS 和 NPP 相当，高于 AE
	运行压力	1 to 10 Torr	1 to 10 Torr	Up to 12 Torr	0.3 to 10 Torr	指标相当
	点火气体流量	1 to 6 SLM	1 to 5 SLM	Up to 1 SLM	Up to 6 SLM	略高于 MKS，高于 AE，略低于 NPP
	点火气体压力	1-8 T	1-8 T	0.1-4 T	0.1-10 T	与 MKS 相当，略低于 NPP，高于 AE
	解离率	≥95%@ 1-8 SLM 1-10 Torr	>95%@ 1-8 SLM 1-10 Torr	>98%@ 6 SLM 7 Torr	>95%@ 1-8 SLM 1-10 Torr	指标相当
高级功能	反应腔材料	硬质阳极氧化或微弧氧化	硬质阳极氧化或微弧氧化	硬质阳极氧化	硬质阳极氧化或微弧氧化	与 MKS 和 NPP 相当

注：根据 MKS、AE 和 NPP 公司官网、产品手册等公开信息整理。

由上表可知，Central 系列产品的最大输出功率、气体处理能力、解离率等指标总体达到 MKS、NPP 同规格高端产品水平，部分能力范围高于 AE 相关产品。

b、Pilotage 系列

Pilotage 主要应用于腔室清洗、薄膜沉积等工艺，属于大功率、大流量规格产品。与 Central 相比，可有效缩短腔室清洗时间，并具备较高的功率控制精度，可适配 FCVD 等薄膜沉积工艺。

公司选取 MKS RPS-CM 系列产品、NPP VONE NVA 系列产品进行比较，相关竞品均为 MKS 和 NPP 同规格高端产品。具体如下：

项目		神州半导体	MKS	NPP	对比情况
		Pilotage 系列	RPS-CM 系列	VONE NVA 系列	
性能指标	最大输出功率	15kW	12kW	15kW	与 NPP 相当，高于 MKS
	运行气体最大流量	16 SLM	12 SLM	16 SLM	与 NPP 相当，高于 MKS
	运行压力	0.1 to 10 Torr	1 to 15 Torr	0.3 to 10 Torr	与 MKS 相当，略高于 NPP
	点火气体流量	1-6 SLM	1 to 5 SLM	Up to 6 SLM	与 NPP 相当，略高于 MKS
	点火气体压力	0.1-10 T	1-10 T	0.1-10 T	与 NPP 相当，略高于 MKS
	解离率	≥95%@ 1-16 SLM 0.1-10 Torr	>98%@ 1-12 SLM 1-10 Torr	无公开信息	略低于 MKS
高级功能	反应腔材料	硬质阳极氧化或微弧氧化	硬质阳极氧化或微弧氧化	硬质阳极氧化或微弧氧化	指标相当
	功率精度	±1%	±1%	±1%	指标相当

注：根据 MKS 和 NPP 公司官网、产品手册等公开信息整理。

由上表可知，公司 Pilotage 系列产品在最大功率、气体处理流量、点火能力、功率精度等方面达到国际高端同类产品水平。

c、Major 系列

Major 系列主要用于去胶、灰化及表面处理等工艺。公司选取 MKS Revolution 系列、NPP FARO NAS 系列产品进行比较。其中，MKS 相关型号为该应用场景的高端主流产品，NPP 相关型号为其面向相同应用场景推出的较新产品。具体如下：

项目		神州半导体	MKS	NPP	对比情况
		Major 系列	Revolution 系列	FARO NAS 系列	
性能指标	最大输出功率	6kW	6kW	6kW	指标相当
	运行气体最大流量	1-10 SLM	1-10 SLM	1-10 SLM	指标相当
	运行压力	＜4 Torr	＜4 Torr	0.5-2 Torr	与 MKS 相当，高于 NPP
	点火气体流量	1-10 SLM	1 to 10 SLM	Up to 6 SLM	与 MKS 相当，高于 NPP
	点火气体成分	氧气、氮气，典型比例 9:1	氧气、氮气，典型比例 9:1	氧气、氮气，典型比例 9:1	指标相当
	点火气体压力	＜2 Torr	＜2 Torr	＜2 Torr	指标相当
高级功能	反应腔材料	石英	石英	石英	指标相当

注：根据 MKS 和 NPP 公司官网、产品手册等公开信息整理。

由上表可知，Major 系列产品的最大功率、运行气体处理能力、点火气体处理能力等方面与国际竞品总体相当。

（5）技术支持服务与行业主要竞争者的对比情况

公司技术支持服务主要面向芯片产线，为产线在役设备配套的等离子体电源系统提供检测、维修等服务，主要竞争者包括 AE、MKS 等原厂。

芯片产线通常需要连续运行，设备故障导致的停机、停产损失远高于相关技术支持服务费用，且服务效果需要经过产线设备长期运行检验。因此，客户持续合作能够从实际应用层面反映服务商的维修质量、响应能力和交付稳定性。

AE、MKS 等海外原厂掌握自有产品的原始设计及技术标准，主要为自有品牌提供相应服务。公司积累了多品类、多品牌、多型号产品的故障处理及工况经验，服务覆盖主流品牌的多类型号；同时，公司已在北京、上海、深圳、武汉、沈阳和大连等国内主要半导体产业集聚地区建立服务网点。部分原厂产品需跨境返修或由指定服务中心处理，公司在跨品牌服务、综合服务能力、本地化响应和交付效率等方面形成差异化优势。

公司技术支持服务已获得多家境内外头部芯片厂商和设备厂商认可，并与主要客户保持长期合作。根据 QYResearch 统计，2025 年公司在中国大陆等离子体电源系统技术支持服务市场份额排名第一，AE 和 MKS 分别位列第二和第三。

（三）发行人技术水平及特点

在半导体等离子体电源系统领域，公司是中国大陆产品布局最全面、技术最先进、服务最完善的企业之一，已形成了以先进制程等离子体电源系统自主研发与全方位技术支持服务双轮驱动的发展模式。

公司主营业务产品及服务的技术水平及特点，主要如下：

1、自研产品

公司自研产品覆盖等离子体射频电源系统、远程等离子体源系统、高压脉冲电源系统等，适配半导体先进制程，主要情况如下：

在等离子体射频电源系统方面，公司产品具有甚高频（最高可达 60MHz）、大功率（最高可达 50kW）等特点，支持多级高频同步脉冲及变频、快速阻抗匹

配、多级脉冲匹配、自动功分等功能，适配先进刻蚀、薄膜沉积等工艺；在远程等离子体源系统方面，公司具备自主研发生产其阳极氧化工艺解离腔体的能力，产品具备高洁净度、耐腐蚀、高稳定性、高解离率、高点火成功率等特点，适配先进薄膜沉积、去胶、清洗等工艺；在高压脉冲电源系统方面，产品作为新型刻蚀工艺核心配套电源方案，具有高电压（最高可达 15kV）、大功率（最大可达 120kW）等特点，支持重构脉冲波形、多级高频同步脉冲及变频等功能，适配先进刻蚀工艺，已经通过国内先进制程芯片产线的工艺验证，更是未来实现 4XX 层级别芯片制程不可或缺的核心配套技术方案之一。

目前，公司自研的产品已批量导入中微公司、拓荆科技、北方华创等国内头部半导体设备厂商，服务于客户 C、客户 A、客户 B、客户 D 等国内头部芯片产线，可适配 14 纳米及以下逻辑芯片、2XX 层及以上存储芯片等先进制程产线，有力推动了我国半导体先进制程关键工艺设备的国产化进程，为我国半导体先进制程“高深宽比”场景下的三维异构集成等前沿技术突破提供核心底层支撑。

2、技术支持服务

在技术支持服务领域，公司已经发展成为国内规模领先的等离子体电源系统专业技术支持服务商，为国内外主要芯片产线提供等离子体电源系统的检测、维修和性能升级等技术支持服务。在国际贸易冲突持续升级、海外原厂服务收缩的行业背景下，公司有效保障了国内芯片产线的正常运转。

目前，公司的技术支持服务已覆盖客户 A、台积电、英特尔、三星电子、SK 海力士、美光科技、德州仪器、客户 B、客户 E、客户 C、客户 D、华润微等国内外主流芯片产线，以及应用材料、中微公司、拓荆科技、北方华创等国内外知名半导体设备厂商。公司系国内少数在该领域同时进入应用材料、英特尔、三星电子、SK 海力士等国际头部厂商供应链的企业。

公司掌握的核心技术具体内容参见本招股说明书“第五节/七/（二）/1、”。公司凭借较强的技术实力，承担及参与了多个国家级重大科研任务攻关，具体内容参见本招股说明书“第五节/七/（六）/2、”。公司产品技术先进性获得了业界权威机构与头部客户的高度认可，具体参见本招股说明书“第五节/一/（二）/4、”。公司主要产品关键技术指标与主要竞品的对比情况，具体参见本招股说

明书“第五节/三/（二）/2、”。

（四）发行人竞争优势

1、公司具备持续研发创新和技术迭代能力

公司自成立以来，始终保持高强度的研发投入，持续深耕等离子体电源系统高端市场，顺利实现了等离子体射频电源系统、远程等离子体源系统、高压脉冲电源系统等在内的多个产品的商业化落地。目前，公司主要产品的总体性能已达到国际先进水平，并批量应用于国内头部半导体芯片产线，有效突破了海外厂商的长期垄断，实现了高端等离子体电源的自主可控，填补了国内同类产品的技术空白，有力推动了该领域的国产化自主可控。

公司依托较强的研发创新和技术迭代能力，承担及参与了多项国家级重大科研任务攻关，具体内容参见本招股说明书“第五节/七/（六）/2、”。公司系国家高新技术企业，先后获批建设江苏省等离子源工程技术研究中心、江苏省企业技术中心，并获评国家级专精特新重点小巨人企业。

目前，公司已在等离子体电源系统领域构建了完善的核心技术体系，形成了全面的自主知识产权布局，在技术迭代、产品研发与商业化落地方面积累了深厚的行业经验。持续的研发创新与技术迭代能力，是公司保持产品技术先进性、巩固市场竞争力的核心根基。

2、公司具备经验丰富、专业务实的研发技术团队

公司十分重视技术研发团队的建设，打造了行业一流的研发技术团队。截至报告期末，**公司研发人员 138 人，占比 24.64%**。公司创始团队系国内最早从事等离子体电源系统业务的团队之一，核心人员从业年限均在 10 年以上，且在加入公司之前亦具备较长年限在 MKS、AE 或 EQ GLOBAL 等知名国际半导体厂商或技术支持服务商等的从业经验。

公司创始人朱培文先生拥有 25 年以上行业从业经历，曾作为负责人先后主导了科技部国家火炬计划项目、科技部重大专项子课题等的研发工作，获得了江苏省非公有制经济优秀建设者等个人荣誉；叶剑先生拥有 40 年以上行业从业经历，是上海市集成电路行业协会理事会理事，《半导体视界》国际期刊编委，西交利物浦大学客座教授，中国国际科技促进会半导体产业发展分会专家智库成员，

曾在航空/电子领域权威期刊《航空电子技术》《洪都航空》《海军航空大学学报》等发表过多篇文章，曾参与多个航空/电子专用工艺与测试领域的国家级、省级科研项目的研发工作，并曾负责组建 MKS 中国大陆地区技术支持服务团队，担任 MKS 中国大陆地区技术支持服务业务负责人；朱国俊先生、潘小刚先生、尹巧星先生等核心研发团队成员均拥有 10 年以上的行业从业经历。详细情况参见本招股说明书“第四节/九”。

3、公司自研产品业务具有较强的市场竞争优势

（1）产品定位高端市场，适配半导体先进制程需求

公司产品定位于高端市场，产品系列一经推出便批量引入国内头部半导体设备厂商，适配于国内头部芯片产线。

在等离子体射频电源系统方面，公司产品具有甚高频（最高可达 60MHz）、大功率（最高可达 50kW）等特点，支持多级高频同步脉冲及变频、快速阻抗匹配、多级脉冲匹配、自动功分等功能，适配先进刻蚀、薄膜沉积等工艺；在远程等离子体源系统方面，公司具备自主研发生产其阳极氧化解离腔体的能力，产品具备高洁净度、耐腐蚀、高稳定性、高解离率、高点火成功率等特点，适配先进薄膜沉积、去胶、清洗等工艺；公司高压脉冲电源系统属于新型刻蚀工艺方案电源产品，具有高电压（最高可达 15kV）、大功率（最大可达 120kW）等特点，支持重构脉冲波形、多级高频同步脉冲及变频等功能，适配先进刻蚀等工艺，已经通过国内先进制程芯片产线的工艺验证，更是未来实现 4XX 层级别芯片制程不可或缺的核心配套技术方案之一。

目前，公司自研的产品已批量导入中微公司、拓荆科技、北方华创等国内头部半导体设备厂商，服务于客户 C、客户 A、客户 B、客户 D 等国内头部芯片产线，可适配 14 纳米及以下逻辑芯片、2XX 层及以上存储芯片等先进制程产线，有力推动了我国半导体先进制程关键工艺设备的国产化进程，为我国半导体先进制程“高深宽比”场景下的三维异构集成等前沿技术突破提供核心底层支撑。

（2）产品性能表现优异，直接参与国际巨头企业竞争

公司始终瞄准世界半导体技术前沿进行自研产品的研发创新，自研产品等离子体射频电源系统、远程等离子体源系统等系列产品总体性能已达国际同类产品

水平，并在部分关键技术参数取得领先，成功实现了对国际巨头产品的国产化替代。公司产品性能表现优异，直接参与到与美国、日本等国际巨头企业的充分竞争中，受到了下游头部客户的高度认可，具体内容详见本招股说明书“第五节/一/（二）/4、”。

（3）深度绑定头部客户，构建协同合作生态

目前，公司自研产品已经获得了中微公司、拓荆科技、北方华创等国内头部半导体头部设备企业的高度认可，成功导入国内头部芯片产线中。凭借过硬的产品与服务能力，公司斩获多项行业权威奖项，并获得头部客户的高度认可：荣获**2026 年中国证券报“2025 年度新质企业金牛奖（人工智能）”**、2026 年 SEMICON“年度新锐企业奖”、中国 IC 独角兽联盟“2024-2025 中国半导体产线电源领军企业”“2024-2025 中国半导体产线电源最佳解决方案”、2026 年中微公司供应商“合作创新奖”“卓越质量进步奖”、2025 年拓荆科技全球合作伙伴“协作创新奖”、2025 年客户 C 供应商“最佳服务奖”等。

由于半导体制造的高度复杂特性和强协同耦合特性，在先进制程的技术攻关中，行业内普遍采取芯片厂商、设备厂商与核心零部件厂商上下游协同研发创新的模式。公司作为等离子体电源系统领域的先进企业，已与多家国内头部半导体设备厂商、芯片厂商建立了紧密的协同研发合作关系，深度参与其新一代制程及配套设备的研发创新，为其提供相应核心零部件解决方案，为公司持续深化市场渗透、提升市场份额奠定了坚实基础。

4、公司技术支持服务业务具有较强的市场竞争优势

（1）市场份额位居行业前列，具备领先市场地位

公司经过多年行业深耕，已成为等离子体电源系统领域国内规模领先的技术支持服务供应商，服务能力覆盖几乎全部主流品牌的全部型号产品，为我国半导体芯片产线破解“停机风险”，保障产线稳定、持续运转提供有力支撑。根据 QYResearch 统计，2025 年公司在中国大陆等离子体电源领域技术支持服务市场份额排名第一。

对于下游芯片产线客户来说，技术支持服务直接关系到产线的安全生产与稳定运行，因此对技术支持服务商的遴选要求较为严苛，不仅有着较长时间的验证

周期，还会重点考察供应商的过往业绩、行业口碑与市场影响力等。

公司作为中国大陆领先的等离子体电源系统技术支持服务商，有着丰富的过往业绩和广泛的行业影响力，在竞争中可以处于有利地位。

（2）完善的全国服务网点布局，可以快速响应客户需求

等离子体电源系统作为刻蚀设备、薄膜沉积设备等半导体关键工艺设备的核心零部件，若其出现故障，则可能直接导致产线出现停机风险，造成较大的经济损失。因此，下游芯片产线客户通常对技术支持服务有着快速响应的要求，以保障生产的安全稳定。

公司围绕国内核心半导体产业集群与重点客户，已经布局了较为完整的技术支持服务网络，技术支持中心遍布北京、上海、深圳、武汉、沈阳、大连等国内头部半导体产线所在地区，以便快速响应产线客户需求，为其提供高质量、高效率的技术支持服务。

（3）优质广泛的客户资源优势，进入了国际巨头供应链

公司具备较强的客户资源优势。通过多年的积累，公司的技术支持服务已覆盖客户 A、台积电、英特尔、三星电子、SK 海力士、美光科技、德州仪器、客户 B、客户 C、客户 D、华润微等国内外主流芯片产线，以及应用材料、中微公司、拓荆科技、北方华创等国内外知名半导体设备厂商。

国际半导体巨头对供应商有着远高于行业平均水平的验证标准与准入门槛。公司是中国大陆地区少数同时进入美国、韩国等半导体巨头供应链的等离子体电源系统技术支持服务商之一，服务于英特尔、三星电子、SK 海力士、美光科技、德州仪器、应用材料等知名企业，相对于其他竞争对手，有更高的国际化视野和行业影响力。

5、公司自研产品业务和技术支持服务业务双向协同，可以相辅相成，共同发展

公司秉承自研产品业务和技术支持服务业务双线发展的发展路径，两个业务板块相辅相成，具有较强的协同作用。

公司成立初期以等离子体电源系统技术支持服务为主，深度服务国内外主流

芯片产线。通过长期一线产线的实战沉淀，公司不仅实现了业务规模的持续增长，更精准的掌握了一线产线的具体需求，深刻理解主流等离子体电源系统的技术路线与应用场景，积累了大量一线工艺适配经验与技术诀窍（Know-How）。这些核心积累为自研产品业务提供了较为明确的研发方向，使公司能够紧扣产线生产需求开展针对性研发，有效提升研发效率、缩短客户验证周期等；同时，技术支持服务业务稳定的盈利能力，为自研产品业务提供了持续的研发投入保障，支撑多条产品管线研发项目的顺利推进，是公司实现等离子体电源系统国产替代快速突破的核心基础。

报告期内，公司自研产品进入大规模量产阶段，收入规模快速增长。随着自研产品陆续过保，也将为技术支持服务板块带来增量业务需求；同时，公司通过自研产品打磨形成的核心技术体系又可全面复用至技术支持服务业务，有效提升维修精度、服务效率与复杂工艺场景适配能力等，进一步巩固了公司在国内技术支持服务市场的领先优势。

两大业务板块齐头并进、循环赋能，不仅显著增强了客户粘性与综合市场竞争力，更有效平滑了半导体行业周期波动对公司业绩的潜在影响，为公司长期稳定增长提供了坚实保障。

（五）发行人的竞争劣势

1、公司融资渠道相对单一

随着公司品牌影响力与市场份额持续提升，业务规模不断扩大，公司日常运营资金需求、产能建设等资本性支出持续增加；同时，为保持产品技术先进性与核心竞争力，公司需要持续投入大量研发资金推动产品迭代与技术突破。目前公司融资渠道相对单一，主要依靠内部经营积累、股东投入等，一定程度上限制了公司发展，需要进一步拓宽融资渠道，匹配公司业务规模增长需求。

2、公司国际影响力相对较小

报告期内，公司经营规模稳步增长，核心产品或服务已进入部分国内外头部供应链，但与 MKS、AE 等国际半导体巨头相比，公司在国际品牌影响力、海外业务规模等方面仍存在一定差距。未来公司需持续拓展国际市场，提升公司的国际品牌影响力。

3、公司产能相对不足

公司产品的市场需求快速增长，当前产能已经较难满足未来持续增长的订单需求，一定程度上限制了公司发展。随着公司本次募投项目的顺利实施，公司产能相对不足的问题有望得到改善。

四、发行人销售情况和主要客户情况

（一）发行人主要产品或服务的销售情况

1、主要产品的产能、产量、销量情况

公司技术支持服务业务主要系面向芯片产线存量现役电源系统，为客户提供性能修复、精度复刻等服务，实现原厂标准的功能恢复，保障芯片产线稳定运行；该业务主要为需求驱动的定制化模式，亦无需配置大批量产成品库存备货，因此不适用传统制造业通用的产能、产销率统计口径。

公司自研产品业务主要采用“以销定产”的柔性生产模式，核心生产流程以装配、测试等环节为主，未配置传统专用标准化量产生产线，无针对单一品类产品的固定设计产能，实际生产能力取决于装配、测试等环节的综合配套能力；因此，公司结合现有生产测试设备、厂房设施、人员配置等生产要素，按单班制生产模式核定产能规模。

报告期内，公司自研产品的产能、产量、产能利用率、销量、产销率情况，主要如下：

单位：套/台

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
产能	**844**	878	1,211	324
产量	**1,221**	934	1,169	226
产能利用率	**144.67%**	**106.38%**	**96.53%**	**69.75%**
销量	**1,251**	1,148	727	167
产销率	**102.46%**	**122.91%**	**62.19%**	**73.89%**

注：公司 2026 年 1-6 月持续扩大生产团队，产能及产量均有所提升

报告期初，公司自研产品业务进入快速发展阶段，公司针对性完成配套产能扩充，截至报告期末公司产能状态良好。

公司 2023 年、2024 年产销率偏低，主要系同期公司自研产品在产品类型、

型号、客户覆盖数量等方面均实现拓展，业务订单规模大幅增长，相关自研产品主要处于客户验证周期内，2025 年公司对应自研产品已通过客户验证，相关订单已陆续实现收入转化；截至报告期末，公司产能消化情况良好，相关产品不存在滞销情形。

2、报告期内各期销售模式、主要产品的销售数量、价格及变动情况

报告期内各期销售模式、主要产品的销售数量、价格及变动情况参见本招股说明书“第六节/十/（一）/3、”。

（二）报告期内前五大客户及销售情况

报告期内，发行人前五大客户销售情况如下表所示：

单位：万元

年份	序号	客户名称	销售金额	占营业收入的比例
2026 年 1-6 月	**1**	**中微公司**	**14,458.05**	**38.51%**
	2	**拓荆科技**	**5,721.50**	**15.24%**
	3	**客户 C**	**2,889.41**	**7.70%**
	4	**SK 海力士**	**2,472.13**	**6.58%**
	5	**客户 A**	**2,067.38**	**5.51%**
	合计		**27,608.46**	**73.53%**
2025 年度	1	中微公司	31,594.51	48.29%
	2	客户 C	5,200.64	7.95%
	3	客户 A	4,615.88	7.06%
	4	拓荆科技	3,831.64	5.86%
	5	SK 海力士	2,445.38	3.74%
	合计		**47,688.06**	**72.89%**
2024 年度	1	中微公司	13,628.27	30.54%
	2	拓荆科技	4,757.26	10.66%
	3	客户 A	3,169.27	7.10%
	4	英特尔	3,100.97	6.95%
	5	客户 C	2,814.27	6.31%
	合计		**27,470.05**	**61.55%**
2023 年度	1	客户 C	2,657.95	10.18%
	2	应用材料	2,325.82	8.91%
	3	客户 A	2,174.77	8.33%
	4	英特尔	1,760.51	6.74%
	5	客户 D	1,342.63	5.14%
	合计		**10,261.69**	**39.31%**

注：上述客户为合并口径；

上述客户中：

1、英特尔通过其投资平台英特尔亚太持有公司 8.6125%的股份，系公司 5%以上的股东，属于公司的关联方。报告期内，公司主要为英特尔大连工厂提供技术支持服务。2025 年 9 月，英特尔将大连工厂出售给了 SK 海力士，公司继续向 SK 海力士大连工厂提供相关技术支持服务。

2、中微公司通过全资子公司中微半导体直接持有公司 1.3636%的股份，并参股智微厚德、智微攀峰，间接持有公司 1.8610%的股份；

3、拓荆科技通过全资子公司上海岩泉直接持有公司 1.7861%的股份，并参股拓荆芯链，间接持有公司 0.1567%的股份；

除英特尔外，上述客户持有公司的股份比例合计均不达 5%，不属于公司的关联方。

五、发行人采购情况和主要供应商情况

（一）主要原材料及服务的供应情况

1、材料采购及价格变动情况

公司的产品所需的原材料种类、型号众多。报告期内，公司采购原材料包括电源系统备机类、模组类、电子料件类、电容类、功率器件类、结构件、五金件类和腔体类等，主要构成如下：

类别	主要构成
电源系统备机类	射频电源、直流电源、匹配器等
模组类	射频电源模组、匹配器模组等
电子料件类	连接器件、密封圈、继电器等
电容类	真空电容、贴片电容等
功率器件类	晶体管、二极管等
结构件、五金件类	金属类加工件、板材等
腔体类	石英腔体、MAPG 腔体等

（1）主要原材料采购情况

报告期内，公司主要原材料采购情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电源系统备机	**1,693.94**	**8.83%**	3,894.82	18.39%	2,013.52	10.68%	2,949.51	23.48%
模组	**3,008.50**	**15.69%**	3,465.26	16.36%	3,690.81	19.57%	1,364.75	10.87%
电子料件	**5,006.33**	**26.11%**	3,114.18	14.70%	3,928.66	20.83%	1,965.64	15.65%
电容	**2,352.59**	**12.27%**	3,001.88	14.17%	1,548.11	8.21%	2,309.47	18.39%
功率器件	**1,540.98**	**8.04%**	1,479.58	6.99%	1,957.38	10.38%	898.75	7.16%
五金件、结构件	**3,613.39**	**18.85%**	3,530.45	16.67%	2,950.24	15.65%	1,058.68	8.43%
腔体	**1,442.06**	**7.52%**	1,918.57	9.06%	1,950.84	10.35%	1,375.32	10.95%
其他	**516.25**	**2.69%**	774.42	3.66%	816.98	4.33%	637.22	5.07%
合计	**19,174.04**	**100.00%**	**21,179.16**	**100.00%**	**18,856.54**	**100.00%**	**12,559.33**	**100.00%**

（2）主要原材料价格变动情况

报告期内，公司主要原材料的采购单价及变动情况如下：

单位：元/件

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度
	单价	变动	单价	变动	单价	变动	单价
电源系统备机	**24,910.83**	**-42.18%**	43,084.28	18.54%	36,345.14	88.90%	19,240.11
电子料件	**48.79**	**18.98%**	41.01	-12.16%	46.68	34.93%	34.60
模组	**444.97**	**-26.54%**	605.72	12.66%	537.63	-31.50%	784.92
电容	**73.30**	**-26.87%**	100.24	67.69%	59.77	-65.03%	170.93
腔体	**1,527.28**	**3.93%**	1,469.49	13.67%	1,292.80	41.14%	915.96
功率器件	**125.28**	**-8.91%**	137.53	89.74%	72.48	-0.75%	73.03

注：五金件、结构件主要系非标件，价格不具有可比性

由上表可知，2023 年电源系统采购单价较低，主要系当期公司参与了**国际**芯片产线的退役设备拍卖，而 2024 年、2025 年不存在此规模的整线退役采购；**2026 年 1-6 月电源系统采购单价较低，主要系当期公司采购了一批单价较低的应用于太阳能领域的电源系统和小型直流电源用于部分技术支持服务业务客户的特定需求，而 2024 年、2025 年不存在此规模的太阳能电源系统和小型直流电源采购。**2024 年、2025 年采购价格相对较高，主要系部分型号的电源系统采购单价较高，带动了电源系统采购单价升高。公司电子料件、模组、电容、腔体、功率器件的采购价格存在波动，主要系：公司采购的原材料种类、型号、规格众多，不同型号、规格的原材料价格差异较大，同一类原材料的平均采购单价不存

在直接可比性。

2、劳务外包情况

报告期内，发行人劳务外包费用分别为 21.57 万元、57.05 万元、64.91 万元、**33.55 万元**，劳务外包规模相对较小。

（二）主要能源采购情况

报告期内，公司主要能源为电力，耗用情况如下：

项目		2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
用电情况	电费（万元）	**239.88**	519.77	402.08	246.66
	用电量（万度）	**270.29**	568.84	427.33	249.57
	电费单价（元/度）	**0.89**	0.91	0.94	0.99

（三）主要原材料供应商情况

报告期内，公司向前五大原材料供应商采购情况如下：

单位：万元

年份	序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比例	主要采购内容
2026 年 1-6 月	**1**	**扬州双盈商贸有限公司**	**1,776.15**	**9.26%**	**五金件、结构件等**
	2	**苏州联畅电子科技有限公司**	**1,159.49**	**6.05%**	**模组等**
	3	**北京艾兰科技有限公司**	**836.46**	**4.36%**	**电子料件等**
	4	**康姆艾德机械设备（上海）有限公司**	**761.89**	**3.97%**	**电容等**
	5	**大南贸易（昆山）有限公司**	**643.27**	**3.35%**	**电容等**
	合计		**5,177.26**	**27.00%**	**-**
2025 年	1	**成懋半导体科技（苏州）有限公司**	1,393.00	6.58%	电源系统备机等
	2	扬州双盈商贸有限公司	1,297.98	6.13%	五金件、结构件等
	3	苏州联畅电子科技有限公司	1,228.06	5.80%	模组等
	4	康姆艾德机械设备（上海）有限公司	1,217.69	5.75%	电容等
	5	诺远科技	1,124.81	5.31%	腔体等
	合计		**6,261.54**	**29.56%**	**-**
2024 年	1	云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司	1,288.68	6.83%	模组等
	2	扬州双盈商贸有限公司	1,065.00	5.65%	五金件、结构件等
	3	苏州联畅电子科技有限公司	990.68	5.25%	模组等
	4	诺远科技	974.90	5.17%	腔体等

年份	序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比例	主要采购内容
	5	K.TECH Semiconductor Repair Inc.	874.95	4.64%	腔体等
	合计		**5,194.21**	**27.55%**	-
2023年	1	康姆艾德机械设备（上海）有限公司	1,133.38	9.02%	电容等
	2	K.TECH Semiconductor Repair Inc.	1,078.45	8.59%	腔体等
	3	云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司	788.36	6.28%	模组等
	4	苏州智嘉进出口贸易有限公司	619.82	4.94%	电源系统备机等
	5	大南贸易（昆山）有限公司	484.40	3.86%	电容等
	合计		**4,104.42**	**32.68%**	-

注：上述供应商为合并口径。

报告期内，公司前五名供应商中，诺远科技系公司实际控制人朱培文妹妹的配偶刘文丰持股 32.50%的企业。

六、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产

（一）主要固定资产情况

1、固定资产概况

截至报告期末，公司及子公司固定资产总体情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	**1,842.77**	**635.13**	**-**	**1,207.64**	**65.53%**
机器设备	**2,679.87**	**870.92**	**-**	**1,808.95**	**67.50%**
电子设备	**4,302.67**	**2,361.64**	**-**	**1,941.03**	**45.11%**
运输工具	**1,939.90**	**1,378.72**	**-**	**561.18**	**28.93%**
办公设备及其他	**960.36**	**719.41**	**-**	**240.95**	**25.09%**
合计	**11,725.58**	**5,965.83**	**-**	**5,759.75**	**49.12%**

2、房屋建筑物

截至报告期末，公司及子公司拥有的与生产经营相关的自有房屋所有权，情况如下：

权利人	不动产权证号	房屋坐落	用途	房屋建筑面积（㎡）	他项权利
神州半导体	**苏（2026）扬州市不动产权第0070487号**	江苏省扬州市邗江区蜀岗西路19号	工业	12,092.52	无

（二）主要无形资产

公司已取得的无形资产主要为土地使用权、专利、商标、软件著作权等，各无形资产的具体情况参见本招股说明书“第十二节/附件五、六、七、八”。

1、土地使用权

截至本招股说明书签署日，公司与生产经营相关的主要土地使用权 2 宗，其取得、使用符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，已依法办理必要的审批手续，不存在可能被行政处罚的情形，亦不构成重大违法行为。

2、专利

截至报告期末，公司共取得授权专利 **128** 项，其中**境内**发明专利 **72** 项，**境外 PCT 专利 1 项**。公司拥有的专利均处于正常使用状态，与公司的主营业务和主营产品密切相关，主要应用于公司研发、生产等企业经营的各方面，提升了公司工艺技术水平，对公司生产经营较为重要。公司拥有的专利均处于正常使用状态，不存在纠纷或者潜在纠纷。

3、软件著作权、商标情况

截至报告期末，公司共取得软件著作权 **71** 项、作品著作权 7 项、商标 35 项，均用于公司日常的生产经营活动，对公司的生产经营较为重要。公司拥有的软件著作权、商标均处于正常使用状态，不存在纠纷或者潜在纠纷。

（三）资产租赁情况

截至本招股说明书签署日，公司及子公司用于生产经营的主要房屋租赁情况，具体如下：

序号	承租方	出租方	坐落位置	租赁房屋面积（㎡）	租赁期限
1	神州半导体	深圳市龙岗区智慧家园园区管理有限公司[注]	深圳市智慧家园一期 1 栋 B 座 2201 单元	527.84	2024.08.16-2027.08.15
2	神州半导体	武汉光电工业技术研究院有限公司	武汉东湖高新技术开发区韩杨路 1 号光电创新园 A 区 601 室	830.8	2025.01.01-2027.12.31
3	神州半导体	扬州市科光汽车电子电气有限责任公司	扬州市维扬科技园 1 号楼	4,690	2023.01.01-2028.12.31

序号	承租方	出租方	坐落位置	租赁房屋面积（㎡）	租赁期限
4	神州半导体	供应商 D	上海浦东新区锦绣东路 2777 弄 1 号 3 层	1,164.71	2026.02.01-2029.01.31
5	上海昇州	供应商 D	上海浦东新区锦绣东路 2777 弄 1 号 204 室	90.69	2026.04.01-2029.03.31
6	晟州聚能	供应商 D	上海浦东新区锦绣东路 2777 弄 1 号 208 室	102.28	2026.04.01-2029.03.31
7	江苏芯越	扬州市邗江区高新技术创业服务中心	扬州市邗江区吉安路 203 号 C 幢厂房	3,953	**2026.07.01-2027.06.30**
8	神州半导体	成都融智孵化器有限公司	成都市高新区新裕路 467 号 1 栋 1 单元 12 层 1206 号	282	2025.09.10-2027.09.09
9	神州半导体	沈阳嘉润工程技术有限公司	沈阳市浑南区浑南中路 39 号一层 101 室	287	**2026.09.01-2029.08.31**
10	神州半导体	供应商 C	湖北省武汉市东湖新技术开发区 CB 项目 CB-1M-03-02 号场地	223.3	2024.12.10-2027.12.09
11	神州半导体	北京浩轩飞扬科技有限公司	北京经济技术开发区地盛中路 3 号 1 幢 B 座 612 室	148	2025.10.01-2028.09.30
12	神州半导体	无锡市泰同科技有限公司	汇泰商务中心 2 号楼 2202-2 室（无锡市新吴区泰丰路 8-19 号 2202-2）	120	2025.11.15-2028.11.14
13	**神州半导体**	**武汉光电工业技术研究院有限公司。**	**武汉东湖高新技术开发区韩杨路 1 号光电创新园 A 区 602 室**	**208.86**	**2026.08.01-2027.07.31**

注：2025 年 12 月 19 日前，出租方为深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司。根据各方于 2025 年 12 月 19 日签署的《深圳市房屋租赁合同书》之补充协议，自补充协议签署之日起，深圳市龙岗区智慧家园园区管理有限公司概括承继深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司作为出租人在原合同项下的全部权利与义务。

（四）拥有的经营资质情况

公司所从事的业务不涉及特许经营，公司未拥有特许经营权。公司已取得了业务经营所需的资质及认证，符合相关规定。截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司拥有的主要业务资质和许可情况如下：

1、高新企业证书

持证人	证书编号	发证时间	有效期
发行人	GR202532016464	2025.12.19	三年

2、排污许可证及固定污染源排污登记回执

序号	公司名称	类别	编号	行业类别	生产经营场所	有效期	发证机构
1	发行人	固定污染源排污登记回执	91321003MA1MJYYL3K001Z	半导体器件专用设备制造	扬州市邗江区蜀岗西路19号1	2024/01/04-2029/01/03	/
2	发行人	固定污染源排污登记回执	91321003MA1MJYYL3K002W	半导体器件专用设备制造	扬州市邗江区科技园路8号-1号楼	2024/01/17-2029/01/16	/
3	江苏芯越	排污许可证	91321091MA22PLAG0N001Q	机械零部件加工，表面处理	江苏省扬州市高新技术产业开发区吉安路203号	2025/04/11-2030/04/10	扬州市生态环境局

3、易制爆危险化学品从业单位备案证明

公司名称	备案编号	备案品种	备案机关
江苏芯越	91321091MA22PLAG0N	硝酸、过氧化氢溶液（含量>8%）	扬州市公安局邗江分局

4、第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明

公司名称	备案品种	备案时间	备案机关
江苏芯越	硫酸（试剂）	按实际采购情况分别备案	扬州市公安局邗江分局刑警大队

5、对外贸易经营者备案登记表

序号	公司名称	备案登记表编号	备案日期	备案登记机关
1	发行人	01827583	2016/07/13	/
2	江苏芯越	04230873	2022/11/30	扬州市邗江区行政审批局

6、海关进出口货物收发货人备案

序号	公司名称	海关备案编码	资质信息	所在地海关
1	发行人	3210965557	进出口货物收发货人	扬州海关
2	江苏芯越	3210960B82	进出口货物收发货人	扬州海关
3	上海昇州	3122261DJ6	进出口货物收发货人	洋山海关（港区）
4	**晟州聚能**	**3122261JD4**	**进出口货物收发货人**	**浦东海关**

7、管理体系认证证书

序号	公司名称	证书名称	认证标准	证书编号	发证机构	有效期/登记日期
1	发行人	环境管理体系认证证书	ISO 14001：2015	EMS738942	英标管理体系认证	2025/01/13-2028/01/12

序号	公司名称	证书名称	认证标准	证书编号	发证机构	有效期/登记日期
					（北京）有限公司	
2	发行人	质量管理体系认证证书	ISO 9001：2015	FM705376	英标管理体系认证（北京）有限公司	2025/01/17-2028/01/16
3	发行人	知识产权合规管理体系认证证书	GB/T 29490-2023	016ZB25EIP20698R0M	新世纪检验认证有限责任公司	2025/12/22-2028/12/21
4	江苏芯越	质量管理体系认证证书	GB/T 24001-2016 /ISO 9001：2015	00124Q33358R0S/3200	中国质量认证中心有限公司	2024/04/28-2027/04/27
5	上海昇州	环境管理体系认证证书	GB/T 24001-2016 /ISO 14001：2015	11725EU0095-06R1S	上海英格尔认证有限公司	2025/07/12-2028/07/11
6	上海昇州	质量管理体系认证证书	GB/T 19001-2016 /ISO 9001：2015	11725QU0241-06R1S	上海英格尔认证有限公司	2025/07/12-2028/07/11

8、产品认证证书

序号	公司名称	证书名称	认证标准	证书编号	发证机构	有效期/登记日期
1	发行人	认证证书	SEMI S2-0724；SEMI S8-0218；EN 60204-33：2011	CL5071889300001	莱茵检测认证服务（中国）有限公司	2026/03/30
2	发行人	认证证书	SEMI S2-0724；SEMI S8-0218；EN 60204-33：2011	CL5071329700001	莱茵检测认证服务（中国）有限公司	2026/03/10
3	发行人	认证证书	SEMI S2-0724；SEMI S8-0218；EN 60204-33：2011	CL5071329300001	莱茵检测认证服务（中国）有限公司	2026/03/10
4	发行人	认证证书	SEMI S2-0724；SEMI S8-0218；EN 60204-33：2011	CL5071764200001	莱茵检测认证服务（中国）有限公司	2026/03/10
5	发行人	认证证书	SEMI S2-0724；SEMI S8-0218；EN 60204-33：2011	CL5070520200001	莱茵检测认证服务（中国）有限公司	2026/01/22
6	发行人	认证证书	EN 61010-1：2010+A1	AN506788270001	莱茵检测认证服务	2025/06/06

序号	公司名称	证书名称	认证标准	证书编号	发证机构	有效期/登记日期
					（中国）有限公司	
7	发行人	认证证书	EN 61010-1：2010+A1	AN506630310001	莱茵检测认证服务（中国）有限公司	2025/01/17
8	发行人	认证证书	EN 61010-1：2010+A1	AN506547690001	莱茵检测认证服务（中国）有限公司	2024/12/05
9	发行人	认证证书	SEMI-F47-0706（Reapproved 0812）E	10.16.1811	EUROCERT S.A.	2024/03/28
10	发行人	认证证书	SEMI S2-0821, SEMI S8-0218, SEMI S14-0521, SEMI S22-0718E	10.16.1810	EUROCERT S.A.	2024/03/28
11	发行人	认证证书	SEMI S2-0821, SEMI S8-0218, SEMI S14-0521, SEMI S22-0718E	10.16.2375	EUROCERT S.A.	2024/11/07
12	发行人	认证证书	SEMI-F47-0706（Reapproved 0812）E	10.16.2722	EUROCERT S.A.	2024/11/13
13	发行人	认证证书	EN 61000-6-2：2005+AC：2005, EN 61000-6-4：2007+A1：2011, EN 61000-4-34：2007+A1：2009	10.16.1624	EUROCERT S.A.	2023/12/12-2028/12/11
14	发行人	认证证书	SEMI-F47-0706（Reapproved 0812）E	10.16.1623	EUROCERT S.A.	2023/12/12
15	发行人	认证证书	SEMI S2-0821, SEMI S8-0218, SEMI S14-0521, SEMI S22-0718E	10.16.1622	EUROCERT S.A.	2023/12/12
16	发行人	认证证书	EN 61000-6-2：2005+AC：2005, EN 61000-6-4：2007+A1：2011, EN 61000-4-34：2007+A1：2009	10.16.1256	EUROCERT S.A.	2023/04/21-2028/04/20
17	发行人	认证证书	SEMI®S2-0821, SEMI®S8-0218, SEMI®S14-0521, SEMI®S22-0718E	10.16.1159	EUROCERT S.A.	2023/03/23
18	发行人	认证证书	SEMI-F47-0706（Reapproved 0812）E	10.16.1214	EUROCERT S.A.	2023/03/27

序号	公司名称	证书名称	认证标准	证书编号	发证机构	有效期/登记日期
19	发行人	认证证书	SEMI F47-0706 (R0812)	AK507456470001	莱茵检测认证服务（中国）有限公司	2026/09/03
20	发行人	认证证书	EN 61010-1:2010+A1	AN507417650001	莱茵检测认证服务（中国）有限公司	2026/08/07
21	发行人	认证证书	SEMI S2-0724;SEMI S8-0218;EN 60204-33:2011	CL507377220001	莱茵检测认证服务（中国）有限公司	2026/07/14
22	发行人	认证证书	IEC 62477-2:2018; EN IEC 62477-2:2018	AK507363250001	莱茵检测认证服务（中国）有限公司	2026/07/07
23	发行人	认证证书	IEC 62477-2:2018; EN IEC 62477-2:2018	AK507363210001	莱茵检测认证服务（中国）有限公司	2026/07/07
24	发行人	认证证书	SEMI S2-0724;SEMI S8-0218;EN 60204-33:2011	CL507364490001	莱茵检测认证服务（中国）有限公司	2026/07/03
25	发行人	认证证书	EN 61010-1:2010+A1	AN507352100001	莱茵检测认证服务（中国）有限公司	2026/06/26
26	发行人	认证证书	SEMI S2-0724;SEMI S8-0218;EN 60204-33:2011	CL507312940001	莱茵检测认证服务（中国）有限公司	2026/06/17
27	发行人	认证证书	SEMI F47-0706 (R0812)	AK507312540001	莱茵检测认证服务（中国）有限公司	2026/06/17
28	发行人	认证证书	SEMI F47-0706 (R0812)	AK507312780001	莱茵检测认证服务（中国）有限公司	2026/06/17
29	发行人	认证证书	EN 61010-1:2010+A1	AN507321830001	莱茵检测认证服务（中国）有限公司	2026/06/10
30	发行人	认证证书	SEMI F47-0706 (R0812)	AK507263340001	莱茵检测认证服务（中国）有限公司	2026/04/28

序号	公司名称	证书名称	认证标准	证书编号	发证机构	有效期/登记日期
31	发行人	认证证书	SEMI S2-0724;SEMI S8-0218;EN 60204-33:2011	CL507241470001	莱茵检测认证服务（中国）有限公司	2026/04/15

（五）上述资产与公司产品或服务的内在联系

报告期内，公司的固定资产主要为生产经营所需的房屋、机器设备等，上述固定资产为公司进行产品设计、工艺研发和生产制造提供了相应场所及工具，公司相关房屋、机器设备情况良好，是公司进行生产经营活动的必要条件。

公司的无形资产主要为已取得的土地使用权、专利、软件著作权和商标等，是公司现有产品和服务取得市场认可和快速发展的核心竞争力，其中公司核心技术产品有相关知识产权予以保护。

综上所述，公司的主要固定资产、无形资产不存在瑕疵、纠纷或潜在纠纷，不存在对公司持续经营产生重大不利影响情况。

七、发行人核心技术与科研、研发情况

（一）研发部门与研发管理

1、研发管理

公司研发活动由公司研发部门主导，具体参见本招股说明书“第五节/一/（四）/5、”。

公司建立了全流程、标准化的研发管理制度体系，对技术研发与成果转化、知识产权全生命周期管理、专利贡献激励等核心事项作出明确规范；通过对产品技术研发全周期的严格管控与合规审核，对经内部评审的核心技术成果，及时开展专利申请或认定为企业技术秘密；同时制定了明确的研发人员贡献奖励标准，充分激发研发人员创新积极性，加速公司科研成果产业化转化，持续提升公司整体技术研发实力与核心竞争力。

2、研发人员

（1）核心技术人员

公司核心技术人员均为工作多年的核心骨干，为公司技术和产品做出了卓越

贡献。报告期内，公司核心技术人员未发生变化。核心技术人员及对公司研发的具体贡献情况，主要如下：

姓名	行业经验及对公司研发的具体贡献
朱培文	25 年以上从业经验，公司创始人，曾作为负责人先后主导了科技部国家火炬计划项目、科技部重大专项子课题等的研发工作，并主导完成了公司多个其他国家级、省市级项目研发工作，获得了江苏省非公有制经济优秀建设者等个人荣誉，是公司 60 多项专利的发明人。
叶剑	40 年以上从业经验，公司上海研发中心负责人，工程师，上海市集成电路行业协会理事会理事，《半导体视界》国际期刊编委，西交利物浦大学客座教授，中国国际科技促进会半导体产业发展分会专家智库成员，曾在航空/电子领域权威期刊《航空电子技术》《洪都航空》《海军航空大学学报》等发表过多篇文章，曾参与多个航空/电子专用工艺与测试领域的国家级、省级项目研发工作，并曾负责组建 MKS 中国大陆地区技术支持服务团队，担任 MKS 中国大陆地区技术支持服务业务负责人，作为技术专家为公司研发创新持续提供专业建议。
朱国俊	近 20 年从业经验，公司研发总监，在电子工程领域国际主流权威期刊 IEEE 发表过多篇文章，参与公司多个国家级、省级重大项目相关研发工作，参与了公司多项产品研发设计工作，是公司 40 多项专利的发明人。
尹巧星	10 年以上从业经验，公司研发总监，参与公司多个国家级、省级重大项目相关研发工作，参与了公司多项产品研发设计工作，是公司 30 多项专利的发明人。
潘小刚	近 20 年从业经验，公司研发总监，博士，正高级工程师，入选工信部制造业人才支持计划，江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象，扬州市有突出贡献的中青年专家，在电子工程领域国际主流权威期刊 IEEE 发表过多篇文章，参与公司多个国家级、省级重大项目相关研发工作，参与了公司多项产品研发设计工作，是公司 40 多项专利的发明人。

公司核心技术人员稳定，公司与核心技术人员均签署了包含保密、竞业禁止条款的相关协议，严防核心技术外泄，公司核心技术人员适用公司的绩效考核和激励制度。

（2）研发人员结构

公司将隶属于研发部门且具体从事研发活动的人员界定为研发人员，研发人员工作内容与公司研发活动直接相关，符合《监管规则适用指引——发行类第 9 号：研发人员及研发投入》中研发人员的相关定义。

截至报告期末，公司研发人员总数 138 人，占公司员工总数 24.64%，本科为 89 人。具体情况如下：

单位：人

学历	人数	占比
硕士及以上	39	28.26%
本科	89	64.49%
本科以下	10	7.25%

学历	人数	占比
合计	138	100.00%

（二）公司核心技术

1、发行人核心技术情况

公司以半导体制造关键工艺技术——等离子体源技术为基础，聚焦高端等离子体电源系统的研发创新，为我国半导体先进制程产业链提供高端等离子体电源系统产品及全方位技术支持服务。

公司掌握的核心技术主要围绕两大方向：一是从新型拓扑结构、宽禁带半导体等器件应用及其测量、控制、测试等方面构建的等离子体电源系统关键性基础技术；二是针对半导体设备工艺特点，尤其是先进制程对于工艺效果和稳定性等方面的差异化及严苛要求，构建出特定产品领域的产品化支撑技术，有效满足半导体先进制程关键工艺的技术要求。

公司拥有的核心技术的技术来源均为自主研发，并均已应用于公司主营业务中。公司核心技术的主要内容、技术先进性及具体表征、技术所处阶段等情况，主要如下：

技术类别	核心技术名称	技术主要内容	技术先进性及具体表征	技术所处阶段	知识产权保护措施
基础技术	等离子体电源精准测量分析技术	该技术通过高速高分辨率模数转换模块与自主设计的宽频带、高线性度采样电路等，对电源输入/输出参数进行同步实时采集，结合数字模型算法，能够准确测量及分析复杂工况下的电流、电压、有效功率、阻抗及谐波分量等关键参数，该技术系电源系统精准控制的支撑技术。	①检测范围宽：该技术可以实现高动态功率范围检测，在小功率模式下亦可实现精准检测，能适配多种复杂的半导体工艺环境；②检测精度高：该技术基于复杂的阻抗空间校准技术、可编程增益与自适应量程切换技术、先进传感与数据融合技术等，动态范围内实现电压、电流、相位、功率等精准测量取样，平均测量精度±1%，最高可达 0.5%；③快速测量分析：该技术基于高速高分辨率模数转换模块和独特的数字信号处理算法，可实现待测参数的纳秒级实时测量和分析。	批量生产	授权专利 **14** 项、授权软著 **5** 项
	等离子体电源数字化精准控制技术	该技术以全数字化架构取代传统模拟控制系统，通过高速并行处理能力实现等离子体电源功率、频率、相位等参数的实时精准调控，使等离子体电源系统输出具备更高的稳定性和动态响应能力，为等离子体工艺提供稳定可靠的功率驱动能力。	①控制精度高：该技术基于数字化控制极大降低功率控制偏差，频率调谐精度 kHz 级，相位精度<0.5°；②自适应频率调谐能力强：在腔室阻抗快速漂移情况下，显著提升等离子体维持稳定性；③快速控制：数字化架构支持高速指令链路与并行处理，可实现毫秒级输出功率斜坡控制、纳秒级同步控制、包络脉冲上升/下降沿等。	批量生产	授权专利 7 项、授权软著 **2** 项
	等离子体射频高功率功放技术	本技术采用新一代功率器件，通过 3 级以上的多级功放合路及拓扑平衡模式，能够实现射频高功率合成，可形成 7kW 高可靠性单功放模组，并兼具小体积特点。	①功率等级高：本技术通过合适功放架构能够合成 50kW 以上的高功率，满足高深宽比刻蚀场景等对高功率的需求；②可靠性高：在多个不同频率/功率射频电源工作下，存在高驻波或各种交调量影响，电源系统易损坏，本技术采用拓扑平衡模式确保电源系统高可靠性；③高功率密度：通过优化散热通道、提升功放转换效率以实现更高的功率密度。	批量生产	授权专利 8 项
	系统智能故障监测与诊断技术	该技术通过构建“多物理场参数融合+专项故障算法”诊断模型，结合硬件集成采集技术等，能够覆盖输入/输出电路短路、阻抗失配、电机故障、温度异常等故障场景，有效识别用户机台工艺过程中的各项异常情况，有效支撑刻蚀、镀膜等关键工艺设备的稳定、安全、可靠运行。	①全参数实时监测：覆盖射频类（功率、阻抗、频谱等）、RPS 类（温度、流量、功率、解离率等）、匹配器类（电容转矩、误差值等）等多项核心参数，采集频率可达微秒级；②多范围故障识别：包括阻抗失配、功率异常、水路系统故障等故障类型识别判断，故障检测精度高；③基于全参数的精准故障监测，保障客户产线工艺稳定运行。	批量生产	授权专利 **14** 项、授权软著 **6** 项
	高精度智能测试仿	通过采集模块集成技术、分布式控制技术、智能算法、多维度参数协同测控架构、可视化人	①多维度数据采集：采用模块化集成设计，整合高精度模拟量采集模块、高速数字量采集模块、顶尖精密测试仪器集群，可实现模拟量、数字量、射频	批量生产	授权专利 2 项、

技术类别	核心技术名称	技术主要内容	技术先进性及具体表征	技术所处阶段	知识产权保护措施
	真平台技术	机交互技术等，为半导体制程等离子体电源系统提供产线模拟运行测试，以保障产品工艺稳定性与一致性的仿真系统。	量等多类型核心参数的并行测量；②测试精度高、范围广：测试功率最高可达 100kW，频率可达 2.45GHz，功率测量精度控制在±0.5%，频率测量精度可达 0.1Hz，阻抗匹配时间测量精度可达 1 毫秒，模拟电压测量精度可达 0.1mV；③通信兼容性全面：可适配 Analog、Profibus、EtherNet、EtherCat 等全类型通讯端口连接；④仿真模拟智能化：结合公司自主开发智能算法，能够模拟等离子体电源系统在产线端的工况运行状态。		授权软著 **21** 项
产品化支撑技术	高精度功率和阻抗校准技术	该技术基于链路传输模型对射频传感器采样信号进行精准补偿，实现与 VNA 级别相近的校准效果，保障等离子体射频电源系统在先进半导体制程中的精准能量输出。	①全链路补偿，消除关键误差源：传统校准受寄生参数、反射干扰、温漂等影响，本技术通过全链路建模和数字补偿，可显著降低上述影响带来的误差，保障半导体等离子体工艺的一致性；②宽频宽量程校准能力：系统支持多频段、高动态范围射频信号的校准，可覆盖刻蚀、薄膜沉积等半导体工艺应用场景。	批量生产	授权专利 5 项、授权软著 **3** 项
	射频激励等离子体均匀稳定技术	本技术通过高频脉冲调制技术，采用延迟补偿与自适应算法，高线性度功放链路设计，多维度快速电弧检测与分级抑制策略，能够有效抑制驻波效应与电荷积累、降低电弧影响，从而显著改善半导体工艺均匀性、一致性、安全性。	①电弧抑制：通过检测反射功率和配置脉冲时序参数，可快速抑制电弧，避免电弧损伤晶圆及腔室；②高频脉冲调制：本技术可实现 500kHz 脉冲调制频率，纳秒级最小脉宽，搭配直流脉冲电源可实现同步高频脉冲，从而获得更高的电子密度稳定性和阻抗稳定性，实现离子能量分布的精准控制；③高线性度功放：本技术通过先进线性功放架构、高效的线性补偿和波形控制，可有效控制谐波分量，实现波形塑形。	批量生产	授权专利 11 项
	多频多路智能化功分匹配技术	该技术通过多通道运算、智能功分算法闭环控制，结合传感模块实时监控多频段射频参数，自适应调节各通道功率或电流等差异，实现射频电源系统在薄膜沉积、刻蚀工艺中一腔多站等功分匹配应用，有效提升工艺设备空间利用率。	①多频多路智能功分：该技术可根据多路阻抗差异进行自适应功率或电流等调节，能够实现半导体工艺一腔多站功率或电流等参数比例调节；②宽范围电流比在线切换：该技术支持宽范围电流比毫秒级在线切换，如从 10%跳变至 90%，同时支持阻抗自适应匹配，降低系统反射，有效满足半导体工艺对等离子体的动态需求。	批量生产	授权专利 2 项、**授权软著 2 项**
	基于模型预测与微调的自动阻抗匹配	基于 S 参数模型与微调的自动匹配算法，构建了硬件与算法的映射模型，计算实时阻抗，实现更快速的等离子体阻抗匹配。	传统方案存在阻抗匹配慢、容易在目标值附近振荡，造成电容落点偏差大。该技术下阻抗匹配速度可达毫秒级，电容运动曲线一致性高、重复性好，即使在等离子体阻抗剧烈、快速变化的工艺中，也能实现快速跟随和匹配。	批量生产	授权专利 3 项、**授权软著 2 项**

技术类别	核心技术名称	技术主要内容	技术先进性及具体表征	技术所处阶段	知识产权保护措施
	技术				
	耐腐蚀长寿命阳极氧化膜技术	采用二次脉冲阳极氧化工艺，结合沸水封孔、预钝化、水合钝化和协同钝化等多重复合处理，通过调节膜层 OH 键覆盖密度，有效提升氧化膜使用寿命和产品功率运行窗口。	①耐蚀性能强：通过三次封孔方式相结合的后处理与清洗工艺，促进 Al_2O_3 水合反应，堵塞孔隙，提升腔体阳极氧化膜层的硬度，解决了膜层厚度不均、易开裂腐蚀及杂质残留等关键难题，提升了膜层耐腐蚀性；②工艺适应性强：通过影响氧化膜层表面 OH 键覆盖密度，降低 RPS 功率运行窗口下限，满足了 FCVD 等工艺的沉积速率需求，提升了膜层工艺的稳定性与适用性；③成本效益好：该技术下腔体寿命有效延长，客户单台 RPS 设备年维护成本降低约 40-50%。	批量生产	授权专利 **5** 项
	高流量高解离率稳定点火技术	该技术采用“预激发+主点火”双阶段算法设计，能够实现在不同流量、压力下稳定点火并实现气体高效稳定解离，为远程等离子体源系统在复杂工况下提供高可靠性、高解离率性能。	①高点火成功率：在 10-50SLM 高流量、混合气体组分实现气体的稳定点火，有效减少工艺停机时间；②高解离率水平：该技术下实现 NF_3、NH_3、O_2等制程气体的高效、稳定解离，有效提高刻蚀、薄膜沉积等工艺一致性。	批量生产	授权专利 **14** 项
	可重构高功率密度高压直流技术	该技术采用了宽禁带功率器件的模块化单元与智能总线架构技术，实现高功率密度的宽范围高压直流输出，同时支持柔性化拓展、多路独立输出、极性快速切换等核心功能。	①可重构架构：传统高压直流电源受限于刚性架构，设备功能存在固化局限，该技术采用无主从并联智能总线架构，突破传统架构功能边界，实现设备“一机多用”与“弹性扩容”；②高功率密度：基于宽禁带功率器件与谐振变换器拓扑，功率密度最高可达 700W/L，电压范围覆盖 0-15kV，在同等功率输出场景下，产品体积显著缩小，单位散热能耗降低，有效助力客户节省机台空间与能耗成本。	批量生产	授权专利 4 项、授权软著 **5** 项
	离子能量可控源技术	该技术采用多开关调制架构，结合高频脉冲时序同步技术，生成对称或非对称等复杂脉冲波形，实现对离子轰击能量与电荷中和效应的解耦及精细控制。	离子能量可控：传统等离子体源方案受限于正弦波输出模式，离子能量呈宽谱分布（跨度达百级 eV），控制精度低，导致工艺均匀性相对较差；该技术可实现对复杂波形的精细控制，精准调控离子能量，实现 eV 单位范围的离子能量分布，控制精度显著提升，工艺均匀性优于传统方案，可实现原子层级的半导体工艺应用。	批量生产	授权专利 5 项、授权软著 **5** 项
	低储能快速弧反应	该技术运用超低电感回路设计、高频逆变式斩波技术，融合快速电弧检测与抑制算法，能够	①高效电弧管理：传统方案存在电弧抑制响应慢、消弧不充分的痛点，该技术能够实现快速电弧抑制，从传统毫秒级缩短至微秒级，从根源上规避电弧	工艺验证	授权专利 4 项、

技术类别	核心技术名称	技术主要内容	技术先进性及具体表征	技术所处阶段	知识产权保护措施
	电源技术	实现高效电弧管理，进而提升薄膜质量和靶材利用率。	残留对设备的损伤风险；②电源低储能：传统方案因电源储能冗余度高，单次异常能量释放可达上百焦耳，易引发靶材损伤和薄膜缺陷；该技术创新采用低储能电源架构，将单次异常能量释放严格限制在单位焦耳以内，为靶材、基材和薄膜层提供全方位保护。		授权软著 **4** 项

注：授权专利、软著等口径更新至报告期末。

2、核心技术的保护措施

公司的核心技术系公司核心竞争力的基础，公司十分重视对核心技术进行知识产权申请与保护。截至本招股说明书签署日，公司为主要核心技术均申请了专利、软件著作权等进行知识产权保护。

报告期内，公司通过与主要研发人员签署了包含保密、竞业禁止条款的相关协议，明确要求涉及公司核心技术机密的内容，在未申请专利、软件著作权等知识产权保护之前，严禁以任何形式向外界披露。通过上述措施，公司核心技术得到了有效保护，降低了核心技术泄露和流失的风险。

3、核心技术在主营业务中的贡献

报告期内，公司的核心技术产品及服务收入占比情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
核心技术产品及服务收入	**36,541.75**	62,956.45	42,249.56	24,829.60
营业收入	**37,545.34**	65,424.00	44,627.90	26,105.54
核心技术产品及服务占营业收入的比例	**97.33%**	**96.23%**	**94.67%**	**95.11%**

（三）公司研发投入情况

报告期内，公司研发费用占营业收入的比重如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
研发费用	**6,150.20**	10,921.75	5,794.50	3,666.82
营业收入	**37,545.34**	65,424.00	44,627.90	26,105.54
研发费用占营业收入的比例	**16.38%**	**16.69%**	**12.98%**	**14.05%**

（四）公司主要在研项目

报告期内，公司从事的主要研发项目具体情况，主要如下：

单位：万元

项目名称	所处阶段	项目预算	项目拟达到的目标
半导体芯片制程用高解离率耐腐蚀远程等离子源研发及产业化	验证阶段	**19,390.00**	开发大功率型号高解离率、长寿命远程等离子体源系统，研发高效可控磁场聚焦技术，协同等离子体解离腔体实现高气体解离率，研发等离子体在线监控技术，实现制程故障防控，降低芯片生产成本。

项目名称	所处阶段	项目预算	项目拟达到的目标
高稳定性大功率甚高频电源产品开发	验证阶段	**6,300.00**	采用新型器件与先进工艺开发高功率密度甚高频功放模块，研发射频大功率堆叠技术，提升系统集成度水平，升级全数字一体化控制平台，实现纳秒级快速响应，研发 16 级脉冲调制技术，实现纳秒级最小脉宽，全面适配高深宽比刻蚀应用场景。
低复合率等离子离化腔研发	**已结项**	4,500.00	构建远程等离子体源解离腔体气体流场仿真模型，分析气体流场参数对等离子体回旋速度、路径及重组概率的影响，优化腔体结构实现高气体解离率，减弱流体与等离子体对腔体表面的轰击，抑制颗粒物产生，形成低复合率腔体技术方案，提升腔体膜层寿命与芯片生产良率。
高稳定性大功率中频电源产品开发	验证阶段	**3,448.76**	开发宽功率覆盖的中频电源系统产品，采用全数字控制平台实现功率精准控制与快速响应等，搭载多级脉冲、自动变频以及电弧检测与抑制功能等多种核心功能，全面适配半导体制程各类应用场景。

注：在研项目以合并口径统计。

（五）合作研发的情况

报告期内，公司进行的主要合作研发情况，具体如下：

合作方	协议主要内容	研究成果归属	合作期限开始时间	采取的保密措施
扬州大学	**特定电源相关理论模型构建及逻辑设计**	**在合同有效期内，发行人利用扬州大学提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归发行人所有，扬州大学利用发行人提供的技术资料和工作条件所完成的新技术成果，归双方所有。**	**2026 年 4 月**	**合同对各方保密义务进行约定**
重庆臻宝半导体材料有限公司	氮化铝套筒产品合作研发	因履行本合同所产生的最终研发成果、知识产权及其他相关阶段性技术成果均归对方单独所有，但对方需将最终研发成果所涉生产工艺流程无偿教授给发行人；并且，如对方向第三方出售基于前述技术成果所开发的相同产品时，需获得发行人事先书面同意。	2024 年 9 月	合同对各方保密义务进行约定
东南大学	大功率等离子驱动电源动态调节控制及效率提升关键技术研发	本合同项下产生的知识产权、技术成果及所取得的收益归发行人所有。在本合同有效期内，发行人在本合同基础上对于相应技术做出的改进而产生的相关知识产权归发行人所有，进而产生的相关收益归发行人所有。	2024 年 4 月	合同对各方保密义务进行约定
南京林业大学	等离子发生器驱动电源性能优化关键技术研发	除有特别约定外，本合同项下产生的技术成果归属于发行人，且发行人利用本合同约定研究开发成果所申请的知识产权由发行人享有。	2024 年 3 月	合同对各方保密义务进行约定
南京林业大学	超高离化率远程等离子源研发	双方享有申请专利的权利，因本合同产生的相关知识产权（具体包括论文、专利和软件著作权）归双方共有，在对外成果转让时需经双方同意，收益分配另行协商。	2022 年 12 月	合同对各方保密义务进行约定

合作方	协议主要内容	研究成果归属	合作期限开始时间	采取的保密措施
扬州市职业大学（扬州开放大学）	RFG 系列 MOS 替代使用解决方案	在本合同有效期内，发行人利用对方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归发行人所有；在本合同有效期内，对方利用发行人提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双方所有。	2022 年 9 月	合同对各方保密义务进行约定
扬州大学	射频电源及匹配器的仿真研发	双方享有申请专利的权利。	2022 年 9 月	合同对各方保密义务进行约定

（六）公司科研实力及成果情况

1、公司获得的重要奖项荣誉情况

截至本招股说明书签署日，公司获得的主要奖项荣誉，具体如下：

获奖单位	荣誉名称	获得荣誉时间	主要颁发机构	级别
公司	国家专精特新重点小巨人企业	2024 年 10 月	工信部、财政部	国家级
公司	国家专精特新小巨人企业	2023 年 11 月	工信部	国家级
公司	2025 年江苏潜在独角兽企业	2025 年 9 月	江苏省新质生产力促进中心	省级
公司	2025 年江苏瞪羚企业	2025 年 9 月	江苏省新质生产力促进中心	省级
公司	2024 年江苏潜在独角兽企业	2024 年 9 月	江苏省新质生产力促进中心	省级
公司	江苏省等离子源工程技术研究中心	2022 年	江苏省科学技术厅	省级
公司	江苏省企业技术中心	2022 年	江苏省工业和信息化厅	省级
公司	扬州市知识产权优势企业	2024 年	扬州市市场监督管理局（知识产权局）	市级
公司	2023 年度扬州市创新型企业 50 强	2023 年	扬州市科学技术局	市级
公司	**2025 年度新质企业金牛奖（人工智能）**	**2026 年 8 月**	**中国证券报**	**企业/协会**
公司	年度新锐企业奖	2026 年	SEMICON CHINA	企业/协会
公司	2026 年中微公司供应商大会，获“合作创新奖”	2026 年	中微公司	企业/协会
公司	2026 年中微公司供应商大会，获“卓越质量进步奖”	2026 年	中微公司	企业/协会
公司	2025 年拓荆科技全球合作伙伴，获“协作创新奖”	2025 年	拓荆科技	企业/协会
公司	2025 年客户 C 供应商大会，获“最佳服务奖”	2025 年	客户 C	企业/协会
公司	精诚服务奖-零部件组	2025 年	格科微	企业/协会
公司	锐意新星奖	2025 年	研微（江苏）半导体科技有限公司	企业/协会

获奖单位	荣誉名称	获得荣誉时间	主要颁发机构	级别
公司	2024-2025 中国半导体产线电源领军企业	2025 年	中国 IC 独角兽联盟	企业/协会
公司	2024-2025 中国半导体产线电源最佳解决方案	2025 年	中国 IC 独角兽联盟	企业/协会
公司	中国电子专用设备工业协会会员单位	2025 年 1 月	中国电子专用设备工业协会	企业/协会
公司	中国集成电路零部件创新联盟会员单位	2024 年	中国集成电路零部件创新联盟	企业/协会
晟州聚能	上海市集成电路行业协会第七届理事单位	2026 年	上海市集成电路行业协会	企业/协会
晟州聚能	上海市真空协会团体会员	2025 年	上海市真空协会	企业/协会

2、公司所承担重大科研项目

截至本招股说明书签署日，公司所承担的重大科研项目，具体如下：

项目性质	项目/课题名称	项目主要来源	级别	公司角色	项目状态	开始年份
发改委集成电路专项	项目 A	发改委	国家级	项目承担单位	进行中	2026 年
发改委集成电路专项	项目 B 子项目	发改委	国家级	子项目唯一承担单位	进行中	2025 年
科技部重大专项	项目 C 子课题	科技部	国家级	子课题承担单位	验收通过	2022 年
国家重点小巨人“三新”“一强”推进计划项目	项目 D	工信部	国家级	项目承担单位	进行中	2024 年
江苏省科技成果转化专项资金项目	半导体芯片制程用高解离耐腐蚀远程等离子源研发及产业化	江苏省科学技术厅	省级	项目承担单位	**验收中**	2023 年
扬州市科技成果转化专项资金项目	面向高端芯片制造的超高离化率长寿命远程等离子源研发及产业化	扬州市科学技术局	市级	项目承担单位	验收通过	2021 年
扬州市知识产权项目	扬州市企业知识产权战略推进计划项目	扬州市知识产权局	市级	项目承担单位	进行中	2025 年
扬州市邗江区科技项目	半导体等离子处理高精快响应射频电源自动阻抗匹配器研发	扬州市邗江区科学技术局	区级	项目承担单位	验收通过	2021 年
广东省重点领域研发计划项目	远程等离子源研发	广东省科学技术厅	省级	项目参与单位	验收通过	2020 年
发改委集成电路专项	项目 E	发改委	国家级	参与单位	验收通过	2023 年
发改委集成电路专项	项目 F	发改委	国家级	参与单位	进行中	2025 年
发改委集成电路专项	项目 G	发改委	国家级	参与单位	进行中	2024 年
发改委集成电路专项	项目 H	发改委	国家级	参与单位	进行中	2024 年

项目性质	项目/课题名称	项目主要来源	级别	公司角色	项目状态	开始年份
发改委集成电路专项	项目 I	发改委	国家级	参与单位	验收通过	2023 年

3、行业标准制定及其他

公司作为主要起草单位制定《射频电源技术要求》（T/CITS 170—2024）、《等离子体用射频电源技术规范》（T/CITS 159—2024）团体标准。

公司多项科研成果经中国电子专用设备工业协会、中国电工技术学会等权威机构鉴定为达到国际先进水平，具体内容参见本招股说明书“第五节/一/（二）/4、”。

（七）公司保持技术创新的机制、技术储备及创新安排

1、完善研发制度体系，实现全流程规范化研发管理

为规范研发项目全流程推进，实现人力、资金等研发资源的高效合理配置，公司建立了完善的研发管理制度体系，明确了研发项目立项、过程管控、结题验收等全流程的工作要求；同时制定了规范的研发费用核算管理制度，明确研发费用的归集口径、核算方法与审批流程，建立了研发费用专项核算明细账及配套辅助台账，实现研发投入的全流程精细化管控。

2、强化研发人才引育，打造高水平核心研发团队

为深入贯彻公司发展战略，更好的引育高端研发人才、全面客观评价研发人员工作成果，公司建立了全周期的研发人才培养与激励体系。公司常态化组织研发人员开展产品技术专项培训与行业技术交流，持续提升团队专业能力；通过多元化招聘渠道引进行业内高端复合型人才，同时为研发团队制定了完善的绩效考核与激励机制，充分激发研发团队的创新活力。

3、持续加大研发投入，筑牢技术创新与可持续发展根基

公司作为国家高新技术企业、国家级专精特新重点小巨人企业，长期深耕半导体关键工艺设备配套电源系统领域的技术研发与产品创新，持续筑牢公司核心技术壁垒与市场竞争力。

报告期内，公司完成多项核心储备技术与产品的研发攻关，具体参见本招股

说明书“第五节/一/（二）/2、/（4）”，相关产品实现商业化落地后，将进一步丰富公司产品矩阵，拓展客户覆盖边界与市场应用场景。

未来，公司将持续加大核心技术领域研发投入，不断完善全链条研发体系、强化高端研发人才引育，为公司持续技术创新、产品迭代与市场拓展提供坚实保障。

4、健全知识产权保护体系，全方位保障核心技术安全

公司高度重视核心技术与知识产权的全生命周期保护，建立了完善的知识产权管理制度，将知识产权保护工作嵌入产品研发、生产、经营的全流程。公司与核心研发骨干均签署了包含保密、竞业禁止条款的相关协议，严防核心技术外泄；针对研发形成的核心科研成果，经内部评审后，对符合知识产权申请标准的技术及时提交相应知识产权申请，对不适宜公开的核心技术认定为企业商业秘密，通过知识产权布局与技术保密相结合的方式，实现核心技术的全方位保护。

公司通过知识产权全流程管控体系，对产品技术研发的全周期开展严格管理与合规审核，在保障核心技术安全的同时，持续优化知识产权布局、提升知识产权管理水平，确保公司研发活动与知识产权申请不存在重大法律风险，为公司技术创新提供长期稳定的合规保障。

八、环境保护和安全生产情况

（一）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

公司主要从事半导体关键工艺设备核心零部件的研发、生产、销售和技术支持服务等，主要产品为等离子体电源系统和技术支持服务等，主要生产流程为装配和测试等，不存在高危险、重污染的环节。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司属于“半导体器件专用设备制造”，行业代码为“C3562”，不属于重污染行业。

公司在生产过程中产生的主要污染物为少量的废水、废气、一般工业固体废物和危险废物等。公司主要污染物及其处理的具体情况，主要如下：

类别	主要污染物名称	污染物产生原因	处理设施/措施	处理能力及结果
废水	生活污水	主要是日常经营的生活污	由市政污水处理部	处理达标，对环境

类别	主要污染物名称	污染物产生原因	处理设施/措施	处理能力及结果
		水，生产过程中基本不产生污水	门统一收集处理	无影响
废气	无组织废气	锡焊等环节产生的废气，释放量较少	加装烟雾净化器，经常通排风	处理达标，对环境无影响
噪声	生产设备等产生的噪声	机器设备运行	为设备加装减震垫，在车间加装隔音门窗，定期对设备进行维护	厂界环境噪声排放达标
固废	危险废物	生产中使用到的废润滑油、废切削液、废电子垃圾、倒槽槽液污泥、沉渣等，数量较少	交由具有资质的第三方处理	全部处理
	一般工业固体废物	主要是包装用的包装袋、废布、纸箱等，数量较少	交由具有资质的第三方处理	全部处理

（二）环保事故或受到行政处罚的情况

根据生态环境部发布的《环境保护综合名录（2021 年版）》，公司所处行业不属于高危险、重污染行业，公司相关产品不属于高危险、重污染产品。

发行人生产经营活动符合国家环境保护相关的法律、法规和政策规定。报告期内，发行人未出现重大环境保护方面的事故，并未因环境污染原因受到有关部门的重大处罚。

（三）环保支出情况

发行人的环保支出主要为危废处理费用、垃圾处理费用、环境检测费用等。报告期内，发行人环保支出分别为 15.60 万元、26.01 万元、14.85 万元、**6.51 万元**，公司环保相关成本费用与公司生产经营所产生的污染相匹配。

（四）安全生产情况

公司对安全生产保持高度重视，目前已建立健全安全生产管理制度，形成了较为完善的制度体系、组织体系和应急预案措施。报告期内，公司不存在构成重大违法行为或构成发行上市障碍的安全事故。

九、发行人境外经营情况

截至本招股说明书签署日，公司未拥有境外资产。

第六节 财务会计信息与管理层分析

本节财务会计数据及相关财务信息，非经特别说明，均引自经注册会计师审计的财务报表及其附注或根据其中相关数据得出。除另有注明外，公司财务数据和财务指标等均以合并财务报表的数据为基础进行计算。本节的财务会计数据及有关说明反映了公司报告期内经审计财务报表及附注的主要内容，公司提醒投资者关注财务报表和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

一、经审计的财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	**564,574,506.80**	593,979,297.39	126,049,772.50	47,096,481.30
交易性金融资产	**50,186,527.78**	20,018,888.89	26,184,903.70	50,586,560.10
应收票据	**2,066,535.22**	404,112.07	1,785,136.89	316,005.38
应收账款	**256,043,936.25**	200,091,063.21	169,582,621.78	85,674,654.52
应收款项融资	**1,618,659.10**	766,197.99	1,571,085.06	1,865,503.70
预付款项	**29,547,739.76**	13,830,907.81	13,448,052.37	8,616,662.10
其他应收款	**1,389,038.37**	1,109,462.25	3,726,564.01	3,253,028.10
存货	**269,951,769.58**	212,655,657.38	195,148,979.45	113,232,008.27
合同资产	**-**	-	-	447,220.10
其他流动资产	**827,045.40**	503,211.82	24,810.51	92,382.20
流动资产合计	**1,176,205,758.26**	**1,043,358,798.81**	**537,521,926.27**	**311,180,505.77**
非流动资产：				
其他权益工具投资	**5,000,000.00**	-	-	-
固定资产	**57,597,506.54**	57,973,115.29	59,862,832.54	43,468,305.13
在建工程	**106,641,235.32**	83,264,007.43	5,057,917.99	-
使用权资产	**6,929,684.93**	3,252,943.56	5,445,865.48	5,103,775.38
无形资产	**21,542,175.24**	22,193,959.63	23,623,071.95	5,959,874.45
长期待摊费用	**1,709,023.96**	3,033,285.03	5,619,260.01	4,952,837.39
递延所得税资产	**18,071,098.75**	14,132,478.87	9,881,433.52	9,289,543.09
其他非流动资产	**3,504,658.59**	-	86,100.00	2,073,664.00
非流动资产合计	**220,995,383.33**	**183,849,789.81**	**109,576,481.49**	**70,847,999.44**
资产总计	**1,397,201,141.59**	**1,227,208,588.62**	**647,098,407.76**	**382,028,505.21**
流动负债：				

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付账款	**98,519,480.89**	48,624,913.83	33,641,928.57	23,332,563.75
合同负债	**6,364,731.98**	5,660,106.14	7,686,689.69	3,145,760.08
应付职工薪酬	**30,131,097.61**	29,227,608.37	9,187,496.04	19,723,649.98
应交税费	**13,569,637.56**	27,371,130.48	19,492,829.64	10,177,672.49
其他应付款	**68,796.64**	70,600.48	244,240.08	244,609.00
一年内到期的非流动负债	**10,392,124.25**	9,758,379.29	13,410,059.84	12,999,034.08
其他流动负债	**51,272.12**	82,191.06	879,582.76	279,507.90
流动负债合计	**159,097,141.05**	**120,794,929.65**	**84,542,826.62**	**69,902,797.28**
租赁负债	**4,240,375.08**	1,313,658.07	2,766,589.53	5,058,734.86
递延收益	**14,923,300.00**	12,977,733.33	15,700,000.00	15,400,000.00
非流动负债合计	**19,163,675.08**	**14,291,391.40**	**18,466,589.53**	**20,458,734.86**
负债合计	**178,260,816.13**	**135,086,321.05**	**103,009,416.15**	**90,361,532.14**
所有者权益：				
股本	**66,000,000.00**	66,000,000.00	23,456,790.00	22,222,222.00
资本公积	**1,030,587,507.87**	1,020,948,932.43	371,467,699.85	256,035,329.77
盈余公积	**1,633,029.84**	1,633,029.84	11,728,395.00	11,111,111.00
未分配利润	**120,719,787.75**	3,540,305.30	137,436,106.76	2,298,310.30
归属于母公司股东权益合计	**1,218,940,325.46**	**1,092,122,267.57**	**544,088,991.61**	**291,666,973.07**
少数股东权益	**-**	-	-	-
股东权益合计	**1,218,940,325.46**	**1,092,122,267.57**	**544,088,991.61**	**291,666,973.07**
负债和所有者权益总计	**1,397,201,141.59**	**1,227,208,588.62**	**647,098,407.76**	**382,028,505.21**

（二）合并利润表

单位：元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	**375,453,368.10**	654,240,020.56	446,278,959.60	261,055,443.56
减：营业成本	**141,386,191.88**	223,732,784.00	151,237,687.61	99,551,360.03
税金及附加	**1,531,654.36**	6,935,507.08	2,949,649.47	1,882,394.29
销售费用	**14,463,725.16**	36,188,900.38	26,163,025.80	17,897,225.75
管理费用	**31,952,784.79**	64,173,752.34	56,032,465.13	116,775,692.84
研发费用	**61,501,953.16**	109,217,471.04	57,945,031.29	36,668,192.24
财务费用	**581,999.33**	-113,338.42	-212,646.44	536,039.88
其中：利息费用	**97,335.32**	207,152.69	530,037.26	590,505.86
利息收入	**1,202,281.57**	1,718,446.25	465,090.94	385,753.81
加：其他收益	**12,445,982.41**	23,744,362.39	4,573,105.25	2,088,758.34
投资收益	**-67,167.32**	-59,076.65	-123,539.60	-764,807.18

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,179,101.63	762,225.90	993,638.12	861,935.74
信用减值损失	-2,883,317.04	-1,423,766.11	-4,702,026.79	-615,613.92
资产减值损失	-6,007,418.13	-8,225,934.69	770,013.62	-4,530,353.84
资产处置收益	-	-37,249.47	70,893.01	-324,807.65
营业利润	128,702,240.97	228,865,505.51	153,745,830.35	-15,540,349.98
加：营业外收入	-	-	-	1,063,564.57
减：营业外支出	466,872.00	53,493.09	248,889.22	79,638.84
利润总额	128,235,368.97	228,812,012.42	153,496,941.13	-14,556,424.25
减：所得税费用	11,055,886.52	19,455,438.52	17,741,860.67	7,762,415.60
净利润	117,179,482.45	209,356,573.90	135,755,080.46	-22,318,839.85
（一）按经营持续性分类				
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	117,179,482.45	209,356,573.90	135,755,080.46	-22,318,839.85
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-	-	-
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	117,179,482.45	209,356,573.90	135,755,080.46	-21,575,977.51
2、少数股东损益	-	-	-	-742,862.34
其他综合收益税后净额	-	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
综合收益总额	117,179,482.45	209,356,573.90	135,755,080.46	-22,318,839.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,179,482.45	209,356,573.90	135,755,080.46	-21,575,977.51
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-742,862.34
每股收益				
基本每股收益（元/股）	1.78	8.56	-	-
稀释每股收益（元/股）	1.78	8.56		

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现				

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	**355,494,399.56**	698,315,303.62	414,795,180.01	275,839,801.67
收到的税费返还	**222,846.70**	603,305.43	508,722.17	498,442.60
收到其他与经营活动有关的现金	**12,499,801.91**	17,916,424.74	3,180,999.04	16,357,141.42
经营活动现金流入小计	**368,217,048.17**	716,835,033.79	418,484,901.22	292,695,385.69
购买商品、接受劳务支付的现金	**159,757,318.05**	226,576,536.96	206,245,473.08	142,316,702.39
支付给职工以及为职工支付的现金	**83,327,699.25**	141,527,208.22	118,539,551.60	61,673,566.29
支付的各项税费	**44,696,612.79**	64,574,886.22	34,218,615.78	37,566,131.79
支付其他与经营活动有关的现金	**33,829,548.52**	54,889,768.86	42,292,621.13	30,682,680.49
经营活动现金流出小计	**321,611,178.61**	**487,568,400.26**	**401,296,261.59**	**272,239,080.96**
经营活动产生的现金流量净额	**46,605,869.56**	**229,266,633.53**	**17,188,639.63**	**20,456,304.73**
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	**360,000,000.00**	225,000,000.00	135,000,000.00	211,000,000.00
取得投资收益收到的现金	**944,295.42**	1,869,169.71	395,294.52	306,441.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	**-**	36,890.20	99,250.00	380,000.00
投资活动现金流入小计	**360,944,295.42**	**226,906,059.91**	**135,494,544.52**	**211,686,441.96**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	**39,194,597.80**	81,625,515.40	58,732,728.16	26,356,002.44
投资支付的现金	**395,000,000.00**	220,000,000.00	110,000,000.00	255,500,000.00
投资活动现金流出小计	**434,194,597.80**	**301,625,515.40**	**168,732,728.16**	**281,856,002.44**
投资活动产生的现金流量净额	**-73,250,302.38**	**-74,719,455.49**	**-33,238,183.64**	**-70,169,560.48**
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	**-**	320,000,000.00	100,000,000.00	-
取得借款收到的现金	**-**	-	10,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	**-**	**320,000,000.00**	**110,000,000.00**	**-**
偿还债务支付的现金	**-**	-	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付	**-**	-	79,357.21	4,050,000.00

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,446,553.00	6,224,745.16	4,768,922.99	3,008,439.64
筹资活动现金流出小计	1,446,553.00	6,224,745.16	14,848,280.20	7,058,439.64
筹资活动产生的现金流量净额	-1,446,553.00	313,775,254.84	95,151,719.80	-7,058,439.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,313,804.77	-392,907.99	351,115.41	180,441.51
五、现金及现金等价物净增加额	-29,404,790.59	467,929,524.89	79,453,291.20	-56,591,253.88
加：期初现金及现金等价物余额	591,979,297.39	124,049,772.50	44,596,481.30	101,187,735.18
六、期末现金及现金等价物余额	562,574,506.80	591,979,297.39	124,049,772.50	44,596,481.30

二、审计意见

容诚会计师接受公司委托，对公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日、**2026 年 6 月 30 日**的合并及母公司资产负债表，2023 年度、2024 年度、 2025 年度**及 2026 年 1-6 月**的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了“容诚审字[2026]210Z0027 号”和**容诚审字[2026]210Z0307 号**标准无保留意见的审计报告。

容诚会计师认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神州半导体 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日及 **2026 年 6 月 30 日**的合并及母公司财务状况以及 2023 年度、2024 年度、2025 年度及 **2026 年 1-6 月**的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、关键审计事项、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准

（一）关键审计事项

容诚会计师在审计中识别出的关键审计事项具体如下：

1、收入确认

（1）事项描述

相关会计年度：**2026 年 1-6 月**、2025 年度、2024 年度、2023 年度

神州半导体的营业收入分别为**2026 年 1-6 月人民币 37,545.34 万元**、2025 年度人民币 65,424.00 万元、2024 年度人民币 44,627.90 万元、2023 年度人民币 26,105.54 万元。

由于营业收入是神州半导体关键业绩指标之一，系财务报表使用者密切关注的盈利指标，其产生错报的风险较高。因此，容诚会计师将收入确认确定为关键审计事项。

（2）审计应对

针对收入确认，容诚会计师实施的审计程序主要包括：

A. 了解、评价管理层与收入确认相关的关键内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性；

B. 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

C. 对收入实施相关的分析程序，评估各期收入和毛利率变动的合理性；

D. 对于内销收入，选取样本，检查相关支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、运输对账单、客户签收单、验收单等；对于出口收入，选取样本，检查相关支持性文件，包括销售合同、出口报关单、销售发票等，并获取电子口岸信息并与账面记录核对；

E. 选取样本，执行函证程序，函证内容包括应收账款或合同负债余额、本期交易金额、回款金额；

F. 实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；

G. 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

H. 选取样本，对客户进行实地走访，核实营业收入的真实性。

I. 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

2、存货可变现净值

（1）事项描述

神州半导体存货账面价值为**2026 年 6 月 30 日 26,995.18 万元**，2025 年 12

月 31 日 21,265.57 万元，2024 年 12 月 31 日 19,514.90 万元，2023 年 12 月 31 日 11,323.20 万元。

存货采用成本与可变现净值孰低计量。管理层按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值。由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，容诚会计师将存货可变现净值的确认确定为关键审计事项。

（2）审计应对

针对存货可变现净值的确认，容诚会计师实施的审计程序主要包括：

A. 了解、评价管理层与存货可变现净值确认相关的关键内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性；

B. 针对管理层以前年度就存货可变现净值所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

C. 选取样本，评价存货估计售价的合理性，复核估计售价是否与销售合同价格、市场销售价格、历史数据等一致；

D. 评价管理层就存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费所作估计的合理性；

E. 重新计算管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

F. 结合存货监盘，识别是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层就存货可变现净值所作估计的合理性；

G. 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（二）与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准

公司在确定与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平判断标准时，结合自身所处的行业、发展阶段和经营状况，具体从性质和金额两个方面来考虑。从性质来看，主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量；从金额来看，根据各期利润总额绝对值的 5%确定合并财务报表的重要性水平。

四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

自本报告期末起的 12 个月内，公司持续经营能力良好，不存在导致对公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

（二）合并财务报表范围及变化情况

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

1、合并财务报表范围

截至报告期末，公司纳入合并范围的子公司如下：

序号	名称	注册地	持股比例		取得方式
			直接	间接	
1	江苏芯越半导体科技有限公司	江苏省扬州市	100%	-	设立取得
2	上海晟州聚能半导体科技有限公司	上海市	100%	-	设立取得
3	上海昇州半导体科技有限公司	上海市	100%	-	设立取得

2、报告期内合并范围的变化情况

（1）报告期内新增子公司

序号	名称	新增期间	纳入合并范围原因
1	上海晟州聚能半导体科技有限公司	2024 年度	新设

（2）报告期内减少子公司

无。

五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

本节仅披露报告期内与行业相关或对公司财务状况、经营成果及财务报表理解具有重大影响的会计政策及其关键判断、会计估计及其假设的衡量标准、会计政策及会计估计的具体执行标准。公司采用的会计政策符合一般会计原则，与同行业可比公司不存在重大差异。

关于公司采用的会计政策和会计估计的详细说明请参见公司经审计的财务报表附注。

（一）记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

（二）控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1、控制的判断标准和合并范围的确定

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表明本公司能够控制被投资方。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

2、合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企

业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

（1）合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

（2）抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

（3）抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

（4）站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

3、报告期内增减子公司的处理

（1）增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

a. 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

b. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

c. 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

a. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

b. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

c. 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入

合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

4、合并抵销中的特殊考虑

（1）子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

（2）“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

（3）因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

（4）本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

（5）子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有

者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

5、特殊交易的会计处理

（1）购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（2）通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策和会计期间不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上

合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，购买日之前持有的被购买方股权被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，公允价值与其账面价值之间的差额计入留存收益，该股权原计入其他综合收益的累计公允价值变动转出至留存收益；购买日之前持有的被购买方的股权作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或者权益法核算的长期股权投资的，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及权益法核算下的除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益在购买日采用与被投资方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与其相关的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（3）本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。

b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。

c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。

d. 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

e. 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

（三）收入

1、一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预

计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

（3）本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

（5）客户已接受该商品。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时

确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

（1）如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

（2）如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造

服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

（3）如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

2、具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

（1）商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，取得签收或验收单据，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的对价很可能收回，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；

外销产品收入确认需满足以下条件：对于境外客户，本公司已根据合同约定将产品报关，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的对价很可能收回，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。对于保税区客户，公司收入确认条件与内销产品收入一致。

（2）提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同包含对客户商品的维修等履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

公司已根据合同约定向客户提供服务，向客户交付最终的工作内容或成果，经客户确认服务完成后确认收入。

（四）金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

（2）该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

在结算日金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

2、金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

3、金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

（3）以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还

是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

4、衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

5、金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平

均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A.应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、

其他应收款、应收款项融资、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 信用等级较低的银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1　应收一般客户

应收账款组合 2　应收债权凭证

应收账款组合 3　应收合并范围内关联方客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1　应收利息

其他应收款组合 2　应收股利

其他应收款组合 3　应收合并范围内关联方往来款

其他应收款组合 4　账龄组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1　信用等级较高的银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1　未到期质保金

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5	5
1-2 年	15	15
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

B.债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概

率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

6、金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的

合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

（1）终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

（2）继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

（3）继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

7、金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（五）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、合同履约成本等。

2、发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

3、存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

4、存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

（3）本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

（4）资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

5、周转材料的摊销方法

（1）低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

（2）包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

（六）固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

1、确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

2、各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

（七）在建工程

1、在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作

为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

本公司各类别在建工程具体转固标准和时点：

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	主体建设工程及配套工程已实质完工达到预定设计要求并经验收

（八）无形资产

1、无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

2、无形资产使用寿命及摊销

（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50 年	法定使用权
计算机软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产的减值测试情况

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

（3）无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益或计入相关资产的成本。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

3、研发支出归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

4、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

（1）本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

（2）在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（九）股份支付

1、股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

（1）对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

（2）对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

4、股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

（1）授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

（2）完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

（1）授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

（2）完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

5、股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

6、股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

（1）将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

（2）在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

（十）长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（十一）政府补助

1、政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

（1）本公司能够满足政府补助所附条件；

（2）本公司能够收到政府补助。

2、政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

3、政府补助的会计处理

（1）与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与

本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（3）政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（4）政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（十二）重要会计政策和会计估计变更

1、重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则解释第 17 号》

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

（2）保证类质保费用重分类

财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司自 2023 年度开始执行该规定，执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

（3）执行《企业会计准则解释第 19 号》

2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会[2025]32 号，以下简称解释 19 号），自 2026 年 1 月 1 日起施行。执行解释 19 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

2、重要会计估计变更

报告期内，公司未发生重要会计估计变更。

六、经注册会计师核验的非经常性损益表

报告期内，经会计师审验的非经常性损益明细表如下：

单位：万元

项目	2026年1-6月	2025年度	2024年度	2023年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-3.72	7.09	-32.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	856.06	1,244.63	186.96	205.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	117.91	76.22	99.36	86.19
债务重组损益	-6.72	-5.91	-12.35	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46.69	-5.35	-24.89	98.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-8,100.00
非经常性损益总额	920.57	1,305.87	256.17	-7,742.51
减：非经常性损益的所得税影响数	144.48	197.33	40.61	54.35
非经常性损益净额	776.08	1,108.54	215.56	-7,796.87
归属于母公司股东的非经常性损益	776.08	1,108.54	215.56	-7,796.87
归属于母公司股东的净利润	11,717.95	20,935.66	13,575.51	-2,157.60
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	10,941.86	19,827.12	13,359.95	5,639.27

报告期内，发行人归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为-7,796.87万元、215.56万元、1,108.54万元和776.08万元，主要为计入当期损益的政府补助、计入非经常性损益的股份支付、大额存单等产品公允价值变动损益及投资收益，具体请参见本招股说明书“第六节/十/（四）”、“十/（五）”等相关内容。

七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策

（一）主要税种及税率

报告期内，公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率			
		2026年1-6月	2025年度	2024年度	2023年度
增值税	应税收入	6%、13%			

税种	计税依据	税率			
		2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
城市维护建设税	应纳流转税额	7%			
教育费附加	应纳流转税额	3%			
地方教育附加	应纳流转税额	2%			
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%			

报告期内，公司及所属子公司执行的企业所得税税率如下：

纳税主体名称	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
江苏神州半导体科技股份有限公司	**15%**	15%	15%	15%
江苏芯越半导体科技有限公司	**25%**	25%	25%	25%
上海昇州半导体科技有限公司	**20%**	20%	20%	20%
上海晟州聚能半导体科技有限公司	**20%**	20%	20%	—

（二）税收优惠

1、增值税

（1）根据财政部、国家税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号）的相关规定：自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。

本公司 2023 年、2024 年 1 月-10 月享受上述税收优惠。

（2）根据《财政部税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税[2023]17 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计生产、封测、装备、材料企业（以下称集成电路企业）按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。

本公司 2024 年 11 月-12 月、2025 年、**2026 年 1-6 月**享受上述税收优惠。

2、企业所得税

（1）根据《科技部、财政部、国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火〔2016〕32 号）、《关于修订印发<高新技术企业认定管理工作指引>的通知》（国科发火〔2016〕195 号）、《国家税务总局关

于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号），企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起可申报享受企业所得税 15%优惠税率的税收优惠。

发行人为高新技术企业，发行人于 2019 年 12 月 5 日通过了高新技术企业的认定，自 2019 年 1 月 1 日起持续享受企业所得税税率为 15%的税收优惠政策。公司于 2022 年 12 月 12 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局核发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202232015362，有限期：三年。公司于 2025 年 12 月 19 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局核发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202532016464，有限期：三年。

报告期内，本公司享受 15%的企业所得税优惠税率。

（2）根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）规定，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号）规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

报告期内，本公司之子公司上海昇州、晟州聚能享受上述税收优惠。

（3）根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 7 号），自 2023 年 1 月 1 日起，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

（4）根据《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委 工业和信息化部公告 2023 年第 44 号）规定，集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 220%在税前摊销。

本公司报告期内享受上述税收优惠。

八、主要财务指标

（一）主要财务指标

项目	2026 年 1-6 月/2026 年 6 月 30 日	2025 年度/2025 年 12 月 31 日	2024 年度/2024 年 12 月 31 日	2023 年度/2023 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	**7.39**	8.64	6.36	4.45
速动比率（倍）	**5.70**	6.88	4.05	2.83
资产负债率（母公司）	**12.38%**	10.93%	14.81%	22.00%
资产负债率（合并）	**12.76%**	11.01%	15.92%	23.65%
应收账款周转率（次/年）	**3.12**	3.36	3.31	3.05
存货周转率（次/年）	**1.07**	1.02	0.91	1.11
息税折旧摊销前利润（万元）	**14,121.89**	25,254.62	17,220.70	-373.20
归属于公司普通股股东的净利润（万元）	**11,717.95**	20,935.66	13,575.51	-2,157.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（万元）	**10,941.86**	19,827.12	13,359.95	5,639.27
研发投入占营业收入的比例	**16.38%**	16.69%	12.98%	14.05%
利息保障倍数（倍）	**1,318.46**	1,105.56	290.60	-23.65
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	**0.71**	3.47	-	-
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	**18.47**	16.55	-	-
每股净现金流量（元/股）	**-0.45**	7.09	-	-

注：上述财务指标的计算公式如下：
1、流动比率=流动资产/流动负债；
2、速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产-存货）/流动负债；
3、资产负债率=总负债/总资产；
4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
5、存货周转率=营业成本/存货平均余额；
6、息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务费用的利息支出+资本化利息支出+固定资产折旧+使用权资产折旧+长期待摊费用摊销+无形资产摊销；
7、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息支出（包含资本化利息）；

8、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本；
9、归属于公司普通股股东的每股净资产=期末归属于公司普通股股东的净资产/期末总股本；
10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本；
11、2026 年 1-6 月应收账款周转率、存货周转率已年化。

（二）净资产收益率与每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，发行人报告期内的净资产收益率与每股收益如下：

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
			基本每股收益（元）	稀释每股收益（元）
归属于公司普通股股东的净利润	**2026 年 1-6 月**	**10.15**	**1.78**	**1.78**
	2025 年度	31.95	8.56	8.56
	2024 年度	29.06	-	-
	2023 年度	-8.50	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	**2026 年 1-6 月**	**9.48**	**1.66**	**1.66**
	2025 年度	30.26	8.11	8.11
	2024 年度	28.60	-	-
	2023 年度	22.23	-	-

注：上述指标的计算公式如下：
1、加权平均净资产收益=P0÷（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
2、基本每股收益=P0÷S=P0÷（S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk）
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
3、稀释每股收益=P1÷（S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

九、分部信息

报告期内，发行人无经营分部信息。

十、经营成果分析

报告期内，发行人总体经营成果如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	**37,545.34**	65,424.00	44,627.90	26,105.54
营业成本	**14,138.62**	22,373.28	15,123.77	9,955.14
营业毛利	**23,406.72**	43,050.72	29,504.13	16,150.41
期间费用	**10,850.05**	20,946.68	13,992.79	17,187.72
营业利润	**12,870.22**	22,886.55	15,374.58	-1,554.03
利润总额	**12,823.54**	22,881.20	15,349.69	-1,455.64
净利润	**11,717.95**	20,935.66	13,575.51	-2,231.88
归属于母公司所有者的净利润	**11,717.95**	20,935.66	13,575.51	-2,157.60
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	**10,941.86**	19,827.12	13,359.95	5,639.27

报告期内，公司营业收入分别为 26,105.54 万元、44,627.90 万元、65,424.00 万元及 **37,545.34 万元**，归属于母公司所有者的净利润分别为-2,157.60 万元、13,575.51 万元、20,935.66 万元及 **11,717.95 万元**。得益于下游应用行业的不断发展和公司整体竞争力的提升，报告期内公司主营产品的销量持续上升，主营业务收入规模相应增加。

（一）营业收入分析

1、营业收入的构成情况

报告期内，公司营业收入构成如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	**36,741.01**	**97.86%**	64,223.27	98.16%	43,798.12	98.14%	25,783.17	98.77%
其他业务收入	**804.33**	**2.14%**	1,200.73	1.84%	829.77	1.86%	322.38	1.23%
合计	**37,545.34**	**100.00%**	**65,424.00**	**100.00%**	**44,627.90**	**100.00%**	**26,105.54**	**100.00%**

公司核心产品系等离子体电源系统，并向客户提供等离子体电源系统相关的

技术支持服务。报告期内，公司主营业务收入分别为 25,783.17 万元、43,798.12 万元、64,223.27 万元和 **36,741.01 万元**，各期占营业收入比重均超过 **95%**，主营业务突出。此外，公司报告期内其他业务收入分别系 322.38 万元、829.77 万元、1,200.73 万元和 **804.33 万元**，主要系子公司江苏芯越的加工业务。

2024 年及 2025 年，公司主营业务收入规模分别较上年度增长 69.87%和 46.63%，主要系公司自研等离子体射频电源系统于 2024 年成功通过客户验证，并持续实现批量商业化，收入大幅增加。

2、主营业务收入构成分析

（1）按产品结构分析

报告期内，公司主营业务收入按产品及服务类型构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
自研产品销售	**18,721.76**	**50.96%**	35,391.86	55.11%	17,214.64	39.30%	2,117.65	8.21%
技术支持服务	**17,819.99**	**48.50%**	27,564.59	42.92%	24,468.88	55.87%	22,711.95	88.09%
零部件销售及其他	**199.26**	**0.54%**	1,266.82	1.97%	1,548.56	3.54%	953.57	3.70%
受托研发	**-**	**-**	-	-	566.04	1.29%	-	-
合计	**36,741.01**	**100.00%**	**64,223.27**	**100.00%**	**43,798.12**	**100.00%**	**25,783.17**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务收入主要来源于自研产品销售和技术支持服务，具体分析如下：

①按产品具体类别分析

公司的自研产品收入主要来源于等离子体射频电源系统、远程等离子体源系统的销售收入；公司技术支持服务收入同样主要来源于针对等离子体射频电源系统、远程等离子体源系统的服务收入。

报告期内，公司各产品及服务的收入构成情况如下：

单位：万元

项目	产品类别	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
自研	等离子体射	**5,771.21**	**15.71%**	26,788.01	41.71%	10,028.27	22.90%	21.24	0.08%

项目	产品类别	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
产品销售	频电源系统								
	其中：射频电源	**4,326.14**	**11.77%**	26,008.24	40.50%	10,016.67	22.87%	-	-
	阻抗匹配器	**1,445.07**	**3.93%**	779.77	1.21%	11.60	0.03%	21.24	0.08%
	远程等离子体源系统	**8,249.66**	**22.45%**	7,970.85	12.41%	7,170.44	16.37%	2,096.42	8.13%
	高压脉冲电源系统	**4,631.26**	**12.61%**	600.00	0.93%	-	-	-	-
	其他产品	**69.63**	**0.19%**	33.00	0.05%	15.93	0.04%	-	-
	自研产品小计	**18,721.76**	**50.96%**	**35,391.86**	**55.11%**	**17,214.64**	**39.30%**	**2,117.65**	**8.21%**
技术支持服务	等离子体射频电源系统	**10,995.12**	**29.93%**	16,221.62	25.26%	15,343.29	35.03%	13,084.18	50.75%
	其中：射频电源	**7,105.12**	**19.34%**	10,990.35	17.11%	10,360.96	23.66%	8,133.08	31.54%
	阻抗匹配器	**3,890.00**	**10.59%**	5,231.27	8.15%	4,982.33	11.38%	4,951.10	19.20%
	远程等离子体源系统	**4,446.33**	**12.10%**	8,630.73	13.44%	6,709.50	15.32%	7,092.26	27.51%
	直流电源系统	**1,547.80**	**4.21%**	2,274.21	3.54%	1,839.15	4.20%	1,749.12	6.78%
	其他产品	**830.74**	**2.26%**	438.03	0.68%	576.95	1.32%	786.39	3.05%
	技术支持服务小计	**17,819.99**	**48.50%**	**27,564.59**	**42.92%**	**24,468.88**	**55.87%**	**22,711.95**	**88.09%**
零部件销售及其他		**199.26**	**0.54%**	1,266.82	1.97%	1,548.56	3.54%	953.57	3.70%
受托研发		**-**	**-**	-	-	566.04	1.29%	-	-
合计		**36,741.01**	**100.00%**	**64,223.27**	**100.00%**	**43,798.12**	**100.00%**	**25,783.17**	**100.00%**

②按应用领域分析

等离子体射频电源系统、远程等离子体源系统等产品可广泛用于半导体、光伏、显示、医疗等行业，公司产品具有行业领先的技术参数和产品性能，主要系半导体刻蚀设备、薄膜沉积设备等关键工艺设备的核心零部件，定位于半导体先进制程，具有高技术附加值，报告期内实现经营业绩的快速发展。

报告期内，公司主营业务收入按下游主要应用领域的收入构成情况如下：

单位：万元

下游领域	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
半导体	**35,571.41**	**96.82%**	61,254.42	95.38%	40,635.26	92.78%	21,973.61	85.22%
显示	**674.08**	**1.83%**	1,028.16	1.60%	1,512.52	3.45%	2,385.26	9.25%
光伏	**59.42**	**0.16%**	1,295.55	2.02%	510.94	1.17%	233.61	0.91%

下游领域	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他	436.10	1.19%	645.15	1.00%	1,139.41	2.60%	1,190.70	4.62%
合计	36,741.01	100.00%	64,223.27	100.00%	43,798.12	100.00%	25,783.17	100.00%

其中，报告期内，公司自研产品按下游主要应用领域的收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
半导体	18,705.96	99.92%	34,387.16	97.16%	16,723.24	97.15%	2,041.51	96.40%
光伏	-	-	974.70	2.75%	476.40	2.77%	68.14	3.22%
其他	15.79	0.08%	30.00	0.08%	15.00	0.09%	8.00	0.38%
合计	18,721.76	100.00%	35,391.86	100.00%	17,214.64	100.00%	2,117.65	100.00%

由上表可知，报告期内公司主营业务收入增长主要系半导体领域的自研产品收入增长较快所致。随着国产化替代浪潮，下游头部设备厂商国产化采购需求显著增长，带动了公司自研产品收入的增长。

③半导体领域内，按制程分析

公司自研产品按最高适用制程列示收入情况如下：

单位：万元

下游领域	制程	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
半导体领域	先进制程	18,361.73	98.08%	34,189.78	96.60%	16,689.81	96.95%	2,041.51	96.40%
	成熟制程及其他	344.23	1.84%	197.38	0.56%	33.43	0.19%	-	-
	小计	18,705.96	99.92%	34,387.16	97.16%	16,723.24	97.15%	2,041.51	96.40%
其他领域		15.79	0.08%	1,004.70	2.84%	491.40	2.85%	76.14	3.60%
合计		18,721.76	100.00%	35,391.86	100.00%	17,214.64	100.00%	2,117.65	100.00%

由上表可知，报告期内公司半导体领域自研产品基本全部集中于先进制程。

公司技术支持服务涉及的产品按最高适用制程列示收入情况如下：

单位：万元

下游领域	制程	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
半导体领域	先进制程	14,782.80	82.96%	23,973.99	86.97%	20,123.89	82.24%	16,733.39	73.68%
	成熟制程及其他	1,901.61	10.67%	1,661.66	6.03%	1,719.32	7.03%	2,278.50	10.03%
	小计	16,684.41	93.63%	25,635.65	93.00%	21,843.21	89.27%	19,011.89	83.71%

下游领域	制程	2026年1-6月		2025年度		2024年度		2023年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他领域		**1,135.58**	**6.37%**	1,928.95	7.00%	2,625.67	10.73%	3,700.06	16.29%
合计		**17,819.99**	**100.00%**	**27,564.59**	**100.00%**	**24,468.88**	**100.00%**	**22,711.95**	**100.00%**

由上表可知，报告期内公司半导体领域技术支持服务主要集中于先进制程，且在报告期内先进制程收入占比持续提升。

（2）按地区分析

报告期内，公司主营业务收入按客户所在地区划分的具体情况如下：

单位：万元

销售区域	2026年1-6月		2025年度		2024年度		2023年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	**32,172.62**	**87.57%**	60,294.33	93.88%	39,969.91	91.26%	22,961.39	89.06%
境外	**4,568.39**	**12.43%**	3,928.95	6.12%	3,828.21	8.74%	2,821.78	10.94%
合计	**36,741.01**	**100.00%**	**64,223.27**	**100.00%**	**43,798.12**	**100.00%**	**25,783.17**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务收入以境内收入为主，境内收入金额分别为22,961.39 万元、39,969.91 万元、60,294.33 万元和 **32,172.62 万元**。报告期内，公司来源于境外的主营业务收入金额有所增长，但占比**维持在较低水平**，主要系公司境内收入增速较快所致。

（3）按销售模式分析

报告期内，公司主营业务收入按销售模式的划分情况如下：

单位：万元

项目	2026年1-6月		2025年度		2024年度		2023年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	**36,103.29**	**98.26%**	63,531.75	98.92%	42,798.29	97.72%	24,506.08	95.05%
通过贸易商销售	**637.72**	**1.74%**	691.53	1.08%	999.83	2.28%	1,277.09	4.95%
合计	**36,741.01**	**100.00%**	**64,223.27**	**100.00%**	**43,798.12**	**100.00%**	**25,783.17**	**100.00%**

报告期内，公司主要采用直销模式开展业务，能更有效贴近终端市场，提升对重要客户需求的响应速度，深度绑定战略客户。

在直销收入中，公司具有少量经代理商介绍的收入情况，主要系经公司授权，由代理商承揽的技术支持服务业务，报告期各期收入金额分别系 331.70 万元、245.56 万元、209.64 万元**和 209.52 万元**，金额占比较小。

除直销外，公司也采取通过贸易商销售形式作为辅助销售手段，相关收入占比较低且逐年减少。

（4）按季度分析

报告期内，公司主营业务收入按季度划分情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	**13,184.33**	**35.88%**	17,000.68	26.47%	7,837.94	17.90%	5,236.42	20.31%
第二季度	**23,556.68**	**64.12%**	16,136.65	25.13%	9,485.26	21.66%	6,403.20	24.83%
第三季度	-	-	19,501.57	30.37%	12,080.40	27.58%	7,054.29	27.36%
第四季度	-	-	11,584.38	18.04%	14,394.52	32.87%	7,089.26	27.50%
合计	**36,741.01**	**100.00%**	**64,223.27**	**100.00%**	**43,798.12**	**100.00%**	**25,783.17**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务收入不具有明显的季节性特征，其变动主要与下游客户需求相关。

3、不同销售模式下，主要产品平均销售单价及变动情况

报告期各期，公司销售模式和主要产品的销售数量变动情况如下：

单位：个

销售模式	主要产品	2026 年 1-6 月		2025 年		2024 年		2023 年
		销量	变动	销量	变动	销量	变动	销量
直销模式	自研产品	**1,248**	-	1,148	58.13%	726	334.73%	167
	技术支持服务	**6,062**	-	9,026	13.39%	7,960	4.05%	7,650
通过贸易商销售模式	自研产品	**3**	-	-	-	1	-	-
	技术支持服务	**320**	-	284	-12.07%	323	-6.38%	345

由上可知，报告期内公司直销模式下自研产品和技术支持服务销量逐年增加；报告期内公司通过贸易商销售模式下，自研产品仅有 **4** 台零星销售，技术支持服务销量逐年下降。报告期内公司销售以直销模式为主。

报告期各期，公司销售模式和主要产品的平均销售单价变动情况如下：

单位：万元/个

销售模式	主要产品	2026 年 1-6 月		2025 年		2024 年		2023 年
		平均单价	变动	平均单价	变动	平均单价	变动	平均单价
直销	自研产品	**14.98**	**-51.40%**	30.83	30.13%	23.69	86.83%	12.68

模式	技术支持服务	**2.84**	**-4.72%**	2.98	0.76%	2.96	5.44%	2.80
通过贸易商销售模式	自研产品	**7.30**	**-**	-	-	15.00	-	-
	技术支持服务	**1.90**	**-20.56%**	2.39	-17.55%	2.90	-20.81%	3.67

由上表可知，**2023 年度至 2025 年度**公司直销模式下自研产品和技术支持服务平均销售单价逐年提升，**2026 年 1-6 月平均销售单价有所下降**，主要系公司产品结构变化所致，**随着 Advocate 系列射频电源、阻抗匹配器、高压脉冲电源系统逐步放量，相关产品收入占比明显提升，Central 系列远程等离子体源系统收入亦保持较大规模，公司自研产品收入来源进一步拓展，产品结构趋于多元化，平均单价有所下降**；

报告期内公司通过贸易商销售模式下的技术支持服务平均单价有所下降，主要系通过贸易商销售模式的收入金额较小，平均单价易受个别订单影响所致。

（二）营业成本分析

1、营业成本构成分析

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	**13,757.05**	**97.30%**	21,418.91	95.73%	14,480.26	95.75%	9,653.12	96.97%
其他业务成本	**381.57**	**2.70%**	954.36	4.27%	643.51	4.25%	302.02	3.03%
合计	**14,138.62**	**100.00%**	**22,373.28**	**100.00%**	**15,123.77**	**100.00%**	**9,955.14**	**100.00%**

报告期内，公司营业成本分别为 9,955.14 万元、15,123.77 万元、22,373.28 万元和 **14,138.62 万元**，营业成本与营业收入增长趋势具有一致性。

2、主营业务成本构成情况分析

报告期内，公司主营业务成本按产品及服务类型的构成情况具体如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
自研产品	**6,662.41**	**48.43%**	10,133.60	47.31%	5,228.81	36.11%	843.55	8.74%
技术支持服务	**6,997.33**	**50.86%**	10,611.46	49.54%	8,548.75	59.04%	8,584.08	88.93%
零部件销售及其他	**97.31**	**0.71%**	673.86	3.15%	395.26	2.73%	225.48	2.34%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
受托研发	-	-	-	-	307.45	2.12%	-	-
合计	**13,757.05**	**100.00%**	**21,418.91**	**100.00%**	**14,480.26**	**100.00%**	**9,653.12**	**100.00%**

具体分各产品细分类别来看，成本构成如下：

单位：万元

项目	产品类别	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
自研产品	等离子体射频电源系统	**1,872.48**	**13.61%**	6,701.31	31.29%	2,424.93	16.75%	15.09	0.16%
	其中：射频电源	**1,468.56**	**10.67%**	6,441.05	30.07%	2,417.42	16.69%	-	-
	阻抗匹配器	**403.92**	**2.94%**	260.27	1.22%	7.51	0.05%	15.09	0.16%
	远程等离子体源系统	**3,997.80**	**29.06%**	3,180.24	14.85%	2,801.60	19.35%	828.47	8.58%
	高压脉冲电源系统	**770.96**	**5.60%**	248.87	1.16%	-	-	-	-
	其他产品	**21.16**	**0.15%**	3.17	0.01%	2.28	0.02%	-	-
	自研产品小计	**6,662.41**	**48.43%**	**10,133.60**	**47.31%**	**5,228.81**	**36.11%**	**843.55**	**8.74%**
技术支持服务	等离子体射频电源系统	**4,143.42**	**30.12%**	6,029.96	28.15%	4,947.49	34.17%	4,450.26	46.10%
	其中：射频电源	**2,383.72**	**17.33%**	3,708.15	17.31%	2,915.08	20.13%	2,477.75	25.67%
	阻抗匹配器	**1,759.69**	**12.79%**	2,321.80	10.84%	2,032.41	14.04%	1,972.51	20.43%
	远程等离子体源系统	**2,030.68**	**14.76%**	3,705.07	17.30%	2,790.28	19.27%	3,152.90	32.66%
	直流电源系统	**379.86**	**2.76%**	586.23	2.74%	495.57	3.42%	515.58	5.34%
	其他产品	**443.37**	**3.22%**	290.21	1.35%	315.41	2.18%	465.34	4.82%
	技术支持服务小计	**6,997.33**	**50.86%**	**10,611.46**	**49.54%**	**8,548.75**	**59.04%**	**8,584.08**	**88.93%**
零部件销售及其他		**97.31**	**0.71%**	673.86	3.15%	395.26	2.73%	225.48	2.34%
受托研发		-	-	-	-	307.45	2.12%	-	-
合计		**13,757.05**	**100.00%**	**21,418.91**	**100.00%**	**14,480.26**	**100.00%**	**9,653.12**	**100.00%**

公司产品的成本性质如下：

单位：万元

成本性质	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
材料成本	**9,236.11**	**67.14%**	14,806.99	69.13%	9,176.82	63.37%	6,059.91	62.78%
直接人工	**1,457.69**	**10.60%**	1,981.12	9.25%	1,752.98	12.11%	1,175.46	12.18%
制造费用	**3,063.25**	**22.27%**	4,630.81	21.62%	3,550.46	24.52%	2,417.75	25.05%
合计	**13,757.05**	**100.00%**	**21,418.91**	**100.00%**	**14,480.26**	**100.00%**	**9,653.12**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务成本的成本性质构成保持基本稳定，主要由材料成本构成。

（三）毛利及毛利率分析

1、毛利构成及毛利率分析

报告期内，公司主营业务和其他业务的毛利构成及毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
主营业务	**22,983.96**	**62.56%**	42,804.36	66.65%	29,317.86	66.94%	16,130.05	62.56%
其他业务	**422.76**	**52.56%**	246.36	20.52%	186.27	22.45%	20.36	6.31%
合计	**23,406.72**	**62.34%**	**43,050.72**	**65.80%**	**29,504.13**	**66.11%**	**16,150.41**	**61.87%**

2、主营业务毛利构成及毛利率分析

（1）主营业务毛利分析

报告期内，公司主营业务毛利按产品及服务类型构成如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
自研产品	**12,059.34**	**52.47%**	25,258.26	59.01%	11,985.83	40.88%	1,274.10	7.90%
技术支持服务	**10,822.66**	**47.09%**	16,953.13	39.61%	15,920.14	54.30%	14,127.87	87.59%
零部件销售及其他	**101.95**	**0.44%**	592.97	1.39%	1,153.30	3.93%	728.08	4.51%
受托研发	**-**	**-**	-	-	258.59	0.88%	-	-
合计	**22,983.96**	**100.00%**	**42,804.36**	**100.00%**	**29,317.86**	**100.00%**	**16,130.05**	**100.00%**

报告期内，随着公司经营规模的不断扩大，公司主营业务毛利逐年上升，各期主营业务毛利金额分别为 16,130.05 万元、29,317.86 万元、42,804.36 万元和 **22,983.96 万元**。其中，自研产品和技术支持服务合计占比分别为 95.49%、95.18%、98.61%和 **99.56%**，构成公司主营业务毛利主要来源。

（2）主营业务毛利率分析

报告期内，公司主营业务毛利率按产品及服务类型构成如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度

	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
自研产品	**64.41%**	**50.96%**	71.37%	55.11%	69.63%	39.30%	60.17%	8.21%
技术支持服务	**60.73%**	**48.50%**	61.50%	42.92%	65.06%	55.87%	62.20%	88.09%
零部件销售及其他	**51.16%**	**0.54%**	46.81%	1.97%	74.48%	3.54%	76.35%	3.70%
受托研发	**-**	**-**	-	-	45.68%	1.29%	-	-
主营业务	**62.56%**	**100.00%**	**66.65%**	**100.00%**	**66.94%**	**100.00%**	**62.56%**	**100.00%**

公司主营业务毛利率变动原因如下：

①自研产品毛利率

公司 2023 年自研产品主要系远程等离子体源系统，2024 年度完成了先进制程等离子体射频电源系统的产业化突破，收入快速增长，逐步成长为公司收入结构的核心部分之一，2025 年的自研产品收入占主营业务收入比例已提升至 55.11%，居于首位。

公司自研产品毛利率整体较为平稳，2024 年、2025 年相比 2023 年较高，主要系自研等离子体射频电源系统产品于 2024 年开始大量销售，该产品系先进制程的高端产品，毛利率水平较高，带动公司毛利率整体较高。

2026 年 1-6 月，公司自研产品毛利率有所下降，主要系公司当期自研产品销售结构变化，远程等离子体源系统销售占比提升，且主要销售产品型号产业化进程成熟，毛利率相对较低，带动公司自研产品销售整体毛利率有所下降。

②技术支持服务

从对应产品上来看，公司技术支持服务对应产品系等离子体射频电源系统、远程等离子体源系统等，报告期各期毛利率较为平稳。

从业务模式上来看，公司技术支持服务以维修业务为主，公司技术支持服务的收入占比及毛利率情况如下：

项目	2026 年 1-6 月		2025 年		2024 年		2023 年	
	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率
维修	**99.61%**	**60.63%**	99.34%	61.38%	98.66%	64.90%	99.62%	62.13%
其他	**0.39%**	**86.72%**	0.66%	80.38%	1.34%	77.30%	0.38%	80.85%
技术支持服	**100.00%**	**60.73%**	**100.00%**	**61.50%**	**100.00%**	**65.06%**	**100.00%**	**62.20%**

项目	2026 年 1-6 月		2025 年		2024 年		2023 年	
	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率
务合计								

（3）同行业毛利率比较分析

报告期内，同行业可比公司恒运昌、英杰电气、先锋精科、富创精密与公司毛利润及综合毛利率情况如下表所示：

单位：万元

公司名称	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利润	综合毛利率	毛利润	综合毛利率	毛利润	综合毛利率	毛利润	综合毛利率
恒运昌	**13,887.71**	**49.89%**	25,396.09	47.97%	26,232.50	48.51%	14,916.67	45.86%
英杰电气	**26,670.57**	**37.32%**	52,437.30	34.92%	68,547.43	38.50%	65,880.96	37.22%
先锋精科	**16,186.25**	**24.42%**	35,924.76	29.02%	38,425.16	33.83%	16,694.84	29.93%
富创精密	**62,308.94**	**26.89%**	78,774.78	22.23%	78,410.38	25.80%	52,055.23	25.20%
平均值	**29,763.37**	**34.63%**	**48,133.23**	**33.54%**	**52,903.87**	**36.66%**	**37,386.93**	**34.55%**
神州半导体	**23,406.72**	**62.34%**	43,050.72	65.80%	29,504.13	66.11%	16,150.41	61.87%

由上表可知，公司综合毛利率相比可比公司较高，主要系一方面各公司业务结构、主营产品、客户群体有所差异，导致综合毛利率各不相同；另一方面，公司聚焦于高技术附加值、高研发难度、高毛利率的先进制程领域，因此毛利率较高。

具体而言，从功能、性质、应用领域上来看，公司产品与可比公司恒运昌较为相似，与英杰电气、先锋精科和富创精密有所差异，与恒运昌主要产品毛利率比较如下：

企业	主要产品	2026 年 1-6 月		2025 年		2024 年		2023 年	
		毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
恒运昌	自研产品	**54.40%**	**87.20%**	55.32%	78.38%	54.66%	84.34%	54.58%	73.51%
	引进产品	**16.36%**	**11.27%**	13.90%	16.36%	15.12%	15.13%	19.87%	25.31%
	技术服务	**40.17%**	**1.54%**	44.34%	5.27%	55.88%	0.53%	59.97%	1.18%
神州半导体	自研产品	**64.41%**	**50.96%**	71.37%	55.11%	69.63%	39.30%	60.17%	8.21%
	技术支持服务	**60.73%**	**48.50%**	61.50%	42.92%	65.06%	55.87%	62.20%	88.09%

公司自研业务毛利率较高，主要系自 2024 年开始，公司等离子体射频电源

系统产品中的应用于先进存储芯片制造高深宽比刻蚀场景的 AVG、APG 等高端产品持续放量，该产品应用于先进制程芯片产线，结构较为复杂、技术附加值高、竞争对手少，毛利率较高，使得公司整体自研业务毛利率较高。

可比公司恒运昌的自研产品主要系应用于 PECVD 设备中的 RF 产品和 MATCH 产品，该产品与公司产品分属于不同细分领域，产品类型、市场竞争情况、下游客户情况均有所不同，因此毛利率有所差异，且恒运昌 RPS 产品收入较少，在其招股说明书中归类于“其他”中，未披露 RPS 具体收入金额。

恒运昌亦存在少量技术支持服务，2022 年至 2024 年，恒运昌技术服务的毛利率分别为 71.48%、59.97%和 55.88%，与公司技术支持服务业务基本处于同一区间，2025 年**和 2026 年 1-6 月**恒运昌技术服务毛利率下降较多，与公司有所差异，主要系企业经营状况、服务内容、服务对象等有所不同所致。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用及其占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	营收占比	金额	营收占比	金额	营收占比	金额	营收占比
研发费用	**6,150.20**	**16.38%**	10,921.75	16.69%	5,794.50	12.98%	3,666.82	14.05%
管理费用	**3,195.28**	**8.51%**	6,417.38	9.81%	5,603.25	12.56%	11,677.57	44.73%
销售费用	**1,446.37**	**3.85%**	3,618.89	5.53%	2,616.30	5.86%	1,789.72	6.86%
财务费用	**58.20**	**0.16%**	-11.33	-0.02%	-21.26	-0.05%	53.60	0.21%
合计	**10,850.05**	**28.90%**	**20,946.68**	**32.02%**	**13,992.79**	**31.35%**	**17,187.72**	**65.84%**

报告期内，公司期间费用合计金额分别为 17,187.72 万元、13,992.79 万元、20,946.68 万元和 **10,850.05 万元**，占营业收入比例分别为 65.84%、31.35%、32.02%和 **28.90%**，2023 年期间费用合计占营业收入比例较高，主要系股份支付金额 8,596.09 万元所致。其中朱培文无偿受让 5%股权，公司于 2023 年一次性计入管理费用金额 8,100.00 万元，剔除该笔一次性股份支付费用后，2023 年期间费用占营业收入比例降至 34.81%，与 2024 年、2025 年和 **2026 年 1-6 月**指标处于同一区间，公司报告期各期期间费用占营业收入比例整体保持稳定。

1、销售费用

（1）销售费用构成

报告期内，公司销售费用构成及其占比情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	**976.77**	**67.53%**	2,342.03	64.72%	1,433.80	54.80%	941.65	52.61%
会务及招待费	**242.24**	**16.75%**	576.35	15.93%	579.85	22.16%	304.97	17.04%
股份支付	-	-	279.82	7.73%	280.59	10.72%	279.82	15.63%
折旧摊销及租赁费	**69.65**	**4.82%**	158.61	4.38%	76.01	2.91%	61.56	3.44%
交通差旅费	**75.69**	**5.23%**	115.44	3.19%	122.92	4.70%	92.75	5.18%
销售佣金	**40.03**	**2.77%**	72.87	2.01%	55.46	2.12%	69.85	3.90%
其他	**41.99**	**2.90%**	73.77	2.04%	67.68	2.59%	39.12	2.19%
合计	**1,446.37**	**100.00%**	**3,618.89**	**100.00%**	**2,616.30**	**100.00%**	**1,789.72**	**100.00%**

报告期内，公司以直销为主，各期销售费用分别为 1,789.72 万元、2,616.30 万元、3,618.89 万元和 **1,446.37 万元**，占营业收入的比例分别为 6.86%、5.86%、5.53%和 **3.85%**，整体与收入增长相匹配。

公司销售费用主要由职工薪酬、会务及招待费和股份支付构成，前述费用占销售费用的合计比例分别为 85.29%、87.69%、88.38%和 **84.28%**。

（2）销售费用率与同行业可比上市公司的销售费用率比较

报告期内，可比公司与公司销售费用率情况如下表所示：

公司名称	项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
恒运昌	销售费用（万元）	**605.91**	748.72	800.86	652.39
	销售费用率	**2.18%**	1.41%	1.48%	2.01%
英杰电气	销售费用（万元）	**3,095.11**	7,573.53	8,242.15	6,445.50
	销售费用率	**4.33%**	5.04%	4.63%	3.64%
先锋精科	销售费用（万元）	**532.85**	579.67	664.17	501.96
	销售费用率	**0.80%**	0.47%	0.58%	0.90%
富创精密	销售费用（万元）	**4,822.06**	8,378.78	6,061.57	3,661.07
	销售费用率	**2.08%**	2.36%	1.99%	1.77%
平均值	销售费用（万元）	**2,263.98**	4,320.18	3,942.19	2,815.23

公司名称	项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
	销售费用率	**2.35%**	2.32%	2.17%	2.08%
神州半导体	销售费用（万元）	**1,446.37**	3,618.89	2,616.30	1,789.72
	销售费用率	**3.85%**	5.53%	5.86%	6.86%

报告期内，公司销售费用率高于可比公司，主要系相比可比公司而言，公司技术支持服务业务规模较大，客户数量较多，公司用于开拓客户、维护市场所需投入较大，且公司技术支持服务客户中存在较多国际头部芯片产线客户，对销售人员的业务素质要求较高，相应的销售人员薪酬也较高。因此，公司销售费用率相比可比公司较高，公司报告期各期销售费用率较为稳定。

2、管理费用

（1）管理费用构成

报告期内，公司管理费用构成及其占比情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	**2,048.19**	**64.10%**	4,291.68	66.88%	3,390.53	60.51%	2,079.77	17.81%
折旧摊销及租赁费	**333.89**	**10.45%**	578.50	9.01%	571.00	10.19%	447.34	3.83%
中介机构及技术服务费	**138.39**	**4.33%**	466.45	7.27%	321.82	5.74%	127.62	1.09%
股份支付	**339.23**	**10.62%**	386.21	6.02%	596.45	10.64%	8,596.09	73.61%
会务及招待费	**63.95**	**2.00%**	243.74	3.80%	248.40	4.43%	221.46	1.90%
交通差旅费	**78.11**	**2.44%**	122.26	1.91%	100.49	1.79%	71.85	0.62%
其他	**193.52**	**6.06%**	328.52	5.12%	374.56	6.68%	133.44	1.14%
总计	**3,195.28**	**100.00%**	**6,417.38**	**100.00%**	**5,603.25**	**100.00%**	**11,677.57**	**100.00%**

报告期内，公司管理费用金额分别为 11,677.57 万元、5,603.25 万元、6,417.38 万元和 **3,195.28 万元**，占营业收入的比例分别为 44.73%、12.56%、9.81%和 **8.51%**。其中，职工薪酬、折旧摊销及租赁费、中介机构及技术服务费、股份支付构成为公司管理费用的主要组成部分，上述费用报告期各期金额占管理费用总额比例系 96.35%、87.09%、89.18%和 **89.50%**。

报告期内，公司管理费用中职工薪酬金额分别为 2,079.77 万元、3,390.53

万元、4,291.68 万元和 **2,048.19 万元**，**最近三年**呈持续增长趋势，主要系随着公司经营规模增大，业绩表现较好，公司管理人员数量有所增加，平均薪酬有所上涨。

报告期内，公司管理费用中折旧摊销及租赁费金额分别为 447.34 万元、571.00 万元、578.50 万元和 **333.89 万元**，金额较为平稳。

报告期内，公司管理费用中的中介机构及技术服务费金额分别为 127.62 万元、321.82 万元、466.45 万元和 **138.39 万元**，主要由审计费、律师费等构成。

报告期内，公司管理费用中的股份支付费用金额分别为 8,596.09 万元、596.45 万元、386.21 万元和 **339.23 万元**，2023 年股份支付费用金额系 8,596.09 万元，金额较高主要系朱培文无偿受让 5%股权，公司于 2023 年一次性计入管理费用金额 8,100.00 万元，此外 496.09 万元系股份支付分摊金额；2024 年、2025 年以及 **2026 年 1-6 月**股份支付费用金额系股份支付分摊所致。

（2）管理费用率与同行业可比上市公司的管理费用率比较

报告期内，可比公司与公司管理费用率情况如下表所示：

公司名称	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
恒运昌	**10.66%**	8.63%	8.38%	8.41%
英杰电气	**3.39%**	3.16%	3.31%	2.99%
先锋精科	**3.99%**	4.36%	4.29%	6.51%
富创精密	**8.15%**	10.57%	11.24%	10.69%
平均值	**6.55%**	6.68%	6.81%	7.15%
神州半导体	**8.51%**	9.81%	12.56%	44.73%

报告期内，公司管理费用率分别为 44.73%、12.56%、9.81%和 **8.51%**，其中 2023 年管理费用率较高，主要系当年计提股份支付金额较多所致。

公司管理费用率与富创精密、恒运昌总体处于同一区间，高于英杰电气和先锋精科，主要系各公司管理人员数量及薪酬差异所致。

3、研发费用

（1）研发费用构成情况

公司研发投入为研发活动直接相关的投入，包括研发人员职工薪酬、耗用材料、折旧摊销费等，其归集和核算均以相关资源实际投入研发活动为前提。报告

期内，公司所有研发投入均系费用化投入，研发费用具体构成如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	**2,404.19**	**39.09%**	5,070.49	46.43%	2,298.00	39.66%	1,688.85	46.06%
材料费用	**2,162.83**	**35.17%**	2,914.43	26.68%	1,717.13	29.63%	651.92	17.78%
股份支付	**624.63**	**10.16%**	1,201.64	11.00%	789.66	13.63%	787.50	21.48%
折旧与摊销及租赁费	**622.30**	**10.12%**	1,054.32	9.65%	624.09	10.77%	261.67	7.14%
技术服务费	**19.04**	**0.31%**	272.12	2.49%	39.43	0.68%	14.80	0.40%
其他	**317.21**	**5.16%**	408.75	3.74%	326.19	5.63%	262.08	7.15%
总计	**6,150.20**	**100.00%**	**10,921.75**	**100.00%**	**5,794.50**	**100.00%**	**3,666.82**	**100.00%**
研发费用率		**16.38%**		**16.69%**		**12.98%**		**14.05%**

报告期内，公司高度重视技术创新，持续加大研发投入，研发费用分别为3,666.82 万元、5,794.50 万元、10,921.75 万元和 **6,150.20 万元**，最近三年累计研发费用 20,383.07 万元，占最近三年累计营业收入的比例为 14.97%；最近三年研发费用复合增长率为 72.58%。

报告期内，公司研发费用主要由职工薪酬、材料费用、股份支付、折旧与摊销及租赁费构成，上述四项费用在报告期各期合计金额占研发费用的比例分别系92.45%、93.69%、93.77%和 **94.53%**。公司主要研发费用的变化情况如下：

报告期内，公司计入研发费用的职工薪酬分别为 1,688.85 万元、2,298.00 万元、5,070.49 万元和 **2,404.19 万元**，主要系研发人员的工资薪金，包括工资、社保、奖金等。公司报告期内研发人员持续增加，且伴随自研产品的产业化突破，公司对研发人员的薪酬待遇有所提升。

报告期内，公司研发费用中的材料金额分别为 651.92 万元、1,717.13 万元、2,914.43 万元和 **2,162.83 万元**，材料去向主要包括形成样机、消耗等，公司 2025 年材料支出金额增加较多，主要系公司于 2025 年持续加大对高压脉冲电源系统等新型电源系统的研发投入，迭代各版本样机和耗费材料的需求较高，研发投入金额较大。**2026 年 1-6 月，公司研发费用中材料费用持续上升，主要系当期承担了重大科研项目，攻关的产品品类较多，涉及的研发领料较多。**

报告期内，公司研发费用中的股份支付金额分别系 787.50 万元、789.66 万元、1,201.64 万元和 **624.63 万元**，主要系公司对叶剑、朱国俊等研发人员的股

份支付分摊金额。

报告期内，公司研发费用中的折旧摊销费用分别为 261.67 万元、624.09 万元、1,054.32 万元和 **622.30 万元**，主要系用于研发活动的仪器、设备等固定资产的折旧费、租赁研发中心场地的使用权资产折旧以及软件使用费等；报告期内公司研发折旧摊销费用金额持续增长，主要系公司根据项目需求，新增研发设备采购所致。

（2）主要研发项目

报告期内，公司主要研发项目的费用投入情况如下：

单位：万元

项目名称	预算	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
高稳定性大功率甚高频电源产品开发	**6,300.00**	**574.84**	1,408.71	1,047.18	173.19
半导体静电吸盘电源	**1,946.93**	**128.80**	1,312.80	0.82	-
半导体芯片制程用高解离率耐腐蚀远程等离子源研发及产业化	**19,390.00**	**2,122.39**	1,223.27	1,398.13	468.65
高压脉冲发生器	**2,662.85**	**394.17**	1,155.28	748.11	-
功分匹配系统开发	**2,898.54**	**409.43**	998.00	364.17	-
低复合率等离子离化腔研发	4,500.00	**110.93**	858.31	695.03	1,481.16
离子能量可控源	**850.00**	**201.28**	519.60	-	-
高稳定性大功率低频电源产品开发	**800.00**	**131.13**	441.38	95.69	-
单频匹配器产品开发	**1,798.00**	**186.08**	356.95	123.50	-
铁氧体等离子发生器研发	1,840.00	**-3.90**	337.07	676.21	700.80
高稳定性中小功率高频电源开发	**2,460.00**	**494.40**	356.31	204.67	-
高稳定性大功率中频电源产品开发	**3,448.76**	**143.62**	287.02	375.02	607.65
半导体射频功率测量设备及校准系统研制	2,400.00	**359.81**	465.90	-	-
主要项目合计	**51,295.08**	**5,252.98**	9,720.60	5,728.54	3,431.46
其他项目	**4,111.46**	**897.22**	1,201.15	65.96	235.36
研发费用合计	**55,406.54**	**6,150.20**	**10,921.75**	**5,794.50**	**3,666.82**

注：截至报告期末，公司共有 **70 个**在研项目，按其工艺路线、研究产品类别进行合并统计如上。

（3）研发费用率与同行业可比公司对比分析

报告期内，同行业可比公司与公司研发费用率情况如下表所示：

公司名称	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
恒运昌	**16.44%**	15.14%	10.22%	11.36%

公司名称	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
英杰电气	**11.67%**	9.49%	7.67%	5.51%
先锋精科	**5.54%**	5.77%	5.64%	6.51%
富创精密	**6.70%**	7.72%	7.28%	9.97%
平均值	**10.08%**	9.53%	7.70%	8.34%
神州半导体	**16.38%**	16.69%	12.98%	14.05%

注：数据来源为年度报告等公开资料。

由上可知，报告期内，公司研发费用率高于可比公司，主要系公司所处高端等离子体电源系统这一细分领域，国产化率较低，研发难度相对较大，且公司增大研发投入、加快研发进程，自研产品收入增速较快，因此相比可比公司而言，公司研发费用率较高。

报告期内，公司通过持续技术创新，实现产品从“无”到“有”再到“多元拓展”的跨越式发展，积极为我国半导体产业提供自主可控的核心零部件产品，为我国半导体制造关键技术自主可控构筑坚实保障；公司成功研发出的适配高深宽比刻蚀工艺的高压脉冲电源系统，已通过国内先进制程芯片产线的工艺验证，更是未来实现 4XX 层级别芯片制程不可或缺的核心配套技术方案之一，为我国半导体先进制程“高深宽比”场景下的三维异构集成等前沿技术突破提供核心底层支撑。此外，公司还完成了 ESC 吸附电源、ESC 加热电源、溅射电源等多项储备产品的研发工作，进一步丰富了公司自研产品矩阵。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息净支出	**-110.49**	-151.13	6.49	20.48
汇兑净损失	**160.03**	78.71	-39.38	17.25
银行手续费	**8.67**	61.09	11.62	15.88
合计	**58.20**	**-11.33**	**-21.26**	**53.60**

报告期内，公司财务费用金额分别为 53.60 万元、-21.26 万元、-11.33 万元和 **58.20** 万元，各期占营业收入的比例小于 1%，主要包括利息收支、汇兑损益、银行手续费等，金额较小。

（五）利润表其他重要项目分析

1、其他收益

报告期各期，公司其他收益具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
政府补助	**856.06**	**68.78%**	1,244.63	52.42%	186.96	40.88%	205.38	98.33%
个税扣缴税款手续费	**36.12**	**2.90%**	24.63	1.04%	8.18	1.79%	3.49	1.67%
进项税加计抵减	**352.42**	**28.32%**	505.18	21.28%	262.17	57.33%	-	-
研发补偿款	**-**	**-**	600.00	25.27%	-	-	-	-
合计	**1,244.60**	**100.00%**	**2,374.44**	**100.00%**	**457.31**	**100.00%**	**208.88**	**100.00%**

报告期内，公司其他收益金额分别为 208.88 万元、457.31 万元、2,374.44 万元和 **1,244.60 万元**，主要由政府补助、研发补偿款构成。

2、投资收益

报告期内，公司投资收益具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
现金折扣	**-**	**-**	-5.91	99.99%	-12.35	100.00%	-	-
票据贴现利息	**-0.00**	**0.03%**	-0.00	0.01%	-	-	-	-
购买少数股东股权	**-**	**-**	-	-	-	-	-76.48	100.00%
债务重组收益	**-6.72**	**99.97%**						
合计	**-6.72**	**100.00%**	**-5.91**	**100.00%**	**-12.35**	**100.00%**	**-76.48**	**100.00%**

报告期内，公司投资收益金额分别为-76.48 万元、-12.35 万元、-5.91 万元和 **-6.72 万元**，2024 年和 2025 年公司投资收益主要系现金折扣和票据贴现利息，2023 年投资收益主要系公司收回子公司江苏芯越少数股权造成的投资损失。**2026 年 1-6 月，公司债务重组收益系公司与客户红太阳针对应收账款进行沟通协商后的回款抵减，计入债务重组收益。**

3、公允价值变动损益

报告期内，公司公允价值变动损益具体情况如下：

单位：万元

产生公允价值变动损益的来源	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
交易性金融资产	**117.91**	**100.00%**	76.22	100.00%	99.36	100.00%	86.19	100.00%
合计	**117.91**	**100.00%**	**76.22**	**100.00%**	**99.36**	**100.00%**	**86.19**	**100.00%**

报告期内，公司交易性金融资产产生的公允价值变动损益金额分别为 86.19 万元、99.36 万元、76.22 万元和 **117.91 万元**，主要为公司购买理财产品的公允价值变动。

4、信用减值损失和资产减值损失

报告期内，公司信用减值损失和资产减值损失具体情况如下：

单位：万元

科目	项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
信用减值损失	应收账款坏账损失	**-277.74**	**31.24%**	-173.85	18.02%	-375.95	95.61%	-145.64	28.30%
	其他应收款坏账损失	**-10.59**	**1.19%**	31.03	-3.22%	-94.08	23.93%	84.35	-16.39%
	应收票据坏账损失	**-**	**-**	0.44	-0.05%	-0.17	0.04%	-0.27	0.05%
资产减值损失	存货跌价损失	**-600.74**	**67.57%**	-822.59	85.25%	74.65	-18.98%	-450.68	87.58%
	合同资产减值损失	**-**	**-**	-	-	2.35	-0.60%	-2.35	0.46%
合计		**-889.07**	**100.00%**	**-964.97**	**100.00%**	**-393.20**	**100.00%**	**-514.60**	**100.00%**

报告期内，公司信用减值损失和资产减值损失合计为-514.60 万元、-393.20 万元、-964.97 万元和**-889.07 万元**，主要系公司计提应收账款坏账损失和存货跌价准备所致。

报告期内，公司按照存货成本与可变现净值孰低的原则评估存货减值风险，计提存货跌价准备，存货跌价计提情况参见本招股说明书“第六节/十一/（二）/6、”。

（六）主要税项

报告期内，公司主要税种的应缴与实缴明细情况如下：

单位：万元

期间	项目	企业所得税	增值税
2023 年度	期初未交数	1,330.17	758.84
	本期应交数	1,125.88	1,209.64
	本期已交数	2,206.69	1,336.37
	期末未交数	249.36	632.11
2024 年度	期初未交数	249.36	632.11
	本期应交数	1,823.23	2,029.13
	本期已交数	1,532.76	1,626.18
	期末未交数	539.83	1,035.06
2025 年度	期初未交数	539.83	1,035.06
	本期应交数	2,370.65	4,041.90
	本期已交数	1,958.10	3,944.48
	期末未交数	952.37	1,132.48
2026 年 1-6 月	期初未交数	**952.37**	**1,132.48**
	本期应交数	**1,499.45**	**1,726.28**
	本期已交数	**1,467.82**	**2,625.60**
	期末未交数	**984.00**	**233.15**

注：公司各期初、期末未交税费金额=该时点应交税费金额-该时点其他流动资产金额。

十一、资产质量分析

（一）资产构成及变动情况分析

报告期各期末，公司的资产结构如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	**117,620.58**	**84.18%**	104,335.88	85.02%	53,752.19	83.07%	31,118.05	81.45%
非流动资产	**22,099.54**	**15.82%**	18,384.98	14.98%	10,957.65	16.93%	7,084.80	18.55%
资产总计	**139,720.11**	**100.00%**	**122,720.86**	**100.00%**	**64,709.84**	**100.00%**	**38,202.85**	**100.00%**

报告期各期末，公司的资产总额分别为 38,202.85 万元、64,709.84 万元、122,720.86 万元和 **139,720.11 万元**，随着公司业务规模的扩大，公司资产总额呈上升趋势。

从资产结构来看，报告期各期末，公司流动资产占资产总额的比例分别为81.45%、83.07%、85.02%和**84.18%**，非流动资产占资产总额的比例分别为18.55%、16.93%、14.98%和 **15.82%**。

（二）流动资产构成及变动分析

报告期各期末，公司流动资产构成如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	**56,457.45**	**48.00%**	59,397.93	56.93%	12,604.98	23.45%	4,709.65	15.13%
交易性金融资产	**5,018.65**	**4.27%**	2,001.89	1.92%	2,618.49	4.87%	5,058.66	16.26%
应收票据	**206.65**	**0.18%**	40.41	0.04%	178.51	0.33%	31.60	0.10%
应收账款	**25,604.39**	**21.77%**	20,009.11	19.18%	16,958.26	31.55%	8,567.47	27.53%
应收款项融资	**161.87**	**0.14%**	76.62	0.07%	157.11	0.29%	186.55	0.60%
预付款项	**2,954.77**	**2.51%**	1,383.09	1.33%	1,344.81	2.50%	861.67	2.77%
其他应收款	**138.90**	**0.12%**	110.95	0.11%	372.66	0.69%	325.30	1.05%
存货	**26,995.18**	**22.95%**	21,265.57	20.38%	19,514.90	36.31%	11,323.20	36.39%
合同资产	**-**	**0.00%**	-	-	-	-	44.72	0.14%
其他流动资产	**82.70**	**0.07%**	50.32	0.05%	2.48	0.00%	9.24	0.03%
流动资产合计	**117,620.58**	**100.00%**	**104,335.88**	**100.00%**	**53,752.19**	**100.00%**	**31,118.05**	**100.00%**

报告期各期末，公司流动资产分别为 31,118.05 万元、53,752.19 万元、104,335.88 万元和 **117,620.58** 万元。公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、存货、应收账款等构成。

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成，具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存现金	**0.03**	**0.00%**	0.03	0.00%	0.01	0.00%	0.30	0.01%
银行存款	**56,257.42**	**99.65%**	59,197.90	99.66%	12,404.97	98.41%	4,459.35	94.69%
其他货币资金	**200.00**	**0.35%**	200.00	0.34%	200.00	1.59%	250.00	5.31%
合计	**56,457.45**	**100.00%**	**59,397.93**	**100.00%**	**12,604.98**	**100.00%**	**4,709.65**	**100.00%**

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 4,709.65 万元、12,604.98 万元、59,397.93 万元和 **56,457.45 万元**。各期末货币资金占流动资产的比例分别为

15.13%、23.45%、56.93%和**48.00%**。其中，其他货币资金系海关保证金。

2、交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产的金额分别为 5,058.66 万元、2,618.49 万元、2,001.89 万元和**5,018.65 万元**，主要为公司在银行购买的理财产品。

3、应收账款

报告期各期末，公司应收账款基本情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
应收账款余额	**26,975.11**	21,102.09	17,877.39	9,110.64
应收账款坏账准备	**1,370.72**	1,092.98	919.13	543.18
应收账款账面价值	**25,604.39**	20,009.11	16,958.26	8,567.47
营业收入	**37,545.34**	65,424.00	44,627.90	26,105.54
应收账款余额占营业收入的比例	**71.85%**	**32.25%**	**40.06%**	**34.90%**

报告期各期末，公司应收账款余额合计分别为 9,110.64 万元、17,877.39 万元、21,102.09 万元和**26,975.11 万元**，主要源于等离子体电源系统的产品销售业务和技术支持服务业务。

报告期各期末，公司应收账款余额占公司营业收入的比例分别为 34.90%、40.06%、32.25%和 **71.85%**，比例处于合理区间，主要系公司在报告期内严格执行客户信用管理制度。

（1）应收账款账龄分析

单位：万元

账龄	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内（含 1 年）	**26,888.13**	**99.68%**	20,820.15	98.66%	17,665.09	98.81%	8,234.21	90.38%
1 年至 2 年（含 2 年）	**42.06**	**0.16%**	236.17	1.12%	185.45	1.04%	876.43	9.62%
2 年至 3 年（含 3 年）	**30.94**	**0.11%**	31.68	0.15%	26.86	0.15%	-	-
3 年至 4 年（含 4 年）	**1.56**	**0.01%**	14.09	0.07%	-	-	-	-
4 至 5 年	**12.43**	**0.05%**	-	-	-	-	-	-

账龄	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
（含 5 年）								
应收账款余额	**26,975.11**	**100.00%**	**21,102.09**	**100.00%**	**17,877.39**	**100.00%**	**9,110.64**	**100.00%**
减：坏账准备	**1,370.72**	**5.08%**	1,092.98	5.18%	919.13	5.14%	543.18	5.96%
账面价值	**25,604.39**	**94.92%**	**20,009.11**	**94.82%**	**16,958.26**	**94.86%**	**8,567.47**	**94.04%**

报告期各期末，公司应收账款一年以内的账龄金额占比分别为 90.38%、98.81%、98.66%和 **99.68%**，整体应收账款管理能力较强。

（2）应收账款坏账准备计提情况

报告期各期，公司应收账款坏账准备计提情况如下：

单位：万元

账龄	2026 年 6 月 30 日			2025 年 12 月 31 日			2024 年 12 月 31 日			2023 年 12 月 31 日		
	应收账款余额	坏账准备	计提比例	应收账款余额	坏账准备	计提比例	应收账款余额	坏账准备	计提比例	应收账款余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	**26,888.13**	**1,344.41**	**5.00%**	20,820.15	1,041.01	5.00%	17,665.09	883.25	5.00%	8,234.21	411.71	5.00%
1 年至 2 年（含 2 年）	**42.06**	**6.31**	**15.00%**	236.17	35.42	15.00%	185.45	27.82	15.00%	876.43	131.47	15.00%
2 年至 3 年（含 3 年）	**30.94**	**9.28**	**30.00%**	31.68	9.50	30.00%	26.86	8.06	30.00%	-	-	-
3 年至 4 年（含 4 年）	**1.56**	**0.78**	**50.00%**	14.09	7.04	50.00%	-	-	-	-	-	-
4 年至 5 年（含 5 年）	**12.43**	**9.94**	**80.00%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	**26,975.11**	**1,370.72**	**5.08%**	**21,102.09**	**1,092.98**	**5.18%**	**17,877.39**	**919.13**	**5.14%**	**9,110.64**	**543.18**	**5.96%**

根据公司会计政策，除对单项金额重大并已单项计提，或单项金额虽不重大但已单项计提坏账准备的应收款项和无风险之外的应收款项，公司根据账龄分析法对坏账准备进行计提。报告期内，公司未出现单项计提坏账准备相关事项。

报告期各期末，公司坏账准备金额分别为 543.18 万元、919.13 万元、1,092.98 万元和 **1,370.72 万元**，计提比例分别为 5.96%、5.14%、5.18%和 **5.08%**。公司应收账款多数为 1 年以内，坏账准备计提充分，能够覆盖未来可能发生的坏账损失。

（3）公司信用管理与应收账款的期后回款情况

报告期内，公司制定应收账款管理制度并有效执行，公司通常根据合作情况、

业务规模、信用情况等因素给予客户一定的信用额度及账期。

报告期内，公司主要客户信用状况和回款情况良好，各年末应收账款期后回款情况良好，具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款账面余额	**26,975.11**	21,102.09	17,877.39	9,110.64
应收账款期后回款	**13,607.76**	**20,471.11**	**17,832.16**	**9,072.42**
期后回款比例	**50.45%**	**97.01%**	**99.75%**	**99.58%**

注：回款统计至 2026 年 8 月 31 日

（4）主要应收账款对象

报告期各期末，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位：万元

客户名称	2026 年 6 月 30 日	
	应收账款及合同资产账面余额	占应收账款和合同资产期末余额比例（%）
中微半导体（上海）有限公司	**7,031.04**	**26.06**
拓荆科技（上海）有限公司	**3,663.83**	**13.58**
中微半导体设备（上海）股份有限公司	**2,464.99**	**9.14**
爱思开海力士半导体存储技术（大连）有限公司	**1,791.37**	**6.64**
拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司	**1,525.49**	**5.66**
合计	**16,476.72**	**61.08**
客户名称	**2025 年 12 月 31 日**	
	应收账款及合同资产账面余额	占应收账款和合同资产期末余额比例（%）
中微半导体（上海）有限公司	5,071.46	24.03
拓荆科技（上海）有限公司	2,375.44	11.26
客户 A_1	2,155.64	10.22
爱思开海力士半导体存储技术（大连）有限公司	1,939.33	9.19
客户 C	1,149.32	5.45
合计	**12,691.18**	**60.15**
客户名称	**2024 年 12 月 31 日**	
	应收账款及合同资产账面余额	占应收账款和合同资产期末余额比例（%）
中微半导体（上海）有限公司	4,197.83	23.48
英特尔半导体存储技术（大连）有限公司	2,214.58	12.39

拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司	1,206.84	6.75
客户 A_1	1,210.12	6.77
南昌中微半导体设备有限公司	1,025.41	5.74
合计	**9,854.78**	**55.13**
客户名称	**2023 年 12 月 31 日**	
	应收账款及合同资产账面余额	**占应收账款和合同资产期末余额比例（%）**
英特尔半导体存储技术（大连）有限公司	932.05	10.23
客户 A_2	899.14	9.87
中微半导体（上海）有限公司	518.76	5.69
客户 C	458.97	5.04
客户 D	439.53	4.82
合计	**3,248.44**	**35.65**

报告期各期末，公司应收账款前五大客户余额分别为 3,248.44 万元、9,854.78 万元、12,691.18 万元和 **16,476.72 万元**，分别占当期末应收账款余额的 35.65%、55.13%、60.15%和 **61.08%**，公司 2024 年末、2025 年末和 **2026 年 6 月末**的应收账款前五大客户相对集中。

（5）坏账准备计提比例与同行业可比上市公司对比情况

报告期内，公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比上市公司对比如下：

公司名称	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
恒运昌	**5.29%**	5.27%	5.41%	5.09%
英杰电气	**10.98%**	10.92%	10.14%	8.89%
先锋精科	**5.46%**	5.35%	5.39%	5.25%
富创精密	**1.91%**	1.86%	2.73%	4.18%
平均值	**5.91%**	5.85%	5.92%	5.85%
神州半导体	**5.08%**	5.18%	5.14%	5.96%

注：数据来源为年度报告等公开资料。

公司应收账款坏账准备计提比例和可比公司相比不存在重大差异，公司下游客户具备良好的信用状况和回款能力，坏账风险处在较低水平。

4、预付款项

报告期各期末，公司的预付款项余额分别为 861.67 万元、1,344.81 万元、1,383.09 万元和 **2,954.77 万元**，占各期末流动资产的比例分别为 2.77%、2.50%、1.33%和 **2.51%**，预付款项主要系预付原材料采购款。

报告期各期末，公司预付款项前五大供应商较为集中，分别占各期末预付款项余额的 46.79%、79.18%、60.72%和 **77.67%**。

5、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 325.30 万元、372.66 万元、110.95 万元和 **138.90 万元**，占各期末流动资产的比例分别为 1.05%、0.69%、0.11%和 **0.12%**，金额及占比较小，具体情况如下：

单位：万元

款项性质	账面余额			
	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
保证金及押金	**179.61**	143.32	134.39	47.24
备用金及代垫款	**5.69**	1.77	7.62	16.36
无法收回的预付款	**51.76**	53.42	54.63	-
往来款	**-**	-	294.62	286.23
余额合计	**237.06**	**198.51**	**491.26**	**349.82**
坏账准备	**98.16**	87.57	118.60	24.52
账面价值合计	**138.90**	**110.95**	**372.66**	**325.30**

6、存货

（1）存货构成及变动情况分析

报告期各期末，公司存货的账面价值分别为 11,323.20 万元、19,514.90 万元、21,265.57 万元和 **26,995.18 万元**，占流动资产的比例分别为 36.39%、36.31%、20.38%和 **22.95%**。公司存货结构及变动情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
原材料	**18,297.26**	**67.78%**	14,672.04	68.99%	11,924.04	61.10%	8,130.37	71.80%
在产品	**2,299.74**	**8.52%**	1,233.59	5.80%	924.32	4.74%	951.97	8.41%
库存商品	**4,119.60**	**15.26%**	3,164.51	14.88%	1,950.40	9.99%	717.54	6.34%
合同履约成本	**315.95**	**1.17%**	268.62	1.26%	347.97	1.78%	334.56	2.95%
发出商品	**1,275.90**	**4.73%**	1,865.87	8.77%	4,194.51	21.49%	1,000.95	8.84%
委托加工物资	**686.74**	**2.54%**	60.93	0.29%	173.65	0.89%	187.82	1.66%
合计	**26,995.18**	**100.00%**	**21,265.57**	**100.00%**	**19,514.90**	**100.00%**	**11,323.20**	**100.00%**

①原材料

报告期各期末，公司原材料账面价值分别为 8,130.37 万元、11,924.04 万元、14,672.04 万元和 **18,297.26 万元**，主要包含电源系统备机、电容、腔体等。

②在产品

报告期各期末，公司在产品账面价值合计分别为 951.97 万元、924.32 万元、1,233.59 万元和 **2,299.74 万元**，账面价值占比分别为 8.41%、4.74%、5.80%和 **8.52%**，公司各期末在产品规模和变动均较小。

③库存商品

报告期各期末，公司库存商品账面价值分别为 717.54 万元、1,950.40 万元、3,164.51 万元和 **4,119.60 万元**，主要系生产完毕的电源系统产品。

（2）存货跌价准备计提情况及同行业可比上市公司对比情况

①存货跌价准备计提情况

报告期各期末，公司存货减值准备情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日			2025 年 12 月 31 日			2024 年 12 月 31 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	**20,583.01**	**2,285.76**	**18,297.26**	16,453.47	1,781.43	14,672.04	12,992.00	1,067.97	11,924.04	9,371.50	1,241.13	8,130.37
在产品	**2,299.74**	**-**	**2,299.74**	1,233.59	-	1,233.59	924.32	-	924.32	951.97	-	951.97
库存商品	**4,246.57**	**126.98**	**4,119.60**	3,269.10	104.59	3,164.51	2,035.07	84.67	1,950.40	749.46	31.92	717.54
合同履约成本	**315.95**	**-**	**315.95**	268.62	-	268.62	347.97	-	347.97	334.56	-	334.56
发出商品	**1,349.92**	**74.02**	**1,275.90**	1,955.08	89.21	1,865.87	4,240.28	45.77	4,194.51	1,023.07	22.12	1,000.95
委托加工物资	**686.74**	**-**	**686.74**	60.93	-	60.93	173.65	-	173.65	187.82	-	187.82
合计	**29,481.94**	**2,486.76**	**26,995.18**	**23,240.79**	**1,975.23**	**21,265.57**	**20,713.30**	**1,198.40**	**19,514.90**	**12,618.37**	**1,295.17**	**11,323.20**

公司按照存货成本与可变现净值孰低的方式进行存货跌价准备的计提。报告期各期末，公司存货跌价准备分别为 1,295.17 万元、1,198.40 万元、1,975.23 万元和 **2,486.76 万元**，主要系针对原材料计提的存货跌价准备。

②存货跌价准备计提比例与同行业可比上市公司对比情况

报告期各期末，公司与可比公司存货跌价准备比例对比如下：

公司名称	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
恒运昌	**15.09%**	13.89%	8.51%	2.32%
英杰电气	**5.70%**	5.20%	3.13%	0.17%
先锋精科	**8.15%**	8.85%	8.27%	10.58%
富创精密	**14.20%**	12.83%	9.41%	4.77%
平均值	**10.79%**	10.19%	7.33%	4.46%
神州半导体	**8.43%**	8.50%	5.79%	10.26%

注：数据来源为年度报告等公开资料。

公司主要根据存货的可变现净值，计提存货跌价准备，与可比公司计提比例处于合理区间。

7、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产余额分别为 9.24 万元、2.48 万元、50.32 万元和 **82.70 万元**。主要系待抵扣进项税和预缴所得税。

（三）非流动资产构成及变动分析

报告期各期末，公司非流动资产金额分别为 7,084.80 万元、10,957.65 万元、18,384.98 万元和 **22,099.54 万元**，具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
固定资产	**5,759.75**	**26.06%**	5,797.31	31.53%	5,986.28	54.63%	4,346.83	61.35%
在建工程	**10,664.12**	**48.25%**	8,326.40	45.29%	505.79	4.62%	-	-
使用权资产	**692.97**	**3.14%**	325.29	1.77%	544.59	4.97%	510.38	7.20%
无形资产	**2,154.22**	**9.75%**	2,219.40	12.07%	2,362.31	21.56%	595.99	8.41%
长期待摊费用	**170.90**	**0.77%**	303.33	1.65%	561.93	5.13%	495.28	6.99%
递延所得税资产	**1,807.11**	**8.18%**	1,413.25	7.69%	988.14	9.02%	928.95	13.11%
其他非流动资产	**350.47**	**1.59%**	-	-	8.61	0.08%	207.37	2.93%
其他权益工具投资	**500.00**	**2.26%**	-	-	-	-	-	-
非流动资产合计	**22,099.54**	**100.00%**	**18,384.98**	**100.00%**	**10,957.65**	**100.00%**	**7,084.80**	**100.00%**

报告期各期末，公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产和递延所得税资产等构成。

1、固定资产

（1）固定资产构成情况分析

报告期各期末，公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
2026 年 6 月 30 日						
账面原值	**1,842.77**	**2,679.87**	**1,939.90**	**4,302.67**	**960.36**	**11,725.58**
累计折旧	**635.13**	**870.92**	**1,378.72**	**2,361.64**	**719.41**	**5,965.83**
账面价值	**1,207.64**	**1,808.95**	**561.18**	**1,941.03**	**240.95**	**5,759.75**
2025 年 12 月 31 日						
账面原值	1,842.77	2,539.02	1,796.27	3,735.64	960.01	10,873.70
累计折旧	591.37	684.20	1,220.92	1,931.94	647.96	5,076.39
账面价值	**1,251.40**	**1,854.81**	**575.35**	**1,803.69**	**312.05**	**5,797.31**
2024 年 12 月 31 日						
账面原值	1,842.77	2,274.25	1,742.58	2,690.09	940.62	9,490.31
累计折旧	503.84	342.88	874.51	1,283.00	499.80	3,504.03
账面价值	**1,338.94**	**1,931.37**	**868.07**	**1,407.08**	**440.82**	**5,986.28**
2023 年 12 月 31 日						
账面原值	1,842.77	1,015.16	1,406.92	1,620.13	768.34	6,653.33
累计折旧	416.31	147.40	530.33	850.23	362.23	2,306.50
账面价值	**1,426.47**	**867.76**	**876.59**	**769.91**	**406.10**	**4,346.83**

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 4,346.83 万元、5,986.28 万元、5,797.31 万元和 **5,759.75 万元**，占非流动资产的比例分别为 61.35%、54.63%、31.53%和 **26.06%**，主要由房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备构成，报告期各期末占固定资产账面价值合计比例分别为 90.66%、92.64%、94.62%和 **95.82%**，资产结构整体较为稳定。

报告期各期末，公司房屋及建筑物账面价值分别系 1,426.47 万元、1,338.94 万元、1,251.40 万元和 **1,207.64 万元**，系公司位于扬州市的厂房及办公楼。

报告期各期末，公司机器设备账面价值分别系 867.76 万元、1,931.37 万元、1,854.81 万元和 **1,808.95 万元**，2024 年显著上升，2025 年略有下降；公司电子设备账面价值分别系 769.91 万元、1,407.08 万元、1,803.69 万元和 **1,941.03 万元**，整体呈上升趋势，主要系公司经营规模有所增长，所需生产、研发的机器设

备、电子设备增加所致。

报告期各期末，公司运输工具账面价值分别系 876.59 万元、868.07 万元、575.35 万元和 **561.18 万元**，整体呈下降趋势，主要系公司 2025 年新增购置运输工具金额仅系 61.57 万元，金额较小，且公司运输工具按 4 年期折旧，当年折旧金额高于新增购置金额所致。

（2）固定资产的折旧年限与同行业可比上市公司对比情况

固定资产的折旧年限以及同行业可比上市公司对比情况如下表所示：

公司名称	项目	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
恒运昌	房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
	机器设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67
	运输工具	年限平均法	3-4	5.00	23.75-31.67
	电子设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
英杰电气	房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5.00	2.375-9.50
	机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
	运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
	电子设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
先锋精科	房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
	机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
	运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75
	电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
	其他设备及构筑物	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
富创精密	房屋及建筑物	年限平均法	5-20	5.00	4.75-19.00
	机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
	运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75
	电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
	其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00
神州半导体	房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
	机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
	运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75
	电子设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
	办公设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

公司根据企业会计准则、行业生产特点选择适用的固定资产折旧政策及折旧年限，报告期内公司固定资产折旧年限与同行业可比公司相比整体不存在重大差

异。

（3）固定资产减值准备计提情况

报告期内，公司固定资产运行维护状况、使用功能良好，不存在由于损坏等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提减值准备。

2、在建工程

（1）在建工程构成及变动情况

报告期各期末，公司在建工程期末余额具体如下表所示：

单位：万元

项目	类别	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
半导体专用设备制造和维修项目（一期）	总包支出	**8,945.83**	**83.89%**	7,323.41	87.95%	-	-	-	-
	其他支出	**1,718.30**	**16.11%**	1,002.99	12.05%	505.79	100.00%	-	-
合计		**10,664.12**	**100.00%**	**8,326.40**	**100.00%**	**505.79**	**100.00%**	**-**	**-**

（2）重要在建工程转固情况

报告期内，公司在建工程未发生转固情况。

（3）在建工程减值情况

报告期各期末，公司在建工程状况良好，不存在减值迹象，故未计提减值准备。

3、使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产分别为 510.38 万元、544.59 万元、325.29 万元和 **692.97 万元**，占非流动资产比例分别为 7.20%、4.97%、1.77%和 **3.14%**，金额及占比较小，主要为公司租赁的办公场地及设备等。

4、无形资产

报告期各期末，公司无形资产的情况如下：

单位：万元

各期末	项目	账面原值	累计摊销	账面价值
2026 年 6 月 30 日	土地使用权	**2,245.79**	**165.67**	**2,080.12**
	软件	**354.68**	**280.59**	**74.10**
	合计	**2,600.48**	**446.26**	**2,154.22**
2025 年 12 月 31 日	土地使用权	2,245.79	132.79	2,113.00
	软件	332.57	226.17	106.40
	合计	**2,578.36**	**358.97**	**2,219.40**
2024 年 12 月 31 日	土地使用权	2,237.85	85.92	2,151.93
	软件	330.69	120.31	210.38
	合计	**2,568.54**	**206.23**	**2,362.31**
2023 年 12 月 31 日	土地使用权	380.00	57.72	322.28
	软件	295.75	22.04	273.71
	合计	**675.75**	**79.76**	**595.99**

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 595.99 万元、2,362.31 万元、2,219.40 万元和 **2,154.22 万元**，占非流动资产的比例分别为 8.41%、21.56%、12.07%和 **9.75%**，系土地使用权和软件。

报告期内，公司无形资产状况良好，不存在账面价值低于可回收金额的情况，故未计提减值准备。

5、长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用余额分别为 495.28 万元、561.93 万元、303.33 万元和 **170.90 万元**，占非流动资产比例分别为 6.99%、5.13%、1.65%和 **0.77%**，主要为装修费。

6、其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产余额分别为 207.37 万元、8.61 万元、0 万元和 **350.47 万元**，占非流动资产比例分别为 2.93%、0.08%、0%和 **1.59%**。公司各期末其他非流动资产主要系预付工程设备款，金额及占比均较小。

7、其他权益工具投资

公司于 2026 年 1-6 月新增一项其他权益工具投资，系公司参股辽宁聚芯智能装备创新中心有限公司，投资 500.00 万元。

十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

（一）负债构成及变动分析

报告期内，公司负债结构及变动情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	**15,909.71**	**89.25%**	12,079.49	89.42%	8,454.28	82.07%	6,990.28	77.36%
非流动负债	**1,916.37**	**10.75%**	1,429.14	10.58%	1,846.66	17.93%	2,045.87	22.64%
负债合计	**17,826.08**	**100.00%**	**13,508.63**	**100.00%**	**10,300.94**	**100.00%**	**9,036.15**	**100.00%**

报告期各期末，公司负债总额分别为 9,036.15 万元、10,300.94 万元、13,508.63 万元和 **17,826.08 万元**，各期负债主要为流动负债，负债结构整体较为稳定。

（二）流动负债构成及变动分析

报告期各期末，公司流动负债构成如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付账款	**9,851.95**	**61.92%**	4,862.49	40.25%	3,364.19	39.79%	2,333.26	33.38%
合同负债	**636.47**	**4.00%**	566.01	4.69%	768.67	9.09%	314.58	4.50%
应付职工薪酬	**3,013.11**	**18.94%**	2,922.76	24.20%	918.75	10.87%	1,972.36	28.22%
应交税费	**1,356.96**	**8.53%**	2,737.11	22.66%	1,949.28	23.06%	1,017.77	14.56%
其他应付款	**6.88**	**0.04%**	7.06	0.06%	24.42	0.29%	24.46	0.35%
一年内到期的非流动负债	**1,039.21**	**6.53%**	975.84	8.08%	1,341.01	15.86%	1,299.90	18.60%
其他流动负债	**5.13**	**0.03%**	8.22	0.07%	87.96	1.04%	27.95	0.40%
流动负债合计	**15,909.71**	**100.00%**	**12,079.49**	**100.00%**	**8,454.28**	**100.00%**	**6,990.28**	**100.00%**

报告期各期末，公司流动负债金额分别为 6,990.28 万元、8,454.28 万元、12,079.49 万元和 **15,909.71 万元**，主要由应付账款、应付职工薪酬和应交税费组成。

1、应付账款

报告期各期末，公司应付账款构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付材料款	**7,875.93**	**79.94%**	2,476.26	50.93%	3,025.54	89.93%	2,144.17	91.90%
应付工程及设备款	**1,848.41**	**18.76%**	2,235.34	45.97%	215.15	6.40%	140.99	6.04%
应付经营费用及其他	**127.60**	**1.30%**	150.89	3.10%	123.51	3.67%	48.09	2.06%
合计	**9,851.95**	**100.00%**	**4,862.49**	**100.00%**	**3,364.19**	**100.00%**	**2,333.26**	**100.00%**

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 2,333.26 万元、3,364.19 万元、4,862.49 万元和 **9,851.95 万元**，占流动负债的比例分别为 33.38%、39.79%、40.25%和 **61.92%**，主要为应付原材料采购款。报告期内，应付账款余额整体呈上升趋势，2024 年末应付账款余额增长主要系公司自研产品业务实现商业化，相关原材料采购金额增加所致；2025 年末应付账款余额增长主要系公司在建工程项目支出增加所致。

报告期内，公司现金流较为健康，与主要供应商结算货款及时，不存在大额逾期未支付供应商款项的情况。

2、合同负债

报告期各期末，公司合同负债的账面价值分别为 314.58 万元、768.67 万元、566.01 万元和 **636.47 万元**，占流动负债的比例分别为 4.50%、9.09%、4.69%和 **4.00%**。公司合同负债主要为根据销售合同约定收取的预收款项，各期末合同负债金额基本维持稳定。

3、应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
短期薪酬	**3,001.43**	2,912.22	913.18	1,970.20
离职后福利-设定提存计划	**11.67**	10.54	5.57	2.16
合计	**3,013.11**	**2,922.76**	**918.75**	**1,972.36**

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 1,972.36 万元、918.75 万元、2,922.76 万元和 **3,013.11 万元**，占流动负债的比例分别为 28.22%、10.87%、24.20%

和 **18.94%**，主要为公司计提的工资、奖金、津贴和补贴等短期薪酬。2024 年末应付职工薪酬余额相对较低，主要系公司 2024 年的年终奖金于当年发放，2023 年和 2025 年的部分年终奖金于次年发放所致。

4、应交税费

报告期各期末，公司应交税费余额分别为 1,017.77 万元、1,949.28 万元、2,737.11 万元和 **1,356.96 万元**，占流动负债的比例分别为 14.56%、23.06%、22.66%和 **8.53%**，主要系公司应交增值税和应交企业所得税。

5、其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 24.46 万元、24.42 万元、7.06 万元和 **6.88 万元**，主要系押金、保证金等。

6、一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债具体情况如下所示：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一年内到期的租赁负债	**261.55**	162.55	511.55	452.83
一年内到期的预计负债	**777.66**	813.29	829.45	847.07
合计	**1,039.21**	**975.84**	**1,341.01**	**1,299.90**

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额分别为 1,299.90 万元、1,341.01 万元、975.84 万元和 **1,039.21 万元**，金额整体较为稳定。

公司一年内到期的非流动负债主要由预计负债构成，公司预计负债系计提的售后服务费，属于保证类质量保证，公司按照收入金额的一定比例计提，根据公司质保期情况，均在一年以内到期。

（三）非流动负债构成及变动分析

报告期各期末，公司非流动负债构成如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
租赁负债	**424.04**	**22.13%**	131.37	9.19%	276.66	14.98%	505.87	24.73%

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
递延收益	**1,492.33**	**77.87%**	1,297.77	90.81%	1,570.00	85.02%	1,540.00	75.27%
非流动负债	**1,916.37**	**100.00%**	**1,429.14**	**100.00%**	**1,846.66**	**100.00%**	**2,045.87**	**100.00%**

报告期各期末，公司非流动负债金额分别为 2,045.87 万元、1,846.66 万元、1,429.14 万元和 **1,916.37 万元**。公司非流动负债系租赁负债和递延收益。

1、租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债余额分别为 505.87 万元、276.66 万元、131.37 万元和 **424.04 万元**，占非流动负债比例为 24.73%、14.98%、9.19%和 **22.13%**，主要系公司租赁研发办公楼、上海子公司办公场地和设备的租赁负债。

2、递延收益

报告期各期末，公司递延收益余额分别为 1,540.00 万元、1,570.00 万元、1,297.77 万元和 **1,492.33 万元**，该等款项均为政府补助。公司按照《企业会计准则》的要求对相关政府补助进行确认，不存在将不应计入当期损益的政府补助计入当期损益的情况。

（四）偿债能力、流动性分析及持续经营能力的分析

1、偿债能力及流动性风险分析

报告期内，公司偿债能力的财务指标如下：

项目	2026 年 1-6 月/2026 年 6 月 30 日	2025 年度/2025 年 12 月 31 日	2024 年度/2024 年 12 月 31 日	2023 年度/2023 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	**7.39**	8.64	6.36	4.45
速动比率（倍）	**5.70**	6.88	4.05	2.83
资产负债率（母公司）	**12.38%**	10.93%	14.81%	22.00%
资产负债率（合并）	**12.76%**	11.01%	15.92%	23.65%

报告期各期末，公司流动比率分别为 4.45、6.36、8.64 和 **7.39**，速动比率分别为 2.83、4.05、6.88 和 **5.70**，短期偿债能力较强。

报告期各期末，公司母公司资产负债率分别为 22.00%、14.81%、10.93%和 **12.38%**，合并口径资产负债率分别为 23.65%、15.92%、11.01%和 **12.76%**，总体

水平较低，长期偿债能力良好。

2、与同行业可比上市公司偿债能力比较分析

报告期各期末，公司与同行业可比上市公司的偿债指标对比情况如下：

公司名称	项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
恒运昌	流动比率（倍）	**20.06**	8.77	6.21	8.12
	速动比率（倍）	**18.63**	7.12	4.80	7.03
	资产负债率（合并）	**5.38%**	11.19%	16.84%	14.53%
英杰电气	流动比率（倍）	**2.63**	2.70	2.35	2.08
	速动比率（倍）	**1.74**	1.73	1.32	1.01
	资产负债率（合并）	**35.05%**	34.14%	38.83%	44.93%
先锋精科	流动比率（倍）	**2.41**	3.40	3.27	2.48
	速动比率（倍）	**1.71**	2.71	2.70	1.88
	资产负债率（合并）	**31.48%**	24.57%	25.04%	30.54%
富创精密	流动比率（倍）	**1.80**	1.71	2.17	3.43
	速动比率（倍）	**1.32**	1.22	1.65	2.67
	资产负债率（合并）	**50.81%**	48.59%	43.77%	37.29%
平均值	流动比率（倍）	**6.72**	4.15	3.50	4.03
	速动比率（倍）	**5.85**	3.20	2.62	3.15
	资产负债率（合并）	**30.68%**	29.62%	31.12%	31.82%
神州半导体	流动比率（倍）	**7.39**	8.64	6.36	4.45
	速动比率（倍）	**5.70**	6.88	4.05	2.83
	资产负债率（合并）	**12.76%**	11.01%	15.92%	23.65%

如上表所示，报告期内公司流动比率、速动比率高于英杰电气、先锋精科、富创精密，略低于恒运昌；公司资产负债率与恒运昌相近，低于其他可比公司。

3、营运能力分析

报告期各期，公司资产周转能力指标具体情况如下表所示：

项目	2026 年 1-6 月/2026 年 6 月 30 日	2025 年度/2025 年 12 月 31 日	2024 年度/2024 年 12 月 31 日	2023 年度/2023 年 12 月 31 日
应收账款周转率（次/年）	**3.12**	3.36	3.31	3.05
存货周转率（次/年）	**1.07**	1.02	0.91	1.11

注：2026 年 1-6 月应收账款周转率、存货周转率已年化。

由上表可知，报告期内公司应收账款周转率、存货周转率整体保持稳定，公

司营运能力持续向好。

4、与同行业可比上市公司营运能力比较分析

报告期内，公司与同行业可比上市公司营运指标的对比情况如下表所示：

公司名称	项目	2026 年 1-6 月/2026 年 6 月 30 日	2025 年度/2025 年 12 月 31 日	2024 年度/2024 年 12 月 31 日	2023 年度/2023 年 12 月 31 日
恒运昌	应收账款周转率（次/年）	**4.80**	5.63	7.01	7.07
	存货周转率（次/年）	**1.57**	1.59	2.17	2.58
英杰电气	应收账款周转率（次/年）	**3.45**	3.52	4.64	7.35
	存货周转率（次/年）	**0.67**	0.66	0.64	0.66
先锋精科	应收账款周转率（次/年）	**2.38**	2.89	3.51	2.86
	存货周转率（次/年）	**2.45**	2.81	3.08	2.01
富创精密	应收账款周转率（次/年）	**3.06**	2.72	2.98	3.00
	存货周转率（次/年）	**2.68**	2.51	2.32	2.04
平均值	应收账款周转率（次/年）	**3.42**	3.69	4.54	5.07
	存货周转率（次/年）	**1.85**	1.89	2.05	1.82
神州半导体	应收账款周转率（次/年）	**3.12**	3.36	3.31	3.05
	存货周转率（次/年）	**1.07**	1.02	0.91	1.11

注：2026 年 1-6 月应收账款周转率、存货周转率已年化。

报告期内，公司应收账款周转率分别为 3.05 次/年、3.31 次/年、3.36 次/年和 **3.12 次/年**。报告期内，公司加强客户信用期管理，应收账款周转率较为稳定，与可比公司处于同一区间。

报告期内，公司存货周转率分别为 1.11 次/年、0.91 次/年、1.02 次/年和 **1.07 次/年**。报告期内，存货周转率整体保持稳定，高于英杰电气，低于其他可比公司，一方面系公司具有技术支持服务业务，需要储备电源系统备机；另一方面，公司自研产品业务发展较快，需要建立一定的安全库存。

（五）股利分配情况

报告期内，公司未进行股利分配。

十三、现金流量分析

报告期各期，公司的现金流量基本情况如下所示：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动现金流入小计	**36,821.70**	71,683.50	41,848.49	29,269.54
经营活动现金流出小计	**32,161.12**	48,756.84	40,129.63	27,223.91
经营活动产生的现金流量净额	**4,660.59**	**22,926.66**	**1,718.86**	**2,045.63**
投资活动现金流入小计	**36,094.43**	22,690.61	13,549.45	21,168.64
投资活动现金流出小计	**43,419.46**	30,162.55	16,873.27	28,185.60
投资活动产生的现金流量净额	**-7,325.03**	**-7,471.95**	**-3,323.82**	**-7,016.96**
筹资活动现金流入小计	**-**	32,000.00	11,000.00	-
筹资活动现金流出小计	**144.66**	622.47	1,484.83	705.84
筹资活动产生的现金流量净额	**-144.66**	**31,377.53**	**9,515.17**	**-705.84**
汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-131.38**	-39.29	35.11	18.04
现金及现金等价物净增加额	**-2,940.48**	**46,792.95**	**7,945.33**	**-5,659.13**

（一）经营活动产生的现金流量情况

1、经营活动现金流的分析

报告期内，公司经营活动的现金流量情况如下表所示：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	**35,549.44**	69,831.53	41,479.52	27,583.98
收到的税费返还	**22.28**	60.33	50.87	49.84
收到其他与经营活动有关的现金	**1,249.98**	1,791.64	318.10	1,635.71
经营活动现金流入小计	**36,821.70**	**71,683.50**	**41,848.49**	**29,269.54**
购买商品、接受劳务支付的现金	**15,975.73**	22,657.65	20,624.55	14,231.67
支付给职工以及为职工支付的现金	**8,332.77**	14,152.72	11,853.96	6,167.36
支付的各项税费	**4,469.66**	6,457.49	3,421.86	3,756.61
支付其他与经营活动有关的现金	**3,382.95**	5,488.98	4,229.26	3,068.27
经营活动现金流出小计	**32,161.12**	**48,756.84**	**40,129.63**	**27,223.91**
经营活动产生的现金流量净额	**4,660.59**	**22,926.66**	**1,718.86**	**2,045.63**

报告期内，公司经营活动现金流入分别为 29,269.54 万元、41,848.49 万元、71,683.50 万元和 **36,821.70 万元**，随着公司日常的生产经营和销售能力的提升，经营活动现金流入逐年增加。

报告期内，公司经营活动现金流出分别为 27,223.91 万元、40,129.63 万元、48,756.84 万元和 **32,161.12 万元**，主要系公司在报告期内自研产品产业化放量销售，购买的各类原材料金额增加，员工人数规模及薪酬增加。

2、经营活动现金流与收入的匹配情况

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的匹配关系如下表所示：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	**35,549.44**	69,831.53	41,479.52	27,583.98
营业收入	**37,545.34**	65,424.00	44,627.90	26,105.54
销售收现比率	**94.68%**	106.74%	92.95%	105.66%

注：销售收现比率=销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入。

报告期内，受益于公司有效的信用政策管理和客户较好的信用水平及偿债能力，公司销售商品及提供劳务回款情况良好，经营活动现金流入与营业收入规模总体基本匹配。

3、经营活动现金流量净额与净利润的分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与当期净利润之间存在一定差异，主要系受固定资产折旧、存货、股份支付、经营性应收应付项目的增减变化所致。具体调整的项目如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
净利润	**11,717.95**	20,935.66	13,575.51	-2,231.88
加：资产减值准备	**600.74**	822.59	-77.00	453.04
信用减值准备	**288.33**	142.38	470.20	61.56
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	**889.44**	1,604.32	1,224.63	779.99
使用权资产折旧	**179.47**	329.80	259.15	200.16
无形资产摊销	**87.29**	152.74	126.47	22.01
长期待摊费用摊销	**132.43**	265.85	207.75	21.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	**-**	3.72	-7.09	32.48
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	**-**	-	-	-

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	**-117.91**	-76.22	-99.36	-86.19
财务费用（收益以“－”号填列）	**141.11**	60.01	17.89	41.01
投资损失（收益以“－”号填列）	**6.72**	5.91	12.35	76.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	**-393.86**	-425.10	-59.19	-348.67
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	**-**	-	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	**-6,330.35**	-2,573.26	-8,117.05	-7,372.59
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	**-7,767.13**	-2,788.12	-9,467.48	62.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	**4,262.51**	2,598.73	1,985.39	670.90
其他	**963.86**	1,867.67	1,666.69	9,663.41
经营活动产生的现金流量净额	**4,660.59**	22,926.66	1,718.86	2,045.63

（二）投资活动产生的现金流量情况

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收回投资收到的现金	**36,000.00**	22,500.00	13,500.00	21,100.00
取得投资收益收到的现金	**94.43**	186.92	39.53	30.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	**-**	3.69	9.93	38.00
投资活动现金流入小计	**36,094.43**	**22,690.61**	**13,549.45**	**21,168.64**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	**3,919.46**	8,162.55	5,873.27	2,635.60
投资支付的现金	**39,500.00**	22,000.00	11,000.00	25,550.00
投资活动现金流出小计	**43,419.46**	**30,162.55**	**16,873.27**	**28,185.60**
投资活动产生的现金流量净额	**-7,325.03**	**-7,471.95**	**-3,323.82**	**-7,016.96**

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-7,016.96 万元、-3,323.82 万元、-7,471.95 万元和**-7,325.03 万元**，其中投资活动流入和流出的现金主要系公司交易性金融资产的赎回和购入所致。

（三）筹资活动产生的现金流量情况

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资收到的现金	**-**	32,000.00	10,000.00	-
取得借款收到的现金	**-**	-	1,000.00	-

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
筹资活动现金流入小计	**-**	**32,000.00**	**11,000.00**	**-**
偿还债务支付的现金	-	-	1,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	7.94	405.00
支付其他与筹资活动有关的现金	**144.66**	622.47	476.89	300.84
筹资活动现金流出小计	**144.66**	**622.47**	**1,484.83**	**705.84**
筹资活动产生的现金流量净额	**-144.66**	**31,377.53**	**9,515.17**	**-705.84**

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-705.84 万元、9,515.17 万元、31,377.53 万元和**-144.66 万元**，主要为吸收投资收到的现金导致筹资活动产生的现金流量净流入。

十四、持续经营能力分析

（一）业务及产品定位

公司是国内领先的半导体设备核心零部件供应商，主要从事等离子体射频电源系统的研发、生产、销售和维修，围绕等离子体工艺提供核心零部件整体解决方案，实现国产化替代、保障下游芯片产线安全生产。

（二）经营策略及未来计划

未来，公司将抓住半导体产业链国产化和自主可控的机遇，向更先进的制程、更高端的技术发展迈进，从国内领先发展为“国际领先”。具体参见本招股说明书“第七节”。

（三）盈利能力

报告期各期收入分别为 26,105.54 万元、44,627.90 万元、65,424.00 万元和**37,545.34 万元**，2023-2025 年营业收入复合增速为 58.31%，实现高速增长。报告期内，公司归属于母公司股东的净利润分别为-2,157.60 万元、13,575.51 万元、20,935.66 万元和 **11,717.95 万元**，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 5,639.27 万元、13,359.95 万元、19,827.12 万元和 **10,941.86 万元**，盈利能力持续提升，2023-2025 年复合增长率为 87.51%。公司销售规模呈上升趋势，盈利能力良好，整体竞争能力较强，处于快速发展阶段。

本次募集资金到位后，长期来看，随着公司产能升级和配套能力的加强，公

司产品和技术优势将充分得到发挥，核心竞争力和抗风险能力均将进一步加强，整体盈利能力预计将进一步提高。

基于上述分析，公司的持续经营能力不存在重大不利变化，公司管理层认为公司未来的核心竞争力和盈利能力具有充分保障。

十五、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项

（一）报告期内公司的资本性支出情况

报告期内，公司重大资本性支出主要用于购买固定资产、无形资产和其他长期资产等；报告期各期，公司购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金分别为 2,635.60 万元、5,873.27 万元、8,162.55 万元和 **3,919.46 万元**。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划

截至本招股说明书签署日，除募集资金投资项目及为特定战略客户进行产能建设所涉及的资本性支出外，公司未有其他可预见的重大资本性支出计划。

关于本次发行募集资金投资项目，请参见本招股说明书“第七节”；关于为特定战略客户进行产能建设及未来产品销售情况，请参见本招股说明书之“第二节/十”。

十六、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项等

（一）资产负债表日后事项

截至本招股说明书签署日，公司暂无重大期后事项，详见本招股说明书之“第二节/十”。

（二）或有事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在应披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在应披露的其他重要事项。

十七、盈利预测

公司未编制盈利预测报告。

第七节 募集资金运用与未来发展规划

一、本公司募集资金运用情况

（一）募集资金计划及项目投资概况

公司募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关项目，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	实施主体	投资项目备案号	环评批复
1	先进工艺节点集成电路领域电源类零部件研发及产业化项目	104,896.82	85,069.82	发行人	扬维开行审备[2026]22号	不适用
2	技术支持服务体系升级扩容项目	27,061.27	27,061.27	发行人	扬维开行审备[2026]11号	不适用
3	上海产业化基地建设项目	53,451.90	53,451.90	全资子公司	上海市企业投资项目备案证明（项目代码：2602-310115-04-02-846744）	不适用
4	技术研发创新中心建设项目	55,643.34	55,643.34	全资子公司	上海市企业投资项目备案证明（项目代码：2602-310115-04-02-954388）	不适用
5	补充流动资金	31,000.00	31,000.00	发行人	不适用	不适用
合计		**272,053.33**	**252,226.33**	-		

注：对照生态环境部《建设项目环境影响评级分类管理名录》（2021 年版），公司募投项目无需纳入建设项目环境影响评价管理，无须开具环评批复

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额等内容进行适当调整。

如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分将由公司以银行贷款或其他途径解决。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

（二）募集资金重点投向科创领域的具体安排

公司本次募集资金投资项目是基于现有业务发展阶段和技术研发创新要求对现有业务进行的扩充和延伸，是公司进一步提高技术研发实力的必然步骤，也是公司提升核心竞争力的重要举措。

公司本次募集资金主要用于投资“先进工艺节点集成电路领域电源类零部件

研发及产业化项目”、“技术支持服务体系升级扩容项目”、“上海产业化基地建设项目”和“技术研发创新中心建设项目”等，均系围绕公司半导体核心零部件研发、生产、服务全链条投向科技创新领域，符合国家半导体产业自主可控战略和公司发展规划。

“先进工艺节点集成电路领域电源类零部件研发及产业化项目”系公司核心产品的迭代升级与规模化落地载体，通过该项目，公司可以聚焦核心产品，攻克关键技术，建设专业化研发及生产基地。“技术支持服务体系升级扩容项目”拟在全国 12 个核心城市布局技术支持服务中心，进一步提升公司的技术支持服务网络布局。“上海产业化基地建设项目”依托长三角产业集群优势，重点布局技术成熟度高、附加值高、市场需求明确的等离子体电源系统产品的产业化生产，优化生产布局与供应链协同，提升产品量产一致性与交付效率，为承接国产化替代订单提供产能支撑。“技术研发创新中心建设项目”围绕行业前沿方向，搭建高端研发设施，攻关行业技术难题。

通过实施前述项目，有助于公司完善从研发到生产最后再到服务的产业闭环，增强整体研发实力与客户服务能力，构筑更高的竞争壁垒，为公司未来长期稳定发展奠定坚实基础。

公司本次募集资金投资项目均属于科技创新领域，具体请参见本招股说明书“第十二节/附件九”。

（三）募集资金使用管理制度

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司已根据《上市规则》等规范性文件制定了《募集资金管理制度》，并经公司股东会审议通过。公司《募集资金管理制度》对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监督等进行了明确的规定；明确了公司募集资金专项存储制度，募集资金将严格按照规定存放于经董事会批准设立的专项账户进行集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司将在募集资金到位后规定时间内及时与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，按照有关规定对募集资金使用进行管理。

（四）募集资金投资项目对同业竞争和发行人独立性的影响

本次募集资金投资项目均紧密围绕发行人主营业务展开，旨在实现生产线的技术改造升级、加快等离子体电源系统产能建设、完善产业链布局、提升技术研发水平、保持技术先进性、增强抗风险能力。本次募集资金投资项目的实施不会对发行人的独立性产生不利影响，实施后不会产生同业竞争。

（五）募集资金投资项目的确定依据及其与发行人主要业务、核心技术之间的关系

本次募集资金投资项目系公司综合考虑公司长期发展战略、国家产业政策、行业发展情况、下游市场需求等因素综合确定。本次募集资金投资项目是公司现有业务的延伸，其中“先进工艺节点集成电路领域电源类零部件研发及产业化项目”、“上海产业化基地建设项目”主要针对公司自研产品的产业化，有助于公司突破目前产能瓶颈，加快新技术的成果转化，保障新产品顺利如期交付；“技术支持服务体系升级扩容项目”主要针对公司技术支持服务业务，有利于公司完善服务体系，增强客户粘性，进一步建立在技术支持服务领域的竞争优势；“技术研发创新中心建设项目”系针对公司新产品、新技术开展研发攻关，有利于公司技术和产品的有效迭代。

公司募集资金投资项目与公司目前主要业务以及经营战略方向相符，是公司未来业务发展目标的重要组成部分，与公司的主营业务、核心技术紧密相关。

二、募集资金投资项目实施的必要性和可行性

（一）募集资金投资项目实施的必要性

1、有助于响应国家号召，保障我国芯片产线的安全稳定生产，实现核心零部件的自主可控，推动国家半导体关键装备和核心零部件的国产化进程

等离子体电源系统系刻蚀设备、薄膜沉积设备等半导体关键工艺设备的核心零部件，等离子体电源系统的发展，直接决定着我国半导体关键工艺装备的自主可控，进而直接影响着我国芯片产线的安全稳定生产。

长期以来，等离子体电源系统国产化率处于较低水平，市场主要被美国、日本等国家的国际半导体巨头所垄断。近年来美国、日本等国家持续加大对中国大

陆半导体产业链出口限制力度。上述措施使得我国先进制程芯片产线和设备厂商面临难以获取海外原厂设备、零部件以及相应技术支持服务的双重困境。

通过本次募投项目的实施，公司一方面可以继续推进自研产品的商业化进程，为下游客户提供国产等离子体电源系统的核心零部件支持；另一方面也可以增强技术支持服务能力，为芯片产线的安全稳定生产保驾护航，降低芯片产线因原厂技术支持服务团队撤出导致的断供风险。募投项目的实施，有利于我国推动等离子体电源系统核心零部件的自主化进程，从而助力我国半导体产业的发展。

2、有助于在半导体先进制程领域展开持续的技术攻关，提升我国在半导体先进制程领域的综合实力

在半导体先进制程的演进历程中，随着芯片线宽微缩逐步逼近物理极限，三维异构集成等技术方案成为了延续摩尔定律的半导体先进制程的核心路径。无论是逻辑芯片还是存储芯片，依托高深宽比刻蚀、薄膜沉积等关键工艺实现的三维结构，已成为先进制程的主要发展趋势之一，而等离子体电源系统将成为其中的关键。

在先进刻蚀工艺方面，随着芯片三维结构堆叠层数的提升，高深宽比刻蚀工艺的重要性越来越高，对等离子体电源系统的功率需求不断提高，而电源功率的大幅提高将给等离子体电源系统的设计研发带来严峻挑战，如元器件爬电距离受限导致的绝缘击穿风险、大功率输出引发的电磁干扰加剧等问题，直接影响电源系统的输出精度与长期可靠性，成为制约先进制程落地的关键瓶颈。

在先进薄膜沉积工艺方面，高深宽比结构、1X 纳米以下线宽的先进制程中，FCVD 作为创新型沟槽填充技术能够更好的适配先进制程的加工需求；而 FCVD 通常采用远程等离子体源系统作为等离子体的激发装置。因此，远程等离子体源系统是 FCVD 工艺落地的关键部件。

通过本次募投项目的实施，公司可以进一步在先进制程领域展开持续的技术攻关，在半导体尖端领域进行深层次探索，以助力我国半导体先进制程领域综合实力的提升。

3、有助于全面提升公司研发、生产、服务等方面的能力，进而提升公司的品牌影响力和核心竞争力

随着国内半导体行业的迅速发展，下游客户对核心零部件供应商产品迭代速度、产品产能、服务响应等方面的要求越来越高。

公司需要持续加大研发投入，才能匹配行业技术迭代节奏与市场需求。同时，公司面临着产能相对不足、技术支持服务网络相对不完善等问题，亦制约了公司下游市场拓展，导致公司无法充分释放市场潜力，影响市场份额提升。本次募投项目通过建设产业化基地、升级技术支持服务网络、搭建研发创新中心，构建全链条产业生态。一方面扩大高端产品产能，满足客户规模化采购需求。另一方面完善全国技术支持服务布局，提升客户粘性。同时通过研发创新持续更新迭代产品，与下游客户共同建设国内半导体核心装备及零部件生态。

本次募投项目的实施，将强化公司“产品+服务+技术”的综合优势，帮助公司提升品牌影响力和核心竞争力，巩固公司的市场地位。

（二）募集资金投资项目实施的可行性

1、本次募投项目建设符合国家产业政策支持方向

近年来，我国高度重视半导体产业可持续发展，陆续出台一系列政策与规划，从发展指引、股权投资、专项支持、研发补助以及税收优惠等方面均为半导体产业建立了优良可靠的发展环境，推动产业“强长板、补短板、上规模、上水平”。

2026 年 3 月，第十四届全国人民代表大会第四次会议审议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，明确提出要聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节，全链条推动集成电路等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破；同期，第十四届全国人民代表大会第四次会议听取了国务院《2026 年政府工作报告》，报告明确提出要培育壮大新兴产业和未来产业，打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业。2025 年 8 月，工信部、市场监督管理总局发布了《电子信息制造业 2025－2026 年稳增长行动方案》，明确支持集成电路等领域科技创新，支持先进存储、三维异构集成芯片等前沿技术方向基础研究，坚定不移推动“国货国用”，持续推动短板产业补链、强化关键核心技术攻关，提升元器件、零部件等产品可靠性、安全性。而半导体

设备核心零部件，正是我国半导体产业长期存在的短板领域与“卡脖子”关键环节之一。

国家出台的一系列政策法规，为募投项目的实施创造了良好的政策环境。

2、本次募投项目建设以公司优质的客户资源为市场支持

在半导体等离子体电源系统领域，公司通过多年的行业深耕，积累了较多的优质客户资源。

在自研产品方面，公司产品批量进入了中微公司、拓荆科技、北方华创等我国头部半导体设备厂商，服务于客户 C、客户 A、客户 B、客户 D 等国内头部芯片产线，可适配于 14 纳米及以下逻辑芯片、2XX 层及以上存储芯片等先进制程产线。在技术支持服务方面，公司的技术支持服务已覆盖客户 A、台积电、英特尔、三星电子、SK 海力士、美光科技、德州仪器、客户 B、客户 C、客户 D、华润微等国内外主流芯片产线，以及应用材料、中微公司、拓荆科技、北方华创等国内外知名半导体设备厂商。公司系国内少数在该领域同时进入应用材料、英特尔、三星电子、SK 海力士等国际头部厂商供应链的企业。

优质的客户资源为公司募投项目的开展提供了市场支持。

3、本次募投项目建设以公司丰厚的技术积累为技术保障

经过多年的技术积累和攻关，公司已经建立了完整的核心技术体系：一是从新型拓扑结构、宽禁带半导体等器件应用及其测量、控制、测试等方面构建的等离子体电源系统关键性基础技术；二是针对半导体设备工艺特点，尤其是先进制程对于工艺效果和稳定性等方面的差异化及严苛要求，构建出特定产品领域的产品化支撑技术，有效满足半导体先进制程关键工艺的技术要求。

公司承担或参与了多个发改委、科技部、工信部重大科研项目，解决我国半导体产业卡脖子问题，公司为国家高新技术企业、国家级专精特新重点小巨人企业，先后获评 2024 年和 2025 年江苏省潜在独角兽企业、2025 年江苏省瞪羚企业；获批建设江苏省等离子源工程技术研究中心、江苏省企业技术中心；同时为中国电子专用设备工业协会会员单位、中国集成电路零部件创新联盟会员单位。公司凭借核心技术实力与全链条服务能力，斩获多项行业权威奖项，并获得头部客户的高度认可：荣获**2026 年中国证券报“2025 年度新质企业金牛奖（人工智**

能）”、2026 年 SEMICON“年度新锐企业奖”、中国 IC 独角兽联盟“2024-2025 中国半导体产线电源领军企业”“2024-2025 中国半导体产线电源最佳解决方案”、2026 年中微公司供应商“合作创新奖”“卓越质量进步奖”、2025 年拓荆科技全球合作伙伴“协作创新奖”、2025 年客户 C 供应商“最佳服务奖”、2025 年格科微零备件组“精诚服务奖”、2025 年研微半导体“锐意新星奖”等。截至报告期末，公司拥有专利 128 项，其中境内发明专利 72 项，另有软件著作权 71 项。

公司丰厚的技术积累将为募投项目的实施提供技术保障。

三、未来发展战略规划

经过多年的技术积累和业务深耕，公司已经成为中国大陆半导体等离子体电源系统领域产品布局最全面、技术最先进、服务最完善的企业之一。公司部分产品技术水平对标国际品牌，且获得国内外多个头部芯片产线和设备厂商的认可，取得了一定的市场地位。报告期内，公司多个自研产品进入大规模商业化阶段，技术支持服务持续进入了多个知名客户的供应链，营业收入高速增长，并保持着较高的盈利水平，具备良好的持续经营能力。

未来，在自研产品板块，公司将进一步提升在等离子体电源系统的核心竞争力，一方面发挥技术优势，推进行业及下游领域的国产替代进程；另一方面，加强与头部客户的战略合作，持续在先进制程的尖端领域展开技术攻关和探索。

在技术支持服务板块，公司将进一步升级服务能力，完善服务体系，为全球更多的知名产线客户提供优质服务，进一步提升自身的市场地位和行业影响力。

在团队建设方面，公司将持续加强团队能力建设，完善公司治理水平，不断引入优秀的研发人才和管理人才。

在品牌建设方面，公司将进一步开拓国际市场，进入到更多的国际厂商供应链中，完成全球范围内的技术服务网点布局，持续提升公司产品在全球范围内的品牌影响力。

公司秉承“创造等离子能量，驱动人类科技未来”之使命，将在等离子体电源系统领域持续深耕、开拓创新，全力推动我国半导体装备国产化进程，助力我国半导体行业突破发展瓶颈、勇攀技术高峰，为实现“中国芯”自主可控的战略

目标贡献核心力量。

第八节 公司治理与独立性

一、公司治理制度情况

公司根据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，确立、完善了由股东会、董事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东会、董事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《公司章程》以及上市后适用的《公司章程（草案）》；制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》等规则体系，为公司规范发展提供了有力保障。

自股份公司成立以来，股东会、董事会和高级管理人员均能按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则独立有效的运作，没有违法、违规的情况发生。

二、内部控制情况

（一）发行人管理层对内部控制的自我评估意见

发行人董事会认为，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，公司未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

（二）注册会计师对发行人内部控制的鉴证意见

容诚会计师出具了发行人《内部控制审计报告》（容诚审字[2026]210Z0028号），结论为“容诚会计师认为神州半导体公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

三、发行人报告期内违法违规情况

发行人严格按照《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作、依法经营，报告期内不存在重大违法违规行为，也未受到相关主管机关的重大处罚。

四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况

报告期内，公司除“第八节/八/（二）/3/（3）”所描述的资金拆借情形以外，不存在其他资金被占用的情况。

发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力

（一）资产完整

公司由神州有限整体变更设立，承继了神州有限的所有资产、负债及权益。公司合法拥有与生产经营有关的房屋建筑物、机器设备等资产，以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司资产与股东资产严格分离，不存在与股东共用的情况。公司不存在为股东或股东控制的其他公司提供担保的情形，不存在资产被股东占用而损害公司利益的情形。

（二）人员独立

发行人的董事、高级管理人员系严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定通过选举、聘任产生。发行人的高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。发行人的员工均由发行人自行聘用、管理，独立执行劳动、人事、工资管理制度。

（三）财务独立

发行人已设置了独立的财务会计部门、配备了合格的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系、制定了规范的财务会计制度，能够独立开展财务工作、进行财务决策。发行人已开立独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人

及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

（四）机构独立

公司已建立健全规范的法人治理结构和公司运作体系，并制定了相适应的股东会、董事会的议事规则，以及独立董事、董事会各专门委员会和总经理的工作细则等。根据业务经营需要，发行人已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情况。

（五）业务独立

发行人的业务独立于实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的业务系统，独立开展业务。发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（六）主营业务、控制权、管理团队稳定性

发行人主营业务、控制权、管理团队稳定，最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近两年实际控制人没有发生变更。

（七）其他事项

发行人不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

六、同业竞争

（一）同业竞争情况

除发行人及其控股子公司外，公司实际控制人朱培文控制的其他企业为众芯聚能，为公司员工持股平台。该持股平台基本情况参见“第四节/十三/（二）/2、”。

综上所述，公司不存在与实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的情形，不存在同业竞争。

（二）避免同业竞争的承诺

发行人实际控制人朱培文出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容参见本招股说明书“第十二节/附件二/九/（一）”。

七、关联方与关联关系

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，发行人的主要关联方如下：

（一）发行人控股股东、实际控制人

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人为朱培文。控股股东、实际控制人基本情况参见本招股说明书“第四节/七/（一）”。

（二）其他直接或间接持有发行人 5%以上股份的股东

截至本招股说明书签署日，其他直接或间接持有发行人 5%以上股份的股东情况如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	众芯聚能	直接持有公司 23.2535%的股份
2	江苏信基	直接持有公司 20.3183%的股份
3	英特尔亚太	直接持有公司 8.6125%的股份
4	英特尔亚太向上穿透的关联主体[注]	间接持有公司 8.6125%的股份
5	陈觉晓	间接持有公司 20.1964%的股份

注：英特尔亚太系 Intel Corporation（美国 NASDAQ 上市公司）的全资子公司，其向上穿透至 Intel Corporation 的层层主体数量较多，在此不展开列示。

其他直接或间接持有公司 5%以上股份的股东基本情况参见本招股说明书“第四节/七”。

（三）发行人的董事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员

公司董事、高级管理人员均为公司关联方。截至本招股说明书签署日的公司董事、高级管理人员情况，详见本招股说明书“第四节/九”的相关内容。前述人员及与其关系密切的家庭成员（包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）均为发行人的关联自然人。

（四）发行人子公司

截至本招股说明书签署日，发行人控股子公司情况如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	江苏芯越	发行人持股 100%，全资子公司
2	晟州聚能	发行人持股 100%，全资子公司
3	上海昇州	发行人持股 100%，全资子公司

（五）发行人的控股股东、实际控制人控制的其他企业

除发行人及其子公司外，截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人朱培文直接或间接控制的其他企业为发行人员工持股平台众芯聚能。

（六）发行人持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制的或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织是发行人的关联方，主要如下：

序号	关联方	关联关系
1	上海优澳美德医院管理有限公司	实际控制人朱培文任董事，并持有 13%股权；董事陈觉晓任董事，并持有 19.88%股权；董事陈觉晓姐姐任董事长
2	江苏信基科技有限公司	董事陈觉晓担任董事长、执行董事的企业
3	扬州广德信息有限公司	董事陈觉晓担任董事长、总经理的企业
4	扬州汇禧管理咨询有限公司	董事陈觉晓任执行公司事务的董事，持股 70%，其女儿持股 30%的企业
5	立安有限公司	董事陈觉晓配偶担任董事长的企业
6	珠海横琴优联美德健康科技有限公司	董事陈觉晓姐姐担任执行董事、经理、财务负责人的企业
7	惠州大亚湾中联置业有限公司	董事陈觉晓姐姐的配偶担任执行公司事务的董事的企业
8	菏泽市澳泽房地产开发有限公司	董事陈觉晓姐姐的配偶担任董事并持有 40%股权的企业
9	惠州市博成房地产开发有限公司	董事陈觉晓姐姐的配偶担任董事长的企业
10	惠州一代投资有限公司	董事陈觉晓姐姐的配偶担任董事长的企业
11	惠州市和高房地产开发有限公司	董事陈觉晓姐姐的配偶担任董事长的企业
12	中山吉事达通讯有限公司	董事陈觉晓姐姐的配偶担任执行公司事务的董事、财务负责人的企业
13	惠州大亚湾生佳投资有限公司	董事陈觉晓姐姐的配偶担任执行董事、经理的企业
14	厦门澳鑫联合文化传媒有限公司	董事陈觉晓姐姐的配偶担任董事的企业
15	苏州苏珺诺芯半导体科技有限公司	实际控制人朱培文妹妹的配偶任执行董事，持有 60%股权并实际控制；实际控制人朱培文妹妹持有

序号	关联方	关联关系
		40%股权
16	上海爱晶玖半导体技术有限公司	实际控制人朱培文妹妹的配偶担任董事长、实际控制人妹妹担任董事的企业
17	玛奇威芯半导体技术（苏州）有限公司	实际控制人朱培文妹妹的配偶担任董事的企业
18	上海爱晶壹半导体科技有限公司	实际控制人朱培文妹妹的配偶担任董事的企业
19	苏州微骏瑞芯精密科技有限公司	实际控制人朱培文妹妹任执行董事，持有 100%股权并实际控制；历史董事耿微报告期内曾持有 50%股权
20	苏州玛奇威尔企业管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人朱培文妹妹的配偶持有 58.3333%合伙企业财产份额，并担任执行事务合伙人的企业
21	苏州爱浦芯企业管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人朱培文妹妹的配偶持有 56.3636%合伙企业财产份额，并任执行事务合伙人
22	无锡吉特科技有限公司	实际控制人朱培文的妹妹的配偶担任执行董事兼总经理，持股 51.9231%并实际控制
23	江苏镨芯电子科技有限公司	董事郭正担任董事的企业
24	北京中科信半导体股份有限公司	董事郭正担任董事的企业
25	诺远科技（苏州）有限公司	根据实质重于形式原则，公司实际控制人朱培文妹妹的配偶持股 32.50%且有关联交易的企业

（七）报告期内的曾经的关联方，主要如下：

1、报告期内曾经的关联自然人

序号	关联方	曾经的关联关系	目前情况
1	叶剑	报告期内曾任神州半导体监事	已于 2025 年 11 月卸任
2	陈蓉	报告期内曾任神州半导体监事	已于 2025 年 5 月卸任

上述报告期内曾经的关联自然人及其关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等亦为公司报告期内曾经的关联自然人。

2、报告期内曾经的关联法人

序号	关联方	曾经的关联关系	目前情况
1	江苏医联生物科技有限公司	董事陈觉晓曾担任执行董事的企业	已于 2023 年 1 月卸任执行董事
2	珠海硕德投资咨询合伙企业（有限合伙）	董事陈觉晓报告期内曾持有 99%合伙企业财产份额，并任执行事务合伙人	已于 2024 年 1 月卸任执行事务合伙人
3	江苏优联美德医院管理有限公司	董事陈觉晓姐姐曾担任董事的企业	该公司已于 2023 年 4 月注销

序号	关联方	曾经的关联关系	目前情况
4	中创唯一（珠海横琴）中医药科技发展有限公司	董事陈觉晓报告期内曾任董事，并持有 15%股权；董事陈觉晓姐姐报告期内曾任董事	已于 2025 年 8 月卸任董事
5	广东省优联美地实业有限公司	董事陈觉晓姐姐曾担任执行董事、经理的企业	已于 2024 年 11 月卸任执行董事、经理
6	扬州邃芯半导体有限公司	实际控制人朱培文妹妹的配偶担任执行董事，持有 51%股权并实际控制；实际控制人朱培文妹妹持有 49%股权	该公司已于 2024 年 1 月注销
7	上海苏珺诺芯科技服务中心	实际控制人妹妹的配偶 100%投资并实际控制	该公司已于 2023 年 12 月注销
8	广州新锐光掩模科技股份有限公司	董事郭正曾担任董事的企业	已于 2025 年 8 月卸任董事
9	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	报告期内曾直接持有神州半导体 5%以上股份	持股比例于 2025 年 12 月降至 5%以下
10	英特尔半导体存储技术（大连）有限公司	根据实质重于形式原则，公司间接持股 5%以上股东英特尔亚洲控股有限公司控制的企业	英特尔亚洲控股有限公司已于 2025 年 3 月退出持股
11	扬州市邗田房地产经纪有限公司	实际控制人朱培文持股 35%且实际控制人配偶持股 5%的企业	已于 2024 年 9 月注销
12	**福建省南安兴艺木雕有限公司；**	**陈觉晓姐姐的配偶任董事的企业**	**已于 2026 年注销**
13	**福建省南安兴盛塑胶有限公司**	**陈觉晓的姐姐任董事，陈觉晓姐姐的配偶任副董事长的企业**	**已于 2026 年注销**

（八）根据实质重于形式原则认定的其他与发行人有特殊关系，可能导致发行人利益对其倾斜的自然人、法人或其他组织也构成发行人关联方。

（九）在交易发生之日前 12 个月内，或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内，具有《公司法》《上市规则》《企业会计准则第 36 号-关联方披露》等相关法律、法规、规范性文件规定的关于关联方认定标准情形之一的相关方（除已披露的关联方）也构成发行人关联方。

八、关联交易情况

（一）报告期内关联交易汇总表

1、关联采购

报告期内，公司的关联采购情况如下：

单位：万元

项目	关联交易内容	2026 年 1-6 月		2025 年		2024 年		2023 年	
		金额	占当期采购总额比例	金额	占当期采购总额比例	金额	占当期采购总额比例	金额	占当期采购总额比例
江苏信基	采购商品、服务及设备	**35.20**	**0.18%**	112.43	0.53%	210.47	1.12%	336.85	2.68%
诺远科技	采购商品及加工检测费	**603.70**	**3.15%**	1,171.06	5.53%	1,040.70	5.52%	459.98	3.66%
爱晶玖	业务分成	-	-	41.93	0.20%	171.83	0.91%	-	-
爱晶玖	采购商品	**541.89**	**2.83%**	452.69	2.14%	-	-	-	-
苏州微骏	采购商品及加工检测费	-	-	-	-	76.26	0.40%	160.44	1.28%
关联采购金额合计		**1,180.78**	**6.16%**	**1,778.11**	**8.40%**	**1,499.26**	**7.95%**	**957.27**	**7.62%**

2、关联销售

报告期内，公司的关联销售情况如下：

单位：万元

项目	关联交易内容	2026 年 1-6 月		2025 年		2024 年		2023 年	
		金额	占当期收入比例	金额	占当期收入比例	金额	占当期收入比例	金额	占当期收入比例
英特尔	销售商品	-	-	1,447.47	2.21%	3,100.97	6.95%	1,760.51	6.74%
爱晶玖	销售商品	**68.98**	**0.18%**	453.58	0.69%	3.88	0.01%	-	-
诺远科技	销售商品	-	-	-	-	219.28	0.49%	-	-
苏州微骏	销售商品	-	-	-	-	27.70	0.06%	116.00	0.44%
北京中科信	销售商品	-	-	-	-	-	-	10.16	0.04%
关联销售金额合计		**68.98**	**0.18%**	**1,901.04**	**2.91%**	**3,351.83**	**7.51%**	**1,886.67**	**7.23%**

此外，公司关联方英特尔于 2025 年 9 月将大连工厂出售至 SK 海力士，大连工厂名称由“英特尔半导体存储技术（大连）有限公司”变更为“爱思开海力士半导体存储技术（大连）有限公司”，公司 2025 年对爱思开海力士半导体存储技术（大连）有限公司销售收入金额系 1,809.66 万元。

3、关联租赁

报告期内，公司作为承租方，产生的关联租赁情况如下：

单位：万元

年份	出租方名称	租赁资产种类	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
2025 年	江苏信基	房屋及建筑物	74.71	0.49	-
		机器设备	152.41	3.41	-
		合计	**227.12**	**3.90**	**-**
2024 年	江苏信基	房屋及建筑物	99.62	4.46	-
		机器设备	101.88	7.17	-
		合计	**201.50**	**11.63**	**-**
2023 年	江苏信基	房屋及建筑物	74.71	8.91	-
		机器设备	50.94	5.86	253.77
		合计	**125.65**	**14.77**	**253.77**

公司 2026 年 1-6 月不存在关联租赁情况。

4、关联拆借

报告期内，公司不存在资金拆入的情况，但存在资金拆出的情况，具体如下：

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆出			
扬州广德	100.00	2023/1/1	2023/11/17
朱培文	169.29	2023/1/16	2025/10/30
丁书龙	40.84	2023/1/11	2025/11/4
丁书龙	68.70	2023/5/6	2025/11/4

5、关键管理人员薪酬

报告期内公司关键管理人员薪酬情况如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
薪酬总额（万元）	**617.39**	2,428.63	2,156.20	1,620.28
利润总额（万元）	**12,823.54**	22,881.20	15,349.69	-1,455.64
占当期利润总额比例	**4.81%**	**10.61%**	**14.05%**	**-**

注：关键管理人员薪酬口径为个人应发工资总额，不包含公司缴纳的社保公积金及股份支付。**2026 年 1-6 月预提的年终奖未对应到个人，故 2026 年 1-6 月统计口径中未包含预提的年终奖。**

6、关联方应收应付款项

报告期内各期末，公司关联方应收应付情况如下：

单位：万元

项目名称		关联方	2026年6月30日		2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收项目	应收账款	诺远科技	-	-	28.68	4.13	55.57	2.78	-	-
		爱晶玖	-	-	56.04	2.80	-	-	-	-
		英特尔	-	-	-	-	2,214.58	110.73	932.05	46.60
		苏州微骏	-	-	-	-	-	-	60.99	3.05
	预付款项	诺远科技	-	-	43.12	-	-	-	-	-
		苏州微骏	-	-	-	-	-	-	36.26	-
	其他应收款	朱培文	-	-	-	-	152.54	22.88	147.45	7.37
		丁书龙	-	-	-	-	142.08	21.31	138.78	6.94
应付项目	应付账款	江苏信基	-	-	-	-	778.69	-	540.49	-
		诺远科技	90.28	-	-	-	121.54	-	53.77	-
		爱晶玖	351.12	-	-	-	65.52	-	-	-

7、其他关联事项

报告期内，公司的其他关联交易事项包括向江苏信基支付长期挂账应付款项的利息、通过苏州微骏和扬州广德支付专家顾问费、支付刘文丰团队薪酬、扬州邃芯入股及退出江苏芯越、受让江苏信基专利等。

（二）关联交易情况

1、重大关联交易选取标准

公司参考《关联交易管理办法》的相关规定，将重大关联交易的判断标准及依据设定如下：（1）公司与关联自然人发生的交易金额在人民币30万元以上的关联交易；（2）与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产0.1%以上，且超过300万元的关联交易（公司提供担保除外）。不符合上述标准的为一般关联交易。

2、经常性关联交易

除支付董事、历史监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬外，报告期内，公司的重大经常性关联交易主要包括与刘文丰团队合作引起的关联交易以及为英特尔提供技术支持服务：

（1）与刘文丰团队合作引起的关联交易

刘文丰系公司实际控制人朱培文的妹夫，2022 年 10 月至 2025 年 10 月，刘文丰团队曾与公司展开合作，在刘文丰团队与公司合作期间，通过江苏芯越开展了多个项目，产生了相关的关联交易。

A、扬州邃芯入股及退出江苏芯越

江苏芯越成立于 2020 年 10 月，成立之初系发行人全资子公司。在与刘文丰团队合作期间，刘文丰团队作为职业经理人，负责江苏芯越的日常经营。

刘文丰通过其关联企业扬州邃芯于 2022 年 10 月入股江苏芯越，取得了 40%的股权，后于 2023 年 12 月退出江苏芯越。

B、向关联方采购腔体等零部件、销售镀膜腔体

诺远科技系刘文丰关联企业，主要从事机加工业务。报告期内，公司主要通过江苏芯越向诺远科技等关联方采购腔体及其配件，进行镀膜后形成镀膜腔体，交付给母公司神州半导体，用于远程等离子体源系统的生产，并应刘文丰团队要求，销售少量镀膜腔体给关联方。

在该业务中，涉及的关联交易包括：

①向诺远科技采购腔体等零部件。报告期内，公司向诺远科技采购腔体等原材料用于自身产品生产，金额分别为 405.44 万元、864.64 万元、994.86 万元**和 603.70 万元**。2024 年，随着公司远程等离子体源系统产品业务放量，对诺远科技的腔体采购金额增长较快。报告期内，公司向诺远科技采购腔体的价格保持稳定，且与非关联供应商采购价格基本一致，具有公允性。②向江苏信基采购腔体等零部件。报告期内，公司亦存在向江苏信基采购腔体等原材料用于自身产品生产，金额分别为 234.07 万元、9.97 万元、8.73 万元**和 0 万元**，主要集中在 2023 年，且与非关联供应商采购价格基本一致，具有公允性。

③向关联方销售镀膜腔体。报告期内，江苏芯越将少量镀膜腔体销售给诺远科技、爱晶玖和苏州微骏，报告期各期金额分别为 55.26 万元、212.90 万元、10.34 万元**和 68.98 万元**，主要集中在 2024 年，且与江苏芯越销售给神州半导体的价格基本一致，具有公允性。

C、应用材料项目

2023 年，刘文丰团队承揽了应用材料螺丝钉镀膜项目，主要通过对螺丝钉镀膜并销售给国际半导体知名设备厂商应用材料，用于制造半导体设备。

彼时，江苏芯越由刘文丰团队负责管理，该项目由刘文丰团队承揽，经刘文丰团队与神州半导体商议，该项目通过具备供应商资质的江苏芯越实施，具体为江苏芯越向刘文丰团队的关联企业诺远科技、爱晶玖等采购螺丝钉并进行镀膜，再销售给应用材料。按照双方协商，江苏芯越在该项目中毛利率保持 15%左右，关联交易具有公允性。

在该业务中，涉及的关联交易包括：

①向刘文丰的关联企业诺远科技、爱晶玖购买螺丝钉原材料。具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年
诺远科技	采购螺丝钉等原材料	-	30.55	164.98	34.71
爱晶玖	采购螺丝钉等原材料	539.55	412.64	-	-
合计		**539.55**	**443.19**	**164.98**	**34.71**

②向江苏信基采购镀膜加工服务。2025 年 10 月之前，由于江苏信基向江苏芯越迁移相关生产能力的工作尚在过渡中，应终端客户应用材料的要求，江苏芯越通过向公司股东江苏信基采购镀膜加工服务，完成应用材料项目的螺丝钉镀膜工作。具体表现形式为：江苏信基先向江苏芯越采购螺丝钉，镀膜完成后再卖还给江苏芯越，公司按照净额法核算。

报告期内产生的关联采购具体如下：

单位：万元

关联方	项目	2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年
江苏信基	向江苏信基采购螺丝钉镀膜服务	-	23.41	200.50	102.78

D、向关联方提供机加工件镀膜业务

报告期内，刘文丰团队涉及的关联方存在向江苏芯越持续采购机加工件的镀膜服务的情况。在该业务中，**2023 年-2025 年期间，**江苏芯越先向诺远科技采购机加工件及配件，然后镀膜后销售给苏州微骏、爱晶玖、诺远科技等关联方。**2026**

年 1-6 月，江苏芯越以“受托加工方式”执行上述业务，即江苏芯越仅负责镀膜工序并收取加工费，原材料由爱晶玖自行采购，公司于 2026 年 1-6 月不涉及向诺远科技采购机加工件镀膜后再销售至爱晶玖的情况；公司 2026 年 1-6 月销售至爱晶玖的受托加工费系 68.98 万元。

报告期内该业务涉及的关联采购金额如下：

单位：万元

关联方	项目	2025 年	2024 年	2023 年
诺远科技	采购机加工件	145.65	10.61	16.64

报告期内涉及的关联销售金额如下：

单位：万元

关联方	项目	2025 年	2024 年	2023 年
诺远科技	销售镀膜机加工件	-	28.64	-
爱晶玖	销售镀膜机加工件	443.24	3.88	-
苏州微骏	销售镀膜机加工件	-	5.44	60.74
合计		**443.24**	**37.95**	**60.74**

该业务主要集中在 2025 年，且根据市场价格收取镀膜费用，毛利率与综合毛利率基本一致，定价公允。

E、客户 E 项目分成

2024 年，刘文丰控制的公司爱晶玖承揽了客户 E 的半导体零部件业务，由于爱晶玖相关供应商资质尚在办理中，刘文丰团队与神州半导体协商，由神州半导体负责代工，刘文丰团队通过江苏芯越支付费用的方式进行分成。2024 年和 2025 年，公司分别支付爱晶玖分成 41.93 万元和 171.83 万元。

2025 年 8 月，鉴于爱晶玖的相关供应商资质已经办理完成，客户 E 的上述业务由爱晶玖承接，神州半导体的相关代工业务停止。

F、向刘文丰团队支付薪酬

在刘文丰团队和公司合作期间，江苏芯越向其团队发放薪酬。应刘文丰团队要求，2023 年，江苏芯越主要以向苏州微骏支付技术服务费的形式进行支付；2024 年 1-8 月，江苏芯越主要以向刘文丰个人支付技术服务费或薪酬的形式进行支付。2024 年 9 月以后，江苏芯越不再直接支付刘文丰团队薪酬。

报告期内，上述情况涉及的关联交易如下：

单位：万元

支付对象	项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
苏州微骏	支付技术服务费	-	-	-	100.01
刘文丰	支付技术服务费、薪酬	-	-	86.12	-
合计		-	-	**86.12**	**100.01**

（2）为英特尔及 SK 海力士提供技术支持服务

英特尔通过其投资平台英特尔亚太持有公司 8.6125%的股份，系公司 5%以上的股东，属于公司的关联方。报告期内，公司主要为英特尔大连工厂提供技术支持服务，2025 年 9 月，英特尔将大连工厂出售给了 SK 海力士，大连工厂名称由“英特尔半导体存储技术（大连）有限公司”变更为“爱思开海力士半导体存储技术（大连）有限公司”。

公司对英特尔的收入主要系技术支持服务收入，报告期内的关联销售金额分别为 1,760.51 万元、3,100.97 万元、1,447.47 万元**和 0 万元**。报告期各期，公司对英特尔的毛利率与其他先进存储芯片产线客户的毛利率基本处于同一区间，关联交易定价公允。

此外，公司 2025 年对爱思开海力士半导体存储技术（大连）有限公司销售收入金额系 1,809.66 万元。

（3）与中微公司的交易比照关联交易进行核查

根据中微半导体、智微攀峰、智微厚德等股东出具的确认，虽然智微攀峰、智微厚德存在一致行动关系，但上述两家企业与中微半导体不存在一致行动关系，因此中微半导体持有公司 1.3636%的股份，智微攀峰、智微厚德合计持有公司 4.2106%的股份，均不属于公司 5%以上的股东，从而中微公司不属于公司的关联方。

考虑到中微公司系发行人 2025 年第一大客户，保荐机构对公司与中微公司的交易比照关联交易进行了核查：

中微公司系国内半导体刻蚀设备、薄膜沉积设备龙头企业，系我国在先进制程半导体装备领域的主力军。公司产品系面向先进制程的等离子体电源系统，技

术壁垒较高，下游客户需求主要集中在中微公司、拓荆科技和北方华创三家半导体主设备厂商，公司亦向其他两家客户销售了较大金额的自研产品，公司与中微公司的交易具有必要性和合理性。

中微半导体系 2025 年 3 月投资公司，而公司与中微公司接触较早，早期主要为其提供技术支持服务，最早下达的订单时间系 2020 年 3 月。2023 年，为解决国际品牌断供导致的国内等离子体电源系统“卡脖子”问题，公司经下游芯片产线介绍，作为核心零部件厂商，与中微公司的合作加深，在自研产品大规模量产后，实现较大收入增长。

报告期内，公司对中微公司销售的主力产品系 2023 年 1 月研发立项，2023 年 9 月验证测试，2023 年 11 月获得商业化订单，彼时中微公司及其关联方均未与公司洽谈或开展投资事宜。

公司对中微公司的技术支持服务业务，与拓荆科技、北方华创等其他客户的技术支持服务的毛利率可比，具有公允性。公司提供给中微公司的自研产品属于应用先进制程的高端产品，国内仅有公司及另外一家竞争对手具备供货能力，无可以参照的产品定价，公司综合前期研发成本、制造成本等因素进行报价，报告期内毛利率稳定，具有公允性。

3、偶发性关联交易

报告期内，公司的重大偶发性关联交易主要包括与江苏信基业务迁移相关的关联交易、支付外部专家技术咨询费以及关联方资金拆借：

（1）与江苏信基业务迁移相关的关联交易

报告期之前，朱培文、陈觉晓等人前期商定以江苏信基为主体开展表面处理业务、镀膜加工业务，2022 年 10 月，公司与刘文丰团队进行合作，逐步将表面处理、镀膜加工业务迁移至江苏芯越。截至报告期末，江苏信基曾开展的表面处理、镀膜加工业务已由江苏芯越承接，并完成了相应的转移、变更程序。

A、向江苏信基租赁场地及设备的情况

在业务完全转移的过渡期内，江苏芯越存在向江苏信基租赁生产场地和设备的情况：

2019 年 4 月，江苏信基与扬州市邗江区高新技术创业服务中心签订了《房屋租赁协议》，租赁了位于扬州市邗江区吉安路 203 号 1 幢的厂房。江苏芯越成立后，相关厂房由江苏芯越与江苏信基共同使用，江苏芯越根据使用面积，向江苏信基支付租金。报告期内，产生的租金（含税）分别为 74.71 万元、99.62 万元、74.71 万元**和 0 万元**。相关租金按照江苏信基向出租方租赁的价格结合江苏芯越使用的面积比例计算确认，具有公允性。

2023 年 5 月，江苏芯越以融资租赁的方式，租赁了江苏信基加工中心设备，用于过渡期的生产加工。公司于 2023 年 6 月确认了设备资产 253.77 万元，并于 2025 年末提前支付了剩余利息。报告期内，江苏芯越支付的租金（含税）分别为 50.94 万元、101.88 万元、152.41 万元**和 0 万元**。**2026 年 1-6 月，公司向江苏信基以 35.20 万元价格采购了 1 台车辆，用于公司办公使用。**

B、从江苏信基处受让专利的情况

江苏信基最早从事镀膜加工业务，并申请了部分专利。报告期内，江苏信基逐步将业务转移至江苏芯越，同时将相关专利无偿转让给神州半导体。

报告期内，公司于 2023 年 6 月自股东江苏信基处零对价受让 1 项发明专利，**并于 2026 年 3 月自股东江苏信基处零对价受让 1 项外观设计专利和 2 项实用新型专利，于 2026 年 4 月自股东江苏信基处零对价受让 1 项发明专利。**

（2）通过苏州微骏、扬州广德支付专家技术咨询费

报告期内，经刘文丰团队引荐，公司存在向外部技术专家采购技术咨询服务的情况。江苏芯越通过刘文丰控制的企业苏州微骏、陈觉晓的关联企业扬州广德向外部技术专家支付技术咨询费，2023 年度合计向苏州微骏、扬州广德支付技术咨询费 546.85 万元（不含税）。2023 年 12 月以后，公司与外部专家终止了合作，并于合作终止后停止支付技术咨询费。

（3）关联方资金拆借

报告期内，公司存在资金拆出的情况，具体情况如下：

单位：万元

项目	关联方	期初余额	本期借入金额	利息金额	本期偿还金额	期末余额
2023 年度	朱培文	-	169.29	4.86	-	174.15

项目	关联方	期初余额	本期借入金额	利息金额	本期偿还金额	期末余额
2024 年度		174.15	-	5.09	-	179.24
2025 年度		179.24	-	4.23	183.47	-
2023 年度	丁书龙	-	109.54	2.54	-	112.08
2024 年度		112.08	-	3.30	-	115.38
2025 年度		115.38	-	2.74	118.12	-
2023 年度	扬州广德	-	100.00	-	100.00	-

2023 年，朱培文、丁书龙从公司拆借资金用于购买无票的电源系统备机。2023 年 12 月以后，公司停止了上述情况，剩余资金及利息于 2025 年 10 月及 11 月退还完毕。

2023 年，陈觉晓的关联企业扬州广德从公司拆借资金 100 万元，用于其贸易业务的资金周转，同年，扬州广德将拆借资金退还公司。

2026 年 1-6 月，公司不存在资金拆借的情况。

4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

公司报告期内的关联交易未对公司的独立性以及财务状况、经营成果等造成重大不利影响，具备商业合理性、必要性且交易价格公允，关联交易不存在影响公司独立性的情形，不存在损害公司和股东利益的行为。

（三）报告期内发生的关联交易履行公司章程规定的情况及独立董事意见

2026年2月14日，发行人独立董事召开了专门会议，确认公司报告期内（2023年、2024年及2025年）与关联方之间的关联交易是基于诚实公允及商业原则发生，均系发行人根据市场和自身情况，结合生产安排进行，符合发行人实际生产经营的需要，不存在损害发行人及股东利益的情况，也不存在通过关联交易对发行人或关联方进行不正当利益输送的情形。

2026 年 2 月 14 日及 2026 年 3 月 2 日，发行人分别召开第一届董事会第四次会议及 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于对公司报告期内关联交易予以确认的议案》，对发行人报告期内（2023 年、2024 年及 2025 年）发生的关联交易的公允性和合理性予以确认。

2026 年 6 月 4 日，发行人独立董事召开了专门会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。2026 年 6 月 4 日及 2026 年 6 月 24 日，发行

人分别召开第一届董事会第六次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，就发行人2026年度日常性关联交易事项进行了预计，关联董事和关联股东回避表决。

发行人已专门制定《江苏神州半导体科技股份有限公司关联交易管理办法》，规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避表决制度，明确了关联交易公允决策的程序。发行人股东会已对报告期内发生的关联交易进行了审议，且独立董事对上述关联交易进行了确认，该等关联交易公平、公允，不存在损害发行人及非关联股东利益的情况。

（四）为减少和规范关联交易而采取的措施

1、不断提高公司治理水平，严格规范关联交易

公司在《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理准则中明确规定了关联交易的决策程序，要求关联股东和关联董事分别在股东会和董事会审议有关关联交易事项时采取回避表决的措施；在《独立董事工作制度》规定了独立董事对关联交易事项的职权和要求；在《关联交易管理办法》中就关联关系的界定、关联交易的内容、关联交易的实施权限及信息披露做出了明确规定，保证公司与关联方进行交易符合公开、公平、公正的三公原则。公司将不断提升内部治理水平，严格遵守以上规章制度，按规定履行程序，以保证公司关联交易的公允性，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

公司在业务、机构、资产、人员、财务上均独立于各关联方，公司具备面向市场的独立运营能力。公司将根据实际情况规范和减少关联交易，杜绝发生不必要的关联交易。对于正常的、有利于公司发展的、预计将持续存在的关联交易，公司将继续遵循公开、公平、公正的市场原则，严格履行公司的决策程序和关联方回避制度，遵守有关合同协议的规定，做好信息披露工作，切实维护股东的权益。

2、规范和减少关联交易的承诺

为规范和减少关联交易，发行人的控股股东、实际控制人及其一致行动人、持有发行人5%以上股份的主要股东、全体董事、高级管理人员分别出具了承诺，具体内容参见本招股说明书“第十二节/附件二/十”。

第九节 投资者保护

一、本次发行完成前滚存利润的分配安排

2026 年 3 月 2 日，发行人召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过本次发行上市完成后生效的《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案》，规定根据公司本次发行上市方案以及公司的实际情况，若公司在本次发行上市前存在滚存未分配利润，该等滚存未分配利润将由公司本次发行上市后的新老股东按照各自在本次发行上市后的股份比例予以分配。

二、股利分配政策情况

（一）发行人本次发行前的股利分配政策

公司的股利分配严格执行有关法律、法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报。根据《公司法》和《公司章程》，公司的主要股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但章程规定不按持股比例分配的除外。

股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。

公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

3、公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利（或者股份）的派发事项。

（二）发行人本次发行后的股利分配政策

1、本次发行上市后股利分配政策的决策程序

2026 年 3 月 2 日，发行人召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过本次发行上市完成后生效的《公司章程（草案）》《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后未来三年分红回报规划的议案》，明确规定了发行人上市后适用的利润分配原则、利润分配形式、股票股利的条件、现金分红的条件、比例和期间间隔、公司利润分配期间、现金分红比例、发放股票股利的条件、剩余未分配利润的用途、公司利润分配的决策程序和机制及利润分配政策的调整等。

2、本次发行上市后的股利分配政策

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定和要求，为明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制订了《公司章程（草案）》《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后未来三年分红回报规划的议案》，公司发行上市后的利润分配政策具体如下：

（1）利润分配原则

公司分红回报规划结合公司实际情况，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，实行持续、稳定的利润分配政策。

（2）利润分配的形式

公司股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。公司将优先考虑采取现金方式分配股利；根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等合理因素，公司可采取股票或者现金、股票相结合的方式分配股利。

（3）股票股利的条件

在确保足额现金股利分配的前提下，考虑股东意愿和要求，公司可以另行增加股票股利分配和资本公积金转增，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。公司发放股票股利应满足以下条件：

1）公司经营情况良好；

2）公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益；

3）发放的现金股利与股票股利的比例符合公司章程的规定；

4）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的其他条件。

（4）现金分红的条件、比例和期间间隔

1）公司该年度或半年度实现的可分配利润的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2）公司累计可供分配的利润为正值；

3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出系指下列情形之一：

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币；

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以参照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序，提请股东会审议提高现金分红在本次利润分配中的最低比例。

（5）剩余未分配利润的用途

公司将审慎合理地使用剩余未分配利润，剩余未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以逐步扩大公司生产经营规模，促进公司业务快速发展和经营业绩持续增长，有计划有步骤地实现公司未来的发展目标，为公司股东提供更多回报。

（6）利润分配的决策机制与程序

公司董事会应于年度报告或半年度报告公布前，根据公司的利润分配规划和计划，结合公司当期的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜，制订公司年度或者半年度的利润分配预案，经董事会过半数以上表决通过。

独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

利润分配预案经上述程序审议后，由董事会报请股东会批准，利润分配预案应当由出席股东会的股东/股东代表所持表决权的过半数通过。股东会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（7）利润分配政策的调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反证券监管机构的规定，有关调整利润分配政策的议案经公司董事会审议通过后提交公司股东会批准，该议案须经出席股东会会议的股东/股东代表所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构或其他类似特殊安排。公司不存在尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况。

第十节 其他重要事项

一、重大合同

公司签署的重要合同主要涉及正常生产经营活动，包括重大销售合同、重大采购合同、借款与授信合同及其他对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。

（一）销售合同

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人与报告期各期前五大客户签订的已履行完毕或正在履行的主要销售框架协议或与其签订的合同金额在 1,000 万元及以上的销售合同如下：

1、重大销售框架协议

序号	客户名称	合同标的	合同期限	履行情况
1	中微半导体设备（上海）股份有限公司	射频电源、远程等离子源、匹配器	2023 年 11 月至 2025 年 11 月（“初始期限”），在初始期限或延长初始期限（如适用）到期后自动连续延长 12 个月的续约期限，除非任何一方到期前至少 3 个月发出不续约书面通知	正在履行
2	客户 C	备件及其维修等相关服务	2024 年 3 月至无固定期限	正在履行
3	SK 海力士半导体（中国）有限公司	射频类部件维修服务	2024 年 1 月至 2026 年 1 月	**履行完毕**
4	客户 A	以实际订单为准	2025 年 12 月至无固定期限	正在履行
5	拓荆科技（上海）有限公司	以实际订单为准	2023 年 8 月至 **2026 年 1 月**	**履行完毕**
6	**拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司**	**以实际订单为准**	**2026 年 1 月至无固定期限**	**正在履行**
7	**客户 D**	**零部件备件检测、维修等相关服务**	**2026 年 3 月至 2031 年 3 月**	**正在履行**
8	**SK 海力士半导体（中国）有限公司**	**射频类部件维修服务**	**2026 年 1 月至 2029 年 1 月**	**正在履行**
9	**拓荆科技（上海）有限公司**	**以实际订单为准**	**2026 年 1 月至无固定期限**	**正在履行**

2、重大销售合同

序号	客户名称	销售内容	合同金额（万元）	合同签订时间	履行情况

序号	客户名称	销售内容	合同金额（万元）	合同签订时间	履行情况
1	拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司	RPS	1,067.85	2024年10月	履行完毕
2	中微半导体（上海）有限公司	射频电源	2,352.69	2024年1月	履行完毕
3	中微半导体（上海）有限公司	射频电源	1,288.38	2024年3月	**履行完毕**
4	中微半导体（上海）有限公司	射频电源	7,568.97	2024年6月	履行完毕
5	中微半导体（上海）有限公司	射频电源、RPS	以实际履行金额为准[注]	2025年4月	履行完毕
6	中微半导体（上海）有限公司	射频电源	以实际履行金额为准[注]	2025年4月	履行完毕
7	中微半导体（上海）有限公司	射频电源	以实际履行金额为准[注]	2025年5月	履行完毕
8	中微半导体（上海）有限公司	射频电源	以实际履行金额为准[注]	2025年5月	**履行完毕**
9	中微半导体（上海）有限公司	射频电源	以实际履行金额为准[注]	2025年7月	**履行完毕**
10	中微半导体（上海）有限公司	射频电源	5,601.64	2023年11月	履行完毕
11	中微半导体（上海）有限公司	射频电源	3,493.62	2024年2月	履行完毕
12	中微半导体（上海）有限公司	射频电源	3,493.62	2024年3月	履行完毕
13	客户C	射频电源	1,000.00	2025年4月	履行完毕
14	**中微半导体（上海）有限公司**	**高压脉冲电源系统**	**1,446.40**	**2026年1月**	**履行完毕**
15	**客户C**	**以实际订单为准**	**6,199.09**	**2026年3月**	**正在履行**

注：截至报告期末，上表中“合同金额”为“以实际履行金额为准”的合同项下的履行金额均已超过人民币1,000万元。

（二）采购合同

截至2026年6月30日，发行人与报告期各期前五大供应商签订的已履行完毕或正在履行的主要采购框架协议或与其签订的合同金额在 500 万元及以上的采购合同如下：

1、重大采购框架协议

序号	供应商名称	采购内容	合同期限	履行情况
1	南京恒经通电子科技有限公司	与发行人产品相关的零部件，以实际订单为准	2025年9月至2026年9月，无任何一方提前3个月书面提出终止的情况下每年自动连续生效	正在履行
2	**北京艾兰科技有限公司**	**发行人产品相关的零部件，以实际订单为准**	**2025年12月至2026年12月，无任何一方提前3个月书面提出终止的情况下每年自动连续生效。**	**正在履行**

2、重大采购合同

序号	供应商名称	采购内容	合同金额（万元）	合同签订时间	履行情况
1	**成懋半导体科技（苏州）有限公司**	电源	587.60	2024 年 12 月	履行完毕
2	**成懋半导体科技（苏州）有限公司**	电源	601.16	2025 年 2 月	履行完毕
3	康姆艾德机械设备（上海）有限公司	真空电容	600.76	2024 年 11 月	履行完毕
4	苏州智嘉进出口贸易有限公司	电源	710.00	2023 年 4 月	履行完毕
5	**康姆艾德机械设备（上海）有限公司**	**真空电容**	**874.89**	**2025 年 12 月**	**正在履行**
6	**北京艾兰科技有限公司**	**仪器设备**	**863.60**	**2025 年 12 月**	**履行完毕**

（三）授信、借款合同

报告期内，发行人无履行完毕或正在履行的金额在 2,000 万元及以上的重大借款合同。

报告期内，发行人履行完毕或正在履行的金额在 2,000 万元及以上的重大授信如下所示：

序号	受信人	授信银行	授信额度（万元）	授信期限	是否履行完毕	担保情况
1	神州半导体	中国工商银行股份有限公司扬州分行营业部	7,700.00	2025.12.1-2026.9.30	否	--
2	神州半导体	中国工商银行股份有限公司扬州分行营业部	5,000.00	2024.12.1-2025.4.30	是	--
3	神州半导体	中国建设银行股份有限公司扬州邗江支行	8,500.00	2024.6.7-2025.6.7	是	--

（四）其他重大合同

1、建筑工程合同

报告期内，公司履行完毕或正在履行的金额在 2,000 万元及以上的建设工程施工合同情况如下：

序号	承包方	工程内容	合同金额（万元）	签署日期	履行状态
1	江苏扬州建工建设集团有限公司	半导体专用设备制造和维修项目（一期）工程总承包	8,145.43	2024 年 10 月	正在履行

二、对外担保

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司不存在对外担保情况。

三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景以及本次发行上市有实质性影响的重大诉讼、仲裁案件。

四、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人可能对公司产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

第十一节 声明

一、发行人及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事：

朱培文　　陈觉晓　　丁书龙

郭正　　陈卓　　WEI CHEN（陈伟）

江希和

审计委员会成员：

陈卓　　WEI CHEN（陈伟）　　江希和

非董事高级管理人员：

朱国俊　　徐秀云　　丁昊

江苏神州半导体科技股份有限公司

2026年 9月 28日

第十一节 声明

一、发行人及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事：

朱培文	陈觉晓	丁书龙
郭正	陈卓	WEI CHEN（陈伟）
江希和		

审计委员会成员：

陈卓	WEI CHEN（陈伟）	江希和

非董事高级管理人员：

朱国俊	徐秀云	丁昊

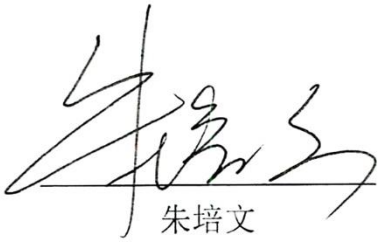
江苏神州半导体科技股份有限公司

2026 年 9 月 28 日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司（或本人）承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人：



朱培文

2026年9月28日

三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

史浩博

保荐代表人：

程万里

解明天

法定代表人（董事长）：

朱 健

国泰海通证券股份有限公司

2026 年 9 月 28 日

四、保荐人（主承销商）董事长、总经理声明

本人已认真阅读江苏神州半导体科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理（总裁）：_____

朱 健（代）

法定代表人（董事长）：_____

朱 健

国泰海通证券股份有限公司

2026 年 4 月 28 日

律师声明

本所及经办律师已阅读《江苏神州半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

单位负责人：

龚牧龙

经办律师：

陈复安　　单颖之　　王安荣

北京市金杜律师事务所

2026 年 9 月 28 日

六、承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读江苏神州半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（以下简称“招股说明书”），确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。

本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

潘 坤

廖 蕊

周心喆

会计师事务所负责人：

刘 维

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年 2月 28日

七、承担评估业务的资产评估机构声明

本机构及签字评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

签字资产评估师：

正式执业会员 资产评估师 刘国帅 32200040

刘国帅

正式执业会员 资产评估师 刘磊 32200056

刘磊

资产评估机构负责人：

王健青

厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司

2026 年 9 月 28 日

八、承担验资业务的机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读江苏神州半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（以下简称“招股说明书”），确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。

本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

潘 坤

廖 蕊

周心喆

会计师事务所负责人：

刘 维

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年 9月28日

第十二节 附件

一、备查文件

（一）发行保荐书；

（二）上市保荐书；

（三）法律意见书；

（四）财务报告及审计报告；

（五）公司章程（草案）；

（六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；

（七）与投资者保护相关的承诺；

（八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项；

（九）内部控制审计报告；

（十）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；

（十一）股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明；

（十二）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；

（十三）募集资金具体运用情况；

（十四）子公司简要情况；

（十五）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查询时间及地点

查阅时间：除法定节假日以外的工作日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00

查阅地点：公司及保荐机构（主承销商）的住所

除以上查阅地点外，投资者可以登录证监会和证券交易所指定网站，查阅《招股说明书》正文及相关附件。

附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

一、发行人关于投资者关系的主要安排

（一）投资者沟通渠道的建立情况

公司董事会秘书为公司投资者关系管理的具体负责人。董事会办公室是公司投资者关系管理的职能部门，由董事会秘书领导，具体负责公司投资者关系管理事务。

（二）未来开展投资者关系管理的规划

公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律、法规、规章和规则及《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，进一步提升公司规范运作水平和透明度。

公司将不断提高公司投资者关系管理工作的专业性，加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，切实维护全体股东利益，特别是中小股东的利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（三）信息披露制度和流程

公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及部门规章的有关规定，制定了《信息披露管理制度》，对公司信息披露的披露内容、具体程序、保密措施等事项进行了详细规定，确保公司按照有关法律法规履行信息披露义务，加强信息披露的管理工作，明确信息披露的具体流程。

二、发行人股利分配决策程序

（一）发行后的股利分配政策及决策程序

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定和要求，为明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司

制订了《公司章程（草案）》《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后未来三年分红回报规划的议案》，公司发行上市后的利润分配政策具体如下：

（1）利润分配原则

公司分红回报规划结合公司实际情况，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，实行持续、稳定的利润分配政策。

（2）利润分配的形式

公司股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。公司将优先考虑采取现金方式分配股利；根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等合理因素，公司可采取股票或者现金、股票相结合的方式分配股利。

（3）股票股利的条件

在确保足额现金股利分配的前提下，考虑股东意愿和要求，公司可以另行增加股票股利分配和资本公积金转增，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。公司发放股票股利应满足以下条件：

1）公司经营情况良好；

2）公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益；

3）发放的现金股利与股票股利的比例符合公司章程的规定；

4）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的其他条件。

（4）现金分红的条件、比例和期间间隔

1）公司该年度或半年度实现的可分配利润的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2）公司累计可供分配的利润为正值；

3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出系指下列情形之一：

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币；

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以参照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序，提请股东会审议提高现金分红在本次利润分配中的最低比例。

（5）剩余未分配利润的用途

公司将审慎合理地使用剩余未分配利润，剩余未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以逐步扩大公司生产经营规模，促进公司业务快速发展和经营业绩持续增长，有计划有步骤地实现公司未来的发展目标，为公司股东提供更多回报。

（6）利润分配的决策机制与程序

公司董事会应于年度报告或半年度报告公布前，根据公司的利润分配规划和计划，结合公司当期的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜，制订公司年度或者半年度的利润分配预案，经董事会过半数以上表决通过。

独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

利润分配预案经上述程序审议后，由董事会报请股东会批准，利润分配预案应当由出席股东会的股东/股东代表所持表决权的过半数通过。股东会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（7）利润分配政策的调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反证券监管机构的规定，有关调整利润分配政策的议案经公司董事会审议通过后提交公司股东会批准，该议案须经出席股东会会议的股东/股东代表所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、股东投票机制的建立情况

发行人目前已按照证监会的有关规定建立了股东投票机制，其中公司章程中对累积投票制、征集投票权的相关安排等进行了约定。发行上市后，发行人将进一步建立完善的股东投票机制。发行人《公司章程（草案）》中股东投票机制的约定如下：

（一）累积投票机制

股东会就选举董事进行表决时，根据章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。前款所

称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。

（二）中小投资者单独计票机制

股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

（三）网络投票方式安排

股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

（四）征集投票权的相关安排

公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

附件二：与投资者保护相关的承诺

一、关于股份锁定的承诺

（一）控股股东、实际控制人及其配偶的承诺

1、控股股东、实际控制人、发行人董事、高级管理人员、核心技术人员朱培文承诺

一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

二、若本人所持的首发前股份在锁定期满后两年内减持的，该等股份的减持价格将不低于发行价；发行人上市后 6 个月内若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的首发前股份的锁定期限自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除权、除息事项，则上述发行价指发行人股票经调整后的价格。

三、发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月。

“届时所持股份”是指本人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份。

四、发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人将不会减持发行人股份。

五、上述股份锁定期届满后，在担任发行人董事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者

委托他人管理本人持有的发行人的股份。本人在任期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内继续遵守前述减持要求。

六、本人在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。

七、本人将及时向发行人报告本人持有的发行人股份及其变动情况。

八、如本人违反上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的实际收益（如有）归发行人所有。

2、控股股东、实际控制人朱培文配偶耿微承诺

一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

二、若本人所持的首发前股份在锁定期满后两年内减持的，该等股份的减持价格将不低于发行价；发行人上市后 6 个月内若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的首发前股份的锁定期限自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除权、除息事项，则上述发行价指发行人股票经调整后的价格。

三、发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月。

“届时所持股份”是指本人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份。

四、发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之

日起至发行人股票终止上市前，本人将不会减持发行人股份。

五、本人在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。

六、本人将及时向发行人报告本人持有的发行人股份及其变动情况。

七、如本人违反上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的实际收益（如有）归发行人所有。

（二）控股股东、实际控制人的一致行动人的承诺

1、控股股东、实际控制人的一致行动人众芯聚能承诺

一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

二、若本企业所持的首发前股份在锁定期满后两年内减持的，该等股份的减持价格将不低于发行价；发行人上市后 6 个月内若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有的首发前股份的锁定期限自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除权、除息事项，则上述发行价指发行人股票经调整后的价格。

三、发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本企业届时所持股份锁定期限 6 个月。

“届时所持股份”是指本企业上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份。

四、发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之

日起至发行人股票终止上市前，本企业将不会减持发行人股份。

五、本企业在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。

六、本企业将及时向发行人报告本企业持有的发行人股份及其变动情况。

七、如本企业违反上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的实际收益（如有）归发行人所有。

2、控股股东、实际控制人的一致行动人江苏信基及其控股股东承诺

控股股东、实际控制人的一致行动人江苏信基及其控股股东、发行人董事陈觉晓承诺如下：

一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

二、若本人/本企业所持的首发前股份在锁定期满后两年内减持的，该等股份的减持价格将不低于发行价；发行人上市后 6 个月内若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人/本企业持有的首发前股份的锁定期限自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除权、除息事项，则上述发行价指发行人股票经调整后的价格。

三、发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6 个月。

“届时所持股份”是指本人/本企业上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份。

四、发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规

定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人/本企业将不会减持发行人股份。

五、上述股份锁定期届满后，陈觉晓在担任发行人董事期间，在满足股份锁定承诺的前提下，陈觉晓每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；如陈觉晓出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份。陈觉晓在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内继续遵守前述减持要求。

六、本人/本企业在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。

七、本人/本企业将及时向发行人报告本人/本企业持有的发行人股份及其变动情况。

八、如本人/本企业违反上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的实际收益（如有）归发行人所有。

（三）其他持股 5%以上股东的承诺

除朱培文、众芯聚能、江苏信基外，其他持股 5%以上股东英特尔亚太承诺如下：

一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

二、本企业在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。

三、若届时法律法规和中国证监会、上海证券交易所对于持股 5%以上股东股份锁定期及减持事项有其他特别规定的，且本企业符合相关适用条件的，本企业上述股份锁定期及减持承诺按届时相关规定为准予以执行。

四、本企业承诺承担并赔偿因违反上述承诺或相关法律法规及规范性文件的

规定而给发行人及其控制的企业造成的一切损失，由此导致的法律后果均由本企业自行承担。

（四）发行人申报前十二个月内新增股东的承诺

1、产发正德承诺

一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

二、就本企业在发行人本次发行上市前取得的 37.5 万股股份，自完成增资扩股工商变更登记手续之日（即 2025 年 12 月 22 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有该部分股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

三、本企业在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。

四、本企业承诺承担并赔偿因违反上述承诺或相关法律法规及规范性文件的规定而给发行人及其控制的企业造成的一切损失，由此导致的法律后果均由本企业自行承担。

2、丰泉创投承诺

一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

二、就本企业在发行人本次发行上市前取得的 51.5625 万股股份，自完成增资扩股工商变更登记手续之日（即 2025 年 12 月 22 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有该部分股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

三、本企业在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。

四、本企业承诺承担并赔偿因违反上述承诺或相关法律法规及规范性文件的

规定而给发行人及其控制的企业造成的一切损失，由此导致的法律后果均由本企业自行承担。

3、光创基金承诺

一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

二、就本企业在发行人本次发行上市前取得的 18.75 万股股份，自完成增资扩股工商变更登记手续之日（即 2025 年 12 月 22 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有该部分股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

三、本企业在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。

四、本企业承诺承担并赔偿因违反上述承诺或相关法律法规及规范性文件的规定而给发行人及其控制的企业造成的一切损失，由此导致的法律后果均由本企业自行承担。

4、华海金浦承诺

一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

二、就本企业在发行人本次发行上市前取得的 37.5 万股股份，自完成增资扩股工商变更登记手续之日（即 2025 年 12 月 22 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有该部分股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

三、本企业在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。

四、本企业承诺承担并赔偿因违反上述承诺或相关法律法规及规范性文件的规定而给发行人及其控制的企业造成的一切损失，由此导致的法律后果均由本企

业自行承担。

5、华虹二期基金承诺

一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

二、就本企业在发行人本次发行上市前取得的 90 万股股份，自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有该部分股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

三、本企业在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。

四、本企业承诺承担并赔偿因违反上述承诺或相关法律法规及规范性文件的规定而给发行人及其控制的企业造成的一切损失，由此导致的法律后果均由本企业自行承担。

6、嘉兴脉波承诺

一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

二、就本企业在发行人本次发行上市前取得的 75 万股股份，自完成增资扩股工商变更登记手续之日（即 2025 年 12 月 22 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有该部分股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

三、本企业在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。

四、本企业承诺承担并赔偿因违反上述承诺或相关法律法规及规范性文件的规定而给发行人及其控制的企业造成的一切损失，由此导致的法律后果均由本企业自行承担。

7、金资创兴承诺

一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

二、就本企业在发行人本次发行上市前取得的 43.125 万股股份，自完成增资扩股工商变更登记手续之日（即 2025 年 12 月 22 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有该部分股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

三、本企业在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。

四、本企业承诺承担并赔偿因违反上述承诺或相关法律法规及规范性文件的规定而给发行人及其控制的企业造成的一切损失，由此导致的法律后果均由本企业自行承担。

8、精选基金承诺

一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

二、就本企业在发行人本次发行上市前取得的 18.75 万股股份，自完成增资扩股工商变更登记手续之日（即 2025 年 12 月 22 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有该部分股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

三、本企业在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。

四、本企业承诺承担并赔偿因违反上述承诺或相关法律法规及规范性文件的规定而给发行人及其控制的企业造成的一切损失，由此导致的法律后果均由本企业自行承担。

9、拓荆芯链承诺

一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

二、就本企业在发行人本次发行上市前取得的 51.5625 万股股份，自完成增资扩股工商变更登记手续之日（即 2025 年 12 月 22 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有该部分股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

三、本企业在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。

四、本企业承诺承担并赔偿因违反上述承诺或相关法律法规及规范性文件的规定而给发行人及其控制的企业造成的一切损失，由此导致的法律后果均由本企业自行承担。

10、扬州产发华映承诺

一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

二、就本企业在发行人本次发行上市前取得的 56.25 万股股份，自完成增资扩股工商变更登记手续之日（即 2025 年 12 月 22 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有该部分股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

三、本企业在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。

四、本企业承诺承担并赔偿因违反上述承诺或相关法律法规及规范性文件的规定而给发行人及其控制的企业造成的一切损失，由此导致的法律后果均由本企业自行承担。

11、长存产业基金承诺

一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

二、就本企业在发行人本次发行上市前取得的 210 万股股份，自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有该部分股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

三、本企业在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。

四、本企业承诺承担并赔偿因违反上述承诺或相关法律法规及规范性文件的规定而给发行人及其控制的企业造成的一切损失，由此导致的法律后果均由本企业自行承担。

12、智微厚德承诺

一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

二、就本企业在发行人本次发行上市前取得的 7.284 万股股份，自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有该部分股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

三、就本企业在发行人本次发行上市前取得的 22.5 万股股份，自完成增资扩股工商变更登记手续之日（即 2025 年 12 月 22 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有该部分股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

四、本企业在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。

五、本企业承诺承担并赔偿因违反上述承诺或相关法律法规及规范性文件的

规定而给发行人及其控制的企业造成的一切损失，由此导致的法律后果均由本企业自行承担。

13、智微攀峰承诺

一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

二、就本企业在发行人本次发行上市前取得的 60.612 万股股份，自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有该部分股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

三、就本企业在发行人本次发行上市前取得的 187.5 万股股份，自完成增资扩股工商变更登记手续之日（即 2025 年 12 月 22 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有该部分股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

四、本企业在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。

五、本企业承诺承担并赔偿因违反上述承诺或相关法律法规及规范性文件的规定而给发行人及其控制的企业造成的一切损失，由此导致的法律后果均由本企业自行承担。

（五）持有发行人股份的董事、高级管理人员及核心技术人员的承诺

1、董事丁书龙，高级管理人员徐秀云、朱国俊、丁昊承诺

一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

二、上述股份锁定期届满后，在担任发行人董事、高级管理人员期间，本人每年转让的持有的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，不转让本人持有的发行人的股份。本人在任期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内继

续遵守前述减持要求。

三、本人将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、高级管理人员的义务，并如实、及时向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情况；本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

四、如本人违反上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的实际收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本人自行承担。

2、核心技术人员叶剑承诺

一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

二、本人作为发行人的核心技术人员，自所持首发前股份限售期届满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持发行人首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；本人自离职后 6 个月内，亦不转让或者委托他人管理本人所持有的首发前股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

三、本人将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于核心技术人员的持股及股份变动的有关规定，并如实、及时向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情况；本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

四、如本人违反上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的实际收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本人自行承担。

（六）发行人其他股东的承诺

持有公司股份的其他股东大基金二期、中微半导体、宜兴高易、上海岩泉和浦宸基金，承诺如下：

一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发

前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。

二、本企业在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。

三、本企业承诺承担并赔偿因违反上述承诺或相关法律法规及规范性文件的规定而给发行人及其控制的企业造成的一切损失，由此导致的法律后果均由本企业自行承担。

二、关于持股意向及减持意向的承诺

（一）实际控制人朱培文、一致行动人众芯聚能的承诺

实际控制人朱培文、一致行动人众芯聚能就持股意向及减持意向作出如下承诺：

一、本人/本企业持续看好发行人业务发展前景，拟长期持有发行人股份。

二、对于本次发行上市前所持有的发行人股份，本人/本企业将严格遵守已作出的关于股份锁定的相关承诺，在锁定期内不出售本次发行上市前持有的发行人股份。

三、在所持发行人股份的锁定期届满后 24 个月内，本人/本企业拟减持发行人股份的，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价（若发行人在本次发行上市后发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价按照规定作相应调整），并在满足本人/本企业已作出各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定。

四、本人/本企业将根据相关法律、法规、规章及证券交易所监管规则等规范性文件的规定进行减持，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

五、本人/本企业在锁定期届满后减持发行人股份的，将严格按照相关法律、法规、规章及证券交易所监管规则等规范性文件的规定及时、准确地履行必要的信息披露义务。

六、若届时法律法规和中国证监会、上海证券交易所对股份锁定期及减持事

项有其他特别规定的，且本人/本企业符合相关适用条件的，本人/本企业上述股份锁定期及减持承诺按届时相关规定为准予以执行。

七、如本人/本企业违反上述承诺，本人/本企业将依法承担相应责任。如因本人/本企业未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本人/本企业将向发行人或其投资者依法予以赔偿，并承担有关法律、法规、规范性文件及监管部门规定的其他责任。

（二）控股股东、实际控制人的一致行动人江苏信基及其控股股东的承诺

控股股东、实际控制人的一致行动人江苏信基及其控股股东陈觉晓就持股意向及减持意向作出如下承诺：

一、本人/本企业持续看好发行人业务发展前景，拟长期持有发行人股份。

二、对于本次发行上市前所持有的发行人股份，本人/本企业将严格遵守已作出的关于股份锁定的相关承诺，在锁定期内不出售本次发行上市前持有的发行人股份。

三、在所持发行人股份的锁定期届满后 24 个月内，本人/本企业拟减持发行人股份的，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价（若发行人在本次发行上市后发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价按照规定作相应调整），并在满足本人/本企业已作出各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定。

四、本人/本企业将根据相关法律、法规、规章及证券交易所监管规则等规范性文件的规定进行减持，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

五、本人/本企业在锁定期届满后减持发行人股份的，将严格按照相关法律、法规、规章及证券交易所监管规则等规范性文件的规定及时、准确地履行必要的信息披露义务。

六、若届时法律法规和中国证监会、上海证券交易所对股份锁定期及减持事项有其他特别规定的，且本人/本企业符合相关适用条件的，本人/本企业上述股份锁定期及减持承诺按届时相关规定为准予以执行。

七、如本人/本企业违反上述承诺，本人/本企业将依法承担相应责任。如因本人/本企业未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本人/本企业将向发行人或其投资者依法予以赔偿，并承担有关法律、法规、规范性文件及监管部门规定的其他责任。

（三）其他持股 5%以上股东的承诺

除朱培文、众芯聚能、江苏信基外，其他持股 5%以上股东英特尔亚太承诺如下：

一、对于本次发行上市前所持有的发行人股份，本企业将严格遵守已作出的关于股份锁定的相关承诺，在锁定期内不出售本次发行上市前持有的发行人股份。

二、在所持发行人股份的锁定期届满后 24 个月内，本企业拟减持发行人股份的，减持价格不低于届时法律、法规及规范性文件规定的价格下限，并在满足本企业已作出各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定。

三、本企业将根据相关法律、法规、规章及证券交易所监管规则等规范性文件的规定进行减持，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

四、本企业在锁定期届满后减持发行人股份的，将严格按照相关法律、法规、规章及证券交易所监管规则等规范性文件的规定及时、准确地履行必要的信息披露义务。

五、若届时法律法规和中国证监会、上海证券交易所对股份锁定期及减持事项有其他特别规定的，且本企业符合相关适用条件的，本企业上述股份锁定期及减持承诺按届时相关规定为准予以执行。

六、如本企业违反上述承诺，本企业将依法承担相应责任。如因本企业未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本企业将向发行人或其投资者依法予以赔偿，并承担有关法律、法规、规范性文件及监管部门规定的其他责任。

三、稳定股价的措施和承诺

公司、控股股东、实际控制人朱培文、全体董事（独立董事及未在公司领取

薪酬的外部董事除外）及高级管理人员就股票上市后稳定股价的措施作出如下承诺：

一、启动稳定股价措施的条件

（一）启动条件：如果公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内股价出现连续 20 个交易日收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数，如果公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等除权、除息事项或者因其他原因导致公司净资产或股份总数发生变化的，则相关的计算对比方法按照证券交易所的有关规定或者其他适用的规定做调整处理，下同）的情况时，公司将按照顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购股票；（2）控股股东增持股票；（3）董事和高级管理人员增持股票。

（二）停止条件：在以下稳定股价具体措施的实施期间内，若（1）公司股票连续 3 个交易日的收盘价均高于公司上一年期末经审计的每股净资产（上一年期末审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；（2）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件；（3）各相关主体在连续 12 个月内购买股份的数量或用于购买股份的数量的金额已达到上限，将停止实施股价稳定措施。

二、稳定股价的具体措施

（一）公司稳定股价的措施

当触发上述股价稳定措施的启动条件时，在确保公司股权分布符合上市条件以及不影响公司正常生产经营的前提下，公司应依照《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后，向社会公众股东回购股份。

公司应在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内召开董事会审议公司回购股份的议案，议案须经公司董事会全体董事过半数表决通过，并在董事会做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、有关议案及召开股东会的通知。回购股份的

议案应包括拟回购股份的价格或价格区间、股份数量、回购期限以及届时有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所相关规定应包含的其他信息。公司股东会对回购股份的议案做出决议，须经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过，该等股份回购议案经股东会审议通过后，公司将依法通知债权人，并报相关监管机构审批或备案以后实施（如需）。在完成必要的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股票回购方案。

公司为稳定股价之目的通过回购股份议案的，回购公司股份的数量、金额应当符合以下条件：

公司单次用于回购股份数量最大限额为公司股本总额的 1%，如公司单次回购股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则公司继续进行回购，12 个月内累计回购股份数量不超过公司股份总数的 2%。

超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

（二）控股股东稳定股价的措施

当公司回购股份方案实施期限届满之日后公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施公司回购股份的股价稳定措施时，公司控股股东应启动通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份的方案：

1、公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持，并承诺就公司稳定股价方案以其所拥有的全部表决票数在股东会上投赞成票。

2、控股股东应在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内，将其增持公司股份的具体计划书面通知公司并由公司公告。控股股东应在稳定股价方案公告后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。

3、公司控股股东为稳定股价之目的增持公司股份的，增持公司股份的数量、金额应当符合以下条件：

（1）连续 12 个月内控股股东增持公司股份的累计资金金额不超过控股股东上一年度获得的公司税后现金分红金额的 50%；

（2）连续 12 个月内累计增持股份数量不超过公司股份总数的 2%。若本项要求与第（1）项矛盾的，以本项为准。

超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

（三）董事、高级管理人员稳定股价的措施

当公司启动股价稳定措施并且控股股东增持股份方案实施期限届满之日后公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施控股股东增持股份的股价稳定措施时，董事、高级管理人员应启动通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份的方案：

1、董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持，并承诺就公司稳定股价方案以其董事身份（如有）在董事会上投赞成票。

2、上述负有增持义务的董事、高级管理人员应在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内，将其增持公司股份的具体计划书面通知公司并由公司公告。该等董事、高级管理人员应在稳定股价方案公告后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。

3、除不可抗力外，上述负有增持义务的董事、高级管理人员为稳定股价之目的增持公司股份的，增持公司股份的数量、金额应当符合以下条件：

自上述股价稳定措施启动条件成就之日起一个会计年度内，董事、高级管理人员增持公司股票的资金金额不低于其上年度从公司领取的税后现金分红（如有）、薪酬和津贴合计金额的 10%，但不超过 30%。

超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预

案。

4、在《稳定股价的预案》有效期内，新聘任的符合上述条件的董事和高级管理人员应当遵守《稳定股价的预案》关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定。公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成新聘任的该等董事、高级管理人员遵守《稳定股价的预案》，并在其获得书面提名前签署相关承诺。

（四）其他稳定股价的措施

1、符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所相关规定并保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东会审议同意，公司可通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价；

2、符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所相关规定前提下，公司可通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价；

3、法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的以及中国证监会、证券交易所认可的其他稳定股价的措施。

三、约束措施

（一）公司未履行稳定股价承诺的约束措施

如公司未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、行政法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东会审议，尽可能地保护公司投资者利益。

（二）控股股东未履行稳定股价承诺的约束措施

如控股股东未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因。如非因不可抗力导致，应同意在履行完毕相关承诺前暂不领取公司分配利润中归属于控股股东的部分，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，尽快研究将投资者利益损失降低

到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。

（三）董事、高级管理人员未履行稳定股价承诺的约束措施

如上述负有增持义务的董事、高级管理人员未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因。如非因不可抗力导致，应调减或停发董事、高级管理人员薪酬和/或津贴，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。

四、关于构成欺诈发行时购回股份的承诺

（一）发行人承诺

发行人作出承诺如下：

一、本公司保证本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形。

二、如本公司不符合法律、法规、规范性文件规定的发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门认定并生效后 5 个工作日内启动股份回购程序，回购本公司本次发行上市公开发行的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。在实施上述股份回购时，如法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券监管规则、公司章程等另有规定的从其规定。

三、如本公司未履行上述承诺，应在中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉，同时按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的法律责任。

（二）控股股东、实际控制人承诺

控股股东、实际控制人朱培文作出承诺如下：

一、本人保证发行人本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形。

二、如发行人不符合法律、法规、规范性文件规定的发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证券监督管理委员会等有权部门认定并生效后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次发行上市公

开发行的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。在实施上述股份回购时，如法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券监管规则、公司章程等另有规定的从其规定。

三、如本人未履行上述承诺，应在中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉，同时按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的法律责任。

五、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

（一）发行人承诺

发行人作出承诺如下：

一、本公司承诺本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

二、若招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺诈手段骗取发行注册的情形，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所或其他有权部门作出最终认定后，依法赔偿投资者损失。

三、若中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定招股说明书及其他信息披露资料所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股：

（一）在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段，自中国证监会、上海证券交易所或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 5 个工作日内，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股；

（二）在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股

已完成上市交易之后，自中国证监会、上海证券交易所或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 10 个工作日内，公司董事会将启动股份回购有关的程序，依照所适用的法律、法规、规范性文件及公司章程等规定回购本次发行的全部股票，回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息或中国证监会认可的其他价格（本公司如有分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。

四、若违反本承诺，不及时进行回购或赔偿投资者损失的，本公司将在股东会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因；因不履行承诺造成股东及社会公众投资者损失的，本公司将依法进行赔偿。

（二）控股股东、实际控制人承诺

控股股东、实际控制人朱培文作出承诺如下：

一、发行人本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

二、若发行人招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺诈手段骗取发行注册的情形，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所或其他有权部门作出最终认定后，依法赔偿投资者损失。

三、若中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定招股说明书及其他信息披露资料所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用控股股东、实际控制人地位督促发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。

（三）董事、高级管理人员承诺

除控股股东、实际控制人朱培文外，发行人全体董事、高级管理人员作出承诺如下：

一、发行人本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责

任。

二、若因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，方式如下：

（1）若证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人首次公开发行股票招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股；

（2）在证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本人因此应当依法承担责任的，本人在收到该等认定书面通知后 30 个工作日（或证券监督管理部门或其他有权部门要求的其他期限）内，将推动发行人及其控股股东等相关主体启动赔偿投资者损失的相关工作。

六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

（一）发行人承诺

发行人作出承诺如下：

一、提升公司整体实力，扩大公司业务规模

公司本次发行上市后，公司的总资产将得到进一步提升，抗风险能力和综合实力明显增强，市场价值明显提升。公司将借助资本市场和良好的发展机遇，不断拓展主营业务规模，充分发挥公司在等离子体射频电源系统领域的优势，推动公司持续、健康、稳定发展。

二、完善公司治理水平，提升公司经营管理能力和盈利能力

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

此外，公司已建立了完善的内部控制体系，将在此基础上积极地、创造性地研究、优化、提升管理保障能力，完善并强化投资决策程序，进一步提高经营和管理水平，有效控制经营风险，提升公司整体盈利能力。

三、加快募集资金投资项目实施进度，加强募集资金管理

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，有利于提升公司的综合竞争力和盈利能力。本次募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目实施进度，尽快实现预期收益。同时，公司将根据《江苏神州半导体科技股份有限公司章程（草案）》《江苏神州半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的要求，加强募集资金管理，规范使用募集资金，以保证募集资金按照既定用途实现收益。

四、完善利润分配政策，强化投资者回报

公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，结合公司实际情况，为明确对公司股东权益分红的回报，进一步细化了《江苏神州半导体科技股份有限公司章程（草案）》中关于股利分配原则的条款，并制定了《江苏神州半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后未来三年分红回报规划》。公司将严格执行利润分配政策，在符合分配条件的情况下，积极实施对股东的利润分配，优化投资回报机制。

（二）控股股东、实际控制人的承诺

控股股东、实际控制人朱培文承诺如下：

一、本人将严格执行关于上市公司治理的各项法律、法规及规章制度，保护发行人及其股东的合法利益，不越权干预发行人的经营管理活动。

二、本人承诺不以任何方式侵占发行人的利益，并遵守相关法律法规及规范性文件的规定。

三、本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项。如果本人违反本人作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关法律法规履行解释、道歉等相应义务，并同意证券监督管理机构的监管措施或自律监管措施；给发行人或者发行人其他

股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。

（三）董事、高级管理人员的承诺

除控股股东、实际控制人朱培文外，发行人全体董事、高级管理人员作出承诺如下：

一、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。

二、本人承诺对职务消费行为进行约束，在职务消费过程中本着节约原则行事，不奢侈、不铺张浪费。

三、本人承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

四、本人承诺在自身职责和权限范围内，积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补即期回报的要求；支持公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守该等制度。

五、在发行人实施股权激励计划（如有）时，本人承诺在自身职责和权限范围内，积极支持股权激励的行权条件与发行人填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。

六、本人承诺将切实履行本人作出的有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担赔偿责任。

七、关于利润分配的承诺

（一）发行人承诺

发行人作出承诺如下：

一、为保护上市后中小投资者利益，本公司在本次发行上市的在审期间不进行现金分红。

二、本公司将严格遵守上市后适用的《公司章程（草案）》及附件议事规则以及《江苏神州半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后未来三年分红回报规划》及公司股东会审议通过的其他利润分配安排，切实保障投资者收益权。

三、如遇相关法律、法规和其他规范性文件修订的，本公司将及时根据该等修订调整公司利润分配政策并严格执行。如本公司未能依照本承诺严格执行利润分配政策的，本公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。

（二）控股股东、实际控制人的承诺

控股股东、实际控制人朱培文承诺如下：

一、根据上市后适用的《公司章程（草案）》及附件议事规则以及《江苏神州半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后未来三年分红回报规划》及发行人股东会审议通过的其他利润分配安排，督促相关方提出利润分配预案；

二、在审议发行人利润分配预案的股东会上，本人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；

三、督促发行人根据相关决议实施利润分配。

八、未履行承诺的约束措施

（一）发行人承诺

一、本公司保证将严格履行在本公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

二、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律法规、本公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

1、本公司将在股东会及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因；

2、对该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、高级管理人员调减或停发薪酬和/或津贴；

3、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东会审议；

4、如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。如该

等已违反的承诺仍可继续履行，本公司将继续履行该等承诺。

三、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律法规、本公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

1、在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；

2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。

（二）控股股东、实际控制人的承诺

控股股东、实际控制人朱培文承诺如下：

一、本人保证将严格履行在发行人上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

二、如本人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行公开承诺事项的，则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

1、本人将在股东会及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因；

2、若因本人未能履行公开承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者由此遭受的损失；

3、在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将暂不收取发行人所分配之红利或派发之红股；

4、如本人因未能履行公开承诺事项而获得经济收益的，该等收益归发行人所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付至发行人指定账户。

三、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律法规、发行人章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

1、在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；

2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资

者利益。

（三）董事、高级管理人员的承诺

除控股股东、实际控制人朱培文外，发行人全体董事、高级管理人员作出承诺如下：

一、本人保证将严格履行在发行人上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

二、如本人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行公开承诺事项的，则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

1、本人将在股东会及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因；

2、若因本人未能履行公开承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失的，本人自愿将本人在发行人上市当年从发行人所领取的全部薪酬和/或津贴（如有）依法对投资者先行进行赔偿，且本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式要求发行人为本人增加薪资或津贴；

3、在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将暂不收取发行人所分配之红利或派发之红股（如适用）；

4、如本人因未能履行公开承诺事项而获得经济收益的，该等收益归发行人所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付至发行人指定账户。

上述第 2 项不适用于未在公司领取薪酬和/或津贴的董事、高级管理人员；第 3 项不适用于未持有公司股份的董事、高级管理人员。

三、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律法规、发行人章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

1、在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。

九、关于避免同业竞争的承诺

（一）控股股东、实际控制人的承诺

控股股东、实际控制人朱培文承诺如下：

1、本人（含本人控制的除发行人及其控股企业以外的其他企业，下同）目前未以任何形式从事与发行人（含发行人直接或间接控制的企业，下同）主营业务构成竞争关系的业务或活动；发行人的资产完整，其资产、业务、人员、财务及机构均独立于本人。

2、自本函出具之日起，本人不会以任何形式从事与发行人主营业务构成竞争关系的业务或活动，或以任何形式支持除发行人以外的其他企业从事与发行人主营业务构成竞争关系的业务或活动。

3、自本函出具之日起，如本人将来不可避免地从事与发行人构成竞争关系的业务或活动，本人将主动或在发行人提出异议后，及时转让或终止前述业务或活动，发行人对该等业务享有优先受让权。

4、上述承诺在本人作为发行人控股股东、实际控制人期间持续有效。

（二）控股股东、实际控制人的一致行动人众芯聚能、江苏信基及其控股股东的承诺

控股股东、实际控制人的一致行动人众芯聚能、江苏信基及其控股股东陈觉晓承诺如下：

1、本人/本企业（含本人/本企业控制的除发行人及其控股企业以外的其他企业，下同）目前未以任何形式从事与发行人（含发行人直接或间接控制的企业，下同）主营业务构成竞争关系的业务或活动；发行人的资产完整，其资产、业务、人员、财务及机构均独立于本人/本企业。

2、自本函出具之日起，本人/本企业不会以任何形式从事与发行人主营业务构成竞争关系的业务或活动，或以任何形式支持除发行人以外的其他企业从事与发行人主营业务构成竞争关系的业务或活动。

3、自本函出具之日起，如本人/本企业将来不可避免地从事与发行人构成竞争关系的业务或活动，本人/本企业将主动或在发行人提出异议后，及时转让或

终止前述业务或活动，发行人对该等业务享有优先受让权。

4、上述承诺在本企业作为发行人控股股东、实际控制人的一致行动人、本人作为江苏信基控股股东期间持续有效。

十、关于规范和减少关联交易的声明与承诺

（一）控股股东、实际控制人的承诺

控股股东、实际控制人朱培文承诺如下：

1、在不对发行人及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本人将采取措施规范并尽量减少与发行人发生关联交易。

2、对于正常经营范围内或存在其他合理原因确需发生或无法避免的关联交易，本人及本人控制的其他企业将与发行人依法签订交易协议，并按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和届时有效的《公司章程》的规定履行批准程序，并保证该等关联交易均将基于公允定价的原则实施。

3、本人将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务，履行批准关联交易的法定审批程序和信息披露义务。

4、保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润或从事其他损害发行人及其他股东、债权人利益的行为。

（二）控股股东、实际控制人一致行动人、持股 5%以上股东众芯聚能、江苏信基及其控股股东的承诺

控股股东、实际控制人的一致行动人、持股 5%以上股东众芯聚能、江苏信基承诺如下：

1、在不对发行人及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本企业将采取措施规范并尽量减少与发行人发生关联交易。

2、对于正常经营范围内或存在其他合理原因确需发生或无法避免的关联交易，本企业及本企业控制的其他企业将与发行人依法签订交易协议，并按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和届时有效的《公司章程》的规定履行批准程序，并保证该等关联交易均将基于公允定价的原则实施。

3、本企业将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务，履行批准关联交易的法定审批程序和信息披露义务。

4、保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润或从事其他损害发行人及其他股东、债权人利益的行为。

控股股东、实际控制人的一致行动人、持股 5%以上股东江苏信基控股股东、发行人董事陈觉晓承诺如下：

1、在不对发行人及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本人将采取措施规范并尽量减少与发行人发生关联交易。

2、对于正常经营范围内或存在其他合理原因确需发生或无法避免的关联交易，本人及本人控制的其他企业将与发行人依法签订交易协议，并按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和届时有效的《公司章程》的规定履行批准程序，并保证该等关联交易均将基于公允定价的原则实施。

3、本人将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务，履行批准关联交易的法定审批程序和信息披露义务。

4、保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润或从事其他损害发行人及其他股东、债权人利益的行为。

（三）其他持股 5%以上股东的承诺

除朱培文、众芯聚能、江苏信基外，其他持股 5%以上股东英特尔亚太承诺如下：

1、本企业将采取措施规范与发行人发生关联交易，不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。

2、对于正常经营范围内或存在其他合理原因确需发生或无法避免的关联交易，本企业及本企业控制的其他企业将与发行人依法签订交易协议，并按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和届时有效的《公司章程》的规定履行批准程序，并保证该等关联交易均将基于公允定价的原则实施。

3、本企业将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务，履行批准关联交易的法定审批程序和信息披露义务。

4、保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润或从事其他损害发行人及其他股东、债权人利益的行为。

（四）董事、高级管理人员的承诺

除朱培文、陈觉晓外，发行人全体董事、高级管理人员作出承诺如下：

1、在不对发行人及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本人将采取措施规范并尽量减少与发行人发生关联交易。

2、对于正常经营范围内或存在其他合理原因确需发生或无法避免的关联交易，本人及本人控制的其他企业将与发行人依法签订交易协议，并按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和届时有效的《公司章程》的规定履行批准程序，并保证该等关联交易均将基于公允定价的原则实施。

3、本人将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务，履行批准关联交易的法定审批程序和信息披露义务。

4、保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润或从事其他损害发行人及其他股东、债权人利益的行为。

十一、关于避免资金占用和违规担保的承诺

发行人的控股股东、实际控制人朱培文承诺如下：

一、截至本函出具之日，不存在发行人或其控股企业的资金被本人及本人控制的其他企业非经营性占用的情况，也不存在发行人或其控股企业为本人及本人控制的其他企业违规提供担保的情形。

二、本人承诺依法行使股东权利，不滥用股东权利损害发行人或发行人其他股东的合法利益，本人及本人控制的其他企业不会以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式非法占用发行人或其控股企业的资金，不会要求发行人或其控股企业违规提供担保。

十二、关于股东信息披露的承诺

发行人承诺如下：

（一）公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息；

（二）公司历史沿革中曾存在股权代持的情形但已完成代持解除，截至本承诺出具之日，公司不存在股权代持情况；

（三）公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；

（四）除已在招股说明书中披露的情形以外，本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在其他直接或间接持有发行人股份的情形；

（五）公司的股东不存在以发行人股权进行不当利益输送情形；

（六）若公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。

十三、关于保持发行人资产、人员、财务、机构和业务独立的承诺函

控股股东、实际控制人朱培文承诺如下：

一、截至本承诺函签署日，本人及本人下属企业在资产、业务、人员、机构、财务等方面均与发行人相互独立，不存在与发行人共用资产或资产混同、相互参与业务开拓、发行人高级管理人员在本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领薪、与发行人机构混同等影响发行人独立性的情形。

二、2023 年 1 月 1 日至今，本人及本人控制的其他企业与发行人存在关联交易（如有），相关交易遵循市场化交易原则，系双方协商确定，交易价格公允。

三、截至本承诺函签署日，本人作为发行人控股股东在发行人股东会层面参与发行人重大事项的决策，不存在干预发行人采购、生产、销售、研发、财务、人事等日常经营决策的情形。

四、本人过去未曾且承诺未来亦不会利用股东表决权谋求不正当利益或作出不利于发行人而有利于本人及本人下属企业的任何决定，不会损害发行人及其他股东的合法权益。

五、本人保证将严格遵循相关法律法规和上海证券交易所及中国证监会的要求，确保发行人按照上市公司的规范独立自主经营，保证发行人的资产、业务、财务、人员、机构独立。

六、上述承诺在本人作为发行人控股股东、实际控制人期间持续有效。

附件三：股东会、董事会、审计委员会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

自整体改制为股份有限公司以来，公司按照《公司法》《证券法》并参照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及规章的要求，已建立并逐步完善由股东会、董事会、审计委员会和管理层组成的治理架构，并分别制定股东会、董事会和审计委员会的议事或工作规则，具体规定独立董事及董事会秘书的职责和权限，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调和制衡的治理机制，为公司的规范、高效运行提供了制度保证。具体运行情况如下：

一、股东会运行情况

公司恪守发行程序，规范运作，制定了《股东会议事规则》，股东严格按照《公司章程》和《股东会议事规则》的规定行使权利。历次股东会的会议通知、召开方式、表决方式、签署等程序及决议内容均符合《公司法》《公司章程》及相关议事规则的规定。自股份有限公司设立之日至本招股说明书签署日，公司共召开 4 次股东会。

二、董事会运行情况

（一）董事会的构成

公司制定了《董事会议事规则》，董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，比例不低于三分之一。董事由股东会选举或更换，任期 3 年，任期届满可连选连任。

（二）董事会的运行情况

自股份有限公司设立至本招股说明书签署日，董事会共召开 5 次会议。公司已制定了《董事会议事规则》，董事会运行规范。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利和履行义务。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与会董事不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

三、审计委员会运行情况

公司审计委员会自设立以来，严格按照《审计委员会工作规则》的规定召开会议，对公司的财务信息及其披露、内外部审计工作和内部控制等事项进行监督，并对公司内部控制、财务审计等相关事务进行讨论和决策，董事会审计委员会依法履行了权利和义务，运行情况良好。

四、独立董事制度的建立健全及履行职责情况

公司董事会设 3 名独立董事，比例不低于公司全体董事的三分之一。独立董事自聘任以来，依据有关法律、法规及《上市规则》《公司法》和《独立董事工作制度》谨慎、认真、勤勉地履行权利和义务，积极参与公司重大经营决策，对公司关联交易发表公允的独立意见，为公司完善治理结构和规范运作发挥了重要作用。

截至本招股说明书签署日，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

五、董事会秘书制度的建立健全及履行职责情况

公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。公司董事会秘书自任职以来，严格按照《公司章程》《董事会秘书工作制度》的相关规定筹备董事会和股东会，勤勉地履行职责。

六、公司治理存在的缺陷及改进情况

公司自设立以来，建立了符合《公司法》《证券法》及其他法律法规要求的公司治理结构。一方面，股东会、董事会、审计委员会和管理层之间建立了相互协调和相互制衡机制，独立董事和《独立董事工作制度》能够有效增强董事会决策的公正性和科学性。另一方面，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，健全了董事会的审计评价、监督制度和薪酬管理制度等，充分发挥各专门委员会的作用。

综上，公司建立健全了由公司股东会、董事会、审计委员会和管理层组成的符合发行上市要求的公司治理结构，为公司高效发展提供了制度保障，不存在重大缺陷。

附件四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

为进一步完善公司治理结构，强化董事会的规范运作、科学决策能力和风险防范能力，确保董事会对管理层的有效监督，公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会其他有关规定，在董事会下设提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构，对董事会负责。各专门委员会的提案提交董事会审议决定。

截至本招股说明书签署日，公司董事会四个专门委员会组成人员具体如下：

董事会专门委员会	主任委员	其他委员
战略委员会	朱培文	陈觉晓、郭正
审计委员会	江希和	陈卓、WEI CHEN（陈伟）
提名委员会	WEI CHEN（陈伟）	陈卓、朱培文
薪酬与考核委员会	陈卓	江希和、朱培文

各专门委员会建立以来，均按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其工作细则等规定规范运作，各委员勤勉尽职履行相应的权利和义务，各专门委员会的建立和有效运行在公司治理过程中发挥了积极的作用。各委员会的主要职责如下：

一、董事会战略委员会

战略委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，主要行使下列职权：

（一）审议公司总体发展战略规划和各专项发展战略规划，并向董事会提出建议；

（二）评估公司各类业务的总体发展状况，并向董事会及时提出发展战略规划调整建议；

（三）审议公司的经营计划、投资和融资方案，并向董事会提出建议；

（四）监督、检查公司经营计划和投资方案的执行情况；

（五）评估公司的治理状况，并向董事会提出建议；

（六）法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定以及董事会授权

的其他事宜。

二、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定以及董事会授权的其他事宜。

三、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

四、审计委员会

公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告和定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所自律规则和《公司章程》规定的其他事项。

附件五：发行人及其子公司拥有的土地使用权清单

截至本招股说明书签署日，公司已取得权利证书且与生产经营相关的主要土地使用权 2 宗，具体如下：

序号	权利人	不动产权证书编号	坐落	建筑面积（㎡）	土地面积（㎡）	权利性质	用途	使用期限	取得方式	他项权利
1	神州半导体	**苏（2026）扬州市不动产权第 0069983 号**	维扬经济开发区，东至纵二路规划道路红线，南至司徒庙路，西至江苏东博汽车电子配件有限公司用地边界，北至扬州德衡数码有限公司用地边界	/	66,805	出让	工业用地	2024.07.18-2074.07.17	受让取得	无
2	神州半导体	**苏（2026）扬州市不动产权第 0070487 号**	蜀岗西路 19 号	12,092.52	17,644.14	出让/**自建房**	工业用地/工业	2057 年 6 月 30 日止	受让取得	无

附件六：发行人及其子公司拥有或使用的商标清单

截至报告期末，发行人及其子公司已取得 35 项中国境内注册商标，具体如下：

序号	商标权人	商标图像	注册号	类别	申请日	有效期	取得方式	他项权利
1	神州半导体		84179138	9	2025.03.20	2025.10.07-2035.10.06	原始取得	无
2	神州半导体		84169580	35	2025.03.20	2025.10.14-2035.10.13	原始取得	无
3	神州半导体		84181954	9	2025.03.20	2025.10.07-2035.10.06	原始取得	无
4	神州半导体		84178035	35	2025.03.20	2025.10.07-2035.10.06	原始取得	无
5	神州半导体	SZSTEVAN	79948882	35	2024.07.23	2025.02.07-2035.02.06	原始取得	无
6	神州半导体	SZSTETHEL	79956085	9	2024.07.23	2025.02.07-2035.02.06	原始取得	无

序号	商标权人	商标图像	注册号	类别	申请日	有效期	取得方式	他项权利
7	神州半导体	SZSTN0RAH	79957253	35	2024.07.23	2025.02.07-2035.02.06	原始取得	无
8	神州半导体	SZSTETHEL	79948892	35	2024.07.23	2025.02.07-2035.02.06	原始取得	无
9	神州半导体	SZSTEVAN	79951936	9	2024.07.23	2025.02.07-2035.02.06	原始取得	无
10	神州半导体	SZSTN0RAH	79950731	9	2024.07.23	2025.01.28-2035.01.27	原始取得	无
11	神州半导体	MAJOR	69310030	35	2023.01.29	2024.01.21-2034.01.20	原始取得	无
12	神州半导体	PILOTAGE	69303221	35	2023.01.29	2023.10.14-2033.10.13	原始取得	无
13	神州半导体	ADVOCATE	69306843	9	2023.01.29	2023.07.14-2033.07.13	原始取得	无

序号	商标权人	商标图像	注册号	类别	申请日	有效期	取得方式	他项权利
14	神州半导体	PILOTAGE	69310366	9	2023.01.29	2024.01.07-2034.01.06	原始取得	无
15	神州半导体	VENUS	68496056	9	2022.11.22	2023.12.07-2033.12.06	原始取得	无
16	神州半导体	HALATION	68478876	35	2022.11.22	2023.08.21-2033.08.20	原始取得	无
17	神州半导体	MIRACLE	68478694	9	2022.11.22	2023.09.14-2033.09.13	原始取得	无
18	神州半导体	HALATION	68498863	9	2022.11.22	2023.09.14-2033.09.13	原始取得	无
19	神州半导体	SZST	67512390	42	2022.09.29	2023.08.14-2033.08.13	原始取得	无
20	神州半导体		67526262	7	2022.09.29	2023.08.21-2033.08.20	原始取得	无

序号	商标权人	商标图像	注册号	类别	申请日	有效期	取得方式	他项权利
21	神州半导体	HALATION	67524755	7	2022.09.29	2023.06.14-2033.06.13	原始取得	无
22	神州半导体	SZST	67503797	35	2022.09.29	2023.06.14-2033.06.13	原始取得	无
23	神州半导体	SZST	67499664	37	2022.09.29	2023.06.14-2033.06.13	原始取得	无
24	神州半导体	SZST	67516964	7	2022.09.29	2023.06.14-2033.06.13	原始取得	无
25	神州半导体		67508405	35	2022.09.29	2023.08.14-2033.08.13	原始取得	无
26	神州半导体		67529509	42	2022.09.29	2023.08.21-2033.08.20	原始取得	无
27	神州半导体		67507570	37	2022.09.29	2023.08.14-2033.08.13	原始取得	无

序号	商标权人	商标图像	注册号	类别	申请日	有效期	取得方式	他项权利
28	神州半导体	HALATION	67510673	9	2022.09.29	2023.08.21-2033.08.20	原始取得	无
29	神州半导体	HALATION	67504963	37	2022.09.29	2023.06.14-2033.06.13	原始取得	无
30	神州半导体	SZST	56709344	9	2021.06.07	2022.02.21-2032.02.20	原始取得	无
31	神州半导体		20947045	37	2016.08.11	2017.10.07-2027.10.06	原始取得	无
32	神州半导体		20946736	9	2016.08.11	2017.11.28-2027.11.27	原始取得	无
33	江苏芯越		67788087	42	2022.10.17	2023.07.14-2033.07.13	原始取得	无
34	江苏芯越		67770956	9	2022.10.17	2023.07.14-2033.07.13	原始取得	无

序号	商标权人	商标图像	注册号	类别	申请日	有效期	取得方式	他项权利
35	江苏芯越		67779151	40	2022.10.17	2023.05.07-2033.05.06	原始取得	无

附件七：发行人及其子公司拥有的专利权清单

一、发行人及其子公司在中国境内拥有的专利权

截至报告期末，发行人及其子公司已取得 127 项中国境内专利权，具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	有效期	取得方式	他项权利
1	神州半导体	高频升压电源的脉宽和容抗联合调压电路	发明授权	ZL201510493666.X	2015.08.13	2017.07.25	申请日起 20 年	继受取得	无
2	神州半导体	一种具有防尘功能的电源产品	发明授权	ZL201710679401.8	2017.08.10	2019.04.02	申请日起 20 年	继受取得	无
3	神州半导体	基于等离子环境的射频电源测试系统及测试方法	发明授权	ZL201711443387.8	2017.12.27	2019.12.13	申请日起 20 年	继受取得	无
4	神州半导体	射频电源模拟控制器	发明授权	ZL201711443475.8	2017.12.27	2020.12.15	申请日起 20 年	继受取得	无
5	神州半导体	一种射频电源的检测方法	发明授权	ZL201910200851.3	2019.03.17	2021.09.14	申请日起 20 年	原始取得	无
6	神州半导体	一种远程等离子源 RPS 腔体阳极氧化方法	发明授权	ZL202011565459.8	2020.12.25	2022.07.26	申请日起 20 年	继受取得	无
7	神州半导体	一种低压穿越电路及低压穿越方法	发明授权	ZL202310525125.5	2023.05.11	2023.08.08	申请日起 20 年	原始取得	无
8	神州半导体	一种可变电容驱动电机转矩控制方法及装置	发明授权	ZL202310564599.0	2023.05.19	2023.08.08	申请日起 20 年	原始取得	无
9	神州半导体	一种射频电源的智能控制方法及系统	发明授权	ZL202310049423.1	2023.02.01	2023.10.24	申请日起 20 年	原始取得	无
10	神州半导体	一种基于远程等离子源	发明授权	ZL202310139819.5	2023.02.20	2023.10.27	申请日起 20 年	原始取	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	有效期	取得方式	他项权利
		的表面清洁管理方法及系统						得	
11	神州半导体	一种等离子系统的点火电路结构及点火保护方法	发明授权	ZL202310766706.8	2023.06.26	2024.01.30	申请日起 20 年	原始取得	无
12	神州半导体	基于多线圈耦合的气体解离电路控制装置及系统	发明授权	ZL202210096379.5	2022.01.26	2024.02.09	申请日起 20 年	原始取得	无
13	神州半导体	基于射频环境的漏水检测告警方法	发明授权	ZL202410014358.3	2024.01.05	2024.03.08	申请日起 20 年	原始取得	无
14	神州半导体	一种射频电源的带载监测保护方法及系统	发明授权	ZL202410109610.9	2024.01.26	2024.03.29	申请日起 20 年	原始取得	无
15	神州半导体	远程等离子发生器的散热调节方法及系统	发明授权	ZL202410026090.5	2024.01.09	2024.03.29	申请日起 20 年	原始取得	无
16	神州半导体	用于远程等离子发生器的温控方法及系统	发明授权	ZL202410095649.X	2024.01.24	2024.04.09	申请日起 20 年	原始取得	无
17	神州半导体	一种远程等离子源拓扑结构及其控制方法	发明授权	ZL202311341984.5	2023.10.16	2024.04.12	申请日起 20 年	原始取得	无
18	神州半导体	一种远程等离子源的预激发点火装置及其控制方法	发明授权	ZL202311489136.9	2023.11.08	2024.05.28	申请日起 20 年	原始取得	无
19	神州半导体	一种远程等离子源预激发点火电路及自适应点火方法	发明授权	ZL202311624391.X	2023.11.30	2024.06.04	申请日起 20 年	原始取得	无
20	神州半导体	射频信号检测器	发明授权	ZL202111228977.5	2021.10.21	2024.06.14	申请日起 20 年	原始取得	无
21	神州半导体	模数转换单元、数模转	发明授权	ZL202311600004.9	2023.11.28	2024.06.14	申请日起 20 年	原始取	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	有效期	取得方式	他项权利
		换单元及信号传输电路						得	
22	神州半导体	一种射频电源功率快速调制方法	发明授权	ZL202311371929.0	2023.10.20	2024.06.25	申请日起 20 年	原始取得	无
23	神州半导体	一种等离子体腔室 arcing 的预测方法及装置	发明授权	ZL202410032425.4	2024.01.10	2024.07.02	申请日起 20 年	原始取得	无
24	神州半导体	一种射频电源的散热控制方法与系统	发明授权	ZL202410116843.1	2024.01.29	2024.07.09	申请日起 20 年	原始取得	无
25	神州半导体	一种用于 FPGA 控制系统中的电压限幅电路	发明授权	ZL202311223921.X	2023.09.21	2024.07.19	申请日起 20 年	原始取得	无
26	神州半导体	一种便于拆装散热的高功率合路器	发明授权	ZL202311298707.0	2023.10.09	2024.08.30	申请日起 20 年	原始取得	无
27	神州半导体	一种三相软启动与跌落保护拓扑结构	发明授权	ZL202410150869.8	2024.02.02	2024.09.27	申请日起 20 年	原始取得	无
28	神州半导体	真空陶瓷可调电容闭环控制系统	发明授权	ZL202111228978.X	2021.10.21	2024.10.22	申请日起 20 年	原始取得	无
29	神州半导体	一种 PCB 等离子体处理设备	发明授权	ZL202411055915.2	2024.08.02	2025.01.03	申请日起 20 年	原始取得	无
30	神州半导体	基于实时频谱分析的射频电源信号同步检测方法	发明授权	ZL202410856477.3	2024.06.28	2025.01.03	申请日起 20 年	原始取得	无
31	神州半导体	一种远程等离子发生器	发明授权	ZL202310421965.7	2023.04.19	2025.01.03	申请日起 20 年	原始取得	无
32	神州半导体	一种射频电源测试装置	发明授权	ZL202411060998.4	2024.08.05	2025.01.14	申请日起 20 年	原始取得	无
33	神州半导体	远程等离子源反应腔体温度控制电路及控制方	发明授权	ZL202410975328.9	2024.07.19	2025.01.21	申请日起 20 年	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	有效期	取得方式	他项权利
		法							
34	神州半导体	用于 TSV 刻蚀设备的智能控制方法	发明授权	ZL202411117967.8	2024.08.15	2025.02.11	申请日起 20 年	原始取得	无
35	神州半导体	一种射频电源的阻抗自适应匹配方法	发明授权	ZL202411122834.X	2024.08.15	2025.02.11	申请日起 20 年	原始取得	无
36	神州半导体	一种射频电源的自适应负载匹配方法及装置	发明授权	ZL202410848709.0	2024.06.27	2025.02.18	申请日起 20 年	原始取得	无
37	神州半导体	一种远程等离子体的磁芯散热温度调节方法及调节系统	发明授权	ZL202410967842.8	2024.07.18	2025.02.25	申请日起 20 年	原始取得	无
38	神州半导体	基于多维度参数验证的 TSV 刻蚀设备故障识别方法	发明授权	ZL202411185470.X	2024.08.27	2025.02.25	申请日起 20 年	原始取得	无
39	神州半导体	一种远程等离子源功率耦合电路及控制系统	发明授权	ZL202411065668.4	2024.08.05	2025.03.04	申请日起 20 年	原始取得	无
40	神州半导体	一种高端射频电源用的可调节高度的吊装蘑菇头装置	发明授权	ZL202411141505.X	2024.08.20	2025.03.21	申请日起 20 年	原始取得	无
41	神州半导体	一种功率控制器	发明授权	ZL202411096760.7	2024.08.12	2025.04.04	申请日起 20 年	原始取得	无
42	神州半导体	一种可快速拆卸的射频输出连接结构	发明授权	ZL202411141425.4	2024.08.20	2025.04.11	申请日起 20 年	原始取得	无
43	神州半导体	一种射频线加工设备及加工方法	发明授权	ZL202411420819.3	2024.10.12	2025.05.30	申请日起 20 年	原始取得	无
44	神州半导体	大功率高稳定性远程等离子源模糊滞环控制方法及电路	发明授权	ZL202510495168.2	2025.04.21	2025.07.01	申请日起 20 年	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	有效期	取得方式	他项权利
45	神州半导体	一种射频电源连接口快拆连接结构	发明授权	ZL202510572170.5	2025.05.06	2025.07.25	申请日起 20 年	原始取得	无
46	神州半导体	一种远程等离子体源的出气口水管故障诊断方法	发明授权	ZL202510644811.3	2025.05.20	2025.08.05	申请日起 20 年	原始取得	无
47	神州半导体	一种远程等离子源的点火控制方法	发明授权	ZL202510740220.6	2025.06.05	2025.08.05	申请日起 20 年	原始取得	无
48	神州半导体	一种远程等离子体源的出气口散热水管结构	发明授权	ZL202510644812.8	2025.05.20	2025.08.19	申请日起 20 年	原始取得	无
49	神州半导体	一种射频电源生产用放电检测设备	发明授权	ZL202510855872.4	2025.06.25	2025.08.26	申请日起 20 年	原始取得	无
50	神州半导体	一种远程等离子源石英腔体气泡消除控制方法及装置	发明授权	ZL202510837240.5	2025.06.23	2025.08.26	申请日起 20 年	原始取得	无
51	神州半导体	一种远程等离子源腔体氧化膜稳定性提升方法	发明授权	ZL202510837238.8	2025.06.23	2025.08.26	申请日起 20 年	原始取得	无
52	神州半导体	一种高功率等离子体结构用散热设备	发明授权	ZL202510896856.X	2025.07.01	2025.09.12	申请日起 20 年	原始取得	无
53	神州半导体	基于射频激励的远程等离子体稳定发生方法	发明授权	ZL202510991165.8	2025.07.18	2025.09.16	申请日起 20 年	原始取得	无
54	神州半导体	基于微波激励的远程等离子体密度均匀化调控方法	发明授权	ZL202511014218.7	2025.07.23	2025.09.23	申请日起 20 年	原始取得	无
55	神州半导体	一种射频电源测试及性能优化方法	发明授权	ZL202511022413.4	2025.07.24	2025.10.10	申请日起 20 年	原始取得	无
56	神州半导体	一种射频信号检波的调试方法	发明授权	ZL202511255117.9	2025.09.04	2025.11.11	申请日起 20 年	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	有效期	取得方式	他项权利
57	神州半导体	一种远程等离子源水蒸气供应系统及其控制方法	发明授权	ZL202510478124.9	2025.04.16	2025.11.21	申请日起 20 年	原始取得	无
58	神州半导体	一种考虑等离子体阻抗变化的功率变换系统特性优化方法	发明授权	ZL202511284601.4	2025.09.10	2025.11.21	申请日起 20 年	原始取得	无
59	神州半导体	一种多通道合路的功率测试系统及方法	发明授权	ZL202511358520.4	2025.09.23	2025.12.12	申请日起 20 年	原始取得	无
60	神州半导体	一种高功率直流电器设备检测方法	发明授权	ZL202511417163.4	2025.09.30	2025.12.12	申请日起 20 年	原始取得	无
61	神州半导体	一种远程等离子体源解离率检测方法	发明授权	ZL202511403537.7	2025.09.29	2025.12.12	申请日起 20 年	原始取得	无
62	神州半导体	等离子发生器的实时监控系统及方法	发明授权	ZL202411851858.9	2024.12.16	2025.12.26	申请日起 20 年	原始取得	无
63	**神州半导体**	**用于测试半导体薄膜塞贝克系数的基片及制备和测试方法**	**发明授权**	**ZL201710521188.8**	**2017.06.30**	**2020.03.13**	**申请日起 20 年**	**继受取得**	**无**
64	**神州半导体**	**一种远程等离子发生器**	**发明授权**	**ZL202510556443.7**	**2025.04.29**	**2026.04.21**	**申请日起 20 年**	**原始取得**	**无**
65	**神州半导体**	**等离子体源磁芯分层水冷热切换控制方法、系统及介质**	**发明授权**	**ZL202511605438.7**	**2025.11.05**	**2026.04.14**	**申请日起 20 年**	**原始取得**	**无**
66	**神州半导体**	**一种等离子体源预处理装置及反应物检测方法**	**发明授权**	**ZL202511902503.2**	**2025.12.17**	**2026.03.20**	**申请日起 20 年**	**原始取得**	**无**
67	**神州半导体**	**等离子体源功率反射功率调控方法、系统及设备**	**发明授权**	**ZL202511605439.1**	**2025.11.05**	**2026.03.13**	**申请日起 20 年**	**原始取得**	**无**

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	有效期	取得方式	他项权利
68	神州半导体	一种 RPS 解离率测试的电热吸附式尾气处理设备	发明授权	ZL202510644813.2	2025.05.20	2026.03.13	申请日起 20 年	原始取得	无
69	神州半导体	一种基于频率簇的等离子体源的控制系统及方法	发明授权	ZL202511902501.3	2025.12.17	2026.03.06	申请日起 20 年	原始取得	无
70	神州半导体	一种远程等离子源负载阻抗扰动保护控制方法及装置	发明授权	ZL202510740219.3	2025.06.05	2026.02.03	申请日起 20 年	原始取得	无
71	神州半导体	一种气体解离腔体放电结构及点火控制方法	发明授权	ZL202511467774.X	2025.10.15	2026.01.30	申请日起 20 年	原始取得	无
72	神州半导体	一种低复合率气体解离腔体结构	发明授权	ZL202511516271.7	2025.10.23	2026.01.30	申请日起 20 年	原始取得	无
73	神州半导体	射频电源数字控制器	实用新型	ZL201920334100.6	2019.03.17	2020.01.03	申请日起 10 年	原始取得	无
74	神州半导体	误差检测器	实用新型	ZL201920334107.8	2019.03.17	2020.01.07	申请日起 10 年	原始取得	无
75	神州半导体	一种阻抗匹配器器件	实用新型	ZL202020679289.5	2020.04.28	2020.10.30	申请日起 10 年	原始取得	无
76	神州半导体	一种 RPS 气体解离装置	实用新型	ZL202020679290.8	2020.04.28	2020.12.04	申请日起 10 年	原始取得	无
77	神州半导体	一种远程等离子体源 RPS 腔体结构	实用新型	ZL202022752230.7	2020.11.24	2021.06.15	申请日起 10 年	继受取得	无
78	神州半导体	一种真空电容组件	实用新型	ZL202121865543.1	2021.08.10	2022.03.04	申请日起 10 年	继受取得	无
79	神州半导体	一种散热效率高的真空可变电容	实用新型	ZL202120149543.5	2021.01.19	2021.08.31	申请日起 10 年	继受取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	有效期	取得方式	他项权利
80	**神州半导体**	**一种联轴器**	**实用新型**	**ZL202022826072.5**	**2020.11.30**	**2021.07.23**	**申请日起 10 年**	**继受取得**	**无**
81	上海昇州	一种阀门用清洗装置	实用新型	ZL202221813503.7	2022.07.13	2022.12.16	申请日起 10 年	继受取得	无
82	上海昇州	一种阀门软管快速接头	实用新型	ZL202221987742.4	2022.07.29	2022.12.16	申请日起 10 年	继受取得	无
83	上海昇州	一种可调节止回阀	实用新型	ZL202221452911.4	2022.06.12	2022.12.20	申请日起 10 年	继受取得	无
84	上海昇州	一种高温高压电动闸阀	实用新型	ZL202122721961.X	2021.11.08	2023.01.20	申请日起 10 年	继受取得	无
85	上海昇州	一种防回流的机械阀门	实用新型	ZL202222226153.0	2022.08.24	2023.01.24	申请日起 10 年	继受取得	无
86	上海昇州	一种新型高强度止回阀	实用新型	ZL202221940646.4	2022.07.26	2023.01.24	申请日起 10 年	继受取得	无
87	上海昇州	一种组合式阀门	实用新型	ZL202222010597.0	2022.08.02	2023.01.24	申请日起 10 年	继受取得	无
88	神州半导体	一种基于 ICP 电感耦合原理的等离子体激发和维持的装置	实用新型	ZL202221153690.0	2022.05.13	2023.03.14	申请日起 10 年	原始取得	无
89	神州半导体	一种射频设备端口连接状态监测装置	实用新型	ZL202320379477.X	2023.03.03	2023.08.15	申请日起 10 年	原始取得	无
90	神州半导体	一种电镀设备电流检测系统	实用新型	ZL202320703759.0	2023.04.03	2023.08.15	申请日起 10 年	原始取得	无
91	神州半导体	一种用于射频环境的漏水检测装置	实用新型	ZL202320538338.7	2023.03.20	2023.09.08	申请日起 10 年	原始取得	无
92	神州半导体	一种远程等离子发生器的散热装置	实用新型	ZL202320887895.X	2023.04.19	2023.09.08	申请日起 10 年	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	有效期	取得方式	他项权利
93	神州半导体	一种三相电压监控电路	实用新型	ZL202320603639.3	2023.03.24	2023.09.08	申请日起 10 年	原始取得	无
94	神州半导体	一种远程等离子发生器的散热系统	实用新型	ZL202320887237.0	2023.04.19	2023.09.15	申请日起 10 年	原始取得	无
95	神州半导体	一种远程等离子发生器的腔体结构	实用新型	ZL202320887249.3	2023.04.19	2023.09.19	申请日起 10 年	原始取得	无
96	神州半导体	一种机柜水路结构	实用新型	ZL202321259611.9	2023.05.23	2023.10.03	申请日起 10 年	原始取得	无
97	神州半导体	一种机柜的控制系统	实用新型	ZL202321259656.6	2023.05.23	2023.10.24	申请日起 10 年	原始取得	无
98	神州半导体	一种等离子清洗机	实用新型	ZL202321971528.4	2023.07.26	2024.03.26	申请日起 10 年	原始取得	无
99	神州半导体	一种射频电源接入器	实用新型	ZL202322615247.1	2023.09.26	2024.04.19	申请日起 10 年	原始取得	无
100	神州半导体	一种热敏电阻温度检测装置	实用新型	ZL202323039686.9	2023.11.10	2024.06.21	申请日起 10 年	原始取得	无
101	神州半导体	一种直流电压采样保护电路	实用新型	ZL202323288022.6	2023.12.04	2024.07.16	申请日起 10 年	原始取得	无
102	神州半导体	一种免开散热孔的全封闭式箱体结构及射频电源	实用新型	ZL202323332664.1	2023.12.07	2024.07.30	申请日起 10 年	原始取得	无
103	神州半导体	一种 MOSFET 驱动电路	实用新型	ZL202420140674.0	2024.01.19	2024.08.06	申请日起 10 年	原始取得	无
104	神州半导体	一种无需冷媒增强散热效果的散热器	实用新型	ZL202323104495.6	2023.11.17	2024.08.13	申请日起 10 年	原始取得	无
105	神州半导体	一种三相电压无源 Boost 电路	实用新型	ZL202420261124.4	2024.02.02	2024.09.27	申请日起 10 年	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	有效期	取得方式	他项权利
106	神州半导体	一种远程等离子解离源散热组件	实用新型	ZL202420160893.5	2024.01.23	2024.10.01	申请日起 10 年	原始取得	无
107	神州半导体	基于可控硅的保护电路及开关电源	实用新型	ZL202421749271.2	2024.07.23	2025.07.01	申请日起 10 年	原始取得	无
108	神州半导体	一种贴片端子快插连接辅助装置	实用新型	ZL202422014817.6	2024.08.20	2025.07.01	申请日起 10 年	原始取得	无
109	神州半导体	一种高端射频电源专用的空气开关保护装置	实用新型	ZL202423010106.8	2024.12.06	2025.11.21	申请日起 10 年	原始取得	无
110	神州半导体	一种高频射频电源风扇用抗干扰装置	实用新型	ZL202520263380.1	2025.02.19	2025.11.28	申请日起 10 年	原始取得	无
111	神州半导体	远程等离子源（Halation-603L）	外观设计	ZL202230801125.X	2022.11.30	2023.04.07	申请日起 15 年	原始取得	无
112	神州半导体	远程等离子源（Halation-608L）	外观设计	ZL202230801043.5	2022.11.30	2023.04.07	申请日起 15 年	原始取得	无
113	神州半导体	远程等离子源（Halation-622L）	外观设计	ZL202230785785.3	2022.11.24	2023.04.11	申请日起 15 年	原始取得	无
114	神州半导体	远程等离子源（Central-1008L）	外观设计	ZL202330162692.X	2023.03.30	2023.08.08	申请日起 15 年	原始取得	无
115	神州半导体	远程等离子源（Major-0610L-Q01）	外观设计	ZL202430411048.6	2024.07.02	2025.01.21	申请日起 15 年	原始取得	无
116	神州半导体	远程等离子源（Major-0610L-Q02W）	外观设计	ZL202430411049.0	2024.07.02	2025.01.21	申请日起 15 年	原始取得	无
117	神州半导体	射频电源（高端 1365A）	外观设计	ZL202430700886.5	2024.11.06	2025.06.13	申请日起 15 年	原始取得	无
118	神州半导体	射频电源（高端 04100Z）	外观设计	ZL202430700918.1	2024.11.06	2025.06.17	申请日起 15 年	原始取得	无
119	神州半导体	射频电源匹配器	外观设计	ZL202430700868.7	2024.11.06	2025.06.24	申请日起 15 年	原始取	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	有效期	取得方式	他项权利
								得	
120	神州半导体	射频匹配器(Focus 00430)	外观设计	ZL202530739330.1	2025.12.15	2026.06.30	申请日起15年	原始取得	无
121	神州半导体	射频电源(Advocate 04R450A)	外观设计	ZL202530747095.2	2025.12.18	2026.06.12	申请日起15年	原始取得	无
122	神州半导体	射频电源(Advocate 1330A)	外观设计	ZL202530747056.2	2025.12.18	2026.06.12	申请日起15年	原始取得	无
123	神州半导体	射频匹配器(Focus 40100L)	外观设计	ZL202530747131.5	2025.12.18	2026.06.09	申请日起15年	原始取得	无
124	神州半导体	射频匹配器(Founder 0205)	外观设计	ZL202530739087.3	2025.12.15	2026.06.09	申请日起15年	原始取得	无
125	神州半导体	射频电源(Advocate 60R35A)	外观设计	ZL202530739395.6	2025.12.15	2026.06.09	申请日起15年	原始取得	无
126	神州半导体	管道清洗结构(SFC-500)	外观设计	ZL202530506546.3	2025.08.26	2026.03.17	申请日起15年	原始取得	无
127	神州半导体	真空电容散热片	外观设计	ZL202130037025.X	2021.01.19	2021.08.10	申请日起10年	继受取得	无

注：根据《中华人民共和国专利法》第四十二条，发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权的期限为十年，申请日为2021年5月31日（含该日）之前的外观设计专利权的期限为十年，申请日为2021年6月1日（含该日）之后的外观设计专利权的期限为十五年，均自申请日起计算。

二、发行人及其子公司在中国境内许可使用的专利权

截至本招股说明书签署日，发行人通过授权许可的方式作为被许可人取得3项发明专利的使用权，具体情况如下：

序号	被许可人	许可人	许可种类	许可期限	专利名称	专利类型	专利号

序号	被许可人	许可人	许可种类	许可期限	专利名称	专利类型	专利号
1	神州半导体	东南大学	普通许可	2024.04.16-2027.04.16	一种用于 LCC 谐振 DC-DC 变换器的混合控制方法	发明专利	ZL201610003348.5
2	神州半导体	东南大学	普通许可	2024.04.16-2027.04.16	一种逆变电路开路故障检测方法	发明专利	ZL201310273628.4
3	神州半导体	东南大学	普通许可	2024.04.16-2027.04.16	一种基于参数自适应的直流变换器优化控制方法	发明专利	ZL202011539344.1

三、发行人及其子公司在中国境外拥有的专利权

截至报告期末，发行人及其子公司拥有 1 项境外 PCT 授权专利，具体情况如下：

序号	专利权人	PCT 申请号	专利名称	对应中文名称	专利号	专利类别	国家/地区	授权日	取得方式
1	神州半导体	PCT/CN2025/087238	REMOTE PLASMA SOURCE (RPS) POWER COUPLING CIRCUIT AND CONTROL SYSTEM	一种远程等离子源功率耦合电路及控制系统	US 12652748 B2	发明	美国	2026.06.09	原始取得

附件八：发行人及其子公司拥有的其他无形资产

一、发行人及其子公司拥有的软件著作权

截至报告期末，发行人及其子公司已取得 **71** 项软件著作权，具体情况如下：

序号	著作权人	作品全称	作品简称	版本号	登记号	取得方式	首次发表日	开发完成日	他项权利
1	神州半导体	神州 Halation-603L 的系统控制软件	603L 系统控制软件（数字）	V1.0	2024SR1257000	原始取得	-	-	无
2	神州半导体	神州 Halation-603L 的工控屏通讯控制软件	603L 通讯系统（工控屏）	V2.6.0	2024SR1251520	原始取得	-		无
3	神州半导体	神州 Halation-608L 的 EtherCAT 通讯数字控制软件	608L-EACT 通讯系统（数字）	V1.0	2024SR0204907	原始取得	2023-04-28	2023-04-27	无
4	神州半导体	神州 Halation-603L 的 EtherCAT 通讯数字控制软件	603L-EACT 通讯系统（数字）	V1.0	2024SR0206436	原始取得	2023-03-12	2023-03-07	无
5	神州半导体	神州 Halation-622L 的 EtherCAT 通讯数字控制软件	622L-EACT 通讯系统（数字）	V1.0	2024SR0200449	原始取得	2023-04-12	2023-04-07	无
6	神州半导体	神州 Halation-608L 的 EtherCAT 通讯模拟控制软件	608L-EACT 通讯系统（模拟）	V1.0	2024SR0199442	原始取得	2023-04-22	2023-04-17	无
7	神州半导体	一种类似操作系统的时间轮转调度的方法软件	-	V1.1.0	2024SR0178704	原始取得	2023-12-06	2023-12-06	无

序号	著作权人	作品全称	作品简称	版本号	登记号	取得方式	首次发表日	开发完成日	他项权利
8	神州半导体	神州智频领航软件	RF PWR	V1.1.0	2024SR0178854	原始取得	未发表	2023-10-20	无
9	神州半导体	Central 系列 RPS 控制板软件	Central DSP 程序	V1.0.0	2024SR0179131	原始取得	2023-04-01	2023-01-10	无
10	神州半导体	神州可变式真空电容容值设定编程上位机软件	可变式真空电容容值设定编程上位机	V1.0	2024SR0129699	原始取得	未发表	2023-01-06	无
11	神州半导体	基于 MODBUS 从站的模拟数据及开关信号的输入输出控制软件	-	V1.0	2022SR0045397	原始取得	未发表	2021-10-31	无
12	神州半导体	EtherCAT 工业以太网与 RS485 通讯的转换软件	-	V1.0	2022SR0045405	原始取得	未发表	2021-07-23	无
13	神州半导体	一种基于半导体制冷片的温度控制算法软件	-	V1.0	2022SR0041582	原始取得	未发表	2021-02-10	无
14	神州半导体	基于 MODBUS 主站的阻抗调节系统软件	-	V1.0	2022SR0042607	原始取得	未发表	2020-10-30	无
15	神州半导体	EtherCAT 工业以太网与 RS232 通讯的转换软件	-	V1.0	2022SR0041704	原始取得	未发表	2021-05-18	无
16	神州半导体	基于 USB 接口的示波器数据采集上位机软件	-	V1.0	2022SR0042645	原始取得	未发表	2020-11-15	无
17	神州半导体	基于功率计 232 接口的功率采集上位机软件	-	V1.0	2022SR0037986	原始取得	未发表	2020-12-24	无

序号	著作权人	作品全称	作品简称	版本号	登记号	取得方式	首次发表日	开发完成日	他项权利
18	神州半导体	真空陶瓷可调电容的闭环控制系统软件	-	V1.0	2022SR0038925	原始取得	未发表	2021-03-29	无
19	神州半导体	基于 EtherCAT 工业以太网的模拟数据及开关信号的输入输出控制软件	-	V1.0	2022SR0042716	原始取得	未发表	2021-08-09	无
20	神州半导体	基于 EtherCAT 工业以太网的实时控制系统软件	-	V1.0	2022SR0042715	原始取得	未发表	2021-09-03	无
21	神州半导体	基于真空陶瓷可调电容的射频自动匹配器匹配算法软件	-	V1.0	2022SR0038942	原始取得	未发表	2020-09-16	无
22	神州半导体	射频电源测试控制系统人机交互程序软件	-	V1.0	2021SR0155541	继受取得	未发表	2017-09-15	无
23	神州半导体	AE 系列射频电源手持式控制器软件	-	V1.0	2020SR0311360	原始取得	2019-10-24	2019-10-23	无
24	神州半导体	八通道数据采集监测系统软件	-	V1.0	2020SR0311368	原始取得	2019-11-28	2019-11-27	无
25	神州半导体	基于 ARM 的 Modbus 协议转自由协议软件	-	V1.0	2020SR0311861	原始取得	2019-12-17	2019-12-17	无
26	神州半导体	APEX 系列电源和 MBX 系列匹配器控制软件	-	V1.0	2020SR0311364	原始取得	2019-10-31	2019-10-30	无
27	神州半导体	Agilent 53210A 系列控制软件	-	V1.0	2020SR0311216	原始取得	2019-11-02	2019-11-01	无
28	神州半导体	GHW 系列电源和 MBX 系列匹配器控制软件	-	V1.0	2020SR0311220	原始取得	2019-11-15	2019-11-14	无

序号	著作权人	作品全称	作品简称	版本号	登记号	取得方式	首次发表日	开发完成日	他项权利
29	神州半导体	三通道电流监控软件	-	V1.0	2019SR0426694	原始取得	未发表	2017-11-22	无
30	神州半导体	RFS 系列射频电源手持式控制器软件	-	V1.0	2019SR0423560	原始取得	未发表	2017-07-11	无
31	神州半导体	CPW 系列直流电源控制软件	-	V1.0	2019SR0423562	原始取得	未发表	2018-11-14	无
32	神州半导体	ADL 系列 PROFIBUS 控制软件	-	V1.0	2019SR0421890	原始取得	未发表	2018-08-23	无
33	神州半导体	ADTEC 系列 PROFIBUS 控制软件	-	V1.0	2019SR0421899	原始取得	未发表	2018-10-17	无
34	神州半导体	MBX 系列匹配器控制软件	-	V1.0	2019SR0422879	原始取得	未发表	2017-06-20	无
35	神州半导体	SMART MATCH 控制软件	-	V1.0	2019SR0422867	原始取得	未发表	2017-08-24	无
36	神州半导体	RGA 系列射频电源控制软件	-	V1.0	2019SR0422874	原始取得	未发表	2017-09-13	无
37	神州半导体	LUMINA 电源 MODBUS 控制软件	-	V1.0	2019SR0422307	原始取得	未发表	2018-06-19	无
38	神州半导体	AMEC 系列匹配器控制软件	-	V1.0	2019SR0421581	原始取得	未发表	2018-05-25	无
39	**神州半导体**	**神州智能射频匹配器综合控制软件**	**-**	**V1.0**	**2026SR0351435**	**原始取得**	**-**	**-**	**无**
40	**神州半导体**	**神州 FPGA 多级脉冲信号发生器系统**	**-**	**V1.0**	**2026SR0351539**	**原始取得**	**-**	**-**	**无**
41	**神州半导体**	**神州射频电源 ECAT 控制与监控平台**	**-**	**V1.0**	**2026SR0351518**	**原始取得**	**-**	**-**	**无**
42	**神州半导体**	**神州射频电源高速数据测控软件**	**-**	**V1.0**	**2026SR0351497**	**原始取得**	**-**	**-**	**无**

序号	著作权人	作品全称	作品简称	版本号	登记号	取得方式	首次发表日	开发完成日	他项权利
43	神州半导体	神州射频电源控制软件	-	V1.0	2026SR0391640	原始取得	-	-	无
44	神州半导体	神州多通道微电流检测的 ESC 电源控制软件	ESC 控制软件	V1.0	2026SR0346237	原始取得	-	-	无
45	神州半导体	神州高压脉冲射频源 DSP 控制软件	-	V1.0	2026SR0346443	原始取得	-	-	无
46	神州半导体	神州高压脉冲射频源监控软件	-	V1.0	2026SR0346555	原始取得	-	-	无
47	神州半导体	神州集成 Wafer 吸附监测的 ESC 电源控制软件	ESC 控制软件	V1.0	2026SR0346133	原始取得	-	-	无
48	神州半导体	神州功分匹配器参数测量与实时监控系统	-	V1.0	2026SR0629269	原始取得	-	-	无
49	神州半导体	神州面向高速信号采集的数据采集与千兆以太网传输软件	-	V1.0	2026SR0636450	原始取得	-	-	无
50	神州半导体	神州 Edge 烧机软件	-	V1.0	2026SR0636490	原始取得	-	-	无
51	神州半导体	神州 XP-3K-3AA1-HM-P 匹配器控制软件	-	V1.0	2026SR0636486	原始取得	-	-	无
52	神州半导体	神州射频电源监控系统	-	V1.0	2026SR0636479	原始取得	-	-	无
53	神州半导体	神州四路均分器操作系统	-	V1.0	2026SR0655161	原始取得	-	-	无
54	神州半导体	神州基于 Qt 的 EtherCAT 主站软件	-	V1.0	2026SR0687549	原始取得	-	-	无

序号	著作权人	作品全称	作品简称	版本号	登记号	取得方式	首次发表日	开发完成日	他项权利
55	上海昇州	昇州阀门防泄漏检测管理系统	-	V1.0	2023SR0210237	原始取得	2022-02-07	2022-02-07	无
56	上海昇州	昇州阀门设计优化处理系统	-	V1.0	2023SR0210247	原始取得	2022-06-20	2022-06-20	无
57	上海昇州	昇州阀门故障分析管理系统	-	V1.0	2023SR0210248	原始取得	2022-03-11	2022-03-11	无
58	上海昇州	昇州阀门使用寿命检测管理系统	-	V1.0	2023SR0210249	原始取得	2022-07-21	2022-07-21	无
59	上海昇州	昇州阀门性能检测管理系统	-	V1.0	2023SR0210263	原始取得	2022-08-23	2022-08-23	无
60	上海昇州	昇州阀门密封安全检测系统	-	V1.0	2023SR0210265	原始取得	2022-05-17	2022-05-17	无
61	上海昇州	昇州阀门故障诊断智能报警系统	-	V1.0	2023SR0210264	原始取得	2022-04-12	2022-04-12	无
62	上海昇州	昇州阀门运行状态监测管理系统	-	V1.0	2023SR0210238	原始取得	2022-09-26	2022-09-26	无
63	上海昇州	昇州高真空阀门压力控制系统	-	V1.0	2023SR0210239	原始取得	2022-10-27	2022-10-27	无
64	晟州聚能	射频匹配器 VISensor 自动校准系统	-	V1.0	2025SR2241442	原始取得	-	-	无
65	晟州聚能	射频匹配器电容匹配范围与效率自动化测试系统	-	V1.0	2025SR2241269	原始取得	-	-	无
66	晟州聚能	射频电源脉冲功率自动化测试系统软件	-	V1.0	2025SR2241398	原始取得	-	-	无
67	晟州聚能	一种射频匹配器电容自动校准系统	-	V1.0	2025SR1985231	原始取得	-	-	无

序号	著作权人	作品全称	作品简称	版本号	登记号	取得方式	首次发表日	开发完成日	他项权利
68	晟州聚能	一种射频匹配器电容偏移测试系统	-	V1.0	2025SR1944465	原始取得	-	-	无
69	晟州聚能	一种基于射频电源多参数自动化测试系统	-	V1.0	2025SR1944096	原始取得	-	-	无
70	**晟州聚能**	**射频混合（CWPulse）匹配器振荡特性自动化测试软件**	**-**	**V1.0**	**2026SR0049120**	**原始取得**	**-**	**-**	**无**
71	**晟州聚能**	**射频混合模式（CWPulse）自动化阻抗匹配与功率测试系统软件**	**-**	**V1.0**	**2026SR0051492**	**原始取得**	**-**	**-**	**无**

注：根据中国版权保护中心《关于调整软件版权登记证书事项的通告》，自 2024 年 4 月 23 日起，软件版权登记证书的登记事项将不再记载“开发完成日期”和“首次发表日期”两项内容，上表部分计算机软件著作权系于 2024 年 4 月 23 日后登记取得，故未披露首次发表日和开发完成日。

二、发行人及其子公司拥有的作品著作权

截至报告期末，发行人及其子公司已取得 7 项作品著作权，具体情况如下：

序号	著作权人	著作权名称	登记号	取得方式	首次发表日	创作完成日	有效期	他项权利
1	神州半导体	HALATION	渝作登字-2023-F-00283749	原始取得	未发表	2020-11-20	首次发表之日起 50 年，若未发表，则创作完成之日起 50 年	无
2	神州半导体	SHIELD	渝作登字-2023-F-00263059	原始取得	未发表	2020-11-20	首次发表之日起 50 年，若未发表，则创作完成之日起 50 年	无
3	神州半导体	VENUS	渝作登字-2023-F-00263060	原始取得	未发表	2020-11-20	首次发表之日起 50 年，若未发表，则创作	无

序号	著作权人	著作权名称	登记号	取得方式	首次发表日	创作完成日	有效期	他项权利
							完成之日起 50 年	
4	神州半导体	FOUNDER	渝作登字-2023-F-00263058	原始取得	未发表	2020-11-20	首次发表之日起 50 年，若未发表，则创作完成之日起 50 年	无
5	神州半导体	Miracle	渝作登字-2023-F-00263057	原始取得	未发表	2020-11-20	首次发表之日起 50 年，若未发表，则创作完成之日起 50 年	无
6	神州半导体	江苏神州半导体科技有限公司标识	国作登字-2016-F-00308583	原始取得	2016-07-15	2016-07-12	首次发表之日起 50 年，若未发表，则创作完成之日起 50 年	无
7	江苏芯越	芯越图形	国作登字-2022-F-10269172	原始取得	2022-09-28	2022-09-08	首次发表之日起 50 年，若未发表，则创作完成之日起 50 年	无

附件九：募集资金运用具体情况

一、募集资金运用具体情况

（一）先进工艺节点集成电路领域电源类零部件研发及产业化项目

1、项目概况

本项目拟在公司已购土地上实施，通过引进高端人才、高端装备等，打造专业化研发及生产制造基地，主要面向各类先进工艺节点集成电路领域电源类零部件，进行研发及产业化。项目建成后，将有助于公司解决下游客户的产品升级需求，助力我国半导体先进制程核心装备的国产化进程，增强我国半导体设备产业链发展韧性和自主可控性，为行业高质量发展提供有力支撑。

2、项目投资概算情况

项目总投资 104,896.82 万元，其中土地购置费用 1,800.00 万元，建筑工程 38,535.00 万元，设备购置费 21,217.55 万元，基本预备费 3,077.63 万元，研发费用 10,145.00 万元，铺底流动资金 30,121.64 万元。投资明细情况，主要如下：

投资项目	金额（万元）	投资比重
土地购置	1,800.00	1.72%
建筑工程	38,535.00	36.74%
设备购置	21,217.55	20.23%
基本预备费	3,077.63	2.93%
研发费用	10,145.00	9.67%
铺底流动资金	30,121.64	28.72%
总投资	**104,896.82**	**100.00%**

3、项目时间周期和时间进度

本项目建设期为 36 个月，项目进度计划内容包括项目前期工作、建筑工程、设备订货采购、设备安装调试、人员招聘培训、技术开发投入、试生产，T4 年开始投产，具体如下：

序号	工作内容	第一年（T1）				第二年（T2）				第三年（T3）			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
1	前期准备工作	*											
2	建筑工程		*	*	*	*	*	*	*				

序号	工作内容	第一年（T1）				第二年（T2）				第三年（T3）			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
3	设备订货采购			*	*	*	*	*	*	*	*	*	
4	设备安装调试				*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	人员招聘培训		*	*						*	*	*	*
6	技术开发投入		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	试生产												*

4、项目的选址情况

该项目建设地为江苏省扬州市维扬经济开发区司徒庙路与新谊路交叉口西150米。

5、项目备案及环评情况

本募投项目的备案手续已完成，并取得备案证“扬维开行审备[2026]22号”，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目不涉及环评批复相关事项，公司已取得由扬州市邗江生态环境局出具的无需环评的说明。

6、项目效益分析

本项目建设期为3年，预计税后项目投资内部收益率为17.63%，税后投资回收期（含建设期）为9.41年。

（二）技术支持服务体系升级扩容项目

1、项目概况

本项目计划在全国范围内通过购买或租赁办公场地的方式，在大连、武汉、深圳、合肥、西安、无锡、北京、上海、青岛、沈阳、重庆、成都等全国主要城市建设技术支持服务中心，包括场地扩容升级、设备添置、人员扩充等，实现现有技术支持服务体系的升级优化。

2、项目投资概算情况

项目预计总投资27,061.27万元，其中13,112.27万元用于建设投资，包括场地租赁、场地购置、设备购置；人员费用13,476.00万元；培训费用473.00万元，具体资金使用计划如下：

序号	科目	投资金额（万元）	投资比例
一	**建设投资**	**13,112.27**	**48.45%**
1	场地租赁	846.72	3.13%
2	场地购置	5,315.00	19.64%
3	设备购置	3,405.55	12.58%
4	装修费用	3,545.00	13.10%
二	**实施费用**	**13,949.00**	**51.55%**
1	人员费用	13,476.00	49.80%
2	培训费用	473.00	1.75%

3、项目时间周期和时间进度

项目建设进度 3 年，项目整体布局规划及网点建设进度如下：

区域	建设地点	功能定位	建设时间	备注	投资方式
华北	北京	区域技术支持服务中心	T1	升级扩容	租赁
	青岛	区域技术支持服务中心		新设	租赁
东北	大连	区域技术支持服务中心		升级扩容	租赁
	沈阳	区域技术支持服务中心		新设	租赁
华东	上海	区域技术支持服务中心		升级扩容	购置
	无锡	区域技术支持服务中心	T2	升级扩容	租赁
华中	合肥	区域技术支持服务中心		升级扩容	租赁
	武汉	区域技术支持服务中心		升级扩容	购置
华南	深圳	区域技术支持服务中心		升级扩容	租赁
西南	重庆	区域技术支持服务中心	T3	新设	租赁
	成都	区域技术支持服务中心		新设	租赁
西北	西安	区域技术支持服务中心		升级扩容	租赁

4、项目的选址情况

如上所述，根据公司战略规划，本项目拟在全国 12 个城市进行布局，形成网格化服务体系。

5、项目备案及环评情况

本募投项目的备案手续已完成，并取得备案证“扬维开行审备[2026]11 号”。本项目属于区域服务网点建设等项目，不涉及生产加工环节，不存在工业污染物排放，对环境基本无影响，根据相关规定无需办理环评报批手续。

（三）上海产业化基地建设项目

1、项目概况

本项目拟在上海建设产业化基地，重点布局技术成熟度高、附加值高、市场需求明确的等离子体电源系统产品的产业化与系统集成，以满足半导体等离子体工艺对高性能、高稳定性电源系统的应用需求。

2、项目投资概算情况

项目总投资 53,451.90 万元，其中土地购置费用 25,160.00 万元，建筑工程 3,737.50 万元，设备购置费 7,327.37 万元，基本预备费 1,811.24 万元，研发费用 3,330.00 万元，铺底流动资金 12,085.78 万元。投资明细见下表。

投资项目	金额（万元）	投资比重
土地购置	25,160.00	47.07%
建筑工程	3,737.50	6.99%
设备购置	7,327.37	13.71%
基本预备费	1,811.24	3.39%
研发费用	3,330.00	6.23%
铺底流动资金	12,085.78	22.61%
总投资	**53,451.90**	**100.00%**

3、项目时间周期和时间进度

本项目建设期为 36 个月，项目进度计划内容包括项目前期工作、建筑工程、设备订货采购、设备安装调试、人员招聘培训、技术开发投入、试生产，T4 年开始投产，具体如下：

序号	工作内容	第一年（T1）				第二年（T2）				第三年（T3）			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
1	前期准备工作	*											
2	建筑工程		*	*	*	*	*	*	*				
3	设备订货采购			*	*	*	*	*	*	*	*	*	
4	设备安装调试				*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	人员招聘培训		*	*						*	*	*	*
6	技术开发投入		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	试生产												*

4、项目的选址情况

根据公司的发展规划和客观情况，本项目将在上海市浦东新区临港购置所需场地，并进行装修。

5、项目备案及环评情况

公司已于2026年2月7日取得上海临港地区开发建设管理委员会出具的《上海市企业投资项目备案证明》（项目代码：2602-310115-04-02-846744），根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目不涉及环评批复相关事项。

6、项目效益分析

本项目建设期为 3 年，预计税后项目投资内部收益率为 12.04%，税后投资回收期（含建设期）为 9.67 年。

（四）技术研发创新中心建设项目

1、项目概况

本次项目将通过购置研发办公场地，引进先进实验及测试设备，招聘专业研发人才，打造高水平技术研发创新中心，并针对多个前沿技术方向开展深入研究与开发，构建公司在高端电源技术方面的差异化竞争优势，为公司持续创新能力提供重要支撑。

2、项目投资概算情况

项目总投资 55,643.34 万元，其中场地购置费用 21,760.00 万元，场地装修 3,640.00 万元，设备购置费 10,012.70 万元，基本预备费 1,770.64 万元，研究开发费用 4,900.00 万元，人员费用 13,560.00 万元。投资明细见下表。

投资项目	金额（万元）	投资比重
场地购置	21,760.00	39.11%
场地装修	3,640.00	6.54%
设备购置	10,012.70	17.99%
人员费用	13,560.00	24.37%
研究开发费用	4,900.00	8.81%
基本预备费	1,770.64	3.18%

投资项目	金额（万元）	投资比重
合计	55,643.34	100.00%

3、项目时间周期和时间进度

上海技术研发创新中心建设项目建设期为三年主要包括前期方案规划设计、研发场地购置及装修、研发设备采购安装调试、研发人员招募及培训、技术开发基础投入、竣工验收等阶段，具体如下：

项目	第一年（T0）				第二年（T1）				第三年（T2）			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
前期方案规划设计	*											
研发场地购置及装修工程		*	*	*								
研发设备采购安装调试			*	*	*	*						
研发人员招募及培训			*	*	*	*	*	*	*	*		
技术开发基础投入				*	*	*	*	*	*	*	*	*
竣工验收												*

4、项目的选址情况

根据公司的发展规划和客观情况，本项目将在上海市浦东新区金桥镇购置所需场地，并进行装修。

5、项目备案及环评情况

公司已于2026年2月6日取得上海市浦东新区发展和改革委员会出具的《上海市企业投资项目备案证明》（项目代码：2602-310115-04-02-954388），根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目不涉及环评批复相关事项。

（五）补充流动资金

1、项目概况

根据公司业务发展规划和对营运资金的需求，公司拟使用募集资金31,000.00万元用于补充流动资金。补充流动资金有利于保证公司生产经营所需资金、进一步优化资产负债结构，降低财务风险，增强公司的反应能力以及市场竞争力，为公司未来的战略发展提供支持。

2、补充流动资金的必要性及合理性

（1）经营规模的扩大需要大量流动资金支持

公司作为半导体设备核心零部件领域的代表性企业之一，充足的流动资金有利于公司保持和发展行业的领先地位。随着公司业务规模的扩大和募投项目的逐渐达产，公司营运资金需求将大幅增加。

（2）持续的研发投入对流动性资金有较大需求

公司主营业务为远程等离子体源系统、等离子体射频电源系统、高压脉冲电源系统等相关产品的研发、生产、销售和技术支持服务，公司需要通过持续的研发投入来保证竞争优势，为了维持技术优势，研发投入势必持续增加，因此公司需要更多的运营资金来应对未来的研发资金需求。

（3）有助于保留和吸引优秀人才

公司是典型的知识密集型和人才密集型企业，优秀人才是公司发展的坚实基础，是公司赖以生存的核心竞争力。充足的流动资金将有助于公司保留和吸引优秀人才。

综上，本次补充流动资金项目的实施，有利于提升公司的资金实力和技术水平，优化公司的资产负债结构，促进公司的健康发展。公司将严格按照中国证监会、证券交易所的有关规定及募集资金管理制度等对补充的流动资金进行管理，做到合理、合规使用。